

А. И. АКСЕНОВ, А. В. НЕФЕДОВ
А. М. ЮШИН

ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМ БЫТОВОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ • ДИОДЫ • ТРАНЗИСТОРЫ

Издательство «Радио и связь»



Основана в 1947 году
Выпуск 1190

А. И. АКСЕНОВ, А. В. НЕФЕДОВ
А. М. ЮШИН

ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМ БЫТОВОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ

•

ДИОДЫ

•

ТРАНЗИСТОРЫ

СПРАВОЧНИК



Москва «Радио и связь»
1993

ББК 32.852
А 42
УДК 621.382(035)

Редакция литературы по электронике

Аксенов А. И. и др.

А 42 Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды. Транзисторы: Справочник / А. И. Аксенов, А. В. Нефедов, А. М. Юшин.— М.: Радио и связь, 1993.— 224 с.: ил.— (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1190).

ISBN 5-256-00964-8.

Приводятся сведения о классификации, условных обозначениях, основных параметрах и габаритных размерах элементов электрических схем бытовой радиоаппаратуры отечественного производства (выпрямительных и импульсных диодов, варикапов, стабилитронов, биполярных и полевых транзисторов), а также их зарубежных аналогах. Даются рекомендации по замене диодов и транзисторов другими приборами отечественного производства, имеющими подобные характеристики.

Предназначается широкому кругу специалистов, занимающихся конструированием, эксплуатацией и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры, а также радиолюбителям.

$А\ \frac{2302030300-017}{046(01)-93}$ 29-92 **ББК 32.852**

ISBN 5-256-00964-8

© Аксенов А. И., Нефедов А. В., Юшин А. М.

Содержание

Предисловие

Отечественная промышленность выпускает разнообразную радиоэлектронную аппаратуру (РЭА) для использования в быту: черно-белые и цветные телевизоры, видеомагнитофоны, радиоприемники, магнитофоны, магнитолы, радиолы, электрофоны, электропроигрыватели, музыкальные центры и др.

В этой аппаратуре используется широкая гамма изделий электронной техники — элементов, составляющих электрическую схему конкретного вида РЭА: диоды, транзисторы, микросхемы, оптопары, кинескопы, резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, коммутирующие элементы и электрические соединители.

Сведения об этих элементах в связи с большим объемом информации предполагается изложить в нескольких изданиях, объединенных общим названием «Элементы схем бытовой радиоаппаратуры». В настоящем справочнике ввиду ограниченного объема систематизированы сведения только о диодах и транзисторах. В последующих изданиях дополнительные названия справочника будут отражать содержащуюся в них информацию: «Микросхемы», «Оптоэлектронные приборы», «Резисторы и конденсаторы».

В настоящем справочнике сведения о диодах, германиевых и кремниевых биполярных и полевых транзисторах даются в табличной форме, где указываются значения их предельно допустимых, классификационных и справочных параметров. В отличие от подобных изданий здесь впервые приводится основное назначение различных видов и конкретных типов приборов.

Для удобства пользования справочником в таблицах электрических параметров приборов даются их габаритные чертежи и цоколевка.

Справочник не заменяет официальных документов (паспортов, технических условий, каталогов), но позволяет рассмотреть большую совокупность приборов, выпускаемых серийно отечественной промышленностью, и осуществить правильный выбор отдельных типономиналов приборов, необходимых при создании или ремонте бытовой радиоаппаратуры.

Раздел 1.
Система условных обозначений и классификация полупроводниковых приборов

Система условных обозначений (маркировка) отечественных полупроводниковых приборов широкого применения основывается на буквенноцифровом коде.

Элементы буквенно-цифрового кода отражают следующую информацию: тип исходного материала, из которого изготовлен прибор, подкласс прибора, функциональное назначение и конструктивно-технологические особенности.

Назначение и содержание элементов маркировки следующие.

Первый элемент — буква или цифра, обозначает исходный полупроводниковый материал, на основе которого изготовлен полупроводниковый прибор.

Второй элемент — буква, определяет подкласс полупроводникового прибора.

Третий элемент — цифра, определяет основные функциональные возможности (допустимое значение рассеиваемой мощности, граничную или максимальную рабочую частоту).

Четвертый, пятый и шестой элементы — цифры и буквы, обозначают порядковый номер разработки технологического типа, а для стабилитронов и стабисторов — напряжение стабилизации и последовательность разработки.

Седьмой элемент — буква, определяет классификацию приборов по параметрам.

Для наборов приборов, не соединенных электрически или соединенных по одноименному выводу, после второго элемента обозначения добавляется буква «С».

Для сверхвысокочастотных приборов, биполярных и полевых транзисторов с парным подбором после последнего элемента обозначения вводится буква «Р».

Для импульсных тиристоров после второго элемента обозначения вводится буква «И».

Для бескорпусных приборов после условного обозначения вводится (через дефис) дополнительная цифра, показывающая конструктивное исполнение (модификацию):

1 — с гибкими выводами без кристаллодержателя (подложки),
2 — с гибкими выводами на кристаллодержателе (подложке),
3 — с жесткими (объемными) выводами без кристаллодержателя,
4 — с жесткими (объемными) выводами на кристаллодержателе,
5 — с контактными площадками без кристаллодержателя (кристалл без выводов),
6 — с контактными площадками на кристаллодержателе (кристалл без выводов на подложке).

Если малые габариты приборов не позволяют использовать буквенное или цифровое обозначение, то на корпус наносится цветная маркировка (точка или цветные полоски). Цветовой код указывается в ТУ.

Примеры условного обозначения приборов:

ГТ313А — германиевый транзистор биполярный, маломощный, высокочастотный, номер разработки 13, группа А; КП904Б — кремниевый полевой транзистор, большой мощности, высокочастотный, номер разработки 4, группа Б; КС175Е — кремниевый стабилитрон с мощностью рассеяния менее 0,3 Вт, напряжением стабилизации 7,5 В, группа Е; КВ102Д — кремниевый варикап подстроечный, номер разработки 2, группа Д. Ниже приведены буквенно-цифровые условные обозначения маркировки полупроводниковых приборов, установленные ОСТ 11.336.919—81, и их соответствующие определения.

Первый элемент обозначения

Условное обозначение	Исходный материал
Г или 1	Германий или его соединения
К или 2	Кремний или его соединения
А или 3	Соединения галлия (например, арсенид галлия)
И или 4	Соединения индия (например, фосфид индия)

Второй элемент обозначения

Условное обозначение	Подкласс (или группа) приборов
Т	Транзисторы (за исключением полевых)
П	Транзисторы полевые
Д	Диоды выпрямительные и импульсные, магнитодиоды, термодиоды
К	Стабилизаторы тока
Ц	Выпрямительные столбы и блоки
С	Стабилитроны, стабисторы и ограничители
В	Варикапы
Л	Излучающие оптоэлектронные приборы
О	Оптопары
Н	Тиристорные диоды
У	Тиристорные триоды
И	Туннельные диоды
Г	Генераторы шума
Б	Приборы с объемным эффектом (приборы Ганна)
А	Сверхвысокочастотные диоды

Третий элемент обозначения

Условное обозначение	Назначение прибора
	Транзисторы биполярные
	Транзисторы малой мощности с мощностью рассеяния $P_К<0{,}3$ Вт :
1	низкой частоты ($f_{гр}<3$ МГц)
2	средней частоты ($f_{гр}=3...30$ МГц)
3	высокой частоты ($f_{гр}>30$ МГц)
	Транзисторы средней мощности ($P_к=0{,}3...1{,}5$ Вт):
4	низкой частоты
5	средней частоты
6	высокой и сверхвысокой частот
	Транзисторы большой мощности ($P_к>1{,}5$ Вт):
7	низкой частоты
8	средней частоты
9	высокой и сверхвысокой частот
	Транзисторы полевые
	Транзисторы малой мощности ($P_С<0{,}3$ Вт):
1	низкой частоты
2	средней частоты
3	высокой и сверхвысокой частот
	Транзисторы средней мощности ($P_С=0{,}3...1{,}5$ Вт):
4	низкой частоты
5	средней частоты
6	высокой и сверхвысокой частот
	Транзисторы большой мощности ($P_С>1{,}5$ Вт):
7	низкой частоты
8	средней частоты
9	высокой и сверхвысокой частот

Продолжение

Условное обозначение	Назначение прибора
	Диоды
	Диоды выпрямительные с прямым током, А:
1	не более 0,3
2	0,3...10
3	Диоды прочие (магнитодиоды, термодиоды)
	Выпрямительные столбы с прямым током, А:
1	не более 0,3
2	0,3...10
	Выпрямительные блоки с прямым током, А:
3	не более 0,3
4	0,3...10
	Диоды импульсные с временем восстановления, нс:
4	более 500
5	150...500
6	30...150
7	5...30
8	1...5
9	с эффективным временем жизни неосновных носителей заряда менее 1 нс
	Диоды СВЧ:
1	смесительные
2	детекторные
3	усилительные
4	параметрические
5	переключательные и ограничительные
6	умножительные и настроечные
7	генераторные
8	прочие (импульсные и др.)
	Диоды туннельные:
1	усилительные
2	генераторные
3	переключательные
4	обращенные
	Стабилитроны, стабисторы и ограничители с напряжением стабилизации, В:
	мощностью менее 0,3 Вт:
1	менее 10
2	10...100
3	более 100
	мощностью 0,3...5 Вт:
4	менее 10
5	10...100
6	более 100
	мощностью 5...10 Вт:
7	менее 10
8	10...100
9	более 100
	Варикапы:
1	подстроечные
2	умножительные (варакторы)
	Оптоэлектронные приборы излучающие, источники инфракрасного излучения:
1	излучающие диоды
2	излучающие модули
	Приборы визуального представления информации:
3	светоизлучающие диоды
4	знаковые индикаторы
5	знаковые табло
6	шкалы
7	экраны
	Оптопары:
Р	резисторные
Д	диодные
У	тиристорные
Т	транзисторные

Окончание

Условное обозначение	Назначение прибора
	Тиристоры триодные с максимальио допустимым средним током (или импульсным) в открытом состоянии, А:
	незапираемые:
1	не более 0,3 (до 15)
2	0,3...10 (15...100)
	более 10 (более 100)
	запираемые:
3	не более 0,3 (до 15)
4	0,3...10 (15...100)
8	более 10 (более 100)
	симметричные:
5	не более 0,3 (до 15)
6	0,3...10 (15...100)
9	более 10 (до 100)
	Генераторы шума:
1	низкочастотные
2	высокочастотные

Четвертый, пятый и шестой элементы обозначения

Условное обозначение	Назначение прибора
От 01 до 999	Определяют порядковый номер разработки технологического типа
От А до Я	Для стабилизаторов и стабисторов, четвертый и пятый элементы определяют напряжение стабилизации, а шестой элемент — последовательность разработки

Седьмой элемент обозначения

Условное обозначение	Назначение прибора
От А до Я (кроме букв З, О, Ч)	Определяет классификацию (разбраковку) по параметрам приборов, изготовленных по единой технологии

Раздел 2.

Диоды

Полупроводниковые диоды (обычно с одним p-n переходом) имеют два вывода (анод и катод) и предназначены для выпрямления, детектирования, стабилизации, модуляции, ограничения и преобразования электрических сигналов. Диоды по функциональному назначению подразделяются на выпрямительные и импульсные диоды, стабилитроны, варикапы и др.

Выпрямительные диоды используются для преобразования переменного тока промышленной частоты 50 Гц... 50 кГц в постоянный (например, КД102, КД106, КД204, КД212).

Работу выпрямительных диодов характеризуют следующие параметры:

максимально допустимое обратное напряжение $U_{обр. max}$ любой формы и периодичности, которое может быть приложено к диоду;

максимально допустимый постоянный прямой ток $I_{пр. max}$;

постоянное прямое напряжение при заданном прямом токе $U_{пр}$;

обратный ток утечки $I_{обр}$ при заданном обратном напряжении;

рабочая частота $f_д$, при которой обеспечиваются заданные токи, напряжение и мощность.

Если частота переменного напряжения, приложенного к диоду, превышает $f_д$, то потери в диоде резко возрастают и он нагревается. В состав параметров всех диодов входят также диапазон температур окружающей среды T и максимальная температура корпуса $T_к$.

В качестве выпрямительных используются диоды не только на основе p-n переходов (полупроводник — полупроводник), но и на основе переходов металл — полупроводник, так называемые диоды с барьером Шотки, отличающиеся более высокими быстродействием и рабочими токами и меньшими значениями напряжений в прямом направлении (например, КД238, КД2991, КД2998).

Диоды с барьером Шотки для импульсных устройств являются практически безынерционными, так как перенос заряда в них обусловлен только основными носителями.

Для работы на более высоких частотах используются универсальные диоды, например КД401, КД407 (для детектирования сигналов до 300 кГц), КД409 (для селекторов телевизоров на частоты до 1 МГц), КД410 (для строчной развертки телевизоров), КД416 (для формирования импульсов с частотой 500 кГц), КД248 (для источников вторичного электропитания).

В качестве выпрямительных диодов используются КД241 (демпфер в оконечных каскадах строчной развертки телевизоров), КД226 (обеспечивает требования «мягкого» восстановления, поэтому у него нормируется скорость спада обратного тока восстановления 1 А/мкс).

Выпрямительные диоды выпускаются в стеклянных (Д2, Д9, ГД113), металлостеклянных (Д7, Д101, КД202—КД210, КД226), металлопластмассовых (КД212, КД213) и пластмассовых (КД106, КД109, КД208, КД209) корпусах.

Импульсные диоды имеют малую длительность переходных процессов при переключении (малую инерционность). При переключениях диода из прямого направления на обратное (запирающее) накопленные носители зарядов обуславливают протекание через диод обратного тока, который может в течение некоторого времени значительно превышать статический обратный ток. Этот процесс называется переходным процессом запирания или процессом восстановления обратного сопротивления диода. При переключениях диода из запирающего направления в прямое имеет место переходный процесс установления прямого сопротивления диода. Такие диоды используются в качестве ключевых элементов схем с сигналами малой длительности. Наименьшее время переключения имеют диоды с выпрямляющим переходом металл — полупроводник.

Основные параметры импульсных диодов:

время обратного восстановления диода $t_{вос. обр}$ — интервал времени от момента подачи импульса обратного напряжения, когда ток через диод равен нулю, до момента, когда обратный ток диода уменьшается до заданного значения;

заряд восстановления диода $Q_{вос}$ — полный заряд диода, вытекающий во внешнюю цепь при переключении диода с заданного прямого тока на заданное обратное напряжение;

время прямого восстановления диода $t_{вос. пр}$ — время, в течение которого напряжение на диоде устанавливается от нуля до установившегося значения;

постоянное прямое напряжение $U_{пр}$; емкость диода $C_д$; максимально допустимые значения обратного напряжения $U_{обр\ max}$ и прямого тока $I_{пр\ max}$.

Примерами импульсных диодов являются КД411 (для цветных телевизоров), КД412 (для цепей регулирования вторичных источников электропитания, инверторов и прерывателей), КД503, КД509, КД512, КД513 (для быстродействующих устройств наносекундного диапазона), КД504 (для ограничения и модуляции импульсов), ГД507, ГД508 (для быстродействующих формирователей импульсов), КД922 и КД923 (для преобразования переменного напряжения высокой частоты).

Во многих случаях применения возникает проблема идентичности параметров диодов, подобранных в одну группу или пару (особенно при разработке быстродействующих схем). Основным параметром, которым должна быть обеспечена аналогичность диодов, является прямое падение напряжения (иногда и значение емкости). Обратный ток при этом не играет существенной роли, так как в быстродействующих схемах для кремниевых диодов значение обратного сопротивления много больше сопротивления нагрузки. Для обеспечения идентичности диодов при работе в широком диапазоне токов и температур требуется их подбор в нескольких точках вольт-амперных характеристик. Например, выпускаются сдвоенные диоды КД205, два диода с общим катодом КД704, два последовательно соединенных диода КД629.

Принцип действия варикапа основан на свойстве емкостей *p-n* перехода изменять свое значение при изменении внешнего смещения. Изменяя напряжения на варикапе, подключенном к колебательному контуру, можно обеспечить дистанционное и безынерционное управление резонансной частотой контура в перестраиваемых генераторах и синтезаторах частот. Таким образом, варикап представляет собой малогабаритный электронный конденсатор переменной емкости, управляемый напряжением.

По функциональному назначению и технологии изготовления приборы этого класса подразделяются на: варикапы общего назначения с резкой зависимостью емкости от напряжения, высоковольтные матрицы, умножительные, а также высокодобротные варианты с резкой зависимостью емкости от напряжения; варикапы для телевизоров и аппаратуры всеволнового диапазона с очень резкой зависимостью емкости от напряжений.

Основными параметрами варикапов являются:

номинальная $C_{ном}$, минимальная C_{min} и максимальная C_{max} емкости между выводами при номинальном, максимальном и минимальном напряжениях смещения;

номинальная добротность $Q_{ном}$ — отношение реактивного сопротивления варикапа к полному сопротивлению потерь при номинальном напряжении;

коэффициент перекрытия по емкости K_C — отношение значений максимальной и минимальной емкостей;

температурный коэффициент емкости $\alpha_{C_в}$ (ТКЕ) — относительное изменение емкости варикапа при заданном смещении в интервале температур; максимально допустимые напряжение U_{max} — максимальное мгновенное значение переменного напряжения, при котором сохраняется заданная надежность, и рассеиваемая мощность P_{max}.

В варикапах имеется взаимосвязь между некоторыми параметрами: увеличение K_C однозначно приводит к уменьшению $Q_в$ и пробивного напряжения $U_{проб}$.

Из множества выпускаемых варикапов необходимо отметить КВ127 (со сверхрезкой зависимостью для АМ-устройств), КВ130 (для селекторов каналов на полевых транзисторах с большим коэффициентом перекрытия), КВ142 (с большим коэффициентом перекрытия по емкости для диапазонов ДВ, СВ и КВ приемников), КВ138 (для блоков УКВ радиоприемников), КВ136 (для схем управления кварцевых генераторов), КВ129А9, КВ130А9, КВ134А9 (для поверхностного монтажа), КВ139 (для диапазонов СВ, ДВ и растянутых диапазонов КВ с управляющим напряжением до 5 В, для малогабаритных радиоприемников с электронной настройкой), КВ144 (для селекторов каналов кабельного телевидения), КВ101 (для радиокапсул медицинской аппаратуры), КВ103, КВ106 (для схем умножения частоты и частотной модуляции), КВС111 (сдвоенные с общим катодом, для перестройки блоков УКВ радиоприемников), КВ112В-1, КВ114, КВ116, КВ126 (для гибридных микросхем), КВ102, КВ104, КВ105, КВ107, КВ109, КВ110, КВ113, КВ115 (подстроечные, для подстройки контуров резонансных усилителей), КВ117 (подстроечные с большим коэффициентом перекрытия по емкости и резкой зависимостью емкости от напряжения), КВ119 (подстроечные для схем настройки широкополосных усилителей), КВС120 (КВС120А — сборки из трех варикапов, КВС120Б — сборки из двух варикапов с общим катодом для электронной настройки приемников), КВ121, КВ123 (подстроечные для селекторов телевизионных каналов с электронным управлением), КВ122 (подстроечные для селекторов телевизионных каналов дециметрового диапазона с электронным управлением), КВ127 (подстроечные для электронной настройки приемников), КВ128 (подстроечные для блоков УКВ автомобильных приемников и магнитол), КВ129 (подстроечные для схем частотных модуляторов), КВ132 (подстроечные для ЧМ-трактов приемно-усилительной аппаратуры), КВ134, КВ135 (подстроечные, для избирательных цепей радиоприемников). Следует отметить и варикапы, выпускаемые в пластмассовых корпусах: КВ121, КВ122, КВ123, КВ127, КВ130, КВ132, КВ134, КВ135 и др.

Стабилитроны имеют на вольт-амперной характеристике участок со слабой зависимостью напряжения от протекающего тока, поэтому уровень напряжения на них остается постоянным при изменении тока в широких пределах. Рабочий участок вольт-амперной характеристики стабилитронов находится в области электрического пробоя *p-n* перехода. Стабилитроны подразделяются на: стабилитроны общего назначения, термокомпенсируемые и аттестуемые прецизионные. Стабилитроны общего назначения используются прежде всего в стабилизаторах и ограничителях постоянного тока или импульсного напряжения, термокомпенсированные и прецизионные — в качестве источников эталонного или опорного напряжения в устройствах, где необходима высокая точность стабилизации уровня напряжения.

Основными параметрами стабилитронов, предназначенных для стабилизации напряжения, являются:

номинальное напряжение стабилизации $U_{ст}$;

динамическое $r_{дин}$ и статическое $r_{стат}$ сопротивления;

температурный коэффициент напряжения стабилизации $\alpha_{U\,ст}$ (при постоянном токе стабилизации);

мощность рассеяния $P_{рас}$;

номинальный сток стабилизации $I_{ст.\,ном}$ — ток, при котором определяются значения классификационных параметров; минимальный ток стабилизации $I_{ст\,min}$ (при токах меньше $I_{ст.\,min}$ увеличивается дифференциальное сопротивление, пробой становится неустойчивым и резко возрастают микроплазменные шумы);

максимально допустимый ток стабилизации $I_{ст\,max}$ — определяется максимально допустимой рассеиваемой мощностью.

Для снижения $\alpha_{U\,ст}$ (в термокомпенсированных стабилитронах) в корпусе размещаются последовательно соединенные *p-n* переходы, работающие в прямом направлении, с равными по значению, но противоположными по знаку температурными коэффициентами стабилизации (КС211, КС515, КС596).

В качестве источников опорного напряжения могут использоваться не только дискретные, но и интегральные стабилитроны. Прецизионные интегральные стабилитроны превосходят классические дискретные прецизионные стабилитроны по основным параметрам и имеют ряд эксплуатационных преимуществ (не требуется прецизионное поддержание рабочих режимов по температуре окружающей среды и току стабилизации). Основные недостатки дискретных прецизионных стабилитронов (высокое $r_{стат}$, зависимость $\alpha_{U\,ст}$ от $I_{ст}$) устраняются в интегральных стабилитронах с помощью схемотехнических решений.

Интегральные стабилитроны в зависимости от используемого опорного элемента создаются как на основе электрического пробоя обратносмещенного *p-n* перехода с использованием эффекта термокомпенсации, так и на основе прямосмещенных *p-n* переходов. Низковольтные интегральные прецизионные стабилитроны, имеющие $U_{ст}=1{,}2...2{,}5$ В, изготовляются по совмещенной технологии с лазерной подгонкой тонкопленочных резисторов на кристалле ИМС, обеспечивающей режим оптимальной компенсации и гарантирующей высокое значение $\alpha_{U_{ст}}$.

Для изготовления стабилитронов с $U_{ст}=8$ В используется стандартная технология ИМС, не требующая лазерной подгонки. Совместная реализация принципов термокомпенсации и термостабилизации кристалла ИМС позволила создать стабилитроны с $\alpha_{U_{ст}}=10^{-4}...10^{-5}$ %/°С. Базовые серии интегральных стабилитронов позволяют создать на их основе источники опорного напряжения с широким спектром номинальных значений $U_{ст}$: 1,2; 2,4; 5; 7,5; 10 В.

Стабисторы являются разновидностью стабилитронов; для стабилизации напряжения до 1 В здесь используется прямая ветвь вольт-амперной характеристики *p-n* перехода (КС115 — стабистор для видеомагнитофонов).

2.1. Буквенные обозначения параметров диодов

Буквенное обозначение по ГОСТ 25529—82		Параметр
Отечественное	Международное	
	Общие параметры диодов	
$I_{\text{пр}}$	I_F	Постоянный прямой ток
$I_{\text{пр, и}}$	I_{FM}	Импульсный прямой ток
$I_{\text{пр, ср}}$	$I_{F\,(AV)}$	Средний прямой ток
$I_{\text{обр}}$	I_R	Постоянный обратный ток
$I_{\text{обр, и}}$	I_{RM}	Импульсный обратный ток
$I_{\text{обр, вос}}$	I_{RR}	Обратный ток восстановления
$U_{\text{пр}}$	U_F	Постоянное прямое напряжение
$U_{\text{пр, и}}$	U_{FM}	Импульсное прямое напряжение
$U_{\text{пр, ср}}$	$U_{F\,(AV)}$	Среднее прямое напряжение
$U_{\text{обр}}$	U_R	Постоянное обратное напряжение
$U_{\text{обр, и}}$	U_{RM}	Импульсное обратное напряжение
$U_{\text{проб}}$	$U_{(BR)}$	Пробивное напряжение
$U_{\text{пр, вос}}$	U_{FR}	Напряжение прямого восстановления
$U_{\text{пр, и, вос}}$	U_{FRM}	Импульсное напряжение прямого восстановления
$P_{\text{пр}}$	P_F	Прямая рассеиваемая мощность
$P_{\text{и}}$	P_M	Импульсная рассеиваемая мощность
$P_{\text{ср}}$	P_{AV}	Средняя рассеиваемая мощность
$P_{\text{обр}}$	P_R	Обратная рассеиваемая мощность
$r_{\text{диф}}$	r_d	Дифференциальное сопротивление
$r_{\text{п}}$	r_s	Последовательное сопротивление потерь
R_{θ}	R_{th}	Тепловое сопротивление
$R_{\theta\,\text{и}}$	$R_{(th)\,P}$	Импульсное тепловое сопротивление
$R_{\theta\text{пер—окр}}$	$R_{th\,ja}$	Тепловое сопротивление переход — среда
$R_{\theta\text{пер—кор}}$	$R_{th\,jc}$	Тепловое сопротивление переход — корпус
$C_{\text{д}}$	C_{tot}	Общая емкость
$C_{\text{пер}}$	C_j	Емкость перехода
$C_{\text{кор}}$	C_{casi}	Емкость корпуса
$Q_{\text{вос}}$	—	Заряд восстановления
$Q_{\text{нк}}$	Q_s	Накопленный заряд
$t_{\text{вос, обр}}$	t_{rr}	Время обратного восстановления
$t_{\text{вос, пр}}$	t_{fr}	Время прямого восстановления
	Параметры выпрямительных диодов	
$I_{\text{пр, и, п}}$	I_{FRM}	Повторяющийся импульсный прямой ток
$I_{\text{вп, ср}}$	I_O	Средний выпрямленный ток
$I_{\text{пр, д}}$	$I_{F\,(RMS)}$	Действующий прямой ток
$I_{\text{пр, уд}}$	I_{FSM}	Ударный прямой ток
$I_{\text{прг}}$	$I_{(OV)}$	Ток перегрузки
$I_{\text{обр, и, п}}$	I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток
$I_{\text{обр, ср}}$	$I_{R\,(AV)}$	Средний обратный ток
$U_{\text{обр, и, р}}$	U_{RWM}	Рабочее импульсное обратное напряжение
$U_{\text{обр, и, п}}$	U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение
$U_{\text{обр, и, нп}}$	U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение
$U_{\text{пор}}$	U_{TO}	Пороговое напряжение
$P_{\text{пр, ср}}$	$P_{F\,(AV)}$	Средняя прямая рассеиваемая мощность
$P_{\text{обр, ср}}$	$P_{R\,(AV)}$	Средняя обратная рассеиваемая мощность
$P_{\text{обр, и, п}}$	P_{RRM}	Повторяющаяся импульсная обратная рассеиваемая мощность
	Параметры стабилитронов	
$I_{\text{ст}}$	I_Z	Ток стабилизации стабилитрона
$I_{\text{ст, и}}$	I_{ZM}	Импульсный ток стабилитрона
$I_{\text{ст min}}$	$I_{Z\,min}$	Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона
$I_{\text{ст max}}$	$I_{Z\,max}$	Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона
$U_{\text{ст}}$	U_Z	Напряжение стабилизации стабилитрона
$r_{\text{ст}}$	r_Z	Дифференцированное сопротивление стабилитрона
$\alpha_{U_{\text{ст}}}$	α_{U_Z}; S_Z	Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона
$\delta_{U_{\text{ст}}}$	δ_{U_Z}	Временна́я нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона
	Основные параметры варикапов, шумовых диодов и стабисторов	
$Q_{\text{в}}$	Q, M	Добротность варикапа
K_C	—	Коэффициент перекрытия по емкости варикапа
$U_{\text{ш}}$	U_{nz}	Постоянное напряжение шумового диода
—	I_S	Ток стабилизации стабистора
—	I_L	Предельный ток стабистора
—	U_S	Напряжение стабилизации стабистора
—	U_L	Предельное напряжение стабистора
—	αI_S	Температурный коэффициент тока стабилизации стабистора

2.2. Параметры выпрямительных диодов, столбов, блоков и импульсных диодов

В приведенных ниже таблицах вместе с основными параметрами диодов даются габаритные чертежи для отдельных групп приборов, имеющих одинаковое конструктивное оформление. Если корпус прибора стандартизован, его тип указывается над габаритным чертежом.

Следует отметить, что в таблице у ряда диодов приведены одинаковые значения параметров и их отличия заключаются в следующем:

два диода имеют общую точку (средний вывод): КДС111А — общий катод, КДС111Б — общий анод, КДС111В — соединены последовательно;
диодные сборки с раздельными выводами: КДС523А, КДС523Б, КДС523АМ, КДС523БМ — из двух диодов, КДС523В, КДС523Г, КДС523ВМ, КДС523ГМ — из четырех диодов;

диодные сборки с общим анодом: КДС526А — из четырех диодов, КДС526Б — из трех диодов, КДС526В — из двух диодов;
КДС627А — диодные матрицы из восьми изолированных диодов;
КДС628 — диодные матрицы из восьми пар (двоек) последовательно соединенных диодов с общим анодом и общим катодом;

КД903А, КД903Б — диодные матрицы из восьми диодов с общим катодом, причем КД903Б выпускаются без выводов 12 и 13;
КД906А, КД906Б, КД906В — выпрямительные мосты из четырех диодов;
КД906Г, КД906Д, КД906Е — две сборки из двух параллельно соединенных диодов;

КД908А, КД909А — диодные матрицы из восьми диодов с общим катодом;
диодные матрицы с общим катодом: КД914А — из четырех диодов, КД914Б — из двух диодов, КД914В — из трех диодов;
КД917А — диодная матрица из восьми диодов с общим анодом;
КД919А — диодная матрица из 16 диодов с общим катодом;

КД205(А—Л) — диодные сборки из двух диодов с раздельными выводами;
КВС111А, КВС111Б — сборки из двух варикапов с общим катодом;

сборки варикапов с общим катодом: КВС120А — из трех варикапов, КВС120Б — из двух варикапов;
КВС120А1 — сборка из трех электрически не связанных варикапов.

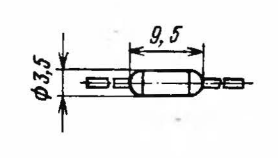
Диоды ГД403 (А—В), предназначенные для детектирования амплитудно-модулированных сигналов, отличаются входными сопротивлениями и коэффициентами передачи АМ-сигналов.

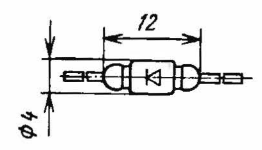
Стабилитроны КС162А, КС168В, КС170А, КС175А, КС182А, КС191А, КС210Б и КС213Б являются двуханодными и предназначены для стабилизации и двустороннего ограничения напряжения.

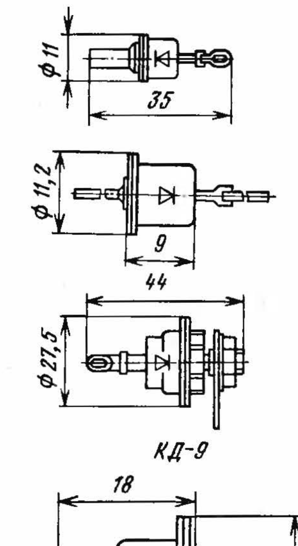
Стабисторы Д219С, Д220С, Д223С, КС107А, КС113А, КС115А, КС119А предназначены для стабилизации постоянного и импульсного напряжений, ограничения импульсов напряжения и в качестве термокомпенсирующих элементов.

Тип прибора	$U_{пр}$, В, не более (при $I_{пр}$, мА)	$I_{обр}$, мкА, не более (при $U_{обр}$, В)	$t_{вос,обр}$, мкс	$C_д$, пФ (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр\,max}$, В; $U^*_{обр,и\,max}$, В	$I_{пр\,max}$, мА; $I_{пр,ср\,max}$, мА; $I^*_{пр,и\,max}$, мА	$f_{д\,max}$, кГц	Габаритный чертеж корпуса
Выпрямительные и импульсные диоды								
Д2Б	1 (5)	100 (10)	3	0,2 (1,5)	10	16	100	КД-4; 7,5; ф3
Д2В	1 (9)	250 (30)	3	0,2 (1,5)	30	25	100	
Д2Г	1 (2)	250 (50)	3	0,2 (1,5)	50	16	100	
Д2Д	1 (4,5)	250 (50)	3	0,2 (1,5)	50	16	100	
Д2Е	1 (4,5)	250 (100)	3	0,2 (1,5)	100	16	100	
Д2Ж	1 (2)	250 (150)	3	0,2 (1,5)	150	8	100	
Д2И	1 (2)	250 (100)	3	0,2 (1,5)	100	16	100	
Д7А	0,5 (300)	100 (50)	—	—	50	300	2,4	9; ф11,2
Д7Б	0,5 (300)	100 (100)	—	—	100	300	2,4	
Д7В	0,5 (300)	100 (150)	—	—	150	300	2,4	
Д7Г	0,5 (300)	100 (200)	—	—	200	300	2,4	
Д7Д	0,5 (300)	100 (300)	—	—	300	300	2,4	
Д7Е	0,5 (300)	100 (350)	—	—	350	300	2,4	
Д7Ж	0,5 (300)	100 (400)	—	—	400	300	2,4	

Д9Б	1	(90)	250	(10)	—	—	—	10	40	100
Д9В	1	(10)	250	(30)	—	—	—	30	20	100
Д9Г	1	(30)	250	(30)	—	—	—	30	30	100
Д9Д	1	(60)	250	(30)	—	—	—	30	30	100
Д9Е	1	(30)	250	(50)	—	—	—	50	20	100
Д9Ж	1	(10)	250	(100)	—	—	—	100	15	100
Д9И	1	(30)	120	(30)	—	—	—	30	30	100
Д9К	1	(60)	60	(30)	—	—	—	30	30	100
Д9Л	1	(30)	250	(100)	—	—	—	100	15	100
Д9М	1	(60)	250	(30)	—	—	—	30	30	100
Д10	1,5	(3)	100	(10)	—	—	—	10	16	100
Д10А	1,5	(5)	200	(10)	—	—	—	10	16	100
Д10Б	1,5	(8)	200	(10)	—	—	—	10	16	100
Д101	2	(2)	10	(75)	—	—	—	75	30	—
Д101А	1	(1)	10	(75)	—	—	—	75	30	—
Д102	2	(2)	10	(50)	—	—	—	50	30	—
Д102А	1	(1)	10	(50)	—	—	—	50	30	—
Д103	2	(2)	30	(30)	—	—	—	30	30	—
Д103А	1	(1)	30	(30)	—	—	—	30	30	—
Д104	2	(2)	5	(100)	0,5	0,7	(1)	100	30	150
Д104А	1	(1)	5	(100)	0,5	0,7	(0,3)	100	30	150
Д105	2	(2)	5	(75)	0,5	0,7	(1)	75	30	150
Д105А	1	(1)	5	(75)	0,5	0,7	(0,3)	75	30	150
Д106	2	(2)	5	(30)	0,5	0,7	(1)	30	30	150
Д106А	1	(1)	5	(30)	0,5	0,7	(0,3)	30	30	150
Д202	1	(400)	500	(100)	—	—	—	100	400	20
Д203	1	(400)	500	(200)	—	—	—	200	400	20
Д204	1	(400)	500	(300)	—	—	—	300	400	20
Д205	1	(400)	500	(400)	—	—	—	400	400	20
Д206	1	(100)	50	(100)	—	—	—	100	100	1
Д207	1	(100)	50	(200)	—	—	—	200	100	1
Д208	1	(100)	50	(300)	—	—	—	300	100	1
Д209	1	(100)	50	(400)	—	—	—	400	100	1
Д210	1	(100)	50	(500)	—	—	—	500	100	1
Д211	1	(100)	50	(600)	—	—	—	600	100	1
Д214	1,2	($10\cdot10^3$)	3000	(100)	—	—	—	100	$10\cdot10^3$	1,1
Д214А	1	($10\cdot10^3$)	3000	(100)	—	—	—	100	$10\cdot10^3$	1,1
Д214Б	1,5	($5\cdot10^3$)	3000	(100)	—	—	—	100	$5\cdot10^3$	1,1
Д215	1,2	($10\cdot10^3$)	3000	(200)	—	—	—	200	$10\cdot10^3$	1,1
Д215А	1	($10\cdot10^3$)	3000	(200)	—	—	—	200	$10\cdot10^3$	1,1
Д215Б	1,5	($5\cdot10^3$)	3000	(200)	—	—	—	200	$5\cdot10^3$	1,1
МД217	1	(100)	50	(800)	—	—	—	800	100	1
МД218	1	(100)	50	(1000)	—	—	—	1000	100	1
МД218А	1,1	(100)	50	(1200)	—	—	—	1200	100	1



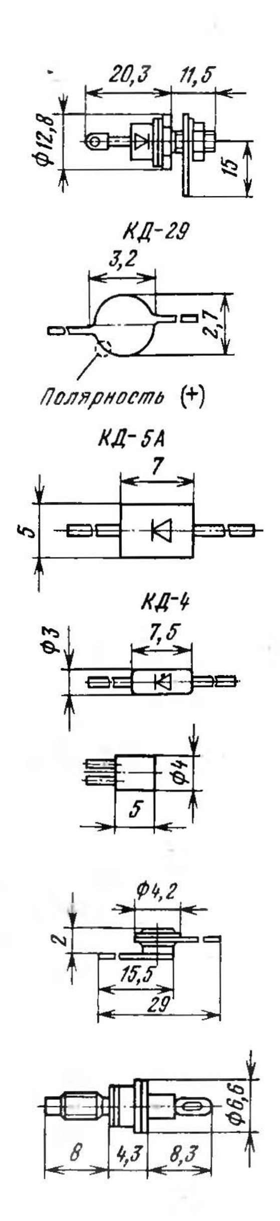




Продолжение

Тип прибора	$U_{пр}$, В, не более	(при $I_{пр}$, мА)	$I_{обр}$, мкА, не более	(при $U_{обр}$, В)	$t_{вос, обр}$, мкс	$C_д$, пФ	(при $U_{обр}$, В)	$U_{обр\ max}$, В; $U^*_{обр, и\ max}$, В	$I_{пр\ max}$, мА; $I_{пр, ср\ max}$, мА; $I^*_{пр, и\ max}$, мА	$f_{д\ max}$, кГц	Габаритный чертеж корпуса
Д223	1	(50)	1	(50)	—	—	—	50	50	—	
Д223А	1	(50)	1	(100)	—	—	—	100	50	—	
Д223Б	1	(50)	1	(150)	—	—	—	150	50	—	
МД226	1	(300)	50	(400)	—	—	—	400	300	1	
МД226А	1	(300)	50	(300)	—	—	—	300	300	1	
МД226Е	1	(300)	50	(200)	—	—	—	200	300	1	
Д226	1	(300)	50	(400)	—	—	—	400	300	1	
Д226А	1	(300)	50	(300)	—	—	—	300	300	1	
Д226Е	1	(300)	50	(200)	—	—	—	200	300	1	
Д229А	1	(400)	50	(200)	—	—	—	200	400	1	
Д229Б	1	(400)	50	(400)	—	—	—	400	400	1	
Д229В	1	(400)	200	(100)	—	—	—	100	400	1	
Д229Г	1	(400)	200	(200)	—	—	—	200	400	1	
Д229Д	1	(400)	200	(300)	—	—	—	400	300	1	
Д229Е	1	(400)	200	(400)	—	—	—	400	400	1	
Д229Ж	1	(700)	200	(100)	—	—	—	100	700	1	
Д229И	1	(700)	200	(200)	—	—	—	200	700	1	
Д229К	1	(700)	200	(300)	—	—	—	300	700	1	
Д229Л	1	(700)	200	(400)	—	—	—	400	700		
Д231	1	($10\cdot10^3$)	3000	(300)	—	—	—	300	$10\cdot10^3$	1,1	
Д231А	1	($10\cdot10^3$)	3000	(300)	—	—	—	300	$10\cdot10^3$	1,1	
Д231Б	1,5	($5\cdot10^3$)	3000	(300)	—	—	—	300	$5\cdot10^3$	1,1	
Д232	1	($10\cdot10^3$)	3000	(400)	—	—	—	400	$10\cdot10^3$	1,1	
Д232А	1	($10\cdot10^3$)	3000	(400)	—	—	—	400	$10\cdot10^3$	1,1	
Д232Б	1,5	($5\cdot10^3$)	3000	(400)	—	—	—	400	$5\cdot10^3$	1,1	
Д233	1	($10\cdot10^3$)	3000	(500)	—	—	—	500	$10\cdot10^3$	1,1	
Д233Б	1,5	($5\cdot10^3$)	3000	(500)	—	—	—	500	$5\cdot10^3$	1,1	
Д234Б	1,5	($5\cdot10^3$)	3000	(600)	—	—	—	600	$5\cdot10^3$	1,1	
Д237А	1	(300)	50	(200)	—	—	—	200	300	1	
Д237Б	1	(300)	50	(400)	—	—	—	400	300	1	
Д237В	1	(100)	50	(600)	—	—	—	600	100	1	
Д237Е	1	(200)	50	(200)	—	—	—	200	200	1	
Д237Ж	1	(200)	50	(400)	—	—	—	400	200	1	
Д242	1,25	($10\cdot10^3$)	3000	(100)	—	—	—	100	$10\cdot10^3$	1,1	
Д242А	1	($10\cdot10^3$)	3000	(100)	—	—	—	100	$10\cdot10^3$	1,1	
Д242Б	1,5	($5\cdot10^3$)	3000	(100)	—	—	—	100	$5\cdot10^3$	1,1	
Д243	1,25	($10\cdot10^3$)	3000	(200)	—	—	—	200	$10\cdot10^3$	1,1	
Д243А	1	($10\cdot10^3$)	3000	(200)	—	—	—	200	$10\cdot10^3$	1,1	
Д243Б	1,5	($5\cdot10^3$)	3000	(200)	—	—	—	200	$5\cdot10^3$	1,1	
Д245	1,25	($10\cdot10^3$)	3000	(300)	—	—	—	300	$10\cdot10^3$	1,1	
Д245А	1	($10\cdot10^3$)	3000	(300)	—	—	—	300	$10\cdot10^3$	1,1	
Д245Б	1,5	($5\cdot10^3$)	3000	(300)	—	—	—	300	$5\cdot10^3$	1,1	

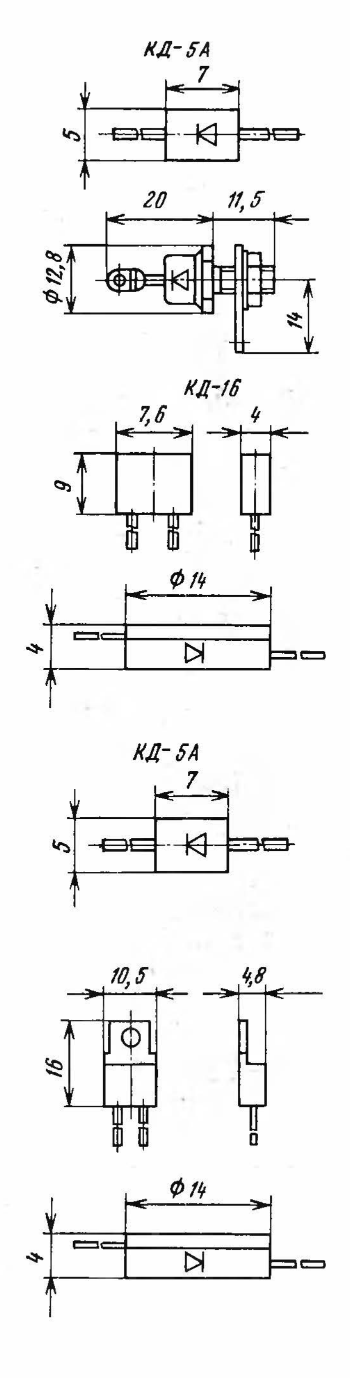
Д246	1,25 $(10\cdot10^3)$	3000 (400)	—	—	—	400	$10\cdot10^3$	1,1
Д246А	1 $(10\cdot10^3)$	3000 (400)	—	—	—	400	$10\cdot10^3$	1,1
Д246Б	1,5 $(5\cdot10^3)$	3000 (400)	—	—	—	400	$5\cdot10^3$	1,1
Д247	1,25 $(10\cdot10^3)$	3000 (500)	—	—	—	500	$10\cdot10^3$	1,1
Д247Б	1,5 $(5\cdot10^3)$	3000 (500)	—	—	—	500	$5\cdot10^3$	1,1
Д248Б	1,5 $(5\cdot10^3)$	3000 (600)	—	—	—	600	$5\cdot10^3$	1,1
Д302	0,3 $(1\cdot10^3)$	800 (200)	—	—	—	200	$1\cdot10^3$	1
Д303	0,35 $(3\cdot10^3)$	1000 (150)	—	—	—	150	$3\cdot10^3$	1
Д304	0,3 $(5\cdot10^3)$	2000 (100)	—	—	—	100	$5\cdot10^3$	1
Д305	0,35 $(10\cdot10^3)$	2500 (50)	—	—	—	50	$10\cdot10^3$	1
КД102А	1 (100)	0,1 (250)	—	—	—	250	100	1
КД102Б	1 (100)	1 (300)	—	—	—	300	100	20
КД103А	1 (100)	0,5 (50)	1	20	5	50	100	20
КД103Б	1,2 (100)	0,5 (50)	4	20	5	50	100	20
КД104А	1 (10)	3 (300)	3	—	—	300	10	20
КД105Б	1,0 (300)	100 (400)	—	—	—	400*	300	1
КД105В	1,0 (300)	100 (600)	—	—	—	800*	300	1
КД105Г	1,0 (300)	100 (800)	—	—	—	800*	300	1
КД106А	1,0 (300)	10 (100)	0,385	74...153	(5)	100*	3*	1
ГД107А	1,0 (10)	20 (10)	—	—	—	15	20	—
ГД107Б	0,4 (1,5)	100 (20)	—	—	—	20	20	—
КД109А	1,0 (300)	100 (100)	—	—	—	100*	300	—
КД109Б	1,0 (300)	100 (300)	—	—	—	300*	300	—
КД109В	1,0 (300)	100 (600)	—	—	—	600*	300	—
АД110А	1,5 (10)	5 (20)	10	3	—	30	10	1000
АД112А	3,0 (300)	100 (50)	—	—	—	50	300	—



Продолжение

Тип прибора	$U_{пр}$, не более (при $I_{пр}$, мА)	$I_{обр}$, мкА, не более (при $U_{обр}$, В)	$t_{вос, обр}$, мкс	$C_д$, пФ (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр\ max}$, В $U^*_{обр, и\ max}$	$I_{пр\ max}$, мА $I_{пр, ср\ max}$, мА $I^*_{пр, и\ max}$, мА	$f_{д\ max}$, кГц	Габаритный чертеж корпуса
ГД113А	1,0 (30)	250 (80)	—	— —	115*	15	—	КД-4
КД202А	0,9 ($5\cdot10^3$)	800 (50)	—	— —	50*	$5\cdot10^3$	1,2	
КД202В	0,9 ($5\cdot10^3$)	800 (100)	—	— —	100*	$5\cdot10^3$	1,2	
КД202Д	0,9 ($5\cdot10^3$)	800 (200)	—	— —	200*	$5\cdot10^3$	1,2	
КД202Ж	0,9 ($5\cdot10^3$)	800 (300)	—	— —	300	$5\cdot10^3$	1,2	
КД202К	0,9 ($5\cdot10^3$)	800 (400)	—	— —	400*	$5\cdot10^3$	1,2	
КД202М	0,9 ($5\cdot10^3$)	800 (500)	—	— —	500*	$5\cdot10^3$	1,2	
КД202Р	0,9 ($5\cdot10^3$)	800 (600)	—	— —	600*	$5\cdot10^3$	1,2	
КД203А	1,0 ($10\cdot10^3$)	$1,5\cdot10^3$ (600)	—	— —	420	$10\cdot10^3$	1	
КД203Б	1,0 ($10\cdot10^3$)	$1,5\cdot10^3$ (800)	—	— —	560	$10\cdot10^3$	1	
КД203В	1,0 ($10\cdot10^3$)	$1,5\cdot10^3$ (800)	—	— —	560	$10\cdot10^3$	1	
КД203Г	1,0 ($10\cdot10^3$)	$1,5\cdot10^3$ ($1\cdot10^3$)	—	— —	700	$10\cdot10^3$	1	
КД203Д	1,0 ($10\cdot10^3$)	$1,5\cdot10^3$ ($1\cdot10^3$)	—	— —	700	$10\cdot10^3$	1	
КД204А	1,4 (600)	150 (400)	1,5	— —	400*	400	1	КД-11
КД204Б	1,4 (600)	100 (200)	1,5	— —	200*	600	50	
КД204В	1,4 (600)	50 (50)	1,5	— —	50*	$1\cdot10^3$	50	
КД205А	1,0 (500)	100 (500)	—	— —	500	500	5	
КД205Б	1,0 (500)	100 (400)	—	— —	400	500	5	
КД205В	1,0 (500)	100 (300)	—	— —	300	500	5	
КД205Г	1,0 (500)	100 (200)	—	— —	200	500	5	
КД205Д	1,0 (500)	100 (100)	—	— —	100	500	5	
КД205Е	1,0 (300)	100 (500)	—	— —	500	300	5	
КД205Ж	1,0 (500)	100 (600)	—	— —	600	500	5	
КД205И	1,0 (300)	100 (700)	—	— —	700	300	5	
КД205К	1,0 (700)	100 (100)	—	— —	100	700	5	
КД205Л	1,0 (700)	100 (200)	—	— —	200	700	5	
КД206А	1,2 ($1\cdot10^3$)	700 (400)	10	— —	400	$10\cdot10^3$	1	
КД206Б	1,2 ($1\cdot10^3$)	700 (500)	10	— —	500	$10\cdot10^3$	1	
КД206В	1,2 ($1\cdot10^3$)	700 (600)	10	— —	600	$10\cdot10^3$	1	

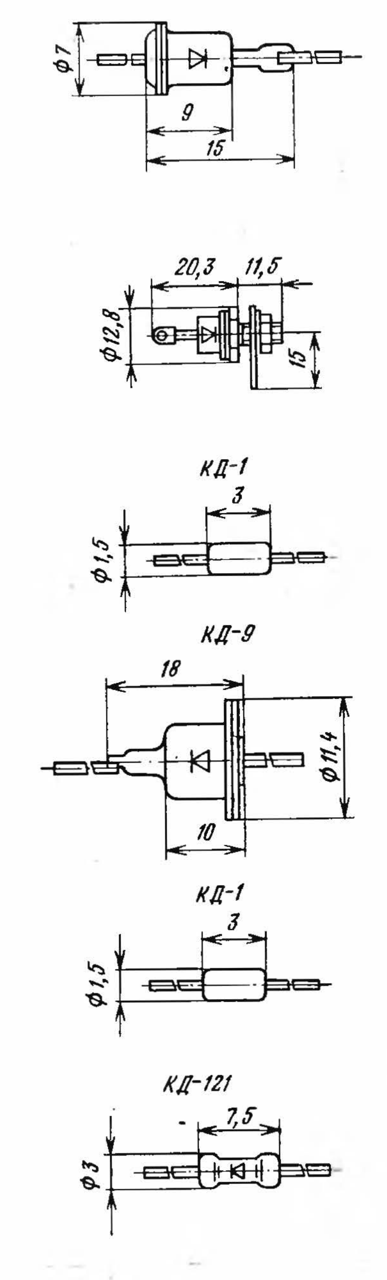
КД208А	1,0	(1·10³)	100	(100)	—	—	—	100	1,5·10³	1
КД209А	1,0	(700)	100	(400)	—	—	—	400	700	1
КД209Б	1,0	(500)	100	(600)	—	—	—	600	500	1
КД209В	1,0	(500)	100	(800)	—	—	—	800	500	1
КД210А	1,0	(10·10³)	4,5·10³	(800)	—	—	—	800	5·10³	1
КД210Б	2,0	(10·10³)	4,5·10³	(800)	—	—	—	800	10·10³	1
КД210В	2,0	(10·10³)	4,5·10³	(1·10³)	—	—	—	1000	5·10³	1
КД210Г	2,0	(10·10³)	4,5·10³	(1·10³)	—	—	—	1000	10·10³	1
КД212А	1,0	(1·10³)	50	(200)	0,3	45	(100)	200	1·10³	100
КД212Б	1,2	(1·10³)	100	(200)	0,3	45	(100)	200	1·10³	100
КД212В	1,0	(1·10³)	100	(100)	0,5	45	(100)	100	1·10³	100
КД212Г	1,2	(1·10³)	100	(100)	0,5	45	(100)	100	1·10³	100
КД213А	1,0	(10·10³)	200	(200)	0,3	550	(100)	200	10·10³	100
КД213Б	1,2	(10·10³)	200	(200)	0,17	550	(100)	200	10·10³	100
КД213В	1,2	(10·10³)	200	(200)	0,5	550	(100)	200	10·10³	100
КД213Г	1,2	(10·10³)	200	(100)	0,3	550	(100)	100	10·10³	100
КД221А	1,4	(0,7·10³)	50	(100)	1,5	—	—	100	0,7·10³	1
КД221Б	1,4	(0,5·10³)	50	(200)	1,5	—	—	200	0,5·10³	1
КД221В	1,4	(0,3·10³)	100	(400)	1,5	—	—	400	0,3·10³	1
КД221Г	1,4	(0,3·10³)	150	(600)	1,5	—	—	600	0,3·10³	1
КД226А	1,4	(1,7·10³)	50	(100)	0,25	—	—	100	1,7·10³	—
КД226Б	1,4	(1,7·10³)	50	(200)	0,25	—	—	200	1,7·10³	—
КД226В	1,4	(1,7·10³)	50	(400)	0,25	—	—	400	1,7·10³	—
КД226Г	1,4	(1,7·10³)	50	(600)	0,25	—	—	600	1,7·10³	—
КД226Д	1,4	(1,7·10³)	50	(800)	0,25	—	—	800	1,7·10³	—
КД244А	1,3	(10·10³)	100	(100)	0,05	—	—	100	10·10³	200
КД244Б	1,3	(10·10³)	100	(100)	0,035	—	—	100	10·10³	200
КД244В	1,3	(10·10³)	100	(200)	0,05	—	—	200	10·10³	200
КД244Г	1,3	(10·10³)	100	(200)	0,035	—	—	200	10·10³	200
КД2994А	1,3	(20·10³)	100	(100)	0,05	—	—	200	20·10³	200
КД2994Б	1,3	(20·10³)	100	(100)	0,05	—	—	200	20·10³	200
КД2994В	1,3	(20·10³)	100	(100)	0,05	—	—	200	20·10³	200
КД2994Г	1,3	(20·10³)	100	(100)	0,05	—	—	200	20·10³	200
КД2997А	1	(30·10³)	200	(200)	0,2	—	—	200	30·10³	100
КД2997Б	1	(30·10³)	200	(100)	0,2	—	—	100	30·10³	100
КД2997В	1	(30·10³)	200	(50)	0,2	—	—	50	30·10³	100
КД2999А	1	(20·10³)	200	(250)	0,2	—	—	200	20·10³	100
КД2999Б	1	(20·10³)	200	(200)	0,2	—	—	100	20·10³	100
КД2999В	1	(20·10³)	200	(100)	0,2	—	—	50	20·10³	100



Продолжение

Тип прибора	$U_{пр}$, В, не более (при $I_{пр}$, мА)		$I_{обр}$, мкА, не более (при $U_{обр}$, В)		$t_{вос, обр}$, мкс	$C_д$, пФ (при $U_{обр}$, В)		$U_{обр\,max}$, В; $U^*_{обр,\,и\,max}$, В	$I_{пр\,max}$, мА; $I_{пр,\,ср\,max}$, мА; $I^*_{пр,\,и\,max}$, мА	$f_{д\,max}$, кГц	Габаритный чертеж корпуса
КД401А	1,0	(5)	5	(75)	2	1	(5)	75*	30	150	
КД401Б	1,0	(10)	5	(75)	2	1,5	(5)	75*	30	150	
ГД402А	0,45	(15)	50	(10)	—	0,8	(5)	15	30	$60 \cdot 10^3$	КД-121
ГД402Б	0,45	(15)	50	(10)	—	0,5	(5)	15	30	$10 \cdot 10^3$	
ГД403А	0,5	(5)	—	—	—	—	—	5	5	465	
ГД403Б	0,5	(5)	—	—	—	—	—	5	5	465	
ГД403В	0,5	(5)	—	—	—	—	—	5	5	465	
КД407А	—	—	0,5	(24)	—	1	(5)	24	50	$(50...300) \times 10^3$	КД-121
КД409А	—	—	0,5	(24)	—	2	(15)	24	50	$(50...1000) \times 10^3$	КД-17
КД410А	2,0	(50)	$3 \cdot 10^3$	(100)	3	—	—	1000	50	—	
КД410Б	2,0	(50)	$3 \cdot 10^3$	(100)	3	—	—	600	50	—	

КД411А	1,4	(10^3)	700	(700)	25	—	—	700*	$2\cdot10^3$	30
КД411Б	1,4	(10^3)	700	(600)	—	—	—	600*	$2\cdot10^3$	30
КД411В	1,4	(10^3)	700	(500)	25	—	—	500*	$2\cdot10^3$	30
КД411Г	2,0	(10^3)	700	(400)	—	—	—	400*	$2\cdot10^3$	30
КД411АМ	1,4	(10^3)	300	(700)	0,5	—	—	700*	$2\cdot10^3$	30
КД411БМ	1,4	(10^3)	300	(750)	0,5	—	—	750*	$2\cdot10^3$	30
КД411ВМ	1,4	(10^3)	300	(600)	1,5	—	—	600*	$2\cdot10^3$	30
										30
КД411ГМ	2,0	(10^3)	300	(500)	1,5	—	—	500*	$2\cdot10^3$	30
КД412А	2,0	($10\cdot10^3$)	100	(1000)	1,5	—	—	1000	20*	20
КД412В	2,0	($10\cdot10^3$)	100	(800)	1,5	—	—	800	20*	20
КД421В	2,0	($10\cdot10^3$)	100	(600)	1,5	—	—	600	20*	20
КД412Г	2,0	($10\cdot10^3$)	100	(400)	1,5	—	—	400	20*	20
КД413А	1,0	(20)	—	—	—	0,7	(0)	24	20	$100\cdot10^3$
КД413Б	1,0	(20)	—	—	—	0,7	(0)	24	20	$100\cdot10^3$
КД416А	3,0	($15\cdot10^3$)	$400\cdot10^3$	(400)	—	—	—	400	300	0,5
КД416Б	3,0	($15\cdot10^3$)	$200\cdot10^3$	(200)	—	—	—	200	300	0,5
КД417А	1,0	(20)	—	—	—	0,4	(0)	24	20	—
КД503А	1,0	(10)	10	(30)	0,01	5	(0)	30	20	$350\cdot10^3$
КД503Б	1,2	(10)	10	(30)	0,01	2,5	(0)	30	20	$350\cdot10^3$



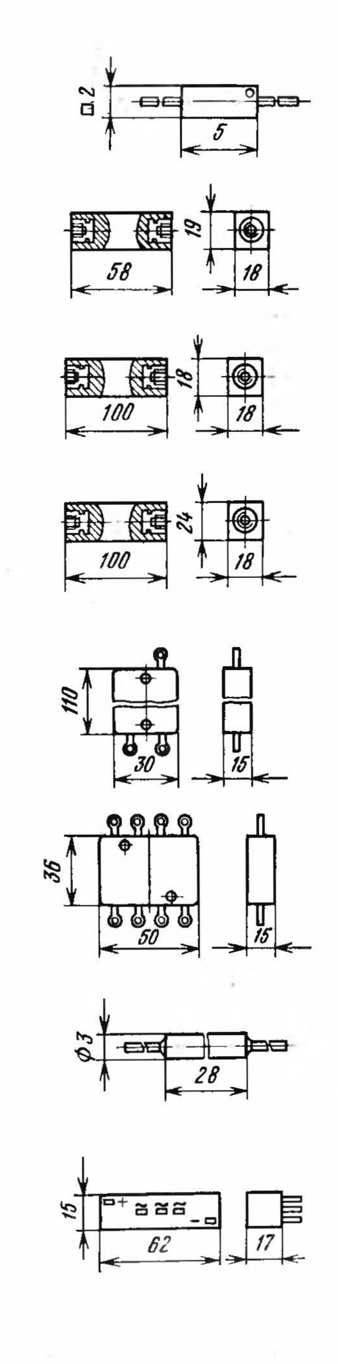
Продолжение

Тип прибора	$U_{пр}$, В, не более (при $I_{пр}$, мА)	$I_{обр}$, мкА, не более (при $U_{обр}$, В)	$t_{вос, обр}$, мкс	$C_д$, пФ (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр\,max}$, В $U^*_{обр,\,и\,max}$, В	$I_{пр\,max}$, мА $I_{пр,\,ср\,max}$, мА $I^*_{пр,\,и\,max}$, мА	$f_{д\,max}$, кГц	Габаритный чертеж корпуса
КД504А	1,2 (100)	2 (40)	—	20,0 (5)	40	240	—	
ГД507А ГД508А ГД508Б	0,5 (5) 0,7 (10) 0,65 (10)	50 (20) 60 (8) 100 (8)	0,1 — —	0,8 (5) 0,75 (0,5) 0,75 (0,5)	20 8 8	16 10 10	— — —	КД-121
КД509А КД510А	1,1 (100) 1,1 (200)	5 (50) 5 (50)	— —	— — 4,0 (0)	70* 50	100 200	— —	КД-8
ГД511А ГД511Б ГД511В	0,6 (5) 0,6 (5) 0,6 (5)	50 (10) 100 (10) 200 (10)	— — —	1,0 (5) 1,0 (5) 1,0 (5)	12 12 12	15 15 15	— — —	
КД512А	1,0 (1)	5 (15)	0,001	1,0 (5)	15	20	—	КД-121
КД513А	1,1 (100)	5 (50)	0,004	4,0 (0)	50	100	—	КД-14

КД514А	1,0	(10)	5	(6)	—	0,9	(0)	10	10	—	КД-121; 7,5; Ф3
АД516А	1,5	(2)	2	(10)	0,001	0,5	(0)	10	2	—	Ф3,8; 6
АД516Г	1,5	(2)	2	(10)	0,001	0,35	(0)	10	2	—	
КД518А	0,57	(1)	—	—	—	—	—	—	100	—	КД-14; 5; 2,5; 4,5
КД519А	1,1	(100)	5	(30)	—	4,0	(0)	30	30	—	КД-121; 7,5; Ф3
КД519Б	1,1	(100)	5	(30)	—	2,5	(0)	30	30	—	
КД520А	1,0	(20)	1	(15)	0,004	3,0	(5)	15	20	—	КД-1; 3; Ф1,5
КД521А	1,0	(50)	1	(75)	0,004	4,0	(0)	75	50	—	КД-8; Ф2; 3,8
КД521Б	1,0	(50)	1	(60)	0,004	4,0	(0)	60	50	—	
КД521В	1,0	(50)	1	(50)	0,004	4,0	(0)	50	50	—	
КД521Г	1,0	(50)	1	(30)	0,004	4,0	(0)	30	50	—	
КД521Д	1,0	(50)	1	(12)	0,004	4,0	(0)	12	50	—	
КД522А	1,1	(100)	2	(30)	0,004	4,0	(0)	30	100	—	
КД522Б	1,1	(100)	5	(50)	0,004	4,0	(0)	50	100	—	

Тип прибора	$U_{пр}$, В, не более (при $I_{пр}$, мА)	$I_{обр}$, мкА, не более (при $U_{обр}$, В)	$t_{вос, обр}$, мкс	$C_д$, пФ (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр\ max}$, В; $U^*_{обр, и\ max}$, В	$I_{пр\ max}$, мА; $I_{пр, ср\ max}$, мА; $I^*_{пр, и\ max}$, мА	$f_{д\ max}$, кГц	Габаритный чертеж корпуса
КД529А	3,5 $(20 \cdot 10^3)$	$1,5 \cdot 10^3$ $(2 \cdot 10^3)$	2	— —	$2 \cdot 10^3$*	$8 \cdot 10^3$	5	
КД529Б	3,5 $(20 \cdot 10^3)$	$1,5 \cdot 10^3$ $(2 \cdot 10^3)$	3	— —	$2 \cdot 10^3$*	$8 \cdot 10^3$	5	
КД529В	3,5 $(20 \cdot 10^3)$	$1,5 \cdot 10^3$ $(1,6 \cdot 10^3)$	2	— —	$1,6 \cdot 10^3$*	$8 \cdot 10^3$	5	
КД529Г	3,5 $(20 \cdot 10^3)$	$1,5 \cdot 10^3$ $(1,6 \cdot 10^3)$	3	— —	$1,6 \cdot 10^3$*	$8 \cdot 10^3$	5	
КД922А	1,0 (50)	0,5 (15)	—	1,0 (0)	18	50	10^6	КД-1
КД922Б	1,0 (35)	0,5 (15)	—	1,0 (0)	21	35	10^6	
КД922В	0,55 (10)	0,5 (10)	—	1,0 (0)	10	10	10^6	
КД923А	1,0 (100)	5,0 10	—	3,6 (0)	14	100	$7 \cdot 10^5$	
Выпрямительные столбы и блоки								
КЦ105В	7,0 (100)	100 $(6 \cdot 10^3)$	3	— —	$6 \cdot 10^3$*	100	10	
КЦ105Г	7,0 (75)	100 $(8 \cdot 10^3)$	3	— —	$7 \cdot 10^3$*	75	10	
КЦ105Д	7,0 (50)	100 $(10 \cdot 10^3)$	3	— —	$8,5 \cdot 10^3$*	50	10	
КЦ106А	25,0 (10)	5 $(4 \cdot 10^3)$	3,5	— —	$4 \cdot 10^3$	10	20	
КЦ106Б	25,0 (10)	5 $(6 \cdot 10^3)$	3,5	— —	$6 \cdot 10^3$	10	20	
КЦ106В	25,0 (10)	5 $(8 \cdot 10^3)$	3,5	— —	$8 \cdot 10^3$	10	20	
КЦ106Г	25,0 (10)	5 $(10 \cdot 10^3)$	3,5	— —	$10 \cdot 10^3$	10	20	
КЦ106Д	25,0 (10)	5 $(2 \cdot 10^3)$	3,5	— —	$2 \cdot 10^3$	10	20	
КЦ109А	7,0 (300)	10 $(6 \cdot 10^3)$	1,5	— —	$6 \cdot 10^3$*	300	—	

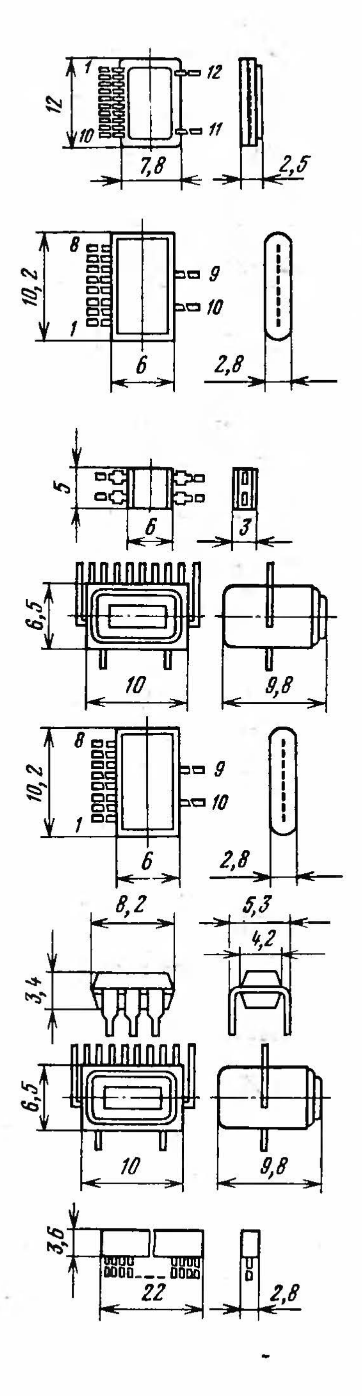
КЦ111А	12,0	(1)	0,1	$(3\cdot10^3)$	—	—	—	$3\cdot10^3$	1	20
КЦ201А	3,0	(500)	100	$(2\cdot10^3)$	—	—	—	$2\cdot10^3$*	500	1
КЦ201Б	3,0	(500)	100	$(4\cdot10^3)$	—	—	—	$4\cdot10^3$*	500	1
КЦ201В	6,0	(500)	100	$(6\cdot10^3)$	—	—	—	$6\cdot10^3$*	500	1
КЦ201Г	6,0	(500)	100	$(8\cdot10^3)$	—	—	—	$8\cdot10^3$*	500	1
КЦ201Д	6,0	(500)	100	$(10\cdot10^3)$	—	—	—	$10\cdot10^3$*	500	1
КЦ201Е	10,0	(500)	100	$(15\cdot10^3)$	—	—	—	$15\cdot10^3$*	500	1
КЦ401А	2,5	(400)	500	(500)	—	—	—	500*	400	1
КЦ401Г	2,5	(500)	500	(500)	—	—	—	500*	500	1
КЦ407А	2,5	(200)	5,0	(400)	5	—	—	400*	500	120
КЦ409А	2,5	$(3\cdot10^3)$	3,0	(600)	—	—	—	600*	$3\cdot10^3$	1
КЦ409Б	2,5	$(3\cdot10^3)$	3,0	(500)	—	—	—	500*	$3\cdot10^3$	1
КЦ409В	2,5	$(3\cdot10^3)$	3,0	(400)	—	—	—	400*	$3\cdot10^3$	1
КЦ409Г	2,5	$(3\cdot10^3)$	3,0	(300)	—	—	—	300*	$3\cdot10^3$	1
КЦ409Д	2,5	$(3\cdot10^3)$	3,0	(200)	—	—	—	200*	$3\cdot10^3$	1
КЦ409Е	2,5	$(3\cdot10^3)$	3,0	(100)	—	—	—	100*	$3\cdot10^3$	1
КЦ409Ж	2,5	$(6\cdot10^3)$	3,0	(200)	—	—	—	200*	$6\cdot10^3$	1
КЦ409И	2,5	$(6\cdot10^3)$	3,0	(100)	—	—	—	100*	$6\cdot10^3$	1



Окончание

Тип прибора	$U_{пр}$, не более (при $I_{пр}$, мА)		$I_{обр}$, мкА, не более (при $U_{обр}$, В)		$t_{вос, обр}$, мкс	$C_д$, пФ (при $U_{обр}$, В)		$U_{обр\,max}$, В; $U^*_{обр,\,и\,max}$, В	$I_{пр\,max}$, мА; $I_{пр,\,ср\,max}$, мА; $I^*_{пр,\,и\,max}$, мА	$f_{д\,max}$, кГц	Габаритный чертеж корпуса
КЦ410А	1,2	($3\cdot10^3$)	50,0	(50)	—	—	—	50*	$3\cdot10^3$	—	
КЦ410Б	1,2	($3\cdot10^3$)	50,0	(100)	—	—	—	100*	$3\cdot10^3$	—	
КЦ410В	1,2	($3\cdot10^3$)	50,0	(200)	—	—	—	200*	$3\cdot10^3$	—	
КЦ412А	1,2	(500)	50,0	(50)	—	—	—	50*	$1\cdot10^3$	—	
КЦ412Б	1,2	(500)	50,0	(100)	—	—	—	100*	$1\cdot10^3$	—	
КЦ412В	1,2	(500)	50,0	(200)	—	—	—	200*	$1\cdot10^3$	—	
			Диодные сборки								
КДС111А	1,2	(100)	3,0	(300)	—	—	—	300	200	20	
КДС111Б	1,2	(100)	3,0	(300)	—	—	—	300	200	20	
КДС111В	1,2	(100)	3,0	(300)	—	—	—	300	200	20	
КДС523А	1,0	(20)	5,0	(50)	4	2	(0,1)	50	20	—	
КДС523Б	1,0	(20)	5,0	(50)	4	2	(0,1)	50	20	—	
КДС523В	1,0	(20)	5,0	(50)	4	2	(0,1)	50	20	—	
КДС523Г	1,0	(20)	5,0	(50)	4	2	(0,1)	50	20	—	
КДС523АМ	1,0	(20)	5,0	(50)	4	2	(0,1)	50	20	—	
КДС523БМ	1,0	(20)	5,0	(50)	4	2	(0,1)	50	20	—	
КДС523ВМ	1,0	(20)	5,0	(50)	4	2	(0,1)	50	20	—	
КДС523ГМ	1,0	(20)	5,0	(50)	4	2	(0,1)	50	20	—	
КДС526А	1,1	(5,0)	—	—	5	5	(0)	15	20	—	
КДС526Б	1,1	(5,0)	—	—	5	5	(0)	15	20	—	
КДС526В	1,1	(5,0)	—	—	5	5	(0)	15	20	—	
КДС627А	1,3	(200)	2,0	(50)	40	5	(0)	50	200	—	

КДС628А	1,3	(300)	5,0	(50)	50	32	(0)	50	200	—
КД903А	1,2	(75)	0,5	(20)	150	150	(5)	20	75	—
КД903Б	1,2	(75)	0,5	(20)	150	150	(5)	20	75	—
КД906А	1,0	(50)	2,0	(75)	1	20	(5)	75	100	100
КД906Б	1,0	(50)	2,0	(50)	1	20	(5)	50	100	100
КД906В	1,0	(50)	2,0	(30)	1	20	(5)	30	100	100
КД906Г	1,0	(50)	2,0	(75)	1	40	(5)	75	100	100
КД906Д	1,0	(50)	2,0	(50)	1	40	(5)	50	100	100
КД906Е	1,0	(50)	2,0	(30)	1	40	(5)	30	100	100
КД908А	1,2	(200)	5,0	(50)	30	5	(0)	40	200	—
КД909А	1,2	(200)	10,0	(40)	70	5	(0)	40	200	—
КД914А	1,0	(5)	1,0	(20)	—	—	—	20	20	—
КД914Б	1,0	(5)	1,0	(20)	—	—	—	20	20	—
КД914В	1,0	(5)	1,0	(20)	—	—	—	20	20	—
КД917А	1,2	(200)	5,0	(50)	10	40	(0,05)	40	200	—
КД919А	1,35	(100)	1,0	(40)	100	6	(10,0)	40	100	—



2.3. Параметры варикапов

Тип прибора	$C_д$, пФ				$Q_в$		
	мин.	макс.	$U_{обр}$, В	$f_{изм}$, МГц	мин.	$U_{обр}$, В	$f_{изм}$, МГц
КВ101	200	240	0,8	—	12 150	4	10 1,0
КВ102А	14	23	4	10	40	4	50
КВ102Б	19	30	4	10	40	4	50
КВ102В	25	40	4	10	40	4	50
КВ102Г	19	30	4	10	100	4	50
КВ102Д	19	30	4	10	40	4	50
КВ103А	18	32	4	10	50	4	50
КВ103Б	28	48	4	10	40	4	50
КВ104А	90	120	4	1...10	100	4	10
КВ104Б	106	144	4	1...10	100	4	10
КВ104В	128	192	4	1...10	100	4	10
КВ104Д	128	192	4	1...10	100	4	10
КВ104Е	95	143	4	1...10	150	4	10
КВ105А	400	600	4	1	500	4	1
КВ105Б	400	600	4	1	500	4	1
КВ106А	20	50	4	1...10	40	4	50
КВ106Б	15	35	4	1...10	60	4	50
КВ107А	10	40	2...9	1...10	20	—	10
КВ107Б	10	40	6...18	1...10	20	—	10
КВ107В	30	65	2...9	1...10	20	—	10
КВ107Г	30	65	6...18	1...10	20	—	10
КВ109А	2,3	2,8	25	1...10	300	3	50
КВ109Б	2,0	2,3	25	1...10	300	3	50
КВ109В	8	16	3	1...10	160	3	50
КВ109Г	8	17	3	1...10	160	3	50
КВ110А	10	18	4	1...10	300	4	50
КВ110Б	14,4	21,6	4	1...10	300	4	50
КВ110В	17,6	26,4	4	1...10	300	4	50
КВ110Г	12	18	4	1...10	150	4	50
КВ110Д	14,4	21,6	4	1...10	150	4	50
КВ110Е	17,6	26,4	4	1...10	150	4	50

$I_{обр}$, мкА (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр}$, В	$P_{пр}$, Вт (при $T_{изм}$, °C)	T, °C	$\alpha_{C_в}$, 1/°C (при $U_{обр}$, В)	Габаритный чертеж корпуса
1 (4)	4	— —	—10...+55	— —	1,6; Ф3,3
1 (45)	45	90 мВт —	—40...+85	— —	КД-28; Ф2,4; 3,5
1 (45)	45	90 мВт	—40...+85	— —	
1 (45)	45	90 мВт —	—40...+85	— —	
1 (45)	45	90 мВт —	—40...+85	— —	
1 (80)	80	90 мВт —	—40...+85	— —	
10 (80)	80	5 (—40...+70)	—40...+85	— —	20; 11,5; Ф12,8; 14
10 (80)	80	5 (—40...+70)	—40...+85	— —	
5 (45)	45	0,1 (40)	—40...+85	— —	Ф4,5; 4,8
5 (45)	45	0,1 (40)	—40...+85	— —	
5 (80)	80	0,1 (40)	—40...+85	— —	
5 (80)	80	0,1 (40)	—40...+85	— —	
5 (45)	45	0,1 (40)	—40...+85	— —	
20 (90)	90	0,15 (50)	—40...+100	$5\cdot10^{-4}$ (4)	Ф11,4; 19
20 (50)	50	0,15 (50)	—40...+100	$5\cdot10^{-4}$ (4)	
20 (120)	120	7 (75)	—60...+100	— —	20; 11,5; Ф12,8; 14
20 (90)	90	5 (75)	—60...+100	— —	
100 —	5,5...16	0,1 (—40...+50)	—40...+70	— —	Ф5,8; 5,3
100 —	13...31	0,1 (—40...+50)	—40...+70	— —	
100 —	5,5...16	0,1 (—40...+50)	—40...+70	— —	
100 —	13...31	0,1 (—40...+50)	—40...+70	— —	
0,5 (25)	25	5 мВт (50)	—40...+85	$(500\pm300)\times10^{-6}$ (3)	КД-17; 2,9; 2,4; 4; 2,5
0,5 (25)	25	5 мВт (50)	—40...+85	$(500\pm300)\times10^{-6}$ (3)	
0,5 (25)	25	5 мВт (50)	—40...+85	$(500\pm300)\times10^{-6}$ (3)	
0,5 (25)	25	5 мВт (50)	—40...+85	$(500\pm300)\times10^{-6}$ (3)	
1 (45)	45	0,1 (—60...+50)	—40...+85	— —	Ф3; 7
1 (45)	45	0,1 (—60...+50)	—40...+85	— —	
1 (45)	45	0,1 (—60...+50)	—40...+85	— —	
1 (45)	45	0,1 (—60...+50)	—40...+85	— —	
1 (45)	45	0,1 (—60...+50)	—40...+85	— —	
1 (45)	45	0,1 (—60...+50)	—40...+85	— —	

Тип прибора	$C_д$, пФ				$Q_в$		
	мин.	макс.	$U_{обр}$, В	$f_{изм}$, МГц	мин.	$U_{обр}$, В	$f_{изм}$, МГц
КВС111А	29,7	36,3	4	1	200	4	50
КВС111Б	29,7	36.3	4	1	150	4	50
КВ112А-1	9,6	14,4	4	1	200	4	50
КВ112Б-1	12,0	18,0	4	1	200	4	50
КВ113А	54,4	81,6	4	1	300		10
КВ113Б	54,4	81,6	4	1	300		10
КВ114А	54,4	81,6	4	1	300		10
КВ114Б	54,4	81,6	4	1	300		10
КВ115А	100	700	0	—	—	—	—
КВ115Б	100	700	0	—	—	—	—
КВ115В	100	700	0	—	—	—	—
КВ116А-1	168	252	1	1	100	1	1
КВ117А	26,4	39,6	3	1...10	180	—	1
КВ117Б	26,4	39.6	3	1...10	150	—	1
КВ119А	168	252	1	1...10	100	1	1
КВС120А	230	320	1	1...10	100	1	1
КВС120Б	230	320	1	1...10	100	1	1
КВС120А1	230	320	1	1...10	100	1	1

$I_{обр}$, мкА (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр}$, В	$P_{пр}$, Вт (при $T_{изм}$, °С)	T, °С	$\alpha_{C_в}$, 1/°С (при $U_{обр}$, В)	Габаритный чертеж корпуса
1 (30) 1 (30)	30 30	— — — —	—40...+100 —40...+100	$500\cdot10^{-6}$ (4) $500\cdot10^{-6}$ (4)	7,2; 2,8; 6
1 (25) 1 (25)	25 25	0,1 (50) 0,1 (50)	—40...+85 —40...+85	$5\cdot10^{-4}$ (4...25) $5\cdot10^{-4}$ (4...25)	1,2; 8; Ф0,9
10 (150) 10 (115)	150 115	0,1 (—60...+50) 0,1 (—60...+50)	—40...+85 —40...+85	$500\cdot10^{-6}$ (4) $500\cdot10^{-6}$ (4)	7,2; 3; 7,2
10 (150) 10 (115)	150 115	— — — —	—40...+85 —40...+85	$5\cdot10^{-4}$ (4) $5\cdot10^{-4}$ (4)	2; Ф2; 9
0,1 (50) 0,05 (50) 0,01 (50)	100 100 100	— — — — — —	—40...+85 —40...+85 —40...+85	— — — — — —	Ф7; 9; 15
0,5 (10)	10	— —	—40...+85	$2\cdot10^{-3}$ (1)	□1,2; □1,2
1 (25) 1 (25) 1 (10)	25 25 12	0,1 (50) 0,1 (50) — —	—40...+100 —40...+100 —40...+85	$600\cdot10^{-6}$ (3) $600\cdot10^{-6}$ (3) — —	Ф3; 7
0,5 (30) 0,5 (30)	32 32	— — — —	—45...+85 —45...+85	— — — —	Ф9,4; 6,6
0,5 (30)	32	— —	—45...+85	— —	Точка (катод); 6; 7,5; 3

Тип прибора	$C_д$, пФ				$Q_в$		
	мин.	макс.	$U_{обр}$, В	$f_{изм}$, МГц	мин.	$U_{обр}$, В	$f_{изм}$, МГц
КВ121А	4,3	6,0	25	1...10	200	25	50
КВ121Б	4,3	6,0	25	1...10	150	25	50
КВ122А	2,3	2,8	25	1	450	25	50
КВ122Б	2,0	2,3	25	1	450	25	50
КВ122В	1,9	3,1	25	1	300	25	50
КВ123А	2,6	3,8	25	1...10	250	25	50
КВ126А-5	2,6	3,8	25	1...10	200	25	50
КВ126АГ-5	2,6	3,8	25	1...10	200	25	50
КВ127А	230	280	1	1...10	140	1	10
КВ127Б	230	360	1	1...10	140	1	10
КВ127В	260	320	1	1...10	140	1	10
КВ127Г	230	320	1	1...10	140	1	10
КВ128А	22	28	1	1...10	300	—	50
КВ128АК	22	28	1	1...10	300	—	50
КВ129А	7,2	10,8	3	1...10	50	—	
КВ130А	3,7	4,5	12	1...10	300	—	50
КВ132А	38		1,6	1...10	300	4	50
КВ134А	486	594	1	1...10	400	4	50
КВ135А	486	594	1	1...10	150	1	1

$I_{обр}$, мкА (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр}$, В	$P_{пр}$, Вт (при $T_{изм}$, °С)	T, °С	$\alpha_{C_в}$, 1/°С (при $U_{обр}$, В)	Габаритный чертеж корпуса
0,5 (28)	30	— —	−40...+100	— —	КД-17
0,5 (28)	30	— —	−40...+100	— —	
0,2 (28)	30	— —	−40...+100	— —	
0,2 (28)	30	— —	−40...+100	— —	
0,2 (28)	30	— —	−40...+100	— —	
0,05 (25)	28	— —	−40...+100	$(500+300)\times10^{-6}$ (25)	КД-1А
0,5 (25)	28	— —	−60...+100	$800\cdot10^{-6}$ (4)	
0,5 (25)	28	— —	−60...+100	$800\cdot10^{-6}$ (4)	
0,5 (30)	32	— —	−60...+100	— —	КД-17
0,5 (30)	32	— —	−60...+100	— —	
0,5 (30)	32	— —	−60...+100	— —	
0,5 (30)	32	— —	−60...+100	— —	
0,05 (10)	12	— —	−60...+100	$800\cdot10^{-6}$ (4)	КД-1А
0,05 (10)	12	— —	−60...+100	$800\cdot10^{-6}$ (4)	
0,005 (8)	25	— —	−60...+100	$800\cdot10^{-6}$ (4)	
0,05 (28)	28	— —	−60...+100	— —	КД-17
0,005 (5)	12	— —	−60...+100	— —	
0,05 (10)	23	— —	−60...+100	— —	
0,05 (10)	13	— —	−60...+100	— —	КД-129

Тип прибора	$C_д$, пФ				$Q_в$		
	мин.	макс.	$U_{обр}$, В	$f_{изм}$, МГц	мин.	$U_{обр}$, В	$f_{изм}$, МГц
КВ136А	17,1	18,9	4	10	400	4	40
КВ136Б	19,8	24,2	4	10	400	4	40
КВ136В	17,1	18,9	4	10	500	4	40
КВ136Г	19,8	24,2	4	10	500	4	40
КВ138А	14	18	2	10	200	3	50
КВ138Б	17	21	2	10	200	3	50
КВ139А	500	620	1	10	160	1,5	1
КВ142А	60	85	10	—	300	—	1
КВ142Б	70	115	10	—	300	—	1
Д901А	22	32	4	10	25	4	50
Д901Б	22	32	4	10	30	4	50
Д901В	28	38	4	10	25	4	50
Д901Г	28	38	4	10	30	4	50
Д901Д	34	44	4	10	25	4	50
Д901Е	34	44	4	10	30	4	50
Д902	6	12	4	50	30	4	50

$I_{обр}$, мкА (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр}$, В	$P_{пр}$, Вт (при $T_{изм}$, °С)	T, °С	$\alpha C_в$, 1/°С (при $U_{обр}$, В)	Габаритный чертеж корпуса
0,02 (25)	30	— —	−60...+125	$4\cdot10^{-4}$ (4)	
0,02 (25)	30	— —	−60...+125	$4\cdot10^{-4}$ (4)	
0,02 (25)	30	— —	−60...+125	$4\cdot10^{-4}$ (4)	
0,02 (25)	30	— —	−60...+125	$4\cdot10^{-4}$ (4)	
0,05 (5)	12	— —	−60...+100	$8\cdot10^{-4}$ (2)	КД-17
0,05 (5)	12	— —	−60...+100	$8\cdot10^{-4}$ (2)	
0,5 (12)	16	0,6 мВт (100)	−60...+100	$8\cdot10^{-4}$ (3)	КД-129
0,05 (32)	32	— —	−60...+100	$4{,}3\cdot10^{-4}$ (1)	КД-17
0,05 (32)	32	— —	−60...+100	$4{,}3\cdot10^{-4}$ (1)	
1 (80)	80	250 (25)	−60...+125	(45)	
1 (45)	45	250 (25)	−60...+125	$200\cdot10^{-6}$ (45)	
1 (80)	80	250 (25)	−60...+125	$200\cdot10^{-6}$ (45)	
1 (45)	45	250 (25)	−60...+125	$200\cdot10^{-6}$ (45)	
1 (80)	80	250 (25)	−60...+125	$200\cdot10^{-6}$ (45)	
1 (45)	45	250 (25)	−60...+125	$200\cdot10^{-6}$ (45)	
10 (25)	25	— —	−40...+100	— —	

2.4. Параметры стабилитронов и стабисторов

Тип прибора	$U_{ст}$, В				$\alpha U_{ст}$, %/°C	$\delta U_{ст}$, %	$U_{пр}$, В (при $I_{пр}$, мА)	$r_{ст}$, Ом (при $I_{ст}$, мА)	$I_{ст}$, мА		$P_{пр}$, Вт	T, °C	Габаритный чертеж корпуса
	мин.	ном.	макс.	$I_{ст}$, мА					мин.	макс.			
Д219С	—	0,57	—	1	—	—	— —	— —	1	50	—	—60...+120	
Д220С	—	0,59	—	1	—	—	— —	— —	1	50	—	—60...+120	
Д223С	—	0,59	—	1	—	—	— —	— —	1	50	—	—60...+120	
Д808	7	—	8,5	5	0,07	±1	1 (50)	12 (1)	3	33	0,28	—60...+125	
Д809	8	—	9,5	5	0,08	±1	1 (50)	18 (1)	3	29	0,28	—60...+125	
Д810	9	—	10,5	5	0,09	±1	1 (50)	25 (1)	3	26	0,28	—60...+125	
Д811	10	—	12	5	0,095	±1	1 (50)	30 (1)	3	23	0,28	—60...+125	
Д813	11,5	—	14	5	0,095	±1	1 (50)	350 (1)	3	20	0,28	—60...+125	
Д814А	7	—	8,5	5	0,07	±1	1 (50)	6 (5)	3	40	0,34	—60...+125	
Д814Б	8	—	8,5	5	0,08	±1	1 (50)	10 (5)	3	36	0,34	—60...+125	
Д814В	9	—	10,5	5	0,09	±1	1 (50)	12 (5)	3	32	0,34	—60...+125	
Д814Г	10	—	12	5	0,095	±1	1 (50)	15 (5)	3	29	0,34	—60...+125	
Д814Д	11,5	—	14	5	0,095	±1	1 (50)	18 (5)	3	24	0,34	—60...+125	
Д815А	5	—	6,2	1 А	0,045	4	1,5 (500)	0,6 (1 А)	50	1,4 А	8	—60...+125	
Д815Б	6,1	—	7,5	1 А	0,05	4	1,5 (500)	0,8 (1 А)	50	1,15А	8	—60...+125	
Д815В	7,4	—	9,1	1 А	0,07	4	1,5 (500)	1,0 (1 А)	50	950	8	—60...+125	
Д815Г	9,0	—	11	500	0,08	4	1,5 (500)	1,8 (500)	25	800	8	—60...+125	
Д815Д	10,8	—	13,3	500	0,09	4	1,5 (500)	2,0 (500)	25	650	8	—60...+125	
Д815Е	13,3	—	16,4	500	0,10	4	1,5 (500)	2,5 (500)	25	550	8	—60...+125	
Д815Ж	16,2	—	19,8	500	0,11	4	1,5 (500)	3,0 (500)	25	450	8	—60...+125	
Д816А	19,6	—	24,2	150	0,12	5	1,5 (500)	7,0 (150)	10	230	5	—60...+130	
Д816Б	24,2	—	29,5	150	0,12	5	1,5 (500)	8,0 (150)	10	180	5	—60...+130	
Д816В	29,5	—	36	150	0,12	5	1,5 (500)	10,0 (150)	10	150	5	—60...+130	
Д816Г	35	—	43	150	0,12	5	1,5 (500)	12,0 (150)	10	130	5	—60...+130	
Д816Д	42,5	—	51,5	150	0,12	5	1,5 (500)	15,0 (150)	110	110	5	—60...+130	
Д817А	50,5	—	61,5	50	0,14	6	1,5 (500)	35 (50)	5	90	5	—60...+130	
Д817Б	61	—	75	50	0,14	6	1,5 (500)	40 (50)	5	75	5	—60...+130	
Д817В	74	—	90	50	0,14	6	1,5 (500)	45 (50)	5	60	5	—60...+130	
Д817Г	90	—	110	50	0,14	6	1,5 (500)	50 (50)	5	50	5	—60...+130	
Д818А	—	9	10,35	10	+0,020	±0,11	— —	70 (3)	3	33	0,3	—60...+125	
								18 (10)	3	33	0,3	—60...+125	
Д818Б	7,65	9	—	10	—0,029	±0,13	— —	18 (10)	3	33	0,3	—60...+125	
Д818В	8,1	9	9,9	10	±0,01	±0,12	— —	18 (10)	3	33	0,3	—60...+125	
Д818Г	8,55	9	9,45	10	±0,005	±0,12	— —	18 (10)	3	33	0,3	—60...+125	
Д818Д	8,55	9	9,45	10	±0,002	±0,12	— —	18 (10)	3	33	0,3	—60...+125	
Д818Е	8,55	9	9,45	10	±0,001	±0,12	— —	18 (10)	3	33	0,3	—60...+125	
КС107А	—	0,7	—	10	—0,3	—	— —	— —	1	100	—	—60...+125	
КС113А	—	1,3		10	—0,3	—	— —	12 (10)	1	100	—	—60...+125	
КС115А	—	1,45	—	3	—	—	— —	— —	—	3	0,23	—60...+125	

КС119А КС133А	— —	1,9 3,3	— —	10 10	−0,3 −0,11	— —	— — 1 (50)	15 (10) 65 (10)	1 3	100 81	— 0,3	−60...+125 −60...+125
КС133Г	2,95	—	3,65	5	—	—	— —	150 (5)	1	37,5	125 мВт	−60...+125
КС139А	—	3,3	—	10	−0,1	—	1 (50)	60 (10)	3	79	0,3	−60...+125
КС139Г	3,5	—	4,3	5	—	—	— —	150 (5)	1	32	125 мВт	−60...+125
КС147А	—	4,7	—	10	−0,09	—	1 (50)	56 (10)	3	58	0,3	−60...+125
КС147Г	4,2	—	5,2	5	—	—	— —	150 (5)	1	26,5	125 мВт	−60...+125
КС156А	—	5,6	—	10	+0,05	—	1 (50)	46 (10)	3	55	0,3	−60...+125
КС156Г	5,0	—	6,2	5	—	—	— —	100 (5)	1	22,4	125 мВт	−60...+125
КС162А	—	6,2	—	10	±0,06	±1,5	— —	35 (10)	3	22	0,15	−55...+100

Продолжение

Тип прибора	$U_{ст}$, В				$\alpha U_{ст}$, %/°C	$\delta U_{ст}$, %	$U_{пр}$, В (при $I_{пр}$, мА)	$r_{ст}$, Ом (при $I_{ст}$, мА)	$I_{ст}$, мА		$P_{пр}$, Вт	T, °C	Габаритный чертеж корпуса
	мин.	ном.	макс.	$I_{ст}$, мА					мин.	макс.			
КС168А	—	6,8	—	10	+0,06	—	1 (50)	28 (10)	3	45	0,3	—60...+125	
КС168В	—	6,8	—	10	±0,05	±1,5	— —	28 (10)	3	20	0,15	—55...+100	
КС170А	6,65	7	7,35	10	±0,01	±1,5	— —	20 (10)	3	20	0,15	—55...+100	
КС175А	—	7,5	—	5	±0,04	±1,5	— —	16 (5)	3	18	0,15	—55...+100	
КС175Е	7,1	7,5	7,9	5	±0,1	—	— —	— —	3	17	0,125	—60...+125	
КС175Ж	7,1	7,5	7,9	4	0,07	±1,5	— —	40 (4)	0,5	17	125 мВт	—60...+125	
КС182А	—	8,2	—	5	±0,05	±1,5	— —	14 (5)	3	17	0,15	—55...+100	
КС182Е	7,4	8,2	9	5	±0,1	—	— —	— —	3	15	0,125	—60...+125	
КС182Ж	7,4	8,2	9	4	0,08	±1,5	— —	40 (4)	0,5	15	125 мВт	—60...+125	
КС190Б	8,5	9	9,5	10	±0,005	—	— —	15 (10)	5	15	0,1	—60...+125	
КС190В	8,5	9	9,5	10	±0,002	—	— —	15 (10)	5	15	0,1	—60...+125	
КС190Г	8,5	9	9,5	10	±0,001	—	— —	15 (10)	5	15	0,1	—60...+125	
КС190Д	8,5	9	9,5	10	±0,0005	—	— —	15 (10)	5	15	0,1	—60...+125	
КС191А	—	9,1	—	5	±0,06	±1,5	— —	18 (5)	3	15	0,15	—55...+100	
КС191Е	8,6	9,1	9,6	5	±0,1	—	— —	— —	3	14	0,125	—60...+125	
КС191Ж	8,6	9,1	9,6	4	0,09	±1,5	— —	40 (4)	0,5	14	125 мВт	—60...+125	

КС191М	8,65	9,1	9,55	10	±0,005	±0,05	—	—	18 (10)	5	15	0,15	—60...+100
КС191Н	8,65	9,1	9,55	10	±0,002	±0,05	—	—	18 (10)	5	15	0,15	—60...+100
КС191П	8,65	9,1	9,55	10	±0,001	±0,05	—	—	18 (10)	5	15	0,15	—60...+100
КС191Р	8,65	9,1	9,55	10	±0,0005	±0,05	—	—	18 (10)	5	15	0,15	—60...+100
КС191С	8,65	9,1	9,55	10	±0,005	±2 мВ	—	—	70 (3)	3	20	0,2	—60...+100
КС191Т	8,65	9,1	9,55	10	±0,0025	±2 мВ	—	—	70 (3)	3	20	0,2	—60...+100
КС191У	8,65	9,1	9,55	10	±0,0001	±2 мВ	—	—	70 (3)	3	20	0,2	—60...+100
КС191Ф	8,65	9,1	9,55	10	±0,0005	±2 мВ	—	—	70 (3)	3	20	0,2	—60...+100
КС210Б	—	10	—	5	±0,07	±1,5	—	—	22 (5)	3	14	0,15	—55...+100
КС210Е	9	10	11	5	±0,1	—	—	—	— —	3	13	0,125	—60...+125
КС210Ж	9	10	11	4	0,09	±1,5	—	—	40 (4)	0,5	13	125 мВт	—60...+125
КС211Б	17	11	12,6	10	+0,02	—	—	—	30 (5)	5	33	0,28	—60...+100
КС211В	9,3	11	11	10	—0,02	—	—	—	30 (5)	5	33	0,28	—60...+125
КС211Г	9,9	11	12,1	10	±0,01	—	—	—	30 (5)	5	33	0,28	—60...+125
КС211Д	9,9	11	12,1	10	±0,005	—	—	—	30 (5)	5	33	0,28	—60...+125
КС211Е	10,4	11	11,6	5	±0,1	—	—	—	— —	3	12	0,125	—60...+125
КС211Ж	10,4	11	11,6	4	0,092	±1,5	—	—	40 (4)	0,5	12	125 мВт	—60...+125
КС212Е	10,8	12	13,2	5	±0,1	—	—	—	— —	3	11	0,125	—60...+125
КС212Ж	10,8	12	13,2	4	0,095	±1,5	—	—	40 (4)	0,5	11	125 мВт	—60...+125
КС213Б	—	13	—	5	+0,08	±1,5	—	—	25 (5)	3	10	0,15	—55...+100
КС213Е	12,3	13	13,7	5	±0,1	—	—	—	— —	3	10	0,125	—60...+125
КС213Ж	12,3	13	13,7	4	0,095	±1,5	—	—	40 (4)	0,5	10	125 мВт	—60...+125
КС215Ж	13,5	15	16,5	2	0,1	±1,5	—	—	70 (2)	0,5	8,3	125 мВт	—60...+125
КС216Ж	15,2	16	16,8	2	0,1	±1,5	—	—	70 (2)	0,5	7,3	125 мВт	—60...+125
КС218Ж	16,2	18	19,8	2	0,1	±1,5	—	—	70 (2)	0,5	6,9	125 мВт	—60...+125
КС220Ж	19	20	21	2	0,1	±1,5	—	—	70 (2)	0,5	6,2	125 мВт	—60...+125
КС222Ж	19,8	22	24,2	2	0,1	±1,5	—	—	70 (2)	0,5	5,7	125 мВт	—60...+125
КС224Ж	22,8	24	25,2	2	0,1	±1,5	—	—	70 (2)	0,5	5,2	125 мВт	—60...+125

Окончание

Тип прибора	$U_{ст}$, В				$\alpha_{U_{ст}}$, %/°C	$\delta U_{ст}$, %	$U_{пр}$, В (при $I_{пр}$, мА)	$r_{ст}$, Ом (при $I_{ст}$, мА)	$I_{ст}$, мА		$P_{пр}$, Вт	T, °C	Габаритный чертеж корпуса
	мин.	ном.	макс.	$I_{ст}$, мА					мин.	макс.			
КС433А	2,97	3,3	3,89	30	—0,1	±1,5	— —	25 (30)	3	191	1	—60...+100	
КС439А	3,52	3,9	4,69	30	—0,1	±1,5	— —	25 (30)	3	176	1	—60...+100	
КС447А	4	4,7	5,3	30	—0,08	±1,5	— —	18 (30)	3	159	1	—60...+100	
КС456А	4,82	5,6	6,16	30	0,05	±1,5	— —	10 (30)	3	139	1	—60...+100	
КС468А	5,78	6,8	7,48	30	0,065	±1,5	— —	5 (30)	3	119	1	—60...+100	
КС482А	6,98	8,2	9	5	0,08	±1,5	1 (50)	200 (1)	1	96	1	—60...+100	
КС510А	8,2	10	11	5	0,1	±1,5	1 (50)	200 (1)	1	79	1	—60...+100	
КС512А	9,9	12	13,2	5	0,1	±1,5	1 (50)	200 (1)	1	67	1	—60...+100	
КС515А	12,3	15	16,5	5	0,1	±1,5	1 (50)	200 (1)	1	53	1	—60...+100	
КС518А	14,7	18	19,8	5	0,1	±1,5	1 (50)	200 (1)	1	45	1	—60...+100	
КС520В	19	20	21	5	±0,001	—	— —	210 (3)	3	22	0,5	—55...+100	
КС522А	17,9	22	24,2	5	0,1	±1,5	1 (50)	200 (1)	1	37	1	—60...+100	
КС527А	22,0	27	29,7	5	0,1	±1,5	1 (50)	200 (1)	1	30	1	—60...+100	
КС531В	29,45	31	32,55	10	±0,005	—	— —	350 (3)	3	15	0,5	—50...+100	
КС533А	29,7	33	36,3	10	0,1	—	1 (50)	100 (3)	3	17	640 мВт	—40...+125	КД-25
КС547В	44,65	47	49,35	5	±0,001	—	— —	490 (3)	3	10	0,5	—50...+100	

КС551А	48	51	54	1,5	±0,12	±1,5	1 (50)	200 (1,5)	1	14,6	1	—60...+125
КС568В	64,6	68	71,4	5	±0,001	—	— —	700 (3)	3	10	0,72	—50...+100
КС591А	86	91	96	1,5	±0,12	±1,5	1 (50)	400 (1,5)	1	8,8	1	—60...+125
КС596В	91,2	96	100,8	5	±0,001	—	— —	980 (3)	3	7	0,72	—50...+100
КС600А	95	100	105	1,5	±0,12	±1,5	1 (50)	450 (1,5)	1	8,1	1	—60...+125
КС620А	102	120	138	50	0,1	—	1,5 (500)	150 (50)	5	42	5	—60...+100
КС630А	110,5	130	149,5	50	0,2	—	1,5 (500)	180 (50)	5	38	5	—60...+100
КС650А	127,5	150	172,5	25	0,2	—	1,5 (500)	270 (25)	2,5	33	5	—60...+100
КС680А	153	180	207	25	0,2	—	1,5 (500)	330 (25)	2,5	28	5	—60...+100

Раздел 3.

Транзисторы

3.1. Биполярные транзисторы

Биполярные транзисторы представляют собой полупроводниковые приборы с двумя *p-n* переходами, имеют три электрода (эмиттер, база, коллектор) и применяются для усиления и переключения электрических сигналов.

Среди транзисторов имеются приборы как общего назначения (в том числе усилительные, переключательные и генераторные), так и специализированные, отличающиеся специфическим сочетанием параметров: для применения в схемах с автоматической регулировкой усиления, для работы в микроамперном диапазоне токов, двухэмиттерные, однопереходные, сдвоенные и счетверенные, с малой емкостью обратной связи, универсальные (по сочетанию параметров), комплементарные пары транзисторов, составные и лавинные транзисторы.

В связи с тем, что датчики контролируемых параметров (например, термопары, мостовые схемы с термосопротивлением) имеют выходные напряжения, изменяющиеся от десятков микровольт до десятков милливольт, то транзисторные модуляторы, преобразующие эти малые напряжения постоянного тока в переменные для последующего усиления, должны иметь хорошие метрологические характеристики. При работе транзистора в качестве модулятора ключевым элементом служит промежуток коллектор-эмиттер, сопротивление которого изменяется в зависимости от полярности управляющего напряжения, приложенного к одному из *p-n* переходов транзистора. Различают работу такого ключа в нормальном включении (управляющее напряжение $U_у$ приложено между базой и эмиттером) и инверсном включении ($U_у$ приложено между базой и коллектором). Если $U_у$ приложено, например, в *p-n-p* транзисторе минусом к базе, то оба перехода транзистора будут смещены в прямом направлении (режим насыщения — ключ открыт). При изменении полярности $U_у$ оба перехода смещаются в обратном направлении (режим отсечки — ключ закрыт). В реальном режиме точки пересечения прямых режима насыщения и режима отсечки не совпадают с началом координат. Поэтому промежуток коллектор-эмиттер характеризуется остаточным сопротивлением $r_{ост}$ и напряжением $U_{ост}$ в открытом состоянии, а также сопротивлением $r_{закр}$ и остаточным током $I_{закр}$ в закрытом состоянии (у идеального ключа $r_{ост}=0$, $U_{ост}=0$, $r_{закр}=\infty$, $I_{закр}=0$). Остаточные параметры ограничивают значение (уровень) полезной мощности в нагрузке. Следует отметить, что транзисторный ключ в инверсном включении имеет примерно на порядок меньшие значения $U_{ост}$ и $I_{закр}$, чем в прямом включении (особенно для сплавных транзисторов, у которых площадь коллектора много больше площади эмиттера).

Для некоторых транзисторов (например, КТ209) нормируются остаточные параметры. Кроме того, разработаны двухэмиттерные транзисторы, которые имеют еще меньшие значения остаточных параметров (например, КТ118).

Транзистор типа КТ339, предназначенный специально для работы в усилителях промежуточной частоты (УПЧ), имеет малую емкость обратной связи, что позволяет обеспечить стабильное усиление без использования внешних дополнительных цепей нейтрализации. Транзисторы типов ГТ328 и КТ3128 предназначены для применения в радиоприемниках с автоматической регулировкой усиления, телевизорах (каскады ПТК и УПЧ), блоках УКВ приемников: за счет смещения их рабочей точки можно регулировать усиление в широком диапазоне. Комплементарные транзисторы (со структурами *p-n-p* и *n-p-n*) ГТ402 и ГТ403, ГТ703 и ГТ705, КТ502 и КТ503, КТ680 и КТ681, КТ814 и КТ815, КТ816 и КТ817, КТ818 и КТ819 могут использоваться в паре в схемах с дополнительной симметрией.

Имеется также группа транзисторов в миниатюрном корпусе для поверхностного монтажа в составе гибридных микросхем (например, малошумящие КТ3129 и КТ3130; переключательные КТ3145 и КТ3146,для работы в ключевых схемах, модуляторах, преобразователях, линейных стабилизаторах напряжения КТ664 и КТ665; для СВЧ усилителей КТ3168, КТ3169).

Транзисторы универсального назначения (например, КТ630) имеют оптимальное сочетание параметров и характеристик, удовлетворяющих различным требованиям, что позволяет использовать их в аппаратуре вместо некоторых усилительных и переключательных транзисторов.

Лавинные транзисторы ГТ338 и КТ3122 предназначены для работы в режиме электрического пробоя коллекторного перехода. Они применяются в релаксационных генераторах в ждущем или автоколебательном режиме и позволяют получить необходимые быстродействие и амплитуду импульсов с более высокими надежностью и стабильностью, чем обычные транзисторы, используемые в режиме электрического пробоя.

Составные транзисторы представляют собой соединение двух биполярных транзисторов по определенной схеме (например, в схеме Дарлингтона соединены коллекторы, входом служит база первого транзистора, а эмиттером — эмиттер второго более мощного транзистора). Такие транзисторы функционально соответствуют одному транзистору с высоким коэффициентом передачи тока, примерно равным произведению коэффициентов передачи составляющих его одиночных транзисторов. Составные транзисторы (например, КТ712, КТ825, КТ827, КТ829, КТ834, КТ852, КТ853, КТ973) применяются в стабилизаторах напряжения непрерывного и импульсного действия, бесконтактных электронных системах зажигания в двигателях внутреннего сгорания (например, КТ848), устройствах управления двигателями, в различных усилительных и переключательных устройствах.

Для экономичной радиоэлектронной аппаратуры созданы маломощные кремниевые транзисторы с различной структурой, которые могут нормально функционировать в микроамперном диапазоне токов (например, КТ3102, КТ3107,

КТ3129, КТ3130).

Кроме того, разработаны транзисторы:

высоковольтные для оконечных каскадов строчной развертки черно-белых и цветных телевизоров (например, КТ872);

импульсные для работы на индуктивную нагрузку (КТ997);

для высококачественных усилителей низкой частоты (КТ9115), линейных высокочастотных каскадов класса А и широкополосных усилителей (КТ939);

для схем с повышенной устойчивостью к интермодуляционным искажениям (КТ3109);

для сбалансированных фазоинверсных каскадов высококачественных УНЧ и видеоусилителей телевизоров (КТ940, КТ9115);

для высокочастотных широкополосных усилителей с малой постоянной времени $\tau_к$ (КТ368);

для строчной и кадровой разверток телевизоров (КТ805);

для УНЧ и кадровой развертки телевизоров (КТ807);

для линейных и импульсных устройств (КТ315 — первый отечественный прибор в пластмассовом корпусе);

универсальные транзисторы для вычислительных устройств (КТ349, КТ350, КТ351, КТ352);

для предварительных каскадов видеоусилителей телевизоров (КТ342);

для применения в ключевых схемах, прерывателях, модуляторах и демодуляторах, во входных каскадах усилителей (КТ201 и КТ203);

высоковольтные для строчной развертки телевизоров (КТ808) — при непосредственном включении отклоняющих катушек в цепь коллектора они выдерживают импульсы 800...1000 В;

для мощных модуляторов (КТ917 и КТ926).

3.2. Буквенные обозначения параметров биполярных транзисторов

Ниже приводятся буквенные обозначения параметров транзисторов, соответствующие публикации МЭК 148 и стандартизованные ГОСТ 20003—74.

Буквенное обозначение по ГОСТ 2003—74		Параметр
отечественное	международное	
$I_{КБО}$	I_{CBO}	Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор — база и разомкнутом выводе эмиттера
$I_{ЭБО}$	I_{EBO}	Обратный ток эмиттера — ток через эмиттерный переход при заданном обратном напряжении эмиттер — база и разомкнутом выводе коллектора
$I_{КЭО}$	I_{CEO}	Обратный ток коллектор — эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор — эмиттер и разомкнутом выводе базы
$I_{КЭR}$	I_{CER}	Обратный ток коллектор — эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор — эмиттер и сопротивлении в цепи база — эмиттер
$I_{КЭК}$	I_{CES}	Обратный ток коллектор — эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор — эмиттер и короткозамкнутых выводах базы и эмиттера
$I_{КЭV}$	I_{CEV}	Обратный ток коллектор — эмиттер при запирающем напряжении (смещении) в цепи база — эмиттер
$I_{КЭХ}$	I_{CEX}	Обратный ток коллектор — эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор — эмиттер и обратном напряжении база — эмиттер
$I_{К\,max}$	$I_{C\,max}$	Максимально допустимый постоянный ток коллектора
$I_{Э\,max}$	$I_{E\,max}$	Максимально допустимый постоянный ток эмиттера
$I_{Б\,max}$	$I_{B\,max}$	Максимально допустимый постоянный ток базы
$I_{К,\,и\,max}$	$I_{CM\,max}$	Максимально допустимый импульсный ток коллектора
$I_{Э,\,и\,max}$	$I_{EM\,max}$	Максимально допустимый импульсный ток эмиттера
$I_{кр}$	—	Критический ток биполярного транзистора
$U_{КБО\,проб}$	$U_{(BR)\,CBO}$	Пробивное напряжение коллектор — база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера
$U_{ЭБО\,проб}$	$U_{(BR)\,EBO}$	Пробивное напряжение эмиттер — база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора
$U_{КЭО\,проб}$	$U_{(BR)\,CEO}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданном токе коллектора и разомкнутой цепи базы
$U_{КЭR\,проб}$	$U_{(BR)\,CER}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданном токе коллектора и заданном (конечном) сопротивлении в цепи база — эмиттер
$U_{КЭК\,проб}$	$U_{(BR)\,CES}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданном токе коллектора и короткозамкнутых выводах базы и эмиттера
$U_{КЭV\,проб}$	$U_{(BR)\,CEV}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при запирающем напряжении в цепи база — эмиттер
$U_{КЭХ\,проб}$	$U_{(BR)\,CEX}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданных обратных напряжениях база — эмиттер и установленном значении тока $I_К$

Буквенное обозначение по ГОСТ 2003—74		Параметр
отечественное	международное	
$U_{КЭО\,гр}$	$U_{(L)\,CEO}$	Граничное напряжение транзистора — напряжение между коллектором и эмиттером при разомкнутой цепи базы и заданном токе эмиттера
$U_{СМК}$	U_{pt}	Напряжение смыкания транзистора
$U_{КЭ\,нас}$	$U_{CE\,sat}$	Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при заданных токах базы и коллектора
$U_{БЭ\,нас}$	$U_{BE\,sat}$	Напряжение насыщения база — эмиттер при заданных токах базы и коллектора
$U_{ЭБ\,пл}$	$U_{EB\,fl}$	Плавающее напряжение эмиттер — база — напряжение между эмиттером и базой при заданном обратном напряжении коллектор — база и разомкнутой цепи эмиттера
$U_{КБ\,max}$	$U_{CB\,max}$	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор — база
$U_{КЭ\,max}$	$U_{CE\,max}$	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор — эмиттер
$U_{ЭБ\,max}$	$U_{EB\,max}$	Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер — база
$U_{КЭ,\,и\,max}$	$U_{CEM\,max}$	Максимальное допустимое импульсиое напряжение коллектор — эмиттер
$U_{КБ,\,и\,max}$	$U_{CBM\,max}$	Максимальио допустимое импульсное напряженне коллектор — база
$U_{ЭБ,\,и\,max}$	$U_{EBM\,max}$	Максимальио допустимое импульсное напряжение эмиттер — база
P	P_{tot}	Постоянная рассеиваемая мощность транзистора
$P_{ср}$	P_{AV}	Средняя рассеиваемая мощность транзистора
$P_{И}$	P_{RM}	*Импульсная рассеиваемая мощность транзистора*
$P_{К}$	P_{C}	Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
$P_{К,\,т\,max}$	—	Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом
$P_{вых}$	P_{out}	Выходная мощность транзистора
$P_{и\,max}$	$P_{M\,max}$	Максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность
$P_{К\,max}$	$P_{C\,max}$	Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора
$P_{К\,ср\,max}$	—	Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность коллектора
$r'_{б}$	r'_{bb}, r'_{b}	Сопротивление базы
$r_{КЭ\,нас}$	$r_{CE\,sat}$	Сопротивление насыщения
$C_{11э}$, $C_{11б}$	C_{11e}, $C_{11в}$	Входная емкость транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$C_{22э}$, $C_{22б}$	C_{22e}, $C_{22в}$	Выходная емкость транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$C_{к}$	C_{c}	Емкость коллекторного перехода
$C_{э}$	C_{e}	Емкость эмиттерного перехода
$f_{гр}$	$f_{т}$	Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером
f_{max}	f_{max}	Максимальная частота генерации
$f_{h21э}$, $f_{h21б}$	f_{h21e}, f_{hfe}; $f_{h21в}$, f_{hfb}	Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой
$t_{вкл}$	t_{on}	Время включения
$t_{выкл}$	t_{off}	Время выключения
$t_{зд}$	t_{d}	Время задержки
$t_{нр}$	t_{r}	Время нарастания
$t_{рас}$	t_{s}	Время рассасывания
$t_{сп}$	t_{f}	Время спада
$h_{11э}$, $h_{11б}$	h_{11e}, h_{11b}, h_{ie}, h_{ib}	Входное сопротивление в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и с общей базой
$h_{21э}$, $h_{21б}$	h_{21e}, h_{21b}; h_{fe}, h_{fb}	Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и базой соответственно
$h_{12э}$, $h_{12б}$	h_{12e}, h_{12b}; h_{re}, h_{rb}	Коэффициент обратной связи по напряжению транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$h_{22э}$, $h_{22б}$	h_{22e}, h_{22b}; h_{oe}, h_{ob}	Выходная полная проводимость транзистора в режиме малого сигиала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$\|h_{21э}\|$	$\|h_{21e}\|$	Модуль коэффициента передачи тока транзистора на высокой частоте
$h_{11Э}$	h_{11E}, h_{IE}	Входное сопротивление транзистора в режиме большого сигнала для схемы с общим эмиттером
$h_{21Э}$	h_{21E}, h_{FE}	Статический коэффициент передачи тока для схемы с общим эмиттером в режиме большого сигнала
$Y_{21Э}$	Y_{21E}	Статическая крутизна прямой передачи в схеме с общим эмиттером
$y_{11э}$, $y_{11б}$	y_{11e}, y_{11b}; y_{ie}, y_{ib}	Входная полная проводимость траизистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$y_{12э}$, $y_{12б}$	y_{12e}, y_{12b}; y_{re}, y_{rb}	Полная проводимость обратной передачи транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$y_{21э}$, $y_{21б}$	y_{21e}, y_{21b}; y_{fe}, y_{fb}	Полная проводимость прямой передачи транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$y_{22э}$, $y_{22б}$	y_{22e}, y_{22b}; y_{oe}, y_{ob}	Выходная полиая проводимость траизистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$S_{11э}$, $S_{11б}$, $S_{11к}$	S_{11e}, S_{11b}, S_{11c}; S_{ie}, S_{ib}, S_{ic}	Коэффициеит отражения входной цепи транзистора для схем с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно

Буквенное обозначение по ГОСТ 2003—74		Параметр
отечественное	международное	
$S_{12э}$, $S_{12б}$, $S_{12к}$	S_{12e}, S_{12b}, S_{12c}, S_{re}, S_{rb}, S_{rc}	Коэффициент обратной передачи напряжения для схемы с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно
$S_{22э}$, $S_{22б}$, $S_{22к}$	S_{22e}, S_{22b}, S_{22c}; S_{oe}, S_{ob}, S_{oc}	Коэффициент отражения выходной цепи транзистора для схемы с общим эмиттером, общей базой, общим коллектором соответственно
$S_{21э}$, $S_{21б}$, $S_{21к}$	S_{21e}, S_{21b}, S_{21c}; S_{fe}, S_{fb}, S_{fc};	Коэффициент прямой передачи для схем с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором соответствеино
—	f_{se}, f_{sb}, f_{sc}	Частота, при которой коэффициент прямой передачи равен 1 ($\|S_{21e}\|=1$, $\|S_{21b}\|=1$, $\|S_{21c}\|=1$)
$K_{у, P}$	G_P	Коэффициент усиления по мощности
—	G_A, G_a	Номинальный коэффициент усиления по мощности
$K_ш$	F	Коэффициент шума транзистора
$\tau_к$, $r'_б C_к$	τ_c, $r'_{bb} C_c$	Постоянная времени цепи обратной связи иа высокой частоте
T	T_A, T_{amb}	Температура окружающей среды
$T_к$	T_c, T_{case}	Температура корпуса
$T_п$	T_j, T_J	Температура перехода
$R_{т, п-с}$	R_{thja}	Тепловое сопротивление от перехода к окружающей среде
$R_{т, п-к}$	R_{thjc}	Тепловое сопротивление от перехода к корпусу
$R_{т, к-с}$	R_{thca}	Тепловое сопротивление от корпуса к окружающей среде
$\tau_{т, п-к}$	τ_{thjc}	Тепловая постоянная времени переход — корпус
$\tau_{т, п-с}$	τ_{thja}	Тепловая постоянная времени переход — окружающая среда
$\tau_{т, к-с}$	τ_{thca}	Тепловая постоянная времени корпус — окружающая среда

3.3. Параметры германиевых транзисторов

В таблицах параметров германиевых и кремниевых транзисторов приняты следующие обозначения технологий их изготовления: С — сплавные, Д — диффузионные, ТД — тройной диффузии; СД — сплавно-диффузионные; К — конверсионные; М — меза; П — планарные; ПЭ — планарно-эпитаксиальные.

Режимы измерения параметров $h_{21э}$ ($U_К$, $I_К$), $I_{КБО}$ ($U_К$), $C_К$ ($U_К$), $K_ш$ ($f_{изм}$), $P_{вых}$ ($f_{изм}$) указывают в скобках.

Режим измерения параметра $U_{КЭR\,проб}$ указывается в скобках для конкретного сопротивления в цепи базы в килоомах (к).

Значения параметров приводятся для температуры окружающей среды $T=25$ °С.

Для параметров $I_{КБО}$, $f_{гр}$, $t_{выкл}$, $К_ш$ и других приводятся знаки $\geqslant$ (больше) или $\leqslant$ (меньше). Если они отсутствуют, то уквзывается типовое значение параметра.

В некоторых графах таблиц приводятся несколько параметров, отмеченных*, **, ***, которым соответствуют зиачения с теми же знаками.

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^*_{К,т\,max}$, $P^{**}_{К,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
МП9А	*n-p-n*, С	150	⩾1*	15	15	20 (150)*	⩽30* (30 В)
МП10	*n-p-n*, С	150	⩾1*	15	15	20 (150*)	⩽30* (30 В)
МП10А	*n-p-n*, С	150	⩾1*	30	30	20 (150)*	⩽30* (30 В)
МП10Б	*n-p-n*, С	150	⩾1*	30	30	20 (150)*	⩽50* (30 В)
МП11	*n-p-n*, С	150	⩾2*	15	15	20 (150)*	⩽30* (30 В)
МП11А	*n-p-n*, С	150	⩾2*	15	15	20 (150)*	⩽30* (30 В)
МП13	*p-n-p*, С	150	⩾0,5*	15	15	20 (150)*	⩽30 (15 В)
МП13Б	*p-n-p*, С	150	⩾1*	15	15	20 (150)*	⩽30 (15 В)
МП14	*p-n-p*, С	150	⩾1*	15	15	20 (150)*	⩽30 (15 В)
МП14А	*p-n-p*, С	150	⩾1*	30	30	20 (150)*	⩽30 (30 В)
МП14Б	*p-n-p*, С	150	⩾1*	30	30	20 (150)*	⩽50 (30 В)
МП14И	*p-n-p*, С	150	⩾1*	30	30	20 (150)*	⩽50 (30 В)
МП15	*p-n-p*, С	150	⩾2*	15	15	20 (150)*	⩽30 (15 В)
МП15А	*p-n-p*, С	150	⩾2*	15	15	20 (150)*	⩽30 (15 В)
МП15И	*p-n-p*, С	150	—	15	15	20 (150)*	—
МП16	*p-n-p*, С	200	⩾1*	15	15	50 (300)*	⩽25 (25 В)
МП16А	*p-n-p*, С	200	⩾1*	15	15	50 (300)*	⩽25 (15 В)
МП16Б	*p-n-p*, С	200	⩾2*	15	15	50 (300)*	⩽25 (15 В)
МП16Я1	*p-n-p*, С	150	—	15* (100)	15	300*	⩽50* (15 В)
МП16Я11	*p-n-p*, С	150	—	15* (100)	15	300*	⩽50* (15 В)
МП20А	*p-n-p*, С	150	⩾2*	30	30	300*	⩽50 (30 В)
МП20Б	*p-n-p*, С	150	⩾1,5*	30	30	300*	⩽50 (30 В)
МП21В	*p-n-p*, С	150	⩾1,5*	40	40	300*	⩽50 (40 В)
МП21Г	*p-n-p*, С	150	⩾1*	60	40	300*	⩽50 (60 В)
МП21Д	*p-n-p*, С	150	⩾1*	60	40	300*	⩽50 (50 В)
МП21Е	*p-n-p*, С	150	⩾0,7*	70	40	300*	⩽50 (50 В)
МП25	*p-n-p*, С	200	⩾0,2*	40	40	300*	⩽75 (40 В)
МП25А	*p-n-p*, С	200	⩾0,2*	40	40	400*	⩽75 (40 В)
МП25Б	*p-n-p*, С	200	⩾0,5*	40	40	400*	⩽75 (40 В)
МП26	*p-n-p*, С	200	⩾0,2*	70	70	300*	⩽75 (70 В)
МП26А	*p-n-p*, С	200	⩾0,2*	70	70	400*	⩽75 (70 В)
МП26Б	*p-n-p*, С	200	⩾0,5*	70	70	400*	⩽75 (70 В)
П27	*p-n-p*, С	30	⩾1*	5* (0,5 к)	—	6	⩽3 (5 В)
П27А	*p-n-p*, С	30	⩾1*	5* (0,5 к)	—	6	⩽3 (5 В)
П28	*p-n-p*, С	30	⩾5*	5* (0,5 к)	—	6	⩽3 (5 В)
П29	*p-n-p*, С	30	⩾5*	10*	12	100*	⩽4 (12 В)
П29А	*p-n-p*, С	30	⩾5*	10*	12	100*	⩽4 (12 В)
П30	*p-n-p*, С	30	⩾10*	12*	12	100*	⩽4 (12 В)
МП35	*n-p-n*, С	150	⩾0,5*	15	—	20 (150)*	⩽30 (5 В)
МП36А	*n-p-n*, С	150	⩾1*	15	—	20 (150)*	⩽30 (5 В)
МП37А	*n-p-n*, С	150	⩾1*	30	—	20 (150)*	⩽30 (5 В)
МП37Б	*n-p-n*, С	150	⩾1*	30	—	20 (150)*	⩽30 (5 В)
МП38	*n-p-n*, С	150	⩾2*	15	—	20 (150)*	⩽30 (5 В)
МП38А	*n-p-n*, С	150	⩾2*	15	—	20 (150)*	⩽30 (5 В)
МП39	*p-n-p*, С	150	⩾0,5*	15* (10 к)	5	20 (150)*	⩽15 (5 В)
МП39Б	*p-n-p*, С	150	⩾0,5*	15* (10 к)	5	20 (150)*	⩽15 (5 В)
МП40	*p-n-p*, С	150	⩾1*	15* (10 к)	5	20 (150)*	⩽15 (5 В)
МП40А	*p-n-p*, С	150	⩾1*	30* (10 к)	5	20 (150)*	⩽15 (5 В)
МП41	*p-n-p*, С	150	⩾1*	15* (10 к)	5	20 (150)*	⩽15 (5 В)
МП41А	*p-n-p*, С	150	⩾1*	15* (10 к)	5	20 (150)*	⩽15 (5 В)
МП42	*p-n-p*, С	200	⩾2*	15* (3 к)	—	150*	—
МП42А	*p-n-p*, С	200	⩾1,5*	15* (3 к)	—	150*	—
МП42Б	*p-n-p*, С	200	⩾1*	15* (3 к)	—	150*	—

$h_{21Э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, $r^*_{БЭ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
15...45 (5 В; 1 мА)	≤60 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	—	
15...30 (5 В; 1 мА)	≤60 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	—	
15...30 (5 В; 1 мА)	≤60 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	—	
25...50 (5 В; 1 мА)	≤60 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	—	
25...55 (5 В; 1 мА)	≤60 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	—	
45...100 (5 В; 1 мА)	≤60 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	—	
≥12 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	≤150*	—	
20...60 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	≤12 (1 кГц)	—	
20...40 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	≤150*	—	
20...40 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	≤150*	—	
30...60 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	≤150*	—	
20...80 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	≤20	≤150*	≤1400*	
30...60 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	≤150*	—	
50...100 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	≤150*	—	
—	—	≤10	—	—	
20...35 (1 В; 10 мА)	—	≤15	—	≤2000*	
30...50 (1 В; 10 мА)	—	≤15	—	≤1500*	
45...100 (1 В; 1 мА)	—	≤15	—	≤1000*	
20...70 (10 В; 100 мА)	—	≤6,6	—	—	
10...70 (10 В; 100 мА)	—	≤6,6	—	—	
50...150 (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	
80...200 (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	
20...100 (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	
20...80 (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	
60...200 (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	
30...150 (5 В; 25 мА)	—	≤1	—	—	
13...25 (20 В; 2,5 мА)	≤20 (20 В)	≤2,2	—	≤1500***	
20...50 (20 В; 2,5 мА)	≤20 (20 В)	≤2	—	≤1500***	
30...80 (20 В; 2,5 мА)	≤20 (20 В)	≤1,8	—	≤1500***	
13...25 (35 В; 1,5 мА)	≤15 (35 В)	≤2,2	—	≤1500***	
20...50 (35 В; 1,5 мА)	≤15 (35 В)	≤2,2	—	≤1500***	
30...80 (35 В; 1,5 мА)	≤15 (35 В)	≤1,8	—	≤1500***	
20...100 (5 В; 0,5 мА)	—	—	≤10 (1 кГц)	—	
20...170(5 В; 0,5 мА)	—	—	≤5 (1 кГц)	—	
20...200 (5 В; 0,5 мА)	—	—	≤5 (1 кГц)	—	
20...50 (0,5 В; 20 мА)	≤20 (6 В)	10	—	≤6000	
40...100 (0,5 В; 20 мА)	≤20 (6 В)	10	—	≤6000	
80...180 (0,5 В; 20 мА)	≤20 (6 В)	10	—	≤6000	
13...125 (5 В; 1 мА)	—	—	≤220*	—	
15...45 (5 В; 1 мА)	—	—	≤10 (1 кГц)	—	
15...30 (5 В; 1 мА)	—	—	≤220*	—	
25...50 (5 В; 1 мА)	—	—	≤220*	—	
25...55 (5 В; 1 мА)	—	—	≤220*	—	
45...100 (5 В; 1 мА)	—				
≥12 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	—	—	
20...60 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	≤12 (1 кГц)	—	
20...40 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	—	—	
20...40 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	—	—	
30...60 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	—	—	
50...100 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В)	—	—	—	
20...35* (1 В; 10 мА)	—	≤20	—	≤2000***	
30...50* (1 В; 10 мА)	—	≤20	—	≤1500***	
45...100* (1 В; 10 мА)	—	≤20	—	≤1000***	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
ГТ108А	p-n-p, С	75	⩾0,5*	5	5	50	⩽10 (5 В)
ГТ108Б	p-n-p, С	75	⩾1*	5	5	50	⩽10 (5 В)
ГТ108В	p-n-p, С	75	⩾1*	5	5	50	⩽10 (5 В)
ГТ108Г	p-n-p, С	75	⩾1*	5	5	50	⩽10 (5 В)
МГТ108А	p-n-p, С	75	⩾0,5*	10 (18 имп.)	5	50	⩽10 (5 В)
МГТ108Б	p-n-p, С	75	⩾1*	10 (18 имп.)	5	50	⩽10 (5 В)
МГТ108В	p-n-p, С	75	⩾1*	10 (18 имп.)	5	50	⩽10 (5 В)
МГТ108Г	p-n-p, С	75	⩾1*	10 (18 имп.)	5	50	⩽10 (5 В)
МГТ108Д	p-n-p, С	75	⩾1*	10 (18 имп.)	5	50	⩽10 (5 В)
ГТ109А	p-n-p, С	30	⩾1*	10 (18 имп.)	—	20	⩽5 (5 В)
ГТ109Б	p-n-p, С	30	⩾1*	10 (18 имп.)	—	20	⩽5 (5 В)
ГТ109В	p-n-p, С	30	⩾1*	10 (18 имп.)	—	20	⩽5 (5 В)
ГТ109Г	p-n-p, С	30	⩾1*	10 (18 имп.)	—	20	⩽5 (5 В)
ГТ109Д	p-n-p, С	30	⩾3*	10 (18 имп.)	—	20	⩽2 (1,2 В)
ГТ109Е	p-n-p, С	30	⩾5*	10 (18 имп.)	—	20	⩽2 (1,2 В)
ГТ109Ж	p-n-p, С	30	—	10 (18 имп.)	—	20	⩽1 (1,5 В)
ГТ109М	p-n-p, С	30	⩾1*	10 (18 имп.)	—	20	⩽5 (5 В)
ГТ115А	p-n-p, С	50	⩾1*	20	20	30	⩽40 (20 В)
ГТ115Б	p-n-p, С	50	⩾1*	30	20	30	⩽40 (30 В)
ГТ115В	p-n-p, С	50	⩾1*	20	20	30	⩽40 (20 В)
ГТ115Г	p-n-p, С	50	⩾1*	30	20	30	⩽40 (30 В)
ГТ115Д	p-n-p, С	50	⩾1*	20	20	30	⩽40 (20 В)
ГТ122А	n-p-n, С	150	⩾1*	35	—	20 (150)*	⩽20 (5 В)
ГТ122Б	n-p-n, С	150	⩾1*	20	—	20 (150)*	⩽20 (5 В)
ГТ122В	n-p-n, С	150	⩾2*	20	—	20 (150)*	⩽20 (5 В)
ГТ122Г	n-p-n, С	150	⩾2*	20	—	20 (150)*	⩽20 (5 В)
ГТ124А	p-n-p, С	75	⩾1*	25	10	100*	⩽15 (15 В)
ГТ124Б	p-n-p, С	75	⩾1*	25	10	100*	⩽15 (15 В)
ГТ124В	p-n-p, С	75	⩾1*	25	10	100*	⩽15 (15 В)
ГТ124Г	p-n-p, С	75	⩾1*	25	10	100*	⩽15 (15 В)
ГТ125А	p-n-p, С	150	⩾1*	35	20	300*	⩽15 (15 В)
ГТ125Б	p-n-p, С	150	⩾1*	35	20	300*	⩽15 (15 В)
ГТ125В	p-n-p, С	150	⩾1*	35	20	300*	⩽15 (15 В)
ГТ125Г	p-n-p, С	150	⩾1*	35	20	300*	⩽15 (15 В)
ГТ125Д	p-n-p, С	150	⩾1*	35	20	300*	⩽15 (15 В)
ГТ125Е	p-n-p, С	150	⩾1*	35	20	300*	⩽15 (15 В)
ГТ125Ж	p-n-p, С	150	⩾1*	35	20	300*	⩽15 (15 В)
ГТ125И	p-n-p, С	150	⩾1*	70	20	300*	⩽15 (15 В)
ГТ125К	p-n-p, С	150	⩾1*	70	20	300*	⩽15 (15 В)
ГТ125Л	p-n-p, С	150	⩾1*	70	20	300*	⩽15 (15 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
20...50 (5 В; 1 мА) 35...80 (5 В; 1 мА) 60...130 (5 В; 1 мА) 110...250 (5 В; 1 мА)	50 (5 В) 50 (5 В) 50 (5 В) 50 (5 В)	— — — —	— — — —	≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000	
25...50 (6 В; 1 мА) 35...80 (5 В; 1 мА) 60...130 (5 В; 1 мА) 110...250 (5 В; 1 мА) 30...120 (5 В; 1 мА)	— — — — —	— — — — —	— — — — ≤6 (1 кГц)	≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000	
20...50 (5 В; 1 мА) 35...80 (5 В; 1 мА) 60...130 (5 В; 1 мА) 110...250 (5 В; 1 мА) 20...70 (5 В; 1 мА) 50...100 (5 В; 1 мА) ≥100* (1,5 В) 20...80 (5 В; 1 мА)	≤30 (5 В) ≤30 (5 В) ≤30 (5 В) ≤30 (5 В) ≤40 (1,2 В) ≤40 (1,2 В) — ≤30 (5 В)	— — — — — — — —	— — — — — — — ≤12 (1 кГц)	≤10 000 ≤10 000 ≤10 000 ≤10 000 ≤10 000 ≤10 000 ≤10 000 ≤10 000	
20...80 (1 В; 25 мА) 20...80 (1 В; 25 мА) 60...150 (1 В; 25 мА) 60...150 (1 В; 25 мА) 125...250 (1 В; 25 мА)	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	
15...45 (5 В; 1 мА) 15...45 (5 В; 1 мА) 30...60 (5 В; 1 мА) 30...60 (5 В; 1 мА)	— — — —	— — — —	200* 200* 200* 200*	— — — —	
28...56 (0,5 В; 0,1 А) 45...90 (0,5 В; 0,1 А) 71...162 (0,5 В; 0,1 А) 120...200 (0,5 В; 0,1 А)	— — — —	≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5	— — — —	— — — —	
28...56 (0,5 В; 25 мА) 45...90 (5 В; 25 мА) 71...140 (5 В; 25 мА) 120...200 (5 В; 25 мА) 28* (0,5 В; 100 мА) 45...90 (5 В; 25 мА) 71...140 (5 В; 25 мА) 28...56* (0,5 В; 100 мА) 45...90* (0,5 В; 100 мА) 71...140* (0,5 В; 100 мА)	— — — — — — — — — —	≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, мГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
П201Э	p-n-p, С	10* Вт	⩾0,1*	45	—	1,5 А	⩽0,4 мА
П201Э*	p-n-p, С	10* Вт	⩾0,2*	45	—	1,5 А	⩽0,4 мА
П202Э	p-n-p, С	10* Вт	⩾0,1*	70	—	2 А	⩽0,4 мА
П203Э	p-n-p, С	10* Вт	⩾0,2*	70	—	2 А	⩽0,4 мА
П207	p-n-p, С	100* Вт	—	40**	—	25 А	⩽16 мА
П207А	p-n-p, С	100* Вт	—	40**	—	25 А	⩽16 мА
П208	p-n-p, С	100* Вт	—	60**	—	25 А	⩽25 мА
П208А	p-n-p, С	100* Вт	—	60**	—	25 А	⩽25 мА
П209	p-n-p, С	60* Вт	⩾0,1**	40**	25	12 А	⩽8 мА
П209А	p-n-p, С	60* Вт	⩾0,1**	40**	25	12 А	⩽8 мА
П210	p-n-p, С	60* Вт	⩾0,1**	60**	25	12 А	⩽12 мА
П210А	p-n-p, С	60* Вт	⩾0,1**	65**	25	12 А	⩽8 мА (45 В)
П210Б	p-n-p, С	45* Вт	⩾0,1**	65	25	12 А	⩽15 мА
П210В	p-n-p, С	45* Вт	⩾0,1**	45	25	12 А	⩽15 мА
П210Ш	p-n-p, С	60* Вт	⩾0,1**	64*	25	12 А	⩽8 мА (65 В)
П213	p-n-p, С	11,5* Вт	⩾0,2*	45	15	5 А	⩽0,15 мА
П213А	p-n-p, С	10* Вт	⩾0,2*	45	10	5 А	⩽1 мА
П213Б	p-n-p, С	10* Вт	⩾0,2*	45	10	5 А	⩽1 мА
П214	p-n-p, С	10* Вт	⩾0,2*	60	15	5 А	⩽0,3 мА
П214А	p-n-p, С	10* Вт	⩾0,2*	60	15	5 А	⩽0,3 мА
П214Б	p-n-p, С	11,5* Вт	⩾0,2*	60	15	5 А	⩽0,15 мА
П214В	p-n-p, С	10* Вт	⩾0,2*	60	10	5 А	⩽1,5 мА
П214Г	p-n-p, С	10* Вт	⩾0,2*	60	10	5 А	⩽1,5 мА
П215	p-n-p, С	10* Вт	⩾0,2*	80	15	5 А	⩽0,3 мА
П216	p-n-p, С	30* Вт	⩾0,2*	40	15	7,5 А	⩽0,5 мА
П216А	p-n-p, С	30* Вт	⩾0,2*	40	15	7,5 А	⩽0,5 мА
П216Б	p-n-p, С	24* Вт	⩾0,2*	35	15	7,5 А	⩽1,5 мА
П216В	p-n-p, С	24* Вт	⩾0,2*	35	15	7,5 А	⩽2 мА
П216Г	p-n-p, С	24* Вт	⩾0,2*	50	15	7,5 А	⩽2,5 мА
П216Д	p-n-p, С	24* Вт	⩾0,2*	50	15	7,5 А	⩽2 мА
П217	p-n-p, С	30* Вт	⩾0,2*	60	15	7,5 А	⩽0,5 мА
П217А	p-n-p, С	30* Вт	⩾0,2*	60	15	7,5 А	⩽0,5 мА
П217Б	p-n-p, С	30* Вт	⩾0,2*	60	15	7,5 А	⩽0,5 мА
П217В	p-n-p, С	24* Вт	⩾0,2*	60	15	7,5 А	⩽3 мА
П217Г	p-n-p, С	24* Вт	⩾0,2*	60	15	7,5 А	⩽3 мА
ГТ305А	p-n-p, СД	75	⩾140	15	1,5	40 (100)*	—
ГТ305Б	p-n-p, СД	75	⩾160	15	1,5	40 (100)*	—
ГТ305В	p-n-p, СД	75	⩾160	15	0,5	40 (100)*	⩽4 (15 В)
ГТ308А	p-n-p, СД	150 (360)**	⩾90	20	3	50 (120)*	⩽2 (5 В)
ГТ308Б	p-n-p, СД	150 (360)**	⩾120	20	3	50 (120)*	⩽2 (5 В)
ГТ308В	p-n-p, СД	150 (360)**	⩾120	20	3	50 (120)*	⩽2 (5 В)
ГТ308Г	p-n-p, СД	150 (360)**	⩾120	20*	3	50 (120)*	⩽2 (5 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
⩾20* (10 В; 0,2 А) ⩾40* (10 В; 0,2 А) ⩾20* (10 В; 0,2 А)	— — — —	⩽1,25 ⩽1,25 ⩽1,25 ⩽1,25	— — — —	— — — —	
5...15 5...12 ⩾15 ⩾15 ⩾15 ⩾15 ⩾15* (2 В; 5 А) ⩾15* (2 В; 5 А) ⩾10* (2 В; 5 А) ⩾10* (2 В; 5 А) ⩾15 (2 В; 5 А)	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	
20...50* (5 В; 1 А) ⩾20* (5 В; 0,2 А) ⩾40* (5 В; 0,2 А) 20...60* (5 В; 0,2 А) 50...150* (5 В; 0,2 А) 20...150* (5 В; 0,2 А) ⩾20* (5 В; 0,2 А) —	— — — — — — — —	⩽0,16 — ⩽1,25 ⩽0,3 ⩽0,3 ⩽0,3 ⩽1,25 ⩽1,25	— — — — — — — —	— — — — — — — —	
20...150* (5 В; 0,2 А) ⩾16 (0,75 В; 4 А) 20...80 (0,75 В; 4 А) ⩾10 (3 В; 2 А) ⩾30 (3 В; 2 А) ⩾5 (3 В; 2 А) 15...30 (3 В; 2 А) ⩾16 (0,75 В; 4 А) 20...60 (5 В; 1 А) ⩾20 (5 В; 1 А) ⩾15* (1 В; 4 А) 15...40 (3 В; 2 А)	— — — — — — — — — — — —	⩽0,3 ⩽0,2 ⩽0,2 ⩽0,25 ⩽0,25 — ⩽0,25 ⩽0,5 ⩽0,5 ⩽0,5 ⩽0,25 ⩽0,5	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	
25...80* (1 В; 10 мА) 60...180* (1 В; 10 мА) 40...120* (5 В; 5 мА)	⩽7 (5 В) ⩽7 (5 В) ⩽5,5 (5 В)	⩽50 ⩽50 —	— — ⩽6 (1,6 МГц)	⩽300 ⩽300 ⩽300	
20...75* (1 В; 10 мА) 50...120* (1 В; 10 мА) 80...200* (1 В; 10 мА) 80...150 (1 В; 10 мА)	⩽8 (5 В) ⩽8 (5 В) ⩽8 (5 В) ⩽8 (5 В)	⩽30 ⩽24 ⩽24 ⩽24	— — ⩽8 (1,6 МГц) ⩽8 (1,6 МГц)	⩽400 ⩽1000* ⩽400 ⩽500 ⩽1000*	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
ГТ309А	p-n-p, СД	75	≥120	10	1,5	10	≤5 (5 В)
ГТ309Б	p-n-p, СД	75	≥120	10	1,5	10	≤5 (5 В)
ГТ309В	p-n-p, СД	75	≥80	10	1,5	10	≤5 (5 В)
ГТ309Г	p-n-p, СД	75	≥80	10	1,5	10	≤5 (5 В)
ГТ309Д	p-n-p, СД	75	≥80	10	1,5	10	≤5 (5 В)
ГТ309Е	p-n-p, СД	75	≥80	10	1,5	10	≤5 (5 В)
ГТ310А	p-n-p, СД	20 (35 °С)	≥160	12	—	10	≤5 (5 В)
ГТ310Б	p-n-p, СД	20 (35 °С)	≥160	12	—	10	≤5 (5 В)
ГТ310В	p-n-p, СД	20 (35 °С)	≥120	12	—	10	≤5 (5 В)
ГТ310Г	p-n-p, СД	20 (35 °С)	≥120	12	—	10	≤5 (5 В)
ГТ310Д	p-n-p, СД	20 (35 °С)	≥80	12	—	10	≤5 (5 В)
ГТ310Е	p-n-p, СД	20 (35 °С)	≥80	12	—	10	≤5 (5 В)
ГТ311А	n-p-n, П	150	≥300	12	2	50	≤5 (5 В)
ГТ311Б	n-p-n, П	150	≥300	12	2	50	≤5 (5 В)
ГТ311В	n-p-n, П	150	≥450	12	2	50	≤5 (5 В)
ГТ311Г	n-p-n, П	150	≥450	12	2	50	≤5 (5 В)
ГТ311Д	n-p-n, П	150	≥600	12	2	50	≤5 (5 В)
ГТ311Е	n-p-n, П	150	≥250	12 (20 имп.)	2	50	≤5 (12 В)
ГТ311Ж	n-p-n, П	150	≥300	12 (20 имп.)	2	50	≤5 (12 В)
ГТ311И	n-p-n, П	150	≥450	10	1,5	50	≤5 (10 В)
ГТ313А	p-n-p, СД	100	≥300	15	0,7	30	≤5 (12 В)
ГТ313Б	p-n-p, СД	100	≥450	15	0,7	30	≤5 (12 В)
ГТ313В	p-n-p, СД	100	≥350	15	0,7	30	≤5 (12 В)
ГТ320А	p-n-p, Д	200	≥80	20	3	150 (300)*	≤10 (20 В)
ГТ320Б	p-n-p, Д	200	≥120	20	3	150 (300)*	≤10 (20 В)
ГТ320В	p-n-p, Д	200	≥160	20	3	150 (300)*	≤10 (20 В)
ГТ321А	p-n-p, К	160 (20 Вт)**	≥ 60	40**	4	200 (2* А)	≤500 (60 В)
ГТ321Б	p-n-p, К	160 (20 Вт)**	≥60	40**	4	200 (2* А)	≤500 (60 В)
ГТ321В	p-n-p, К	160 (20 Вт)**	≥60	40**	4	200 (2* А)	≤500 (60 В)
ГТ321Г	p-n-p, К	160 (20 Вт)**	≥60	30**	2,5	200 (2* А)	≤500 (45 В)
ГТ321Д	p-n-p, К	160 (20 Вт)**	≥60	30**	2.5	200 (2* А)	≤500 (45 В)
ГТ321Е	p-n-p, К	160 (20 Вт)**	≥60	30**	2,5	200 (2* А)	≤500 (45 В)
ГТ322А	p-n-p, СД	50	≥80	25	0,25	10	≤4 (25 В)
ГТ322Б	p-n-p, СД	50	≥80	25	0,25	10	≤4 (25 В)
ГТ322В	p-n-p, СД	50	≥80	25	0,25	10	≤4 (25 В)
ГТ322Г	p-n-p, СД	50	≥50	15	0,25	5	≤4 (15 В)
ГТ322Д	p-n-p, СД	50	≥50	15	0,25	5	≤4 (15 В)
ГТ322Е	p-n-p, СД	50	≥50	15	0,25	5	≤4 (15 В)
ГТ323А	n-p-n, СД	500	200	20	2	1000	30
ГТ323Б	n-p-n, СД	500	200	20	2	1000	30
ГТ323В	n-p-n, СД	500	300	20	2	1000	30

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
20...70 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	—	≤500	
60...180 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	≤6 (1,6 МГц)	≤500	
20...70 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	≤6 (1,6 МГц)	≤1000	
60...180 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	—	≤1000	
20...70 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	—	≤1000	
60...180 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	—	≤1000	
20...70 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≤3 (1,6 МГц)	≤300	
60...180 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≤3 (1,6 МГц)	≤300	
20...70 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤300	
60...180 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤300	
20...70 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤500	
60...180 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤4 (1,6 кГц)	≤500	
15...80* (3 В; 15 мА).	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤ 50*	
30...180* (3 В; 15 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤50*	
15...50* (3 В; 15 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤50*	
30...80* (3 В; 15 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤50*	
60...180* (3 В; 15 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤50*	
20...80* (3 В; 15 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤75; ≤50*	
50...200* (3 В; 15 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤100; ≤50*	
100...300* (3 В; 15 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤100; ≤50*	
20...250 (5 В; 5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤4,6	—	≤75	
20...250 (5 В; 5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤4,6	—	≤40	
30...170 (5 В; 5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤4,6	—	≤75	
20...80* (1 В; 10 мА)	≤8 (5 В)	≤8,5	—	≤500	
50...160* (1 В; 10 мА)	≤8 (5 В)	≤8,5	—	≤500	
80...250* (1 В; 10 мА)	≤8 (5 В)	≤8,5	—	≤600	
20...60* (3 В; 0,5 А)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600	
40...120* (3 В; 0,5 А)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600	
80...200* (3 В; 0,5 А)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600	
20...60* (3 В; 0,5 А)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600	
40...120* (3 В; 0,5 А)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600	
80...200* (3 В; 0,5 А)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600	
30...100 (5 В; 1 мА)	≤1,8 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤50	
50...120 (5В; 1 мА)	≤1,8 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤100	
20...120 (5 В; 1 мА)	≤2,5 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤200	
50...120 (5 В; 1 мА)	≤2,5 (5 В)	—	—	—	
20...70 (5 В; 1 мА)	≤1,8 (5 В)	—	—	—	
50...120 (5 В; 1 мА)	≤1,8 (5 В)	—	—	—	
20...60 (5 В; 0,5 А)	30	—	—	—	
40...120 (5 В; 0,5 А)	30	—	—	—	
80...200 (5 В; 5 А)	30	—	—	—	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{\text{К max}}$, $P^{*}_{\text{К, т max}}$, $P^{**}_{\text{К, и max}}$, мВт	$f_{\text{гр}}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{\text{КБО проб}}$, $U^{*}_{\text{КЭR проб}}$, $U^{**}_{\text{КЭО проб}}$, В	$U_{\text{ЭБО проб}}$, В	$I_{\text{К max}}$, $I^{*}_{\text{К, и max}}$, мА	$I_{\text{КБО}}$, $I^{*}_{\text{КЭR}}$, $I^{**}_{\text{КЭО}}$, мкА
ГТ328А	*p-n-p*, ПЭ	50 (55 °С)	⩾400	15* (5 к)	0,25	10	⩽10 (15 В)
ГТ328Б	*p-n-p*, ПЭ	50 (55 °С)	⩾300	15* (5 к)	0,25	10	⩽10 (15 В)
ГТ328В	*p-n-p*, ПЭ	50 (55 °С)	⩾300	15* (5 к)	0,25	10	⩽10 (15 В)
ГТ329А	*n-p-n*, П	50 (40 °С)	⩾1200	10	0,5	20	⩽5 (10 В)
ГТ329Б	*n-p-n*, П	50 (40 °С)	⩾1680	10	0,5	20	⩽5 (10 В)
ГТ329В	*n-p-n*, П	50 (40 °С)	⩾990	10	1	20	⩽5 (10 В)
ГТ329Г	*n-p-n*, П	25 (60 °С)	⩾700	10	0,5	20	⩽5 (10 В)
ГТ330Д	*n-p-n*, П	50 (45 °С)	⩾500	10 (20 имп.)	1,5	20	⩽5 (10 В)
ГТ330Ж	*n-p-n*, П	50 (45 °С)	⩾1000	10 (20 имп.)	1,5	20	⩽5 (10 В)
ГТ330И	*n-p-n*, П	50 (45 °С)	⩾500	10 (20 имп.)	1,5	20	⩽5 (10 В)
ГТ335А	*p-n-p*, СД	200 (45 °С)	⩾80	20	3	150 (250)*	⩽10
ГТ335Б	*p-n-p*, СД	200 (45 °С)	⩾80	20	3	150 (250)*	⩽10
ГТ335В	*p-n-p*, СД	200 (45 °С)	⩾80	20	3	150 (250)*	⩽10
ГТ335Г	*p-n-p*, СД	200 (45 °С)	⩾300	20	3	150 (250)*	⩽10
ГТ335Д	*p-n-p*, СД	200 (45 °С)	⩾300	20	3	150 (250)*	⩽10
ГТ338А	*p-n-p*, СД	100	—	20 (8**)	—	1000	⩽30 (20 В)
ГТ338Б	*p-n-p*, СД	100	—	20 (13**)	—	1000	⩽30 (20 В)
ГТ338В	*p-n-p*, СД	100	—	20 (5**)	—	1000	⩽30 (20 В)
ГТ341А	*n-p-n*, П	35 (60 °С)	⩾1500	10	0,3	10	⩽5 (10 В)
ГТ341Б	*n-p-n*, П	35 (60 °С)	⩾1980	10	0,3	10	⩽5 (10 В)
ГТ341В	*n-p-n*, П	35 (60 °С)	⩾1500	10	0,5	10	⩽5 (10 В)
ГТ346А	*p-n-p*, ПЭ	50 (55 °С)	⩾700	20	0,3	10	⩽10 (20 В)
ГТ346Б	*p-n-p*, ПЭ	50 (55 °С)	⩾550	20	0,3	10	⩽10 (20 В)
ГТ346В	*p-n-p*, ПЭ	50 (55 °С)	⩾550	20	0,3	10	⩽10 (20 В)
ГТ362А	*n-p-n*, П	40	⩾2400	5 (55 °С)	0,2	10	⩽5 (5 В)
ГТ362Б	*n-p-n*, П	40	⩾2400	5 (55 °С)	0,2	10	⩽5 (5 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
20...200* (5 В; 4 мА) 40...200* (5 В; 3 мА) 10...70* (5В; 3 мА)	⩽1,5 (5 В) ⩽1,5 (5 В) ⩽1,5 (5 В)	— — —	⩽7 (180 МГц) ⩽7 (180 МГц) ⩽7 (180 МГц)	⩽ 5 ⩽10 ⩽10	
15...300* (5 В; 5 мА) 15...300* (5 В; 5 мА) 15...300* (5 В; 5 мА) 15...300 (5 В; 5 мА) 30...400* (5 В; 5 мА) 30...400* (5 В; 5 мА) 10...400* (5 В; 5 мА)	⩽2 (5 В) ⩽3 (5 В) ⩽3 (5 В) ⩽2 (5 В) ⩽3 (5 В) ⩽3 (5 В) ⩽3 (5 В)	— — — — ⩽15 ⩽15 ⩽15	⩽4 (400 МГц) ⩽6 (400 МГц) ⩽6 (400 МГц) ⩽5 (400 МГц) ⩽8 (400 МГц) — ⩽8 (400 МГц)	⩽15 ⩽30 ⩽20 ⩽15 ⩽30; 50* ⩽50; 50* ⩽30; 50*	
40...70* (3 В; 50 мА) 60...100* (3 В; 50 мА) 40...70* (3 В; 50 мА) 60...100* (3 В; 50 мА) 50...100* (3 В; 50 мА)	⩽8,5 ⩽8,5 ⩽8,5 ⩽8,5 ⩽8,5	— — — — —	— — — — —	— ⩽100* ⩽150* — ⩽150*	
— — —	⩽2 (5 В) ⩽2 (5 В) ⩽2 (5 В)	— — —	— — —	$t_{нр}$⩽1 нс $t_{нр}$⩽1 нс $t_{нр}$⩽1 нс	
15...300* (5 В; 5 мА) 15...300* (5 В; 5 мА) 15...300* (5 В; 5 мА)	⩽1 (5 В) ⩽1 (5 В) ⩽1 (5 В)	— — —	⩽4,5 (1 ГГц) ⩽5,5 (1 ГГц) ⩽5,5 (1 ГГц)	⩽10 ⩽10 ⩽10	
10...150 (10 В; 2 мА) 10...150 (10 В; 2 мА) 15...150 (10 В; 2 мА)	⩽1,3 (5 В) ⩽1,3 (5 В) ⩽1,3 (5 В)	— — —	⩽6 (800 МГц) ⩽8 (800 МГц) ⩽7 (200 МГц)	⩽3 ⩽5,5 ⩽6	
10...200 (3 В; 5 мА) 10...250 (3 В; 5 мА)	⩽1 (5 В) ⩽1 (5 В)	— —	⩽4,5 (2,25 ГГц) ⩽5,5 (2,25 ГГц)	⩽10 ⩽20	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К, max}$, $P^{*}_{К, т max}$, $P^{**}_{К, и max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО проб}$, $U^{*}_{КЭR проб}$, $U^{**}_{КЭО проб}$, В	$U_{ЭБО проб}$, В	$I_{К max}$, $I^{*}_{К, и max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
ГТ376А	p-n-p, ПЭ	35 (85 °С)	⩾1020	7**	0,25	10	⩽5 (7 В)
ГТ383А-2	n-p-n, П	25 (55 °С)	⩾2400	5* (1 к)	0,5	10	⩽5 (5 В)
ГТ383Б-2	n-p-n, П	25 (55 °С)	⩾1500	5* (1 к)	0,5	10	⩽5 (5 В)
ГТ383В-2	n-p-n, П	25 (55 °С)	⩾3600	5* (1 к)	0,5	10	⩽5 (5 В)
П401	p-n-p, СД	100	⩾30	10	1	20	⩽10 (5 В)
П402	p-n-p, СД	100	⩾50	10	1	20	⩽5 (5 В)
ГТ402А	p-n-p, С	300; 600	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽20 (10 В)
ГТ402Б	p-n-p, С	300; 600	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽20 (10 В)
ГТ402В	p-n-p, С	300; 600	⩾1*	40* (0,2 к)	—	500	⩽20 (10 В)
ГТ402Г	p-n-p, С	300; 600	⩾1*	40* (0,2 к)	—	500	⩽20 (10 В)
ГТ402Д	p-n-p, С	0,3; 0,6	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
ГТ402Е	p-n-p, С	0,3; 0,6	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
ГТ402Ж	p-n-p, С	0,3; 0,6	⩾1*	40 (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
ГТ402И	p-n-p, С	0,3; 0,6	⩾1*	40 (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
П403	p-n-p, СД	100	⩾100	10	1	20	⩽5 (5 В).
П403А	p-n-p, СД	100	⩾80	10	1	20	⩽5 (5 В)
ГТ403А	p-n-p, С	4* Вт	⩾0,008**	45	20	1250	⩽50 (45 В)
ГТ403Б	p-n-p, С	4* Вт	⩾0,008**	45	20	1250	⩽50 (45 В)
ГТ403В	p-n-p, С	5* Вт	⩾0,008**	60	20	1250	⩽50 (60 В)
ГТ403Г	p-n-p, С	4* Вт	⩾0,006**	60	20	1250	⩽50 (60 В)
ГТ403Д	p-n-p, С	4* Вт	⩾0,006**	60	30	1250	⩽50 (60 В)
ГТ403Е	p-n-p, С	5* Вт	⩾0,008**	60	20	1250	⩽50 (60 В)
ГТ403Ж	p-n-p, С	4* Вт	⩾0,008*	80	20	1250	⩽50 (80 В)
ГТ403И	p-n-p, С	4* Вт	⩾0,008**	80	20	1250	⩽50 (80 В)
ГТ403Ю	p-n-p, С	4* Вт	⩾0,008**	45	20	1250	⩽50 (45 В)
ГТ404А	n-p-n, С	600; 300	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
ГТ404Б	n-p-n, С	600; 300	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
ГТ404В	n-p-n, С	600; 300	⩾1*	40* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
ГТ404Г	n-p-n, С	600; 300	⩾1*	40* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
ГТ404Д	n-p-n, С	600; 300	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
ГТ404Е	n-p-n, С	600; 300	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
ГТ404Ж	n-p-n, С	600; 300	⩾1*	40* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
ГТ404И	n-p-n, С	600; 300	⩾1*	40* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
10...150* (5 В; 2 мА)	⩽1,2 (5 В)	—	⩽3,5 (180 МГц)	⩽15	
15...250 (3,2 В; 5 мА) 10...250 (3,2 В; 5 мА) 15...250 (3,2 В; 5 мА)	⩽1 (3,2 В) ⩽1 (3,2 В) ⩽1 (3,2 В)	— — —	⩽4,5 (2,25 ГГц) ⩽4 (1 ГГц) ⩽5,5 (2,83 ГГц)	⩽10 ⩽10 ⩽15	
16...300 (5 В; 5 мА) 16...250 (5 В; 5 мА)	⩽15 (5 В) ⩽10 (5 В)	— —	— —	⩽3500 ⩽1000	
30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА)	— — — — — — — —	⩽5 ⩽5 ⩽5 ⩽5 ⩽5 ⩽5 ⩽5 ⩽5	— — — — — — — —	— — — — — — — —	
30...100 (5 В; 5 мА) 16...200 (5 В; 5 мА)	⩽10 (5 В) ⩽10 (5 В)	— —	— —	⩽500 ⩽500	
20...60 (5 В; 0,1 А) 50...150 (5 В; 0,1 А) 20...60 (5 В; 0,1 А) 50...150 (5 В; 0,1 А) 50...150 (5 В; 0,1 А) 30* (0,45 А) 20...60 (5 В; 0,1 А) 30* (0,45 А) 30...60 (5 В; 0,1 А)	— — — — — — — — —	⩽1 ⩽1 ⩽1 ⩽1 ⩽1 ⩽1 ⩽1 ⩽1 ⩽1	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	
30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА)	— — — — — — — —	⩽6 ⩽6 ⩽6 ⩽6 ⩽6 ⩽6 ⩽6 ⩽6	— — — — — — — —	— — — — — — — —	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^*_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^*_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
ГТ405А	*p-n-p*, С	0,6 Вт	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
ГТ405Б	*p-n-p*, С	0,6 Вт	⩾1*	25* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
ГТ405В	*p-n-p*, С	0,6 Вт	⩾1*	40* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
ГТ405Г	*p-n-p*, С	0,6 Вт	⩾1*	40* (0,2 к)	—	500	⩽25 (10 В)
ГТ406А	*p-n-p*, С	0,6 Вт	0,006**	25	20	1250	⩽50 (25 В)
П416	*p-n-p*, Д	100 (360)*	⩾40	12	3	25 (120)*	⩽3 (10 В)
П416А	*p-n-p*, Д	100 (360)*	⩾60	12	3	25 (120)*	⩽3 (10 В)
П416Б	*p-n-p*, Д	100 (360)*	⩾80	12	3	25 (120)*	⩽3 (10 В)
П417	*p-n-p*, СД	50	⩾200	8	0,7	10	⩽3 (10 В)
П417А	*p-n-p*, СД	50	⩾200	8	0,7	10	⩽3 (10 В)
П417Б	*p-n-p*, СД	50	⩾200	8	0,7	10	⩽3 (10 В)
П422	*p-n-p*, СД	100	⩾50	10* (1 к)	—	20	⩽5 (5 В)
П423	*p-n-p*, СД	100	⩾100	10* (1 к)	—	20	⩽5 (5 В)
П605	*p-n-p*, К	3 Вт	—	45	1	1500	⩽2000 (45 В)
П605А	*p-n-p*, К	3 Вт	—	45	0,5	1500	⩽2000 (45 В)
П606	*p-n-p*, К	1,25 Вт	⩾30	35	1	1500	⩽2000 (35 В)
П606А	*p-n-p*, К	1,25 Вт	⩾30	35	0,5	1500	⩽2000 (35 Вт)
П607	*p-n-p*, К	1,5 Вт	⩾60	30	1,5	300 (600)*	⩽300 (30 В)
П607А	*p-n-p*, К	1,5 Вт	⩾60	30	1,5	300 (600)*	⩽300 (30 В)
П608	*p-n-p*, К	1,5 Вт	⩾90	30	1,5	300 (600)*	⩽300 (30 В)
П608А	*p-n-p*, К	1,5 Вт	⩾90	30	1,5	300 (600)*	⩽300 (30 В)
П609	*p-n-p*, К	1,5 Вт	⩾120	30	1,5	300 (600)*	⩽300 (30 В)
П609А	*p-n-p*, К	1,5 Вт	⩾120	30	1,5	300 (600)*	⩽300 (30 В)
ГТС609А	*p-n-p*, СД	500 (43 °С)	⩾60	50	2,5	700*	⩽40 (30 В)
ГТС609Б	*p-n-p*, СД	500 (43 °С)	⩾60	50	2,5	700*	⩽40 (30 В)
ГТС609В	*p-n-p*, СД	500 (43 °С)	⩾60	50	2,5	700*	⩽40 (30 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
30...80 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	
60...150 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	
30...80 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	
60...150 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	
50...150* (5 В; 0,1 А)	—	—	—	—	
20...80 (5 В; 5 мА)	⩽8 (5 В)	⩽40	—	⩽500 ⩽1000*	
60...120 (5 В; 5 мА)	⩽8 (5 В)	⩽40	—	⩽500	
90...250 (5 В; 5 мА)	⩽8 (5 В)	⩽40	—	⩽500 ⩽1000*	
24...100 (5 В; 5 мА)	⩽5 (5 В)	—	—	⩽400	
65...200 (5 В; 5 мА)	⩽5 (5 В)	—	—	⩽400	
75...250 (5 В; 5 мА)	⩽6 (5 В)	—	—	⩽400	
24...100 (5 В; 1 мА)	⩽10 (5 В)	—	⩽10 (1,6 МГц)	⩽1000	
24...100 (5 В; 1 мА)	⩽10 (5 В)	—	⩽10 (1,6 МГц)	⩽500	
20...60* (3 В; 0,5 А)	⩽130 (20 В)	⩽40	—	⩽3000*	
40...120* (3 В; 5 А)	⩽130 (20 В)	⩽40	—	⩽4000*	
20...60* (3 В; 0,5 А)	⩽130 (20 В)	⩽40	—	⩽3000*	
40...120* (3 В; 0,5 А)	⩽130 (20 В)	⩽40	—	⩽4000*	
20...80* (3 В; 0,25 А)	⩽50 (10 В)	⩽10	—	⩽3000*	
60...200* (3 В; 0,25 А)	⩽50 (10 В)	⩽10	—	⩽3000*	
40...120 (3 В; 0,25 А)	⩽50 (10 В)	⩽10	—	⩽3000*	
80...240 (3 В; 0,25 А)	⩽50 (10 В)	⩽10	—	⩽3000*	
40...120 (3 В; 0,25 А)	⩽50 (10 В)	⩽10	—	⩽3000*	
80...240 (3 В; 0,25 А)	⩽50 (10 В)	⩽10	—	⩽3000*	
30...100 (3 В; 0,5 А)	⩽50 (10 В)	⩽3,2	—	⩽700*	
50...160 (3 В; 0,5 А)	⩽50 (10 В)	⩽3,2	—	⩽700*	
80...420 (3 В; 0,5 А)	⩽50 (10 В)	⩽3,2	—	⩽700*	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, F^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $K^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, МКа
ГТ612А-4	*n-p-n*, П	570	⩾1500	12	0,2	120 (200)*	⩽5 (12 В)
ГТ701А	*p-n-p*, С	50* Вт	⩽0,05*	55* (140 имп.)	15	12 А	6 мА
ГТ703Б	*p-n-p*, С	15* Вт	0,010**	20 (0,05 к)	10	3,5 А	⩽500
ГТ703Б	*p-n-p*, С	15* Вт	0,010**	20 (0,05 к)	10	3,5 А	⩽500
ГТ703В	*p-n-p*, С	15* Вт	0,010**	30 (0,05 к)	10	3,5 А	⩽500
ГТ703Г	*p-n-p*, С	15* Вт	0,010**	30 (0,05 к)	10	3,5 А	⩽500
ГТ703Д	*p-n-p*, С	15* Вт	0,010	40 (0,05 к)	10	3,5 А	⩽500
ГТ705А	*n-p-n*, С	15* Вт	0,010**	20*	10	3,5 А	⩽500
ГТ705Б	*n-p-n*, С	15* Вт	0,010**	20*	10	3,5 А	⩽3,5 мА
ГТ705В	*n-p-n*, С	15* Вт	0,010**	30*	30	3,5 А	⩽3,5 мА
ГТ705Г	*n-p-n*, С	15* Вт	0,010**	30*	10	3,5 А	⩽500
ГТ705Д	*n-p-n*, С	15* Вт	0,010	20*	10	3,5 А	⩽500
ГТ804А	*p-n-p*, СД	15* Вт	⩾10	100**	—	10 А	—
ГТ804Б	*p-n-p*, СД	15* Вт	⩾10	140**	—	10 А	—
ГТ804В	*p-n-p*, СД	15* Вт	⩾10	190**	—	10 А	—
ГТ806А	*p-n-p*, СД	30* Вт	⩾10*	75	1,5	15 А	—
ГТ806Б	*p-n-p*, СД	30* Вт	⩾10*	100	1,5	15 А	—
ГТ806В	*p-n-p*, СД	30* Вт	⩾10*	120	1,5	15 А	—
ГТ806Г	*p-n-p*, СД	30* Вт	⩾10*	50	1,5	15 А	—
ГТ806Д	*p-n-p*, СД	30* Вт	⩾10*	140	1,5	15 А	—
ГТ810А	*p-n-p*, СД	15* Вт	⩾15	200	1,4	10 А	⩽20 мА
ГТ905А	*p-n-p*, СД	6 Вт	⩾60	75	0,4	3 А (7* А)	⩽20 мА
ГТ905Б	*p-n-p*, СД	6 Вт	⩾60	60	0,4	3 А (7* А)	⩽20 мА
ГТ906А	*p-n-p*, СД	15* Вт; 300** Вт	⩾30	75	1,4	6 А	⩽8 мА (75 В)
ГТ906АМ	*p-n-p*, СД	15* Вт; 300** Вт	⩾30	75	1,4	6 А	⩽8 мА (75 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
—	≤3,5 (5 В)	—	0,2** (2 ГГц)	≤7	
≥10* (2 В; 6 А)	—	—	—	—	
30...70* (1 В; 50 мА) 50...100* (1 В; 50 мА) 30...70* (1 В; 50 мА) 50...100* (1 В; 50 мА) 20...45* (1 В; 50 мА) 30...70* (1 В; 50 мА) 50...100* (1 В; 50 мА) 30...70* (1 В; 50 мА) 50...100* (1 В; 60 мА) 90...250* (1 В; 50 мА)	— — — — — — — — — —	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	
20...150* (10 В; 5 А) 20...150* (10 В; 5 А) 20...150* (10 В; 5 А)	— — —	— — —	— — —	≤1000* ≤1000* ≤1000*	
10...100* (10 А) 10...100* (10 А) 10...100* (10 А) 10...100* (10 А) 10...100* (10 А)	— — — — —	≤0,04 ≤0,04 ≤0,04 ≤0,04 ≤0,04	— — — — —	— — — — —	
15* (10 В; 5 А) 35...100* (70 В; 3 А) 35...100* (70 В; 3 А)	— ≤200 (30 В) ≤200 (30 В)	≤0,07 ≤0,17 ≤0,17	— — —	≤5* мкс ≤300; 4* мкс ≤300; 4* мкс	
30...150* (10 В; 5 А)	—	—	—	≤5000*	
30...150* (10 В; 5 А)	—	—	—	≤5000*	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К\,т\,max}$, $P^{**}_{К\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КОЭ\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ104А	*p-n-p*, ПЭ	150 (60 °С)	⩾5*	30**	10	50	⩽1 (30 В)
КТ104Б	*p-n-p*, ПЭ	150 (60 °С)	⩾5*	15**	10	50	⩽1 (15 В)
КТ104В	*p-n-p*, ПЭ	150 (60 °С)	⩾5*	15**	10	50	⩽1 (15 В)
КТ104Г	*p-n-p*, ПЭ	150 (60 °С)	⩾5*	30	10	50	⩽1 (30 В)
КТ117А	*n*-база, ПЭ	300	0,2***	30	30	50 (1* А)	⩽1 (30 В)
КТ117Б	*n*-база, ПЭ	300	0,2***	30	30	50 (1* А)	⩽1 (30 В)
КТ117В	*n*-база, ПЭ	300	0,2***	30	30	50 (1* А)	⩽1 (30 В)
КТ117Г	*n*-база, ПЭ	300	0,2***	30	30	50 (1* А)	⩽1 (30 В)
КТ118А	*p-n-p*, ПЭ	100 (100 °С)	—	15	31	50	⩽0,1 (15 В)
КТ118Б	*p-n-p*, ПЭ	100 (100 °С)	—	15	31	50	⩽0,1 (15 В)
КТ118В	*p-n-p*, ПЭ	100 (100 °С)	—	15	31	50	⩽0,1 (15 В)
КТ119А	*n*-база, ПЭ	25	0,2***	20	20	10 (50*)	—
КТ119Б	*n*-база, ПЭ	25	0,2***	20	20	10 (50*)	—
КТ120А	*p-n-p*, ПЭ	10	⩾1	60	10	10 (20*)	⩽0,5 (60 В)
КТ120Б	*p-n-p*, ПЭ	10	⩾1	30	10	10 (20*)	⩽0,5 (30 В)
КТ120В	*p-n-p*, ПЭ	10	⩾1	60	10	10 (20*)	⩽0,5 (60 В)
КТ120А-1	*p-n-p*, ПЭ	10 (15**)	—	60	10	10	⩽0,5 (60 В)
КТ120В-1	*p-n-p*, ПЭ	10 (35**)	—	60	10	10	—
КТ120А-5	*p-n-p*, ПЭ	10	—	60	10	10	—
КТ120В-5	*p-n-p*, ПЭ	20	—	60	10	10	—
КТ127А-1	*n-p-n*, П	15 (60 °С)	⩾0,1**	25	3	50	⩽1 (25 В)
КТ127Б-1	*n-p-n*, П	15 (60 °С)	⩾0,1**	25	3	50	⩽1 (25 В)
КТ127В-1	*n-p-n*, П	15 (60 °С)	⩾0,1**	45	3	50	⩽1 (25 В)
КТ127Г-1	*n-p-n*, П	15 (60 °С)	⩾0,1**	45	3	50	⩽1 (25 В)
КТ201А	*n-p-n*, ПЭ	150 (90 °С)	⩾10	20	20	20 (100*)	⩽1 (20 В)
КТ201Б	*n-p-n*, ПЭ	150	⩾10	20	20	20 (100*)	⩽1 (20 В)
КТ201В	*n-p-n*, ПЭ	150	⩾10	10	10	20 (100*)	⩽1 (10 В)
КТ201Г	*n-p-n*, ПЭ	150	⩾10	10	10	20 (100*)	⩽1 (20 В)
КТ201Д	*n-p-n*, ПЭ	150	⩾10	10	10	20 (100*)	⩽1 (20 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21э}$	$C_К$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, $r^*_{БЭ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
9...36 (5 В; 1 мА) 20...80 (5 В; 1 мА) 40...160 (5 В; 1 мА) 15...60 (5 В; 1 мА)	⩽50 (5 В) ⩽50 (5 В) ⩽50 (5 В) ⩽50 (5 В)	⩽50 ⩽50 ⩽50 ⩽50	⩽120* ⩽120* ⩽120* ⩽120*	— — — —	
0,5...0,7 ($U_{Б1Б2}$=10 В) 0,65...0,9 ($U_{Б1Б2}$=10 В) 0,5...0,7 ($U_{Б1Б2}$=10 В) 0,65...0,9 ($U_{Б1Б2}$=10 В)	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	
— — —	— — —	100 100 120	— — —	⩽500** ⩽500** ⩽500**	
0,5...0,65 ($U_{Б1Б2}$=10 В) 0,6...0,75 ($U_{Б1Б2}$=10 В)	— —	— —	— —	— —	
20...200 (5 В; 1 мА) 20...480 (5 В; 1 мА) 10...200 (5 В; 1 мА)	⩽5 (5 В) ⩽5 (5 В) ⩽5 (5 В)	⩽50 — ⩽110	— — —	— — —	
20...200 (5 В; 1 мА) 20...200 (5 В; 1 мА)	⩽5 (5 В) ⩽5(5 В)	⩽50 ⩽110	— —	— —	
20...200 (5 В; 1 мА) 20...200 (5 В; 1 мА)	⩽5 (5 В) ⩽5 (5 В)	— —	— —	— —	
15...60 (5 В; 1 мА) 40...200 (5 В; 1 мА) 15...60 (5 В; 1 мА) 40...200 (5 В; 1 мА)	⩽5 (5 В) ⩽5 (5 В) ⩽5 (5 В) ⩽5 (5 В)	⩽170 ⩽170 ⩽170 ⩽170	— — — —	— — — —	
20...60 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА) 70...210 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА)	⩽20 (5 В) ⩽20 (5 В) ⩽20 (5 В) ⩽20 (5 В) ⩽20 (5 В)	— — — — —	— — — — ⩽15 (1 кГц)	— — — — —	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ201АМ	*n-p-n*, ПЭ	150	≥10	20	20	20 (100*)	≤1 (20 В)
КТ201БМ	*n-p-n*, ПЭ	150	≥10	20	20	20 (100*)	≤1 (20 В)
КТ201ВМ	*n-p-n*, ПЭ	150	≥10	10	10	20 (100*)	≤1 (10 В)
КТ201ГМ	*n-p-n*, ПЭ	150	≥10	10	10	20 (100*)	≤1 (10 В)
КТ201ДМ	*n-p-n*, ПЭ	150	≥10	10	10	20 (100*)	≤1 (10 В)
КТ202А-1	*p-n-p*, ПЭ	15 (55 °С)	≥5	15	10	10 (25*)	≤1 (15 В)
КТ202Б-1	*p-n-p*, ПЭ	15 (55 °С)	≥5	15	10	10 (25*)	≤1 (15 В)
КТ202В-1	*p-n-p*, ПЭ	15 (55 °С)	≥5	30	10	10 (25*)	≤1 (30 В)
КТ202Г-1	*p-n-p*, ПЭ	15 (55 °С)	≥5	30	10	10 (25*)	≤1 (30 В)
КТ202Д-1	*p-n-p*, ПЭ	15 (55 °С)	≥5	15	10	10 (25*)	≤1 (15 В)
КТ203А	*p-n-p*, ПЭ	150 (75 °С)	≥5*	60	30	10 (50*)	≤1 (60 В)
КТ203Б	*p-n-p*, ПЭ	150 (75 °С)	≥5*	30	15	10 (50*)	≤1 (30 В)
КТ203В	*p-n-p*, ПЭ	150 (75 °С)	≥5*	15	10	10 (50*)	≤1 (15 В)
КТ203АМ	*p-n-p*, ПЭ	150 (75 °С)	≥5*	60	30	10 (50*)	≤1 (60 В)
КТ203БМ	*p-n-p*, ПЭ	150 (75 °С)	≥5*	30	15	10 (50*)	≤1 (30 В)
КТ203ВМ	*p-n-p*, ПЭ	150 (75 °С)	≥5*	15	10	10 (50*)	≤1 (15 В)
КТ206А	*n-p-n*, ПЭ	15	≥10	20* (3 к)	20	20	≤1 (20 В)
КТ206Б	*n-p-n*, ПЭ	15	≥10	12* (3 к)	12	20	≤1 (12 В)
КТ207А	*p-n-p*, ПЭ	15	≥5	60	30	10 (50*)	≤0,05 (60 В)
КТ207Б	*p-n-p*, ПЭ	15	≥5	30	15	10 (50*)	≤0,05 (30 В)
КТ207В	*p-n-p*, ПЭ	15	≥5	15	10	10 (50*)	≤0,05 (15 В)
КТ208А	*p-n-p*, ПЭ	200 (60 °С)	≥5	20* (10 к)	10	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208Б	*p-n-p*, ПЭ	200 (60 °С)	≥5	20	10	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208В	*p-n-p*, ПЭ	200 (60 °С)	≥5	20	10	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208Г	*p-n-p*, ПЭ	200 (60 °С)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208Д	*p-n-p*, ПЭ	200 (60 °С)	≥5	30* (10 к)	10	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208Е	*p-n-p*, ПЭ	200 (60 °С)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208Ж	*p-n-p*, ПЭ	200 (60 °С)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208И	*p-n-p*, ПЭ	200 (60 °С)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208К	*p-n-p*, ПЭ	200 (60 °С)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208Л	*p-n-p*, ПЭ	200 (60 °С)	≥5	60	20	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208М	*p-n-p*, ПЭ	200 (60 °С)	≥5	60	20	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ209А	*p-n-p*, ПЭ	200 (35 °С)	≥5	15	10	300 (500*)	≤1* (15 В)
КТ209Б	*p-n-p*, ПЭ	200 (35 °С)	≥5	15	10	300 (500*)	≤1* (15 В)
КТ209В	*p-n-p*, ПЭ	200 (35 °С)	≥5	15	10	300 (500*)	≤1* (15 В)
КТ209Г	*p-n-p*, ПЭ	200 (35 °С)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1* (30 В)
КТ209Д	*p-n-p*, ПЭ	200 (35 °С)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1* (30 В)
КТ209Е	*p-n-p*, ПЭ	200 (35 °С)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1* (30 В)
КТ209Ж	*p-n-p*, ПЭ	200 (35 °С)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1* (45 В)
КТ209И	*p-n-p*, ПЭ	200 (35 °С)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1* (45 В)
КТ209К	*p-n-p*, ПЭ	200 (35 °С)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1* (45 В)
КТ209Л	*p-n-p*, ПЭ	200 (35 °С)	≥5	60	20	300 (500*)	≤1* (60 В)
КТ209М	*p-n-p*, ПЭ	200 (35 °С)	≥5	60	20	300 (500*)	≤1* (60 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, $r^*_{БЭ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$τ_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
20...60 (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В)	—	—	—	
30...90 (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В)	—	—	—	
30...90 (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В)	—	—	—	
70...210 (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В)	—	—	—	
30...90 (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В)	—	≤15 (1 кГц)	—	
15...70 (5 В; 1 мА)	≤25 (5 В)	≤50	—	≤1000*	
40...160 (5 В; 1 мА)	≤25 (5 В)	≤50	—	≤1000*	
15...70 (5 В; 1 мА)	≤25 (5 В)	≤50	—	≤1000*	
40...160 (5 В; 1 мА)	≤25 (5 В)	≤50	—	≤1000*	
100...300 (5 В; 1 мА)	≤25 (5 В)	≤50	—	≤1000*	
≥9 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	—	≤300*	—	
30...150 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	≤50	≤300*	—	
30...200 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	≤25	≤300*	—	
≥9 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	—	≤300*	—	
30...150 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	≤50	≤300*	—	
30...200 (5 В; 1мА)	≤10 (5 В)	≤25	≤300*	—	
30...90* (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В)	—	—	—	
70...120* (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В)	—	—	—	
≥9 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	≤100	≤300*	—	
30...150 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	≤10	≤300*	—	
30...200 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	≤50	≤300*	—	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤5 (1 кГц)	—	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤5 (1 кГц)	—	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
80...160* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤5 (1 кГц)	—	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ210А	p-n-p, ПЭ	25	⩾10	15	10	20 (40*)	⩽10 (15 В)
КТ210Б	p-n-p, ПЭ	25	⩾10	30	10	20 (40*)	⩽10 (30 В)
КТ210В	p-n-p, ПЭ	25	⩾10	60	10	20 (40*)	⩽10 (60 В)
КТ211А-1	p-n-p, ПЭ	25	⩾10	15	5	20 (50*)	⩽10 (15 В)
КТ211Б-1	p-n-p, ПЭ	25	⩾10	15	5	20 (50*)	⩽10 (15 В)
КТ211В-1	p-n-p, ПЭ	25	⩾10	15	5	20 (50*)	⩽10 (15 В)
КТ214А-1	p-n-p, ПЭ	50	⩾5	80**	30	50 (100*)	⩽1 (30 В)
КТ214Б-1	p-n-p, ПЭ	50	⩾5	80**	7	50 (100*)	⩽1 (30 В)
КТ214В-1	p-n-p, ПЭ	50	⩾5	60**	7	50 (100*)	⩽1 (30 В)
КТ214Г-1	p-n-p, ПЭ	50	⩾5	40**	7	50 (100*)	⩽1 (30 В)
КТ214Д-1	p-n-p, ПЭ	50	⩾5	30**	7	50 (100*)	⩽1 (30 В)
КТ214Е-1	p-n-p, ПЭ	50	⩾5	20**	20	50 (100*)	⩽1 (30 В)
КТ215А-1	n-p-n, ПЭ	50	⩾5	80**	5	50 (100*)	⩽100* (30 В)
КТ215Б-1	n-p-n, ПЭ	50	⩾5	80**	5	50 (100*)	⩽100* (30 В)
КТ215В-1	n-p-n, ПЭ	50	⩾5	60**	5	50 (100*)	⩽100* (30 В)
КТ215Г-1	n-p-n, ПЭ	50	⩾5	40**	5	50 (100*)	⩽100* (30 В)
КТ215Д-1	n-p-n, ПЭ	50	⩾5	30**	5	50 (100*)	⩽100* (30 В)
КТ215Е-1	n-p-n, ПЭ	50	⩾5	20**	5	50 (100*)	⩽100* (30 В)
КТ216А	p-n-p, ПЭ	75	⩾5	60	30	10	⩽0,05
КТ216Б	p-n-p, ПЭ	75	⩾5	30	15	10	⩽0,05
КТ216В	p-n-p, ПЭ	75	⩾5	30	10	10	⩽1
КТ218А-9	p-n-p, ПЭ	200	⩾5	80	30	50	⩽1
КТ218Б-9	p-n-p, ПЭ	200	⩾5	80	7	50	⩽1
КТ218В-9	p-n-p, ПЭ	200	⩾5	60	7	50	⩽1
КТ218Г-9	p-n-p, ПЭ	200	⩾5	40	7	50	⩽1
КТ218Д-9	p-n-p, ПЭ	200	⩾5	30	7	50	⩽1
КТ218Е-9	p-n-p, ПЭ	200	⩾5	20	20	50	⩽1
КТ301	n-p-n, П	150 (60 °С)	⩾20	20	3	10 (20*)	⩽10
КТ301А	n-p-n, П	150 (60 °С)	⩾20	20	3	10 (20*)	⩽10
КТ301Б	n-p-n, П	150 (60 °С)	⩾20	30	3	10 (20*)	⩽10
КТ301В	n-p-n, П	150 (60 °С)	⩾20	30	3	10 (20*)	⩽10
КТ301Г	n-p-n, П	150 (60 °С)	⩾30	30	3	10	⩽10 (20 В)
КТ301Д	n-p-n, П	150 (60 °С)	⩾30	30	3	10	⩽10 (20 В)
КТ301Е	n-p-n, П	150 (60 °С)	⩾30	30	3	10	⩽10 (30 В)
КТ301Ж	n-p-n, П	150 (60 °С)	⩾30	20	3	10	⩽10 (20 В)
КТ302А	n-p-n, П	100 (50 °С)	—	15	4	10	⩽1 (15 В)
КТ302Б	n-p-n, П	100 (50 °С)	—	15	4	10	⩽1 (15 В)
КТ302В	n-p-n, П	100 (50 °С)	—	15	4	10	⩽1 (15 В)
КТ302Г	n-p-n, П	100 (50 °С)	—	15	4	10	⩽1 (15 В)
КТ306А	n-p-n, ПЭ	150 (90 °С)	⩾300	15	4	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)
КТ306Б	n-p-n, ПЭ	150 (90 °С)	⩾500	15	4	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)
КТ306В	n-p-n, ПЭ	150 (90 °С)	⩾300	15	4	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)
КТ306Г	n-p-n, ПЭ	150 (90 °С)	⩾500	15	4	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)
КТ306Д	n-p-n, ПЭ	150 (90 °С)	⩾200	15	4	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)
КТ306АМ	n-p-n, ПЭ	150 (90 °С)	⩾300	15	4	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)
КТ306БМ	n-p-n, ПЭ	150 (90 °С)	⩾500	15	4	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)
КТ306ВМ	n-p-n, ПЭ	150 (90 °С)	⩾300	15	4	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)
КТ306ГМ	n-p-n, ПЭ	150 (90 °С)	⩾500	15	4	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)
КТ306ДМ	n-p-n, ПЭ	150 (90 °С)	⩾200	15	4	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, $r^*_{БЭ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
80...240 (5 В; 1 мА)	⩽25 (5 В)	⩽50	—	—	
80...240 (5 В; 1 мА)	⩽25 (5 В)	⩽50	—	—	
40...120 (5 В; 1 мА)	⩽25 (5 В)	⩽50	—	—	
40...120 (1 В; 40 мА)	⩽20 (5 В)	—	⩽3 (1 кГц)	—	
80...240 (1 В; 40 мА)	⩽20 (5 В)	—	⩽3 (1 кГц)	—	
160...480 (1 В; 40 мА)	⩽20 (5 В)	—	⩽3 (1 кГц)	—	
⩾20 (5 В; 10 мА)	⩽50 (10 В)	⩽60	⩾1200*	—	
30...90 (5 В; 10 мА)	⩽50 (10 В)	⩽60	⩾1200*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	⩽50 (10 В)	⩽60	⩾1200*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	⩽50 (10 В)	⩽60	⩾1200*	—	
⩾80 (1 В; 40 мкА)	⩽50 (10 В)	⩽60	⩾1200*	—	
⩾40 (1 В; 40 мкА)	⩽50 (10 В)	⩽60	⩾1200*	—	
⩾20 (5 В; 10 мА)	⩽50 (10 В)	⩽60	⩾1200*	—	
30...90 (5 В; 10 мА)	⩽50 (10 В)	⩽60	⩾1200*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	⩽50 (10 В)	⩽60	⩾1200*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	⩽50 (10 В)	⩽60	⩾1200*	—	
⩾80 (1 В; 40 мА)	⩽50 (10 В)	⩽60	⩾1200*	—	
⩾40 (1 В; 40 мкА)	⩽50 (10 В)	⩽60	⩾1200*	—	
⩾9 (5 В; 1 мА)	⩽10	—	—	—	
30...150 (5 В; 1 мА)	⩽10	—	—	—	
30...200 (5 В; 1 мА)	⩽10	—	—	—	
⩾20 (5 В; 10 мА)	⩽15	—	—	—	
⩾30 (5 В; 10 мА)	⩽15	—	—	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	⩽15	—	—	—	
⩾40 (5 В; 10 мА)	⩽15	—	—	—	
⩾80 (1 В; 40 мкА)	⩽15	—	—	—	
⩾40 (1 В; 40 мкА)	⩽15	—	—	—	
20...60 (10 В; 3 мА)	⩽10 (10 В)	⩽300	—	—	
40...120 (10 В; 3 мА)	⩽10 (10 В)	⩽300	—	—	
10...32 (10 В; 3 мА)	⩽10 (10 В)	⩽300	—	—	
20...60 (10 В; 3 мА)	⩽10 (10 В)	⩽300	—	—	
10...32 (10 В; 3 мА)	⩽10 (10 В)	⩽300	—	⩽2000	
20...60 (10 В; 3 мА)	⩽10 (10 В)	⩽300	—	⩽2000	
40...120 (10 В; 3 мА)	⩽10 (10 В)	⩽300	—	⩽2000	
80...300 (10 В; 3 мА)	⩽10 (10 В)	⩽300	—	⩽2000	
110...250 (1 В; 11 мА)	—	—	⩽7 (1 кГц)	—	
90...150 (3 В; 2 мА)	—	—	⩽7 (1 кГц)	—	
110...250 (1,5 В; 0,5 мА)	—	—	⩽7 (1 кГц)	—	
200...800 (3,5 В; 5 мА)	—	—	⩽7 (1 кГц)	—	
20...60* (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽30	—	⩽30*	
40...120* (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽30	—	⩽30*	
20...100* (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽30*	⩽500	
40...200* (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽30*	⩽500	
30...150* (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽30*	⩽300	
20...60* (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽30	—	⩽30*	
40...120* (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽30	—	⩽30*	
20...100* (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽30*	⩽500	
40...200* (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽30*	⩽500	
30...150* (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽30*	⩽300	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
П307	n-p-n, П	250	⩾20	80*	3	30 (120*)	⩽20 (80 В)
П307А	n-p-n, П	250	⩾20	80*	3	30 (120*)	⩽20 (80 В)
П307Б	n-p-n, П	250	⩾20	80*	3	15 (120*)	⩽20 (80 В)
П307В	n-p-n, П	250	⩾20	60*	3	30 (120*)	⩽20 (60 В)
П307Г	n-p-n, П	250	⩾20	80*	3	15 (120*)	⩽20 (80 В)
КТ307А-1	n-p-n, ПЭ	15	⩾250	10* (3 к)	4	20 (50*)	⩽0,5 (10 В)
КТ307Б-1	n-p-n, ПЭ	15	⩾250	10* (3 к)	4	20 (50*)	⩽0,5 (10 В)
КТ307В-1	n-p-n, ПЭ	15	⩾250	10* (3 к)	4	20 (50*)	⩽0,5 (10 В)
КТ307Г-1	n-p-n, ПЭ	15	⩾250	10* (3 к)	4	20 (50*)	⩽0,5 (10 В)
П308	n-p-n, П	250	⩾20	120*	3	30 (120*)	⩽20 (120 В)
П309	n-p-n, П	250	⩾20	120*	3	30 (120*)	⩽20 (120 В)
КТ3101А-2	n-p-n, ПЭ	100 (45 °С)	⩾4000	15	2,5	20 (40*)	⩽0,5 (15 В)
КТ3102А	n-p-n, ПЭ	250	⩾150	50	5	100 (200*)	⩽0,05 (50 В)
КТ3102Б	n-p-n, ПЭ	250	⩾150	50	5	100 (200*)	⩽0,05 (50 В)
КТ3102В	n-p-n, ПЭ	250	⩾150	50	5	100 (200*)	⩽0,015 (30 В)
КТ3102Г	n-p-n, ПЭ	250	⩾300	20	5	100 (200*)	⩽0,015 (20 В)
КТ3102Д	n-p-n, ПЭ	250	⩾150	30	5	100 (200*)	⩽0,015 (30 В)
КТ3102Е	n-p-n, ПЭ	250	⩾300	20	5	100 (200*)	⩽0,015 (20 В)
КТ3104А	p-n-p, П	15 (35 °С)	⩾200	30	3,5	10	⩽1 (30 В)
КТ3104Б	p-n-p, П	15 (35 °С)	⩾200	30	3,5	10	⩽1 (30 В)
КТ3104В	p-n-p, П	15 (35 °С)	⩾200	30	3,5	10	⩽1 (30 В)
КТ3104Г	p-n-p, П	15 (35 °С)	⩾200	15	3,5	10	⩽1 (15 В)
КТ3104Д	p-n-p, П	15 (35 °С)	⩾200	15	3,5	10	⩽1 (15 В)
КТ3104Е	p-n-p, П	15 (35 °С)	⩾200	15	3,5	10	⩽1 (15 В)
КТ3106А-2	n-p-n, ПЭ	30 (50 °С)	⩾1000	15* (10 к)	2,5	20 (40*)	⩽0,5 (15 В)
КТ3107А	p-n-p, ПЭ	300	⩾200	50	5	100 (200*)	⩽0,1 (20 В)
КТ3107Б	p-n-p, ПЭ	300	⩾200	50	5	100 (200*)	⩽0,1 (20 В)
КТ3107В	p-n-p, ПЭ	300	⩾200	30	5	100 (200*)	⩽0,1 (20 В)
КТ3107Г	p-n-p, ПЭ	300	⩾200	30	5	100 (200*)	⩽0,1 (20 В)
КТ3107Д	p-n-p, ПЭ	300	⩾200	30	5	100 (200*)	⩽0,1 (20 В)
КТ3107Е	p-n-p, ПЭ	300	⩾200	25	5	100 (200*)	⩽0,1 (20 В)
КТ3107Ж	p-n-p, ПЭ	300	⩾200	25	5	100 (200*)	⩽0,1 (20 В)
КТ3107И	p-n-p, ПЭ	300	⩾200	50	5	100 (200*)	⩽0,1 (20 В)
КТ3107К	p-n-p, ПЭ	300	⩾200	30	5	100 (200*)	⩽0,1 (20 В)
КТ3107Л	p-n-p, ПЭ	300	⩾200	25	5	100 (200*)	⩽0,1 (20 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
16...50* (20 В; 10 мА) 30...90* (20 В; 10 мА) 50...150* (20 В; 10 мА) 50...150* (20 В; 10 мА) 15...50* (20 В; 10 мА)	— — — — —	≤150 ≤200 ≤330 ≤250 ≤250	— — — — —	— — — — —	
≥20 (1 В; 10 мА) ≥40 (1 В; 10 мА) ≥40 (1 В; 10 мА) ≥80 (1 В; 10 мА)	≤6 (1 В) ≤6 (1 В) ≤6 (1 В) ≤6 (1 В)	≤20 ≤20 ≤20 ≤20	— — — —	≤30* ≤30* ≤30* ≤30*	
30...90* (20 В; 10 мА) 16...50* (20 В; 10 мА)	— —	≤330 ≤200	— —	— —	
35...300 (1 В; 5 мА)	≤1,5 (5 В)	—	≤4,5 (2,25 ГГц)	≤10	
100...200 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 1 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 400...1000 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 400...1000 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В) ≤6 (5 В) ≤6 (5 В) ≤6 (5 В) ≤6 (5 В) ≤6 (5 В)	— — — — — —	≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤4 (1 кГц) ≤4 (1 кГц)	≤100 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100	
15...90 (1 В; 2 мА) 50...150 (1 В; 2 мА) 70...280 (1 В; 2 мА) 15...90 (1 В; 2 мА) 50...150 (1 В; 2 мА) 70...280 (1 В; 2 мА)	≤25 (5 В) ≤25 (5 В) ≤25 (5 В) ≤25 (5 В) ≤25 (5 В) ≤25 (5 В)	≤100 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100	≤8 (60 МГц) ≤8 (60 МГц) ≤8 (60 МГц) ≤8 (60 МГц) ≤8 (60 МГц) ≤8 (60 МГц)	≤800 ≤800 ≤800 ≤800 ≤800 ≤800	
≥40 (5 В; 5 мА)	≤2 (5 В)	—	≤2 (120 МГц)	—	
70...140 (5 В; 2 мА) 120...220 (5 В; 2 мА) 70...140 (5 В; 2 мА) 120...220 (5 В; 2 мА) 180...460 (5 В; 3 мА) 120...220 (5 В; 2 мА) 180...460 (5 В; 2 мА) 180...460 (5 В; 2 мА) 380...800 (5 В; 2 мА) 380...800 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В)	≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20	≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤4 (1 кГц) ≤4 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤4 (1 кГц)	— — — — — — — — — —	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^*_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^*_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ3108А КТ3108Б КТ3108В	*p-n-p*, ПЭ *p-n-p*, ПЭ *p-n-p*, ПЭ	300 (360*) 300 (360*) 300 (360*)	⩾250 ⩾250 ⩾300	60* (10 к) 45* (10 к) 45* (10 к)	5 5 5	200 200 200	⩽0,2 (60 В) ⩽0,2 (45 В) ⩽0,2 (45 В)
КТ3109А КТ3109Б КТ3109В	*p-n-p*, ПЭ *p-n-p*, ПЭ *p-n-p*, ПЭ	170 (40 °С) 170 (40 °С) 170 (40 °С)	⩾800 ⩾800 ⩾800	30 25 25	3 3 3	50 50 50	⩽0,1 (20 В) ⩽0,1 (20 В) ⩽0,1 (20 В)
КТ3114Б-6 КТ3114В-6	*n-p-n*, П *n-p-n*, П	25 (100 °С) 25 (100 °С)	⩾4300 ⩾4300	5 5	1 1	15 15	⩽0,5 (5 В) ⩽0,5 (5 В)
КТ3115А-2 КТ3115В-2 КТ3115Г-2	*n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ	70 (70 °С) 70 (70 °С) 50 (85 °С)	⩾5800 ⩾5800 ⩾5800	10* (1 к) 10* (1 к) 7* (1 к)	1 1 1	8,5 8,5 8,5	⩽0,5 (10 В) ⩽0,5 (10 В) ⩽0,5 (7 В)
КТ3117А	*n-p-n*, ПЭ	300 (800**)	⩾200	60	4	400 (800*)	⩽10 (60 В)
КТ312А КТ312Б КТ312В	*n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ	225 225 225	⩾80 ⩾120 ⩾120	20 35 20	4 4 4	30 (60*) 30 (60*) 30 (60*)	⩽10 (20 В) ⩽ 10 (35 В) ⩽10 (25 В)
КТ3120А	*n-p-n*, ПЭ	100	⩾1800	15	3	20 (40*)	⩽0,5 (15 В)
КТ3123А-2 КТ3123Б-2 КТ3123В-2	*p-n-p*, ПЭ *p-n-p*, ПЭ *p-n-p*, ПЭ	150 150 150	5000 5000 5000	15 15 10	3 3 3	30 (50*) 30 (50*) 30 (50*)	0,01 0,01 0,01
КТ3123АМ КТ3123БМ КТ3123ВМ	*p-n-p*, ПЭ *p-n-p*, ПЭ *p-n-p*, ПЭ	150 150 150	5000 5000 5000	15 15 10	3 3 3	30 (50*) 30 (50*) 30 (50*)	0,01 0,01 0,01

$h_{21э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, $r^*_{БЭ\,нас}$, Ом, $K^{**}_{у,Р}$, дБ	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
50...150 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 100...300 (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В) ≤5 (10 В) ≤5 (10 В)	≤25 ≤25 ≤25	≤6 (100 МГц) ≤6 (100 МГц) ≤6 (100 МГц)	≤250 ≤250 ≤250	
≥15 (10 В; 10 мА) ≥15 (10 В; 10 мА) ≥15 (10 В; 10 мА)	≤1 (10 В) ≤1 (20 В) ≤1 (10 В)	≥10** (0,8 ГГц) — —	≤6 (800 МГц) ≤7 (800 МГц) ≤8 (800 МГц)	≤6 ≤10 ≤10	
15...80 (3 В; 1 мА) 15...80 (3 В; 1 мА)	≤0,44 (3 В) ≤0,44 (3 В)	— —	≤2 (400 МГц) ≤3 (400 МГц)	≤8 ≤8	
≥15 (5 В; 5 мА) ≥15 (5 В; 5 мА) ≥15 (5 В; 5 мА)	≤0,6 (5 В) ≤0,6 (5 В) ≤0,6 (5 В)	— — —	≤5 (5 ГГц) ≤6 (4 ГГц) ≤4 (5 ГГц)	≤3,8 ≤3,8 ≤3,8	
40...200* (5 В; 0,2А)	≤10 (10 В)	≤1,2	—	≤80*	
10...100* (2 В; 20 мА) 25...100* (2 В; 20 мА) 50...280* (2 В; 20 мА)	≤5 (10 В) ≤5 (10 В) ≤5 (10 В)	≤40 ≤40 ≤40	— — —	≤500 ≤500 ≤500	
≥40 (1 В; 5 мА)	≤2 (5 В)	≥10** (400 МГц)	≤2 (400 МГц)	≤8	
40 (10 В; 10 мА) 40 (10 В; 10 мА) 40 (10 В; 10 мА)	0,7 0,7 0,7	— — —	2,4 (1 ГГц) 3 (1 ГГц) 2,4 (1 ГГц)	— — —	
40 (10 В; 10 мА) 40 (10 В; 10 мА) 40 (10 В; 10 мА)	0,7 0,7 0,7	— — —	2,4 (1 ГГц) 3 (1 ГГц) 2,4 (1 ГГц)	— — —	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ3126А	p-n-p, ПЭ	150 (30 °С)	⩾500	20	3	20	⩽1 (15 В)
КТ3126Б	p-n-p, ПЭ	150 (30 °С)	⩾500	20	3	20	⩽1 (15 В)
КТ3126А9	p-n-p, ПЭ	110	⩾450	35	3	30	⩽1 (15 В)
КТ3127А	p-n-p, ПЭ	100 (35 °С)	⩾600	20	3	25	⩽1 (15 В)
КТ3128А	p-n-p, ПЭ	100 (35 °С)	⩾800	40	3	20	⩽1 (15 В)
КТ3129А9	p-n-p, ПЭ	75 (100**)	⩾200	50	5	100 (200*)	⩽1 (50 В)
КТ3129Б9	p-n-p, ПЭ	75 (100**)	⩾200	50	5	100 (200*)	⩽1 (50 В)
КТ3129В9	p-n-p, ПЭ	75 (100**)	⩾200	30	5	100 (200*)	⩽1 (30 В)
КТ3129Г9	p-n-p, ПЭ	75 (100**)	⩾200	30	5	100 (200*)	⩽1 (30 В)
КТ3129Д9	p-n-p, ПЭ	75 (100**)	⩾200	20	5	100 (200*)	⩽1 (20 В)
КТ313А	p-n-p, ПЭ	300 (1000*)	⩾200	60	5	350 (700*)	⩽0,5 (50 В)
КТ313Б	p-n-n, ПЭ	300 (1000*)	⩾200	60	5	350 (700*)	⩽0,5 (50 В)
КТ3130А-9	n-p-n, ПЭ	100	⩾150	50	5	100	⩽0,1 (50 В)
КТ3130Б-9	n-p-n, ПЭ	100	⩾150	50	5	100	⩽0,1 (50 В)
КТ3130В-9	n-p-n, ПЭ	100	⩾150	30	5	100	⩽0,1 (30 В)
КТ3130Г-9	n-p-n, ПЭ	100	⩾300	20	5	100	⩽0,1 (20 В)
КТ3130Д-9	n-p-n, ПЭ	100	⩾150	30	5	100	⩽0,1 (30 В)
КТ3130Е-9	n-p-n, ПЭ	100	⩾300	20	5	100	⩽0,1 (20 В)
КТ3130Ж-9	n-p-n, ПЭ	100	⩾150	30	5	100	⩽0,1 (30 В)
КТ3139А	n-p-n, ПЭ	200	⩾150	20	5	200	⩽0,02 (20 В)
КТ3139Б	n-p-n, ПЭ	200	⩾150	32	5	200	⩽0,001 (32 В)
КТ3139В	n-p-n, ПЭ	200	⩾150	32	5	200	⩽0,001 (32 В)
КТ3139Г	n-p-n, ПЭ	200	⩾150	32	5	200	⩽0,05 (32 В)
КТ311А-2	n-p-n, ПЭ	500	⩾300	55	4	60 (70*)	⩽0,075 (55 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, нс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, мс	Габаритный чертеж корпуса
25...100 (5 В; 3 мА) 60...180 (5 В; 3 мА)	⩽2,5 (10 В) ⩽2,5 (10 В)	⩽120 ⩽120	— —	⩽15 ⩽15	
25...150 (5 В; 3 мА)	—	⩽120	—	⩽10	
25...150 (5 В; 3 мА) 15...150 (5 В; 3 мА)	⩽1 (10 В) ⩽1 (10 В)	— —	⩽5 (1 ГГц) 34*	⩽10 ⩽5	
30...120 (5 В; 2 мА) 80...250 (5 В; 3 мА) 80...250 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА)	10 (10 В) 10 (10 В) 10 (10 В) 10 (10 В) 10 (10 В)	⩽20 ⩽20 ⩽20 ⩽20 ⩽20	— — — — —	— — — — —	
30...120 (10 В; 1 мА) 80...300 (10 В; 1 мА)	⩽12 (10 В) ⩽12 (10 В)	⩽3,3 ⩽3,3	— —	⩽120* ⩽120*	
100...250 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 400...1000 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 400...1000 (5 В; 2 мА) 100...500 (5 В; 2 мА)	⩽12 (5 В) ⩽12 (5 В) ⩽12 (5 В) ⩽12 (5 В) ⩽12 (5 В) ⩽12 (5 В) ⩽12 (5 В)	— — — — — — —	⩽10 (1 кГц) ⩽10 (1 КгЦ) ⩽10 (1 кГц) ⩽10 (1 кГц) ⩽10 (1 кГц) ⩽4 (1 кГц) ⩽4 (1 кГц)	— — — — — — —	
⩾200 (5 В; 0,2 мА) ⩾60 (5 В; 2 мА) ⩾120 (5 В; 2 мА) 100...310 (5 В; 2 мА)	⩽4,5 (10 В) ⩽4,5 (10 В) ⩽4,5 (10 В) ⩽4,5 (10 В)	⩽50 ⩽50 ⩽50 ⩽50	⩽85** ⩽85** ⩽85** ⩽85**	⩽270* ⩽270* ⩽270* ⩽270*	
30...120 (5 В; 0,25 мА)	⩽10 (5 В)	⩽10	—	⩽80 ⩽300*	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ3140А	*p-n-p*, ПЭ	200	⩾150	20	5	200	⩽0,02 (20 В)
КТ3140Б	*p-n-p*, ПЭ	200	⩾150	32	5	200	⩽0,001 (32 В)
КТ3140В	*p-n-p*, ПЭ	200	⩾150	32	5	200	⩽0,001 (32 В)
КТ3140Г	*p-n-p*, ПЭ	200	⩾150	32	5	200	⩽0,05 (32 В)
КТ3140Д	*p-n-p*, ПЭ	200	⩾150	20	5	200	⩽0,02 (20 В)
КТ3145А-9	*n-p-n*, ПЭ	200	⩾125	32* (0,1 к)	5	200	⩽0,02 (32 В)
КТ3145Б-9	*n-p-n*, ПЭ	200	⩾125	45* (0,1 к)	5	200	⩽1 (45 В)
КТ3145В-9	*n-p-n*, ПЭ	200	⩾125	45* (0,1 к)	5	200	⩽1 (45 В)
КТ3145Г-9	*n-p-n*, ПЭ	200	⩾125	45* (0,1 к)	5	200	⩽0,05 (45 В)
КТ3145Д-9	*n-p-n*, ПЭ	200	⩾125	45* (0,1 к)	5	100	⩽0,05 (45 В)
КТ3146А-9	*p-n-p*, ПЭ	200	⩾125	32* (0,1 к)	5	200	⩽0,02 (32 В)
КТ3146Б-9	*p-n-p*, ПЭ	200	⩾125	45* (0,1 к)	5	200	⩽1 (45 В)
КТ3146В-9	*p-n-p*, ПЭ	200	⩾125	45* (0,1 к)	5	200	⩽1 (45 В)
КТ3146Г-9	*p-n-p*, ПЭ	200	⩾125	45* (0,1 к)	5	200	⩽0,05 (45 В)
КТ3145Д-9	*p-n-p*, ПЭ	200	⩾125	45* (0,1 к)	5	200	⩽0,05 (45 В)
КТ315А	*n-p-n*, ПЭ	150 (25*)	⩾250	25	6	100	⩽0,5 (10 В)
КТ315Б	*n-p-n*, ПЭ	150 (250*)	⩾250	20	6	100	⩽0,5 (10 В)
КТ315В	*n-p-n*, ПЭ	150 (250*)	⩾250	40	6	100	⩽0,5 (10 В)
КТ315Г	*n-p-n*, ПЭ	150 (250*)	⩾250	35	6	100	⩽0,5 (10 В)
КТ315Д	*n-p-n*, ПЭ	150 (250*)	⩾250	40* (10 к)	6	100	⩽0,6 (10 В)
КТ315Е	*n-p-n*, ПЭ	150 (250*)	⩾250	35* (10 к)	6	100	⩽0,6 (10 В)
КТ315Ж	*n-p-n*, ПЭ	100	⩾250	20* (10 к)	6	50	⩽0,6 (10 В)
КТ315И	*n-p-n*, ПЭ	100	⩾250	60* (10 к)	6	50	⩽0,6 (10 В)
КТ315Р	*n-p-n*, ПЭ	150	⩾250	35* (10 к)	6	100	⩽0,5 (10 В)
КТ3150Б-2	*p-n-p*, ПЭ	120 (65 °С)	⩾1200	35* (10 к)	4	300 (500*)	⩽5 (40 В)
КТ3151А-9	*n-p-n*, ПЭ	200	⩾100	80*	5	100	⩽1
КТ3151Б-9	*n-p-n*, ПЭ	200	⩾100	80*	5	100	⩽1
КТ3151В-9	*n-p-n*, ПЭ	200	⩾100	60*	5	100	⩽1
КТ3151Г-9	*n-p-n*, ПЭ	200	⩾100	40*	5	100	⩽1
КТ3151Д-9	*n-p-n*, ПЭ	200	⩾100	30*	5	100	⩽1
КТ3151Е-9	*n-p-n*, ПЭ	200	⩾100	20*	5	100	⩽1
КТ3153А-9	*n-p-n*, ПЭ	300	⩾250	60	5	400	⩽0,05

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габарнтный чертеж корпуса
⩾200 (5 В; 2 мА)	⩽6,5 (10 В)	⩽50	⩽85**	⩽270*	
⩾60 (5 В; 2 мА)	⩽6,5 (10 В)	⩽50	⩽85**	⩽270*	
120...460 (5 В; 2 мА)	⩽6,5 (10 В)	⩽50	⩽85**	⩽270*	
100...310 (5 В; 2 мА)	⩽6,5 (10 В)	⩽50	⩽85**	⩽270*	
⩾200 (5 В; 2 мА)	⩽6,5 (10 В)	⩽50	⩽85**	⩽270*	
⩾200 (5 В; 2 мА)	⩽11	⩽50	—	⩽1100*	
⩾60 (5 В; 2 мА)	⩽11	⩽50	—	⩽1100*	
120...460 (5 В; 2 мА)	⩽11	⩽50	—	⩽1100*	
100...310 (5 В; 2 мА)	⩽11	⩽50	—	⩽1100*	
120...460 (5 В; 2 мА)	⩽11	⩽50	—	⩽1100*	
⩾200 (5 В; 2 мА)	⩽12	⩽50	—	⩽1100*	
⩾60 (5 В; 2 мА)	⩽12	⩽50	—	⩽1100*	
120...460 (5 В; 2 мА)	⩽12	⩽50	—	⩽1100*	
100...310 (5 В; 2 мА)	⩽12	⩽50	—	⩽1100*	
120...460 (5 В; 2 мА)	⩽12	⩽50	—	⩽1100*	
30...120* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽20	⩽40*	⩽300	
50...350* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽20	⩽40*	⩽500	
30...120* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽20	⩽40*	⩽500	
50...350* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽20	⩽40*	⩽500	
20...90* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽30	⩽40*	⩽1000	
50...350* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽30	⩽40*	⩽1000	
30...250* (10 В; 1 мА)	⩽10 (10 В)	⩽25	—	⩽800	
⩾30* (10 В; 1 мА)	⩽10 (10 В)	⩽45	—	⩽950	
150...350* (10 В; 1 мА)	⩽7 (10 В)	⩽20	—	⩽500	
60...180* (5 В; 2,5 мА)	⩽2 (10 В)	⩽25	—	⩽30*	
⩾20	—	⩽60	—	—	
⩾30	—	⩽60	—	—	
⩾40	—	⩽60	—	—	
⩾40	—	⩽60	—	—	
⩾80	—	⩽60	—	—	
⩾40	—	⩽60	—	—	
100...300	—	⩽2,6	—	—	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^*_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^*_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ3157А	*p-n-p*, ПЭ	200	⩾60	250* (10 к)	5	30 (100*)	⩽0,1 (200 В)
КТ316А	*n-p-n*, ПЭ	150 (90 °С)	⩾600	10* (3 к)	4	50	⩽0,5 (10 В)
КТ316Б	*n-p-n*, ПЭ	150 (90 °С)	⩾800	10* (3 к)	4	50	⩽0,5 (10 В)
КТ316В	*n-p-n*, ПЭ	150 (90 °С)	⩾800	10* (3 к)	4	50	⩽0,5 (10 В)
КТ316Г	*n-p-n*, ПЭ	150 (90 °С)	⩾600	10* (3 к)	4	50	⩽0,5 (10 В)
КТ316Д	*n-p-n*, ПЭ	150 (90 °С)	⩾800	10* (3 к)	4	50	⩽0,5 (10 В)
КТ316АМ	*n-p-n*, ПЭ	150 (85 °С)	⩾600	10* (3 к)	4	50	⩽0,5 (10 В)
КТ316БМ	*n-p-n*, ПЭ	150 (85 °С)	⩾800	10* (3 к)	4	50	⩽0,5 (10 В)
КТ316ВМ	*n-p-n*, ПЭ	150 (85 °С)	⩾800	10* (3 к)	4	50	⩽0,5 (10 В)
КТ316ГМ	*n-p-n*, ПЭ	150 (85 °С)	⩾600	10* (3 к)	4	50	⩽0,5 (10 В)
КТ316ДМ	*n-p-n*, ПЭ	150 (85 °С)	⩾800	10* (3 к)	4	50	⩽0,5 (10 В)
КТ3165А	*p-n-p*, ПЭ	160 (55 °С)	⩾750	40	3	30	⩽0,1 (20 В)
КТ3168А-9	*n-p-n*, ПЭ	180 (55 °С)	⩾3000	15* (10 к)	2,5	28 (56*)	⩽0,5 (15 В)
КТ3169А-9	*p-n-p*, ПЭ	200	⩾750	40	3	30	⩽0,1 (20 В)
КТ317А-1	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾100	5	3,5	15 (45*)	⩽1 (5 В)
КТ317Б-1	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾100	5	3,5	15 (45*)	⩽1 (5 В)
КТ317В-1	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾100	5	3,5	15 (45*)	⩽1 (5 В)
КТ318А-1	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾430	10	3,5	20 (45*)	⩽0,5 (10 В)
КТ318Б-1	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾430	10	3,5	20 (45*)	⩽0,5 (10 В)
КТ318В-1	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾430	10	3,5	20 (45*)	⩽0,5 (10 В)
КТ318Г-1	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾350	10	3,5	20 (45*)	⩽0,5 (10 В)
КТ318Д-1	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾350	10	3,5	20 (45*)	⩽0,5 (10 В)
КТ318Е-1	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾350	10	3,5	20 (45*)	⩽0,5 (10 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
≥50* (20 В; 25 мА)	≤3 (30 В)	≤60	—	—	
20...60* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 20...100* (1 В; 10 мА) 60...300* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В)	≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40	— — — — —	≤10* ≤10* ≤15* ≤150 ≤150	
20...60* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 20...100* (1 В; 10 мА) 60...300* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В)	≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40	— — — — —	≤10* ≤10* ≤15* ≤150 ≤150	
>25* (10 В; 3 мА)	≤0,65 (10 В)	—	≤8 (1 ГГц)	≤30	
60...180 (5 В; 5 мА)	≤1,5 (5 В)	—	≤3 (1 ГГц)	≤10	
≥25 (1 В; 3 мА)	≤0,6 (10 В)	—	≤6 (800 МГц)	—	
25...75 (1 В; 1 мА) 35...120 (1 В; 1 мА) 80...250 (1 В; 1 мА)	≤11 (1 В) ≤11 (1 В) ≤11 (1 В)	≤30 ≤30 ≤30	— — —	≤130* ≤130* ≤130*	
30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА) 30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА)	≤3,5 (5 В) ≤3,5 (5 В) ≤3,5 (5 В) ≤4,5 (5 В) ≤4,5 (5 В) ≤4,5 (5 В)	≤27 ≤27 ≤27 ≤27 ≤27 ≤27	— — — — — —	≤15* ≤15* ≤15* ≤10* ≤10* ≤10*	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К.\,т\,max}$, $P^{**}_{К.\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К.\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ319А-1	*n-p-n*, ПЭ	15	≥100	5	3,5	15	≤1
КТ319Б-1	*n-p-n*, ПЭ	15	≥100	5	3,5	15	≤1
КТ319В-1	*n-p-n*, ПЭ	15	≥100	5	3,5	15	≤1
КТ321А	*p-n-p*, ПЭ	210 (20** Вт)	≥60	60	4	200 (2* А)	≤0,1 (60 В)
КТ321Б	*p-n-p*, ПЭ	210 (20** Вт)	>60	60	4	200 (2* А)	≤0,1 (60 В)
КТ321В	*p-n-p*, ПЭ	210 (20** Вт)	≥60	60	4	200 (2* А)	≤0,1 (60 В)
КТ321Г	*p-n-p*, ПЭ	210 (20** Вт)	≥60	45	4	200 (2* А)	≤0,1 (45 В)
КТ321Д	*p-n-p*, ПЭ	210 (20** Вт)	≥60	45	4	200 (2* А)	≤0,1 (45 В)
КТ321Е	*p-n-p*, ПЭ	210 (20** Вт)	≥60	45	4	200 (2* А)	≤0,1 (45 В)
КТ324А-1	*n-p-n*, ПЭ	15	≥800	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10В)
КТ324Б-1	*n-p-n*, ПЭ	15	≥800	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ324В-1	*n-p-n*, ПЭ	15	≥800	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ324Г-1	*n-p-n*, ПЭ	15	≥600	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ324Д-1	*n-p-n*, ПЭ	15	≥600	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ324Е-1	*n-p-n*, ПЭ	15	≥600	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ325А	*n-p-n*, ПЭ	225 (85 °С)	≥800	15* (3 к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ325Б	*n-p-n*, ПЭ	225 (85 °С)	≥800	15* (3 к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ325В	*n-p-n*, ПЭ	225 (85 °С)	≥1000	15* (3 к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ325АМ	*n-p-n*, ПЭ	225 (85 °С)	≥800	15* (3 к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ325БМ	*n-p-n*, ПЭ	225 (85 °С)	≥800	15* (3 к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ325ВМ	*n-p-n*, ПЭ	225 (85 °С)	≥1000	15* (3 к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ326А	*p-n-p*, ПЭ	200 (30 °С)	≥250	15* (100 к)	5	50	≤0,5 (20 В)
КТ326Б	*p-n-p*, ПЭ	200 (30 °С)	≥400	15* (100 к)	5	50	≤0,5 (20 В)
КТ326АМ	*p-n-p*, ПЭ	200 (30 °С)	≥250	15* (100 к)	5	50	≤0,5 (20 В)
КТ326БМ	*p-n-p*, ПЭ	200 (30 °С)	≥400	15* (100 к)	5	50	≤0,5 (20 В)
КТ331А-1	*n-p-n*, П	15	≥250	15* (10 к)	3	20 (50*)	≤0,2 (15 В)
КТ331Б-1	*n-p-n*, П	15	≥250	15* (10 к)	3	20 (50*)	≤0,2 (15 В)
КТ331В-1	*n-p-n*, П	15	≥250	15* (10 к)	3	20 (50*)	≤0,2 (15 В)
КТ331Г-1	*n-p-n*, П	15	≥400	15* (10 к)	3	20 (50*)	≤0,2 (15 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{21э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
15...55 (1 В; 1 мА)	⩽11 (1 В)	⩽30	—	⩽130*	
45...90 (1 В; 1 мА)	⩽11 (1 В)	⩽30	—	⩽130*	
80...200 (1 В; 1 мА)	⩽11 (1 В)	⩽30	—	⩽130*	
20...60* (3 В; 0,5 А)	⩽80 (10 В)	⩽3,6	—	⩽1000*	
40...120* (3 В; 0,5 А)	⩽80 (10 В)	⩽3,6	—	⩽1000*	
80...200* (3 В; 0,5 А)	⩽80 (10 В)	⩽3,6	—	⩽1000*	
20...60* (3 В; 0,5 А)	⩽80 (10 В)	⩽3,6	—	⩽1000*	
40...120* (3 В; 0,5 А)	⩽80 (10 В)	⩽3,6	—	⩽1000*	
80...200* (3 В; 0,5 А)	⩽80 (10 В)	⩽3,6	—	⩽1000*	
20...60 (1 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	⩽30	—	⩽180; ⩽10*	
40...120 (1 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	⩽30	—	⩽180; ⩽10*	
80...250 (1 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	⩽30	—	⩽180; ⩽10*	
40...120 (1 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	⩽30	—	⩽180; ⩽10*	
20...80 (1 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	⩽30	—	⩽180; ⩽10*	
60...250 (1 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	⩽30	—	⩽180; ⩽10*	
30...90* (5 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	—	—	⩽125	
70...210* (5 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	—	—	⩽125	
160...400* (5 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	—	—	⩽125	
30...90* (5 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	—	—	⩽125	
70...210* (5 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	—	—	⩽125	
160...400* (5 В; 10 мА)	⩽2,5 (5 В)	—	—	⩽125	
20...70* (2 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽30	—	⩽450	
45...160* (2 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽30	—	⩽450	
20...70* (2 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽30	—	⩽450	
45...160* (2 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽30	—	⩽450	
20...60 (5 В; 1 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽4,5 (100 МГц)	⩽120	
40...120 (5 В; 1 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽4,5 (100 МГц)	⩽120	
80...220 (5 В; 1 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽4,5 (100 МГц)	⩽120	
40...120 (5 В; 1 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽4,5 (100 МГц)	⩽120	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ332А-1	n-p-n, П	15	⩾250	15* (10 к)	3	20 (50*)	⩽0,2 (15 В)
КТ332Б-1	n-p-n, П	15	⩾250	15* (10 к)	3	20 (50*)	⩽0,2 (15 В)
КТ332В-1	n-p-n, П	15	⩾250	15* (10 к)	3	20 (50*)	⩽0,2 (15 В)
КТ332Г-1	n-p-n, П	15	⩾500	15* (10 к)	3	20 (50*)	⩽0,2 (15 В)
КТ332Д-1	n-p-n, П	15	⩾500	15* (10 к)	3	20 (50*)	⩽0,2 (15 В)
КТ333А-3	n-p-n, П	15	⩾450	10* (3 к)	3,5	20 (45*)	⩽0,4 (10 В)
КТ333Б-3	n-p-n, П	15	⩾450	10* (3 к)	3,5	20 (45*)	⩽0,4 (10 В)
КТ333В-3	n-p-n, П	15	⩾450	10* (3 к)	3,5	20 (45*)	⩽0,4 (10 В)
КТ333Г-3	n-p-n, П	15	⩾350	10* (3 к)	3,5	20 (45*)	⩽0,4 (10 В)
КТ333Д-3	n-p-n, П	15	⩾350	10* (3 к)	3,5	20 (45*)	⩽0,4 (10 В)
КТ333Е-3	n-p-n, П	15	⩾350	10* (3 к)	3,5	20 (45*)	⩽0,4 (10 В)
КТ336А	n-p-n, ПЭ	50	⩾250	10* (3 к)	4	20 (50*)	⩽0,5 (10 В)
КТ336Б	n-p-n, ПЭ	50	⩾250	10* (3 к)	4	20 (50*)	⩽0,5 (10 В)
КТ336В	n-p-n, ПЭ	50	⩾250	10* (3 к)	4	20 (50*)	⩽0,5 (10 В)
КТ336Г	n-p-n, ПЭ	50	⩾450	10* (3 к)	4	20 (50*)	⩽0,5 (10 В)
КТ336Д	n-p-n, ПЭ	50	⩾450	10* (3 к)	4	20 (50*)	⩽0,5 (10 В)
КТ336Е	n-p-n, ПЭ	50	⩾450	10* (3 к)	4	20 (50*)	⩽0,5 (10 В)
КТ337А	p-n-p, ПЭ	150 (60 °С)	⩾500	6* (10 к)	4	30	⩽1 (6 В)
КТ337Б	p-n-p, ПЭ	150 (60 °С)	⩾600	6* (10 к)	4	30	⩽1 (6 В)
КТ337В	p-n-p, ПЭ	150 (60 °С)	⩾600	6* (10 к)	4	30	⩽1 (6 В)
КТ339АМ	n-p-n, ПЭ	260 (55 °С)	⩾300	40	4	25	⩽1 (40 В)
КТ339А	n-p-n, ПЭ	260 (55 °С)	⩾300	40	4	25	⩽1 (40 В)
КТ339Б	n-p-n, ПЭ	260 (55 °С)	⩾250	25	4	25	⩽1 (25 В)
КТ339В	n-p-n, ПЭ	260 (55 °С)	⩾450	40	4	25	⩽1 (40 В)
КТ339Г	n-p-n, ПЭ	260 (55 °С)	⩾250	40	4	25	⩽1 (40 В)
КТ339Д	n-p-n, ПЭ	260 (55 °С)	⩾250	40	4	25	⩽1 (40 В)
КТ340А	n-p-n, ПЭ	150 (85 °С)	⩾300	15	5	50	⩽1 (15 В)
КТ340Б	n-p-n, ПЭ	150 (85 °С)	⩾300	20	5	50	⩽1 (20 В)
КТ340В	n-p-n, ПЭ	150 (85 °С)	⩾300	15	5	50 (200*)	⩽1 (15 В)
КТ340Г	n-p-n, ПЭ	150 (85 °С)	⩾300	15	5	75 (500*)	⩽1 (15 В)
КТ340Д	n-p-n, ПЭ	150 (85 °С)	⩾300	15	5	50	⩽1 (15 В)
КТ342А	n-p-n, ПЭ	250	⩾250	35	5	50 (300*)	⩽0,05 (25 В)
КТ342Б	n-p-n, ПЭ	250	⩾300	30	5	50 (300*)	⩽0,05 (20 В)
КТ342В	n-p-n, ПЭ	250	⩾300	25	5	50 (300*)	⩽0,05 (10 В)
КТ342АМ	n-p-n, ПЭ	250	⩾250	35	5	50 (300*)	⩽0,05 (25 В)
КТ342БМ	n-p-n, ПЭ	250	⩾300	30	5	50 (300*)	⩽0,05 (20 В)
КТ342ВМ	n-p-n, ПЭ	250	⩾300	25	5	50 (300*)	⩽0,05 (10 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
20...60 (5 В; 1 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽8 (100 МГц)	⩽300	
40...120 (5 В; 1 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽8 (100 МГц)	⩽300	
80...220 (5 В; 1 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽8 (100 МГц)	⩽300	
40...120 (5 В; 1 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽8 (100 МГц)	⩽300	
80...220 (5 В; 1 мА)	⩽5 (5 В)	—	⩽8 (100 МГц)	⩽300	
30...90 (1 В; 10 мА)	⩽3,5 (5 В)	⩽27	—	⩽15*	
50...150 (1 В; 10 мА)	⩽3,5 (5 В)	⩽27	—	⩽15*	
70...280 (1 В; 10 мА)	⩽3,5 (5 В)	⩽27	—	⩽15*	
30...90 (1 В; 10 мА)	⩽4,5 (5 В)	⩽27	—	⩽25*	
50...150 (1 В; 10 мА)	⩽4,5 (5 В)	⩽27	—	⩽25*	
70...280 (1 В; 10 мА)	⩽4,5 (5 В)	⩽27	—	⩽25*	
20...60 (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽30	—	⩽30*	
40...120 (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽30	—	⩽30*	
80 (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽30	—	⩽50*	
20...60 (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽30	—	⩽15*	
40...120 (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽30	—	⩽15*	
⩾80 (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽30	—	⩽15*	
⩾30* (0,3 В; 10 мА)	⩽6 (5 В)	⩽20	—	⩽25*	
⩾50* (0,3 В; 10 мА)	⩽6 (5 В)	⩽20	—	⩽28*	
⩾70* (0,3 В; 10 мА)	⩽6 (5 В)	⩽20	—	⩽28*	
⩾25* (10 В; 7 мА)	⩽2 (5 В)	—	—	⩽25	
⩾25* (10 В; 7 мА)	⩽2 (5 В)	—	—	⩽25	
⩾15* (10 В; 7 мА)	⩽2 (5 В)	—	—	⩽25	
⩾25* (10 В; 7 мА)	⩽2 (5 В)	—	—	⩽50	
⩾40* (10 В; 7 мА)	⩽2 (5 В)	—	—	⩽100	
⩾15* (10 В; 7 мА)	⩽2 (5 В)	—	—	⩽150	
100...300* (1 В; 10 мА)	⩽3,7 (5 В)	⩽20	—	⩽45; ⩽10*	
100* (1 В; 10 мА)	⩽3,7 (5 В)	⩽25	—	⩽40; ⩽15*	
35* (2 В; 0,2)	⩽3,7 (5 В)	⩽2	—	⩽85; ⩽15*	
16* (2 В; 0,5 А)	⩽3,7 (5 В)	⩽1,2	—	⩽85; ⩽15*	
40* (2 В; 0,2 А)	⩽6 (5 В)	⩽30	—	⩽150; ⩽75*	
100...250* (5 В; 1 мА)	⩽8 (5 В)	⩽10	—	⩽200	
200...500* (5 В; 1 мА)	⩽8 (5 В)	⩽10	—	⩽300	
400...1000* (5 В; 1 мА)	⩽8 (5 В)	⩽10	—	⩽700	
100...250* (5 В; 1 мА)	⩽8 (5 В)	⩽10	—	⩽200	
200...500* (5 В; 1 мА)	⩽8 (5 В)	⩽10	—	⩽300	
400...1000* (5 В; 1 мА)	⩽8 (5 В)	⩽10	—	⩽700	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ343А	*p-n-p*, ПЭ	150 (75 °С)	⩾300	17* (10 к)	4	50 (150*)	⩽1 (10 В)
КТ343Б	*p-n-p*, ПЭ	150 (75 °С)	⩾300	17* (10 к)	4	50 (150*)	⩽1 (10 В)
КТ343В	*p-n-p*, ПЭ	150 (75 °С)	⩾300	9* (10 к)	4	50 (150*)	⩽1 (7 В)
КТ345А	*p-n-p*, ПЭ	300 (600**)	⩾350	20* (10 к)	5	200 (300*)	⩽0,5 (20 В)
КТ345Б	*p-n-p*, ПЭ	300 (600**)	⩾350	20* (10 к)	5	200 (300*)	⩽0,5 (20 В)
КТ345В	*p-n-p*, ПЭ	300 (600**)	⩾350	20* (10 к)	5	200 (300*)	⩽0,5 (20 В)
КТ347А	*p-n-p*, ПЭ	150 (75 °С)	⩾500	15* (10 к)	4	50 (110*)	⩽1 (15 В)
КТ347Б	*p-n-p*, ПЭ	150 (75 °С)	⩾500	9* (10 к)	4	50 (110*)	⩽1 (9 В)
КТ347В	*p-n-p*, ПЭ	150 (75 °С)	⩾500	6* (10 к)	4	50 (110*)	⩽1 (6 В)
КТ348А	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾100	5* (3 к)	3,5	15 (45*)	⩽1 (5 В)
КТ348Б	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾100	5* (3 к)	3,5	15 (45*)	⩽1 (5 В)
КТ348В	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾100	5* (3 к)	3,5	15 (45*)	⩽1 (5 В)
КТ349А	*p-n-p*, ПЭ	200 (35 °С)	⩾300	15* (10 к)	4	50 (100*)	⩽1 (10 В)
КТ349Б	*p-n-p*, ПЭ	200 (35 °С)	⩾300	15* (10 к)	4	50 (100*)	⩽1 (10 В)
КТ349В	*p-n-p*, ПЭ	200 (35 °С)	⩾300	15* (10 к)	4	50 (100*)	⩽1 (10 В)
КТ350А	*p-n-p*, ПЭ	300 (30 °С)	⩾100	20	5	600*	⩽1 (10 В)
КТ351А	*p-n-p*, ПЭ	300 (30 °С)	⩾200	15* (10 к)	5	400*	⩽1 (10 В)
КТ351Б	*p-n-p*, ПЭ	300 (30 °С)	⩾200	15* (10 к)	5	400*	⩽1 (10 В)
КТ352А	*p-n-p*, ПЭ	300 (30 °С)	⩾200	20	5	200*	⩽1 (10 В)
КТ352Б	*p-n-p*, ПЭ	300 (30 °С)	⩾200	20	5	200*	⩽1 (10 В)
КТ354А-2	*n-p-n*, ПЭ	30	⩾1100	10* (3 к)	4	10 (20*)	⩽0,5 (10 В)
КТ354Б-2	*n-p-n*, ПЭ	30	⩾1500	10* (3 к)	4	10 (20*)	⩽0,5 (10 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
⩾30* (0,3 В; 10 мА) ⩾50* (0,3 В; 10 мА) ⩾30* (0,3 В; 10 мА)	⩽6 (5 В) ⩽6 (5 В) ⩽6 (5 В)	⩽30 ⩽30 ⩽30	— — —	⩽10* ⩽20* ⩽10*	
⩾20* (1 В; 100 мА) ⩾50* (1 В; 100 мА) ⩾70* (1 В; 100 мА)	⩽15 (5 В) ⩽15 (5 В) ⩽15 (5 В)	⩽3 ⩽3 ⩽3	— — —	⩽70* ⩽70* ⩽70*	
30...400* (0,3 В; 10 мА) 30...400* (0,3 В; 10 мА) 50...400* (0,3 В; 10 мА)	⩽6 (5 В) ⩽6 (5 В) ⩽6 (5 В)	⩽30 ⩽30 ⩽30	— — —	⩽25* ⩽25* ⩽40*	
25...75 (1 В; 1 мА) 35...120 (1 В; 1 мА) 80...250 (1 В; 1 мА)	⩽11 (1 В) ⩽11 (1 В) ⩽11 (1 В)	⩽30 ⩽30 ⩽30	— — —	⩽130* ⩽130* ⩽130*	
20...80* (1 В; 10 мА) 40...160* (1 В; 10 мА) 120...300* (1 В; 10 мА)	⩽6 (5 В) ⩽6 (5 В) ⩽6 (5 В)	⩽30 ⩽30 ⩽30	— — —	— — —	
20...200* (1 В; 0,5А) 20...80* (1 В; 0,5А) 50...200* (1 В; 0,3 А) 25...125* (1 В; 0,2 А) 70...300* (1 В; 0,2 А)	⩽70 (5 В) ⩽20 (5 В) ⩽20 (5 В) ⩽15 (5 В) ⩽15 (5 В)	⩽2 ⩽1,5 ⩽2,25 ⩽3 ⩽3	— — — — —	— — — — ⩽150*	
20...200 (2 В; 5 мА) 45...360 (2 В; 5 мА)	⩽1,3 (5 В) ⩽1,3 (5 В)	— —	⩽10* ⩽10*	⩽25 ⩽30	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ355А	*n-p-n*, ПЭ	225 (85 °С)	⩾1500	15* (3 к)	4	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)
КТ355АМ	*n-p-n*, ПЭ	225 (85 °С)	⩾1500	15* (3 к)	4	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)
КТ357А	*p-n-p*, ПЭ	100 (50 °С)	⩾300	6*	3,5	40 (80*)	⩽5 (6 В)
КТ357Б	*p-n-p*, ПЭ	100 (50 °С)	⩾300	6*	3,5	40 (80*)	⩽5 (6 В)
КТ357В	*p-n-p*, ПЭ	100 (50 °С)	⩾300	20*	3,5	40 (80*)	⩽5 (20 В)
КТ357Г	*p-n-p*, ПЭ	100 (50 °С)	⩾300	20*	3,5	40 (80*)	⩽5 (20 В)
КТ358А	*n-p-n*, ПЭ	100 (50 °С)	⩾80	15	4	30 (60*)	⩽10 (15 В)
КТ358Б	*n-p-n*, ПЭ	100 (50 °С)	⩾120	30	4	30 (60*)	⩽10 (30 В)
КТ358В	*n-p-n*, ПЭ	100 (50 °С)	⩾120	15	4	30 (60*)	⩽10 (15 В)
КТ359А	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾300	15* (3 к)	3,5	20	⩽0,5 (15 В)
						20	⩽0,5 (15 В)
КТ359Б	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾300	15* (3 к)	3,5	20	⩽0,5 (15 В)
КТ359В	*n-p-n*, ПЭ	15	⩾300	15* (3 к)	3,5		
КТ360А-1	*p-n-p*, ПЭ	10 (55 °С)	⩾300	25	5	20 (75*)	⩽1 (25 В)
КТ360Б-1	*p-n-p*, ПЭ	10 (55 °С)	⩾400	20	4	20 (75*)	⩽1 (20 В)
КТ360В-1	*p-n-p*, ПЭ	10 (55 °С)	⩾400	20	4	20 (75*)	⩽1 (20 В)
КТ361А	*p-n-p*, ПЭ	150 (35 °С)	⩾250	25	4	50	⩽1 (10 В)
КТ361Б	*p-n-p*, ПЭ	150 (35 °С)	⩾250	20	4	50	⩽1 (10 В)
КТ361В	*p-n-p*, ПЭ	150 (35 °С)	⩾250	40	4	50	⩽1 (10 В)
КТ361Г	*p-n-p*, ПЭ	150 (35 °С)	⩾250	35	4	50	⩽1 (10 В)
КТ361Д	*p-n-p*, ПЭ	150 (35 °С)	⩾250	40	4	50	⩽1 (10 В)
КТ361Е	*p-n-p*, ПЭ	150 (35 °С)	⩾250	35	4	50	⩽1 (10 В)
КТ361Ж	*p-n-p*, ПЭ	150	⩾250	10	4	50	⩽1 (10 В)
КТ361И	*p-n-p*, ПЭ	150	⩾250	15	4	50	⩽1 (10 В)
КТ361К	*p-n-p*, ПЭ	150	⩾250	60	4	50	⩽1 (10 В)
КТ363А	*p-n-p*, ПЭ	150 (45 °С)	⩾1000	15* (1 к)	4,5	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)
КТ363Б	*p-n-p*, ПЭ	150 (45 °С)	⩾1500	12* (1 к)	4,5	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^{*}_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
80...300* (5 В; 10 мА)	⩽2 (5 В)	—	⩽5,5 (60 МГц)	⩽60	
80...300* (5 В; 10 мА)	2 (5 В)	—	⩽5,5 (60 МГц)	⩽60	
20...100* (0,5 В; 10 мА) 60...300* (0,5 В; 10 мА) 20...100* (0,5 В; 10 мА) 60...300* (0,5 В; 10 мА)	⩽7 (5 В) ⩽7 (5 В) ⩽7 (5 В) ⩽7 (5 В)	⩽30 ⩽30 ⩽30 ⩽30	— — — —	⩽150* ⩽250* ⩽150* ⩽250*	
10...100* (5,5 В; 20 мА) 25...100* (5,5 В; 20 мА) 50...280* (5,5 В; 20 мА)	⩽5 (10 В) ⩽5 (10 В) ⩽5 (10 В)	⩽40 ⩽40 ⩽40	— — —	⩽500 ⩽500 ⩽500	
30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА)	⩽5 (5 В) ⩽5 (5 В) ⩽5 (5 В)	⩽70 ⩽70 ⩽70	⩽6 (20 МГц) ⩽6 (20 МГц) ⩽6 (20 МГц)	⩽100 ⩽100 ⩽100	
20...70 (2 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽35	—	⩽450; ⩽100*	
40...140 (2 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽35	—	⩽450; ⩽200*	
80...240 (2 В; 10 мА)	⩽5 (5 В)	⩽35	—	⩽450; ⩽200*	
20...90 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 40...160 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 20...90 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) ⩾250 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА)	⩽9 (10 В) ⩽9 (10 В) ⩽7 (10 В) ⩽7 (10 В) ⩽7 (10 В) ⩽7 (10 В) ⩽9 (10 В) ⩽9 (10 В) ⩽7 (10 В)	⩽20 ⩽20 ⩽20 ⩽20 ⩽50 ⩽50 ⩽50 ⩽50 ⩽50	⩽40* ⩽40* ⩽40* ⩽40* — — — — —	⩽500 ⩽500 ⩽1000 ⩽500 ⩽250 ⩽1000 ⩽100 ⩽1000 ⩽500	
20...120* (5 В; 5 мА) 40...120* (5 В; 5 мА)	⩽2 (5 В) ⩽2 (5 В)	⩽35 ⩽35	— —	⩽50 ⩽75	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ363АМ	*p-n-p*, ПЭ	150 (45 °С)	⩾1000	15* (1 к)	4,5	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)
КТ363БМ	*p-n-p*, ПЭ	150 (45 °С)	⩾1500	12* (1 к)	4,5	30 (50*)	⩽0,5 (15 В)
КТ364А-2	*p-n-p*, ПЭ	30	⩾250	25	5	200 (400*)	⩽1 (25 В)
КТ364Б-2	*p-n-p*, ПЭ	30	⩾250	25	5	200 (400*)	⩽1 (25 В)
КТ364В-2	*p-n-p*, ПЭ	30	⩾250	25	5	200 (400*)	⩽1 (25 В)
КТ366А	*n-p-n*, П	30 (70 °С)	⩾1000	15	4,5	10 (20*)	⩽0,1 (15 В)
КТ366Б	*n-p-n*, П	30 (70 °С)	⩾1000	15	4,5	20 (40*)	⩽0,1 (15 В)
КТ366В	*n-p-n*, П	30 (70 °С)	⩾1000	15	4,5	45 (70*)	⩽0,1 (15 В)
КТ368А	*n-p-n*, ПЭ	225 (65 °С)	⩾900	15	4	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)
КТ368Б	*n-p-n*, ПЭ	225 (65 °С)	⩾900	15	4	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)
КТ368АМ	*n-p-n*, ПЭ	225 (65 °С)	⩾900	15	4	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)
КТ368БМ	*n-p-n*, ПЭ	225 (65 °С)	⩾900	15	4	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)
КТ369А	*n-p-n*, ПЭ	50	⩾200	45	4	250 (400*)	⩽7 (45 В)
КТ369Б	*n-p-n*, ПЭ	50	⩾200	45	4	250 (400*)	⩽7 (45 В)
КТ369В	*n-p-n*, ПЭ	50	⩾200	65	4	250 (400*)	⩽10 (65 В)
КТ369Г	*n-p-n*, ПЭ	50	⩾200	65	4	250 (400*)	⩽10 (65 В)
КТ369А-1	*n-p-n*, ПЭ	50	⩾200	45	4	250 (400*)	⩽7 (45 В)
КТ369Б-1	*n-p-n*, ПЭ	50	⩾200	45	4	250 (400*)	⩽7 (45 В)
КТ369В-1	*n-p-n*, ПЭ	50	⩾200	65	4	250 (400*)	⩽10 (65 В)
КТ369Г-1	*n-p-n*, ПЭ	50	⩾200	65	4	250 (400*)	⩽10 (65 В)
КТ370А-1	*p-n-p*, ПЭ	15	⩾1000	15* (1 к)	4	15 (30*)	⩽0,5 (15 В)
КТ370Б-1	*p-n-p*, ПЭ	15	⩾1200	15* (1 к)	4	15 (30*)	⩽0,5 (15 В)

Продолжение

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ $r'^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
20...120* (5 В; 5 мА) 40...120* (5 В; 5 мА)	⩽2 (5 В) ⩽2 (5 В)	⩽35 ⩽35	— —	⩽50 ⩽75	
20...70* (1 В; 0,1 А) 40...120* (1 В; 0,1 А) 80...240* (1 В; 0,1 А)	⩽15 (5 В) ⩽15 (5 В) ⩽15 (5 В)	⩽30 ⩽30 ⩽30	— — —	⩽500; ⩽150* ⩽500; ⩽180* ⩽500; ⩽230*	
50...200 (1 В; 1 мА) 50...200 (1 В; 5 мА) 50...200 (1 В; 15 мА)	⩽1,1 (0,1 В) ⩽1,8 (0,1 В) ⩽3,3 (0,1 В)	⩽80 ⩽25 ⩽16	— — —	⩽60; ⩽50* ⩽60; ⩽80* ⩽60; ⩽120*	
50...300* (5 В; 10 мА) 50...300* (5 В; 10 мА)	⩽1,7 (5 В) ⩽1,7 (5 В)	— —	3,3 (60 МГц)	⩽15 ⩽15	
50...300* (5 В; 10 мА) 50...300* (5 В; 10 мА)	⩽1,7 (5 В) ⩽1,7 (5 В)	— —	3,3 (60 МГц)	⩽15 ⩽15	
20...100* (2 В; 0,15 А) 40...200* (2 В; 0,15 А) 20...100* (3 В; 10 мА) 40...200* (3 В; 10 мА)	⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В) ⩽10 (10 В) ⩽10 (10 В)	⩽4 ⩽4 ⩽2,5 ⩽2,5	— — — —	— — — —	
20...100* (2 В; 0,15 А) 40...200* (2 В; 0,15 А) 20...100* (3 В; 10 мА) 40...200* (3 В; 10 мА)	⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В) ⩽10 (10 В) ⩽10 (10 В)	⩽4 ⩽4 ⩽2,5 ⩽2,5	— — — —	— — — —	
20...70 (5 В; 3 мА) 40...120 (5 В; 3 мА)	⩽2 (5 В) ⩽2 (5 В)	⩽35 ⩽35	— —	⩽50; ⩽10* ⩽50; ⩽10*	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h\,21б}$, $f^{**}_{h\,21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ371А	*n-p-n*, ПЭ	100 (65 °С)	⩾3000	10	3	20 (40*)	⩽0,5 (10 В)
КТ372А	*n-p-n*, ПЭ	50 (100 °С)	⩾2400	15* (10 к)	3	10	⩽0,5 (15 В)
КТ372Б	*n-p-n*, ПЭ	50 (100 °С)	⩾3000	15* (10 к)	3	10	⩽0,5 (15 В)
КТ372В	*n-p-n*, ПЭ	50 (100 °С)	⩾2400	15* (10 к)	3	10	⩽0,5 (15 В)
КТ373А	*n-p-n*, ПЭ	150 (55 °С)	⩾350	30* (10 к)	5	50 (200*)	⩽0,05 (25 В)
КТ373Б	*n-p-n*, ПЭ	150 (55 °С)	⩾300	25* (10 к)	5	50 (200*)	⩽0,05 (20 В)
КТ373В	*n-p-n*, ПЭ	150 (55 °С)	⩾300	10* (10 к)	5	50 (200*)	⩽0,05 (10 В)
КТ373Г	*n-p-n*, ПЭ	150 (55 °С)	⩾250	60* (10 к)	5	50 (200*)	⩽0,05 (25 В)
КТ375А	*n-p-n*, ПЭ	200 (400**)	⩾250	60	5	100 (200*)	⩽1 (60 В)
КТ375Б	*n-p-n*, ПЭ	200 (400**)	⩾250	30	5	100 (200*)	⩽1 (30 В)
КТ379А	*n-p-n*, ПЭ	25	⩾250	30* (10 к)	5	30 (100*)	⩽0,05 (30 В)
КТ379Б	*n-p-n*, ПЭ	25	⩾300	25* (10 к)	5	30 (100*)	⩽0,05 (25 В)
КТ379В	*n-p-n*, ПЭ	25	⩾300	10* (10 к)	5	30 (100*)	⩽0,05 (10 В)
КТ379Г	*n-p-n*, ПЭ	25	⩾250	60* (10 к)	5	30 (100*)	⩽0,05 (60 В)
КТ380А	*p-n-p*, ПЭ	15	⩾300	17* (10 к)	4	10 (25*)	⩽1 (10 В)
КТ380Б	*p-n-p*, ПЭ	15	⩾300	17* (10 к)	4	10 (25*)	⩽1 (10 В)
КТ380В	*p-n-p*, ПЭ	15	⩾300	9* (10 к)	4	20 (25*)	⩽1 (7 В)
КТ382А	*n-p-n*, ПЭ	100 (65 °С)	⩾1800	15	3	20 (40*)	⩽0,5 (15 В)
КТ382Б	*n-p-n*, ПЭ	100 (65 °С)	⩾1800	15	3	20 (40*)	⩽0,5 (15 В)
КТ384АМ	*n-p-n*, ПЭ	300	⩾450	30* (5 к)	4	300 (500*)	⩽10 (30 В)
КТ384А-2	*n-p-n*, ПЭ	300	⩾450	30* (5 к)	4	300 (500*)	⩽10 (30 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, $r^*_{БЭ\,нас}$, Ом, $K^{**}_{у,P}$, дБ	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
30...240 (1 В; 10 мА)	⩽1,2 (5 В)	⩾9** (400 МГц)	⩽5 (400 МГц) ⩽10*	⩽15	
⩾10* (5 В; 10 мА) ⩾10* (5 В; 10 мА) ⩾10* (5 В; 10 мА)	⩽1 (5 В) ⩽1 (5 В) ⩽1 (5 В)	— — —	⩽3,5 (1 ГГц) ⩽5,5 (1 ГГц) ⩽5,5 (1 ГГц)	— — —	
100...250 (5 В; 1 мА) 200...600 (5 В; 1 мА) 500...1000 (5 В; 1 мА) 50...125 (5 В; 1 мА)	⩽8 (5 В) ⩽8 (5 В) ⩽8 (5 В) ⩽8 (5 В)	⩽10 ⩽10 ⩽10 ⩽20	— — — —	⩽200 ⩽300 ⩽700 ⩽200	
10...100* (2 В; 20 мА) 50...280* (2 В; 20 мА)	⩽5 (10 В) ⩽5 (10 В)	⩽40 ⩽40	— —	⩽300 ⩽300	
100...250 (5 В; 1 мА) 200...500 (5 В; 1 мА) 400...1000 (5 В; 1 мА) 50...125 (5 В; 1 мА)	⩽8 (5 В) ⩽8 (5 В) ⩽8 (5 В) ⩽8 (5 В)	⩽10 ⩽10 ⩽10 ⩽20	— — — —	— — — —	
30...90 (0,3 В; 10 мА) 50...150 (0,3 В; 10 мА) 30...90 (0,3 В; 10 мА)	⩽6 (5 В) ⩽6 (5 В) ⩽6 (5 В)	⩽30 ⩽30 ⩽30	— — —	10* 20* 10*	
40...330 (1 В; 5 мА) 40...330 (1 В; 5 мА)	⩽2 (5 В) ⩽2 (5 В)	⩾9** (400 МГц) ⩾5** (400 МГц)	⩽3 (400 МГц) ⩽4,5 (400 МГц)	⩽15 ⩽10	
30...180* (1 В; 0,15 А)	⩽4 (10 В)	⩽4	—	⩽15*	
30...180* (1 В; 0,15 А)	⩽4 (10 В)	⩽4	—	⩽15*	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ385АМ	*n-p-n*, ПЭ	300	⩾200	60	4	300 (500*)	⩽10 (60 В)
КТ385А-2	*n-p-n*, ПЭ	300	⩾200	60	4	300 (500*)	⩽10 (60 В)
КТ388Б-2	*p-n-p*, ПЭ	300 (80 °С)	⩾250	50	4,5	250	⩽2 (50 В)
КТ389Б-2	*p-n-p*, ПЭ	300 (80 °С)	⩾450	25* (1 к)	4,5	300	⩽1 (25 В)
КТ391А-2	*n-p-n*, ПЭ	70 (85 °С)	⩾5000	15	2	10	⩽0,5 (10 В)
КТ391Б-2	*n-p-n*, ПЭ	70 (85 °С)	⩾5000	15	2	10	⩽0,5 (10 В)
КТ391В-2	*n-p-n*, ПЭ	70 (85 °С)	⩾4000	10	1	10	⩽0,5 (7 В)
КТ392А-2	*p-n-p*, ПЭ	120 (65 °С)	⩾300	40* (5 к)	4	10 (20*)	⩽0,5 (40 В)
КТ396А-2	*n-p-n*, ПЭ	30 (50 °С)	⩾2100	15	3	40	⩽0,5 (15 В)
КТ397А-2	*n-p-n*, ПЭ	120 (90 °С)	⩾500	40* (10 к)	4	10 (20*)	⩽1 (40 В)
КТ399А	*n-p-n*, ПЭ	150 (55 °С)	⩾1800	15**	3	20 (40*)	⩽0,5 (15 В)
КТ399АМ	*n-p-n*, ПЭ	150 (55 °С)	⩾1800	15**	3	30 (60*)	⩽0,5 (15 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r_б^{1*}$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
20...200* (1 В; 0,15 А)	⩽4 (10 В)	⩽5	—	⩽60*	
20...200* (1 В; 0,15 А)	⩽4 (10 В)	⩽5	—	⩽60*	
25...100* (1 В; 0,12 А) 25...100* (1 В; 0,2 А)	⩽7 (10 В) ⩽10 (10 В)	⩽5 ⩽3	— —	60; ⩽60* ⩽25*; ⩽180	
⩾20 (7 В; 5 мА) ⩾20 (7 В; 5 мА) ⩾20 (7 В; 5 мА)	⩽0,7 (5 В) ⩽0,7 (5 В) ⩽0,7 (5 В)	— — —	⩽4,5 (3,6 ГГц) ⩽5,5 (3,6 ГГц) ⩽6 (3,6 ГГц)	⩽3,7 ⩽3,7 ⩽3,7	
40...180* (5 В; 2,5 мА)	⩽2,5 (5 В)	⩽50	4,5 (100 МГц)	⩽120	
40...250 (2 В; 5 мА)	⩽1,5 (5 В)	⩽11*	—	⩽15	
40...300 (5 В; 2 мА)	⩽1,3 (5 В)	⩽25*	—	⩽40	
⩾40* (1 В; 5 мА)	⩽1,7 (5 В)	—	⩽2 (400 МГц)	⩽8	
⩾40* (1 В; 5 мА)	⩽1,7 (5 В)	—	⩽2 (400 МГц)	⩽8	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ501А	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥5	15* (10 к)	10	300 (500*)	≤1* (15 В)
КТ501Б	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥5	15* (10 к)	10	300 (500*)	≤1* (15 В)
КТ501В	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥5	15* (10 к)	10	300 (500*)	≤1* (15 В)
КТ501Г	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥5	30* (10 к)	10	300 (500*)	≤1* (30 В)
КТ501Д	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥5	30* (10 к)	10	300 (500*)	≤1* (30 В)
КТ501Е	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥5	30* (10 к)	10	300 (500*)	≤1* (30 В)
КТ501Ж	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥5	45* (10 к)	20	300 (500*)	≤1* (45 В)
КТ501И	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥5	45* (10 к)	20	300 (500*)	≤1* (45 В)
КТ501К	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥5	45* (10 к)	20	300 (500*)	≤1* (45 В)
КТ501Л	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥5	60* (10 к)	20	300 (500*)	≤1* (60 В)
КТ501М	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥5	60* (10 к)	20	300 (500*)	≤1* (60 В)
КТ502А	p-n-p, ПЭ	350	5...50	40	5	150 (300*)	≤1 (40 В)
КТ502Б	p-n-p, ПЭ	350	5...50	40	5	150 (300*)	≤1 (40 В)
КТ502В	p-n-p, ПЭ	350	5...50	60	5	150 (300*)	≤1 (60 В)
КТ502Г	p-n-p, ПЭ	350	5...50	60	5	150 (300*)	≤1 (60 В)
КТ502Д	p-n-p, ПЭ	350	5...50	80	5	150 (300*)	≤1 (80 В)
КТ502Е	p-n-p, ПЭ	350	5...50	90	5	150 (300*)	≤1 (90 В)
КТ503А	n-p-n, ПЭ	350	5...50	40	5	150 (300*)	≤1 (40 В)
КТ503Б	n-p-n, ПЭ	350	5...50	40	5	150 (300*)	≤1 (40 В)
КТ503В	n-p-n, ПЭ	350	5...50	60	5	150 (300*)	≤1 (60 В)
КТ503Г	n-p-n, ПЭ	350	5...50	60	5	150 (300*)	≤1 (60 В)
КТ503Д	n-p-n, ПЭ	350	5...50	80	5	150 (300*)	≤1 (80 В)
КТ503Е	n-p-n, ПЭ	350	5...50	100	5	150 (300*)	≤1 (100 В)
КТ504А	n-p-n, П	1 (10*) Вт	≥20	400; 350*	6	1 (2*) А	≤100 (400 В)
КТ504Б	n-p-n, П	1 (10*) Вт	≥20	200* (0,1 к)	6	1 (2*) А	≤100 (250 В)
КТ504В	n-p-n, П	1 (10*) Вт	≥20	275* (0,1 к)	6	1 (2*) А	≤100 (300 В)
КТ505А	p-n-p, П	1 (5*) Вт	≥20	300* (0,1 к)	5	1 (2*) А	≤100 (300 В)
КТ505Б	p-n-p, П	1 (5*) Вт	≥20	250* (0,1 к)	5	1 (2*) А	≤100 (250 В)
КТ506А	n-p-n, П	0,8 (10*) Вт	≥10	800	5	2 (5*) А	≤1000 (800 В)
КТ506Б	n-p-n, П	0,8 (10*) Вт	≥10	600	5	2 (5*) А	≤1000 (800 В)
КТ601А	n-p-n, П	0,25 (0,5*) Вт	≥40	100*	3	30	≤50 (50 В)
КТ601АМ	n-p-n, П	0,5 Вт	≥40	100*	3	30	≤300* (100 В)
КТ602А	n-p-n, П	0,85 (2,8*) Вт	≥150	120	5	75 (500*)	≤70 (120 В)
КТ602Б	n-p-n, П	0,85 (2,8*) Вт	≥150	120	5	75 (500*)	≤70 (120 В)
КТ602В	n-p-n, П	0,85 (2,8*) Вт	≥150	80	5	75 (300*)	≤70 (80 В)
КТ602Г	n-p-n, П	0,85 (2,8*) Вт	≥150	80	5	75 (300*)	≤70 (80 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	Ф5,84; 5,3; 13,7; Э Б К
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≤320*	—	Ф5,2; 5,2; 13,5; К Б Э; 4,1; 1,5
80...240 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≤320*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≤320*	—	
80...240 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≤320*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≤320*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≤320*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≤580*	—	
80...240 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≤580*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≤580*	—	
80...240 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≤580*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≤580*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≤580*	—	
15...100* (5 В; 0,5 А)	≤30 (10 В)	≤2	—	≤2700*	Ф9,4; 6,6; 23; К Э Б
15...100* (5 В; 0,5 А)	≤30 (10 В)	≤2	—	≤2700*	
15...100* (5 В; 0,5 А)	≤30 (10 В)	≤2	—	≤2700*	
25...140* (10 В; 0,5 А)	≤70 (5 В)	≤3,6	—	≤2600*	
25...140* (10 В; 0,5 А)	≤70 (5 В)	≤3,6	—	≤2600*	
30...150* (5 В; 0,3 А)	≤40 (5 В)	≤2	—	≤1560*	
30...150* (5 В; 0,3 А)	≤40 (5 В)	≤2	—	≤1560*	
≥16 (20 В; 10 мА)	≤15 (20 В)	—	—	≤600	Ф11,7; 8; 40; Б Э К
≥16 (20 В; 10 мА)	≤15 (20 В)	—	—	≤600	11,1; 7,8; 2,8; 16; Б К Э
20...80 (10 В; 10 мА)	≤4 (50 В)	≤60	—	≤300	Ф16; 8,5; 32; К Э Б
≥50 (10 В; 10 мА)	≤4 (50 В)	≤60	—	≤300	
15...80 (10 В; 10 мА)	≤4 (50 В)	≤60	—	≤300	
≥50 (10 В; 10 мА)	≤4 (50 В)	≤60	—	≤300	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ602АМ	*n-p-n*, П	0,85 (2,8*) Вт	⩾150	120	5	75 (500*)	⩽70 (120 В)
КТ602БМ	*n-p-n*, П	0,85 (2,8*) Вт	⩾150	120	5	75 (300*)	⩽70 (120 В)
КТ603А	*n-p-n*, ПЭ	0,5 Вт (50 °С)	⩾200	30* (1 к)	3	300 (600*)	⩽10 (30 В)
КТ603Б	*n-p-n*, ПЭ	0,5 Вт (50 °С)	⩾200	30* (1 к)	3	300 (600*)	⩽10 (30 В)
КТ603В	*n-p-n*, ПЭ	0,5 Вт (50 °С)	⩾200	15* (1 к)	3	300 (600*)	⩽5 (15 В)
КТ603Г	*n-p-n*, ПЭ	0,5 Вт (50 °С)	⩾200	15* (1 к)	3	300 (600*)	⩽5 (15 В)
КТ603Д	*n-p-n*, ПЭ	0,5 Вт (50 °С)	⩾200	10* (1 к)	3	300 (600*)	⩽1 (10 В)
КТ603Е	*n-p-n*, ПЭ	0,5 Вт (50 °С)	⩾200	10* (1 к)	3	300 (600*)	⩽1 (10 В)
КТ603И	*n-p-n*, ПЭ	0,5 Вт (50 °С)	⩾200	30* (1 к)	3	300 (600*)	⩽10 (30 В)
КТ604А	*n-p-n*, П	0,8 (3*) Вт	⩾40	300	5	200	⩽50* (250 В)
КТ604Б	*n-p-n*, П	0,8 (3*) Вт	⩾40	250* (1 к)	5	200	⩽50* (250 В)
КТ604АМ	*n-p-n*, П	0,8 (3*) Вт	⩾40	250* (1 к)	5	200	⩽20* (250 В)
КТ604БМ	*n-p-n*, П	0,8 (3*) Вт	⩾40	300	5	200	⩽20* (250 В)
КТ605А	*n-p-n*, П	0,4 Вт (100 °С)	⩾40	300	5	100 (200*)	⩽50* (250 В)
КТ605Б	*n-p-n*, П	0,4 Вт (100 °С)	⩾40	300	5	100 (200*)	⩽50* (250 В)
КТ605АМ	*n-p-n*, П	0,4 Вт (100 °С)	⩾40	300	5	100 (200*)	⩽20* (250 В)
КТ605БМ	*n-p-n*, П	0,4 Вт (100 °С)	⩾40	300	5	100 (200*)	⩽20* (250 В)
КТ606А	*n-p-n*, ПЭ	2,5 Вт (40 °С)	⩾350	60	4	400 (800*)	⩽1,5* (60 В)
КТ606Б	*n-p-n*, ПЭ	2,5 Вт (40 °С)	⩾300	60	4	400 (800*)	⩽1,5* (60 В)
КТ607А-4	*n-p-n*, ПЭ	1,5 Вт	⩾700	40	4	150	⩽1 (30 В)
КТ607Б-4	*n-p-n*, ПЭ	1,5 Вт	⩾700	30	4	150	⩽1 (30 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{21э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, $r^*_{БЭ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
20...80 (10 В; 10 мА) ⩾50 (10 В; 10 мА)	⩽4 (50 В) ⩽4 (50 В)	⩽60 ⩽60	— —	⩽300 ⩽300	
10...80* (2 В; 15 А) ⩾60* (2 В; 0,15 А) 10...80* (2 В; 0,15 А) ⩾60* (2 В; 0,15 А) 20...80* (2 В; 0,15 А) 60...200* (2 В; 0,15 А) ⩾20* (2 В; 0,35 А)	⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В)	⩽7 ⩽7 ⩽7 ⩽7 ⩽7 ⩽7 ⩽3,4	— — — — — — —	⩽100** ⩽100** ⩽100** ⩽100** ⩽100** ⩽100** ⩽100**	
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	⩽7 (40 В) ⩽7 (40 В)	⩽400 ⩽400	— —	— —	
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	⩽7 (40 В) ⩽7 (40 В)	⩽400 ⩽400	— —	— —	
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	⩽7 (40 В) ⩽7 (40 В)	⩽400 ⩽400	— —	⩽250 ⩽250	
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	⩽7 (40 В) ⩽7 (40 В)	⩽400 ⩽400	— —	⩽250 ⩽250	
⩾15* (10 В; 0,10 А) ⩾15* (10 В; 0,10 А)	⩽10 (28 В) ⩽10 (28 В)	⩽5 ⩽5	⩾0,8** (400 МГц) ⩾0,6** (400 МГц)	⩽10 ⩽12	
— —	⩽4 (10 В) ⩽4,5 (10 В)	— —	⩾1** (1 ГГц) ⩾1** (1 ГГц)	⩽18 ⩽25	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^*_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^*_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ608А КТ608Б	*n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ	0,5 Вт 0,5 Вт	⩾200 ⩾200	60 60	4 4	400 (800*) 400 (800*)	⩽10 (60 В) ⩽10 (60 В)
КТ610А КТ610Б	*n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ	1,5 Вт (50 °С) 1,5 Вт (50 °С)	⩾1000 ⩾700	26 26	4 4	300 300	⩽0,5 (26 В) ⩽0,5 (26 В)
КТ611А КТ611Б КТ611В КТ611Г	*n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ	0,8 (3*) Вт 0,8 (3*) Вт 0,8 (3*) Вт 0,8 (3*) Вт	⩾60 ⩾60 ⩾60 ⩾60	200 200 180 180	3 3 3 3	100 100 100 100	⩽200 (180 В) ⩽200 (180 В) ⩽100 (150 В) ⩽100 (150 В)
КТ611АМ КТ611БМ	*n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ	0,8 (3*) Вт 0,8 (3*) Вт	⩾60 ⩾60	200 200	4 4	100 100	⩽100 (180 В) ⩽100 (180 В)
КТ616А КТ616Б	*n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ	0,3 Вт 0,3 Вт	⩾200 ⩾200	20* 20*	4 4	400 (600*) 400 (600*)	⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В)
КТ617А	*n-p-n*, ПЭ	0,5 Вт	⩾150	30	4	400 (600*)	⩽5 (30 В)
КТ618А	*n-p-n*, П	0,5 Вт	⩾40	300	5	100	⩽50* (250 В)
КТ620А КТ620Б	*p-n-p*, ПЭ *p-n-p*, ПЭ	0,225 Вт 0,5 Вт	⩾200 ⩾200	50 50	3 4	400 400	⩽5 (50 В) ⩽5 (50 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_К$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
20...80* (5 В; 0,2 А) 40...160* (5 В; 0,2 А)	⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В)	⩽2,5 ⩽2,5	— —	⩽120* ⩽120*	
50...300* (10 В; 0,15 А) 20...300* (10 В; 0,15 А)	⩽4,1 (10 В) ⩽4,1 (10 В)	— —	— —	⩽55 ⩽22	
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА) 10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	⩽5 (40 В) ⩽5 (40 В) ⩽5 (40 В) ⩽5 (40 В)	⩽400 ⩽400 ⩽400 ⩽400	— — — —	⩽200 ⩽200 ⩽200 ⩽200	
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	⩽5 (40 В) ⩽5 (40 В)	⩽400 ⩽400	— —	⩽200 ⩽200	
⩾40* (1 В; 0,5 А) ⩾25* (1 В; 0,5 А)	⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В)	⩽1,2 ⩽1,2	— —	⩽50* ⩽15*	
⩾30* (2 В; 0,4 А)	⩽15 (10 В)	⩽7	—	⩽120	
⩾30* (40 В; 1 мА)	⩽7 (40 В)	—	—	—	
100* (10 В; 10 мА) 30...100* (5 В; 0,2 А)	— —	⩽2,5 ⩽2,5	— —	— ⩽100*	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^*_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^*_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ624А-2	*n-p-n*, ПЭ	1 Вт	⩾450	30	4	1000 (1300*)	⩽100 (30 В)
КТ624АМ-2	*n-p-n*, ПЭ	1 Вт	⩾450	30	4	1000 (1300*)	⩽100 (30 В)
КТ625А	*n-p-n*, ПЭ	1 Вт	⩾200	40* (5 к)	5	1000 (1300*)	⩽30 (60 В)
КТ625АМ	*n-p-n*, ПЭ	1 Вт	⩾200	60	5	1000 (1300*)	⩽30 (60 В)
КТ625АМ-2	*n-p-n*, ПЭ	1 Вт	⩾200	60	5	1000	⩽30 (60 В)
КТ626А	*p-n-p*, ПЭ	6,5 Вт (60 °С)	⩾75	45	4	500 (1500*)	⩽10 (30 В)
КТ626Б	*p-n-p*, ПЭ	6,5 Вт (60 °С)	⩾75	60	4	500 (1500*)	⩽150 (30 В)
КТ626В	*p-n-p*, ПЭ	6,5 Вт (60 °С)	⩾45	80	4	500 (1500*)	⩽1 мА (80 В)
КТ626Г	*p-n-p*, ПЭ	6,5 Вт (60 °С)	⩾45	20* (0,1 к)	4	0,5 (1,5*) А	⩽150 (20 В)
КТ626Д	*p-n-p*, ПЭ	6,5 Вт (60 °С)	⩾45	20* (0,1 к)	4	0,5 (1,5*) А	⩽150 (20 В)
КТ629А-2	*p-n-p*, ПЭ	1 Вт	⩾250	50	4,5	1000	⩽5 (50 В)
КТ629АМ-2	*p-n-p*, ПЭ	1 Вт	⩾250	50* (1 к)	4,5	1000	⩽5 (50 В)
КТ630А	*n-p-n*, П	0,8 Вт	⩾50	120	7	1000 (2000*)	⩽1 (90 В)
КТ630Б	*n-p-n*, П	0,8 Вт	⩾50	120	7	1000 (2000*)	⩽1 (90 В)
КТ630В	*n-p-n*, П	0,8 Вт	⩾50	150	7	1000 (2000*)	⩽1 (90 В)
КТ630Г	*n-p-n*, П	0,8 Вт	⩾50	100	5	1000 (2000*)	⩽1 (40 В)
КТ630Д	*n-p-n*, П	0,8 Вт	⩾50	60	5	1000 (2000*)	⩽1 (40 В)
КТ630Е	*n-p-n*, П	0,8 Вт	⩾50	60	5	1000 (2000*)	⩽1 (40 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
30...180* (0,5 В; 0,3 А)	⩽15 (5 В)	⩽9	—	⩽18	
30...180* (0,5 В; 0,3 А)	⩽15 (5 В)	⩽9	—	⩽18	
20...200* (1 В; 0,5 А)	⩽9 (10 В)	⩽2,4	—	⩽60	
20...200* (1 В; 0,5 А) 20...200 (1 В; 0,5 А)	⩽9 (10 В) ⩽9 (10 В)	⩽2,4 ⩽1,3	— —	⩽60 ⩽60	
40...260* (2 В; 0,15 А) 30...100* (2 В; 0,15 А) 15...45* (2 В; 0,15 А) 15...60* (2 В; 0,15 А) 40...250* (2 В; 0,15 А)	⩽150 (10 В) ⩽150 (10 В) ⩽150 (10 В) ⩽150 (10 В) ⩽150 (10 В)	⩽2 ⩽2 ⩽2 ⩽2 ⩽2	— — — — —	⩽500 ⩽500 ⩽500 ⩽500 ⩽500	
25...150* (5 В; 0,2 А)	⩽25 (10 В)	⩽2	—	90*	
25...150* (1,2 В; 0,5 А)	⩽25 (10 В)	⩽2	—	—	
40...120* (10 В; 150 мА) 80...240* (10 В; 150 мА) 40...120* (10 В; 150 мА) 40...120* (10 В; 150 мА) 80...240* (10 В; 150 мА) 160...480* (10 В; 150 мА)	⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В)	⩽2 ⩽2 ⩽2 ⩽2 ⩽2 ⩽2	⩾5* ⩾5* ⩾5* ⩾5* ⩾5* ⩾5*	⩽500** ⩽500** ⩽500** ⩽500** ⩽500** ⩽500**	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ632Б	*p-n-p*, ПЭ	0,5 Вт (45 °С)	⩾200	120* (1 к)	5	100 (350*)	⩽1 (120 В)
КТ633А	*n-p-n*, ПЭ	1,2 Вт	⩾500	30	4,5	200 (500*)	⩽10 (30 В)
КТ633Б	*n-p-n*, ПЭ	1,2 Вт	⩾500	30	4,5	200 (500*)	⩽10 (30 В)
КТ634А-2	*n-p-n*, ПЭ	1,2 Вт	⩾1500	30	3	150 (250*)	⩽0,5 мА (30 В)
КТ634Б-2	*n-p-n*, ПЭ	1,3 Вт	⩾1500	30	3	150 (250*)	⩽1 мА (30 В)
КТ635А	*n-p-n*, ПЭ	0,5 Вт	⩾200	60	5	1 (1,2*) А	⩽30 (60 В)
КТ635Б	*n-p-n*, ПЭ	0,5 Вт	⩾250	60	5	1 (1,2*) А	⩽30 (60 В)
КТ637А-2	*n-p-n*, ПЭ	1,5 Вт	⩾1300	30	2,5	200 (300*)	⩽0,1 мА (30 В)
КТ637Б-2	*n-p-n*, ПЭ	1,5 Вт	⩾800	30	2,5	200 (300*)	⩽2 мА (30 В)
КТ639А	*p-n-p*, ПЭ	1 (12,5*) Вт	⩾80	45	5	1,5 (2*) А	⩽0,1 (30 В)
КТ639Б	*p-n-p*, ПЭ	1 (12,5*) Вт	⩾80	45	5	1,5 (2*) А	⩽0,1 (30 В)
КТ639В	*p-n-p*, ПЭ	1 (12,5*) Вт	⩾80	45	5	1,5 (2*) А	⩽0,1 (30 В)
КТ639Г	*p-n-p*, ПЭ	1 (12,5*) Вт	⩾80	60	5	1,5 (2*) А	⩽0,1 (30 В)
КТ639Д	*p-n-p*, ПЭ	1 (12,5*) Вт	⩾80	60	5	1,5 (2*) А	⩽0,1 (30 В)
КТ639Е	*p-n-p*, ПЭ	1 Вт (35 °С)	⩾80	100	5	1,5 (2*) А	⩽0,1 (30 В)
КТ639Ж	*p-n-p*, ПЭ	1 Вт (35 °С)	⩾80	100	5	1,5 (2*) А	⩽0,1 (30 В)
КТ639И	*p-n-p*, ПЭ	1 Вт (35 °С)	⩾80	30	5	1,5 (2*) А	⩽0,1 (30 В)
КТ640А-2	*n-p-n*, ПЭ	0,6 Вт (60 °С)	⩾3000	25	3	60	⩽1 мА (25 В)
КТ640Б-2	*n-p-n*, ПЭ	0,6 Вт (60 °С)	⩾3800	25	3	60	⩽1 мА (25 В)
КТ640В-2	*n-p-n*, ПЭ	0,6 Вт (60 °С)	⩾3800	25	3	60	⩽1 мА (25 В)
КТ643А-2	*n-p-n*, ПЭ	1,1 Вт (50 °С)	—	25	3	120	⩽1 мА (25 В)
КТ644А	*p-n-p*, ПЭ	1 (12,5*) Вт	⩾200	60	5	0,6 А; 1* А	⩽1 (50 В)
КТ644Б	*p-n-p*, ПЭ	1 (12,5*) Вт	⩾200	60	5	0,6 А; 1* А	⩽1 (50 В)
КТ644В	*p-n-p*, ПЭ	1 (12,5*) Вт	⩾200	40**	5	0,6 А; 1* А	⩽1 (50 В)
КТ644Г	*p-n-p*, ПЭ	1 (12,5*) Вт	⩾200	40**	5	0,6 А; 1* А	⩽1 (50 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$τ_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
⩾50 (1 В; 1 мА)	⩽5 (20 В)	⩽25	—	⩽100	
40...140 (1 В; 10 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽5	6 (20 МГц)	⩽30*	
20...160 (1 В; 10 мА)	⩽4,5 (10 В)	⩽5	6 (20 МГц)	⩽30*	
—	⩽2,5 (15 В)		⩾0,2** (5 ГГц)	⩽2	
—	⩽3 (15 В)		⩾0,45** (5 ГГц)	⩽3,5	
25...150* (1 В; 0,5 А)	⩽15 (10 В)	⩽1	—	⩽58; ⩽60**	
20...150* (1 В; 0,5 А)	⩽10 (10 В)	⩽1	—	⩽58; ⩽60**	
30...140* (5 В; 50 мА)	⩽4,5 (15 В)	—	⩾0,5** (3 ГГц)	⩽3	
30...140* (5 В; 50 мА)	⩽4,5 (15 В)	—	⩾0,25** (3 ГГц)	⩽15	
40...100* (2 В; 0,15 А)	⩽50 (10 В)	⩽1	—	⩽200*	
63...160* (2 В; 0,15 А)	⩽50 (10 В)	⩽1	—	⩽200*	
100...250* (2 В; 0,15 А)	⩽50 (10 В)	⩽1	—	⩽200*	
40...100* (2 В; 0,15 А)	⩽50 (10 В)	⩽1	—	⩽200*	
63...160* (2 В; 0,15 А)	⩽50 (10 В)	⩽1	—	⩽200*	
40...100 (2 В; 0,15 А)	⩽50 (10 В)	⩽1	—	⩽200*	
60...100* (2 В; 0,15 А)	⩽50 (10 В)	⩽1	—	⩽200*	
180...400* (2 В; 0,15 А)	⩽50 (10 В)	⩽1	—	⩽200*	
			⩽8 (6 ГГц)		
—	⩽1,3 (15 В)	—	⩾0,1** (7 ГГц)	0,6	
—	⩽1,3 (15 В)	—	⩾0,1** (7 ГГц)	1	
—	⩽1,3 (15 В)	—	⩾0,08** (7 ГГц)	1	
—	⩽1,8 (15 В)	—	⩾0,48** (7 ГГц)	—	
40...120* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽2,7	—	⩽180*	
100...300* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽2,7	—	⩽180*	
40...120* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽2,7	—	⩽180*	
100...300* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽2,7	—	⩽180*	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К.т\,max}$, $P^{**}_{К,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{**}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ645А КТ645Б	*n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ	0,5 (1*) Вт 500	⩾200 ⩾200	60 40	4 4	0,3 А; 0,6* А 300 (600*)	⩽10 (60 В) ⩽10
КТ646А КТ646Б	*n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ	1 (2,5*) Вт 1 Вт	⩾200 ⩾200	60 40	4 (5) 4	1 А; 1,2* А 1 (1,2*) А	⩽10 (60 В) ⩽10
КТ659А	*n-p-n*, ПЭ	1 Вт	⩾300	60	6	1,2 А	⩽0,5 мА (60 В)
КТ660А КТ660Б	*n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ	0,5 Вт 0,5 Вт	⩾200 ⩾200	50 30	5 5	0,8 А 0,8 А	⩽1 (50 В) ⩽1 (30 В)
КТ661А	*p-n-p*, ПЭ	0,4 Вт (1,8* Вт)	⩾200	60	5	0,3 А; 0,6* А	⩽0,01 мА (50 В)
КТ662А	*p-n-p*, ПЭ	0,6 Вт (3* Вт)	⩾200	60	5	0,4 А; 0,6* А	⩽0,01 мА (50 В)
КТ668А КТ668Б КТ668В	*p-n-p*, ПЭ *p-n-p*, ПЭ *p-n-p*, ПЭ	0,5 Вт 0,5 Вт 0,5 Вт	⩾200 ⩾200 ⩾200	50 50 50	5 5 5	0,1 А 0,1 А 0,1 А	⩽15 ⩽15 ⩽15
КТ680А КТ681А	*n-p-n*, ПЭ *p-n-p*, ПЭ	350 (85 °С) 350 (85 °С)	⩾120 ⩾120	30 30	5 5	0,6 (2*) А 0,6 (2*) А	⩽10 (25 В) ⩽10 (25 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, нс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
20...200* (2В; 0,15 А) ≥80 (10 В; 2 мА)	≤5 (10 В) ≤5	≤3,3 —	— —	≤120; ≤50* —	
40...200* (5 В; 0,2 А) 150...200* (5 В; 0,2 А)	≤10 (10 В) ≤10	≤1,7 —	— —	≤120; ≤60* —	
≥35* (1 В; 0,3 А)	≤10 (10 В)	≤9	—	≤80**	
110...220* (10 В; 0,2 А) 200...450* (10 В; 0,2 А)	≤10 ≤10	≤2,4 ≤2,4	— —	— —	
100...300* (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В)	≤3,2	—	≤100**	
100...300* (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В)	≤3,2	—	≤200**	
75...140 (5 В; 2 мА) 125...250 (5 В; 2 мА) 220...475 (5 В; 2 мА)	≤7 ≤7 ≤7	— — —	— — —	— — —	
85...300* (1 В; 0,5 А) 85...300* (1 В; 0,5 А)	— —	≤0,5 ≤0,5	— —	— —	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,т\,max}$, $P^{**}_{К,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ683А	*n-p-n*, П	1,2 (8*) Вт	≥50	150* (3к)	7	1 А; 2* А	≤1 (90 В)
КТ683Б	*n-p-n*, П	1,2 (8*) Вт	≥50	120* (3к)	7	1 А; 2* А	≤1 (90 В)
КТ683В	*n-p-n*, П	1,2 (8*) Вт	≥50	120* (3к)	7	1 А; 2* А	≤1 (90 В)
КТ683Г	*n-p-n*, П	1,2 (8*) Вт	≥50	100* (3к)	5	1 А; 2* А	≤1 (40 В)
КТ683Д	*n-p-n*, П	1,2 (8*) Вт	≥50	60* (3к)	5	1 А; 2* А	≤1 (40 В)
КТ683Е	*n-p-n*, П	1,2 (8*) Вт	≥50	60* (3к)	5	1 А; 2* А	≤1 (40 В)
КТ684А	*p-n-p*, ПЭ	0,8 Вт	≥40	45* (1 к)	5	1 (1,5*) А	≤0,1 (30 В)
КТ684Б	*p-n-p*, ПЭ	0,8 Вт	≥40	60* (1 к)	5	1 (1,5*) А	≤0,1 (30 В)
КТ684В	*p-n-p*, ПЭ	0,8 Вт	≥40	100* (1 к)	5	1 (1,5*) А	≤0,1 (30 В)
КТ685А	*p-n-p*, ПЭ	0,6 Вт	≥200	60	5	0,6 А	≤0,02 (50 В)
КТ685Б	*p-n-p*, ПЭ	0,6 Вт	≥200	60	5	0,6 А	≤0,01 (50 В)
КТ685В	*p-n-p*, ПЭ	0,6 Вт	≥200	60	5	0,6 А	≤0,02 (50 В)
КТ685Г	*p-n-p*, ПЭ	0,6 Вт	≥200	60	5	0,6 А	≤0,01 (50 В)
КТ685Д	*p-n-p*, ПЭ	0,6 Вт	≥350	30	5	0,6 А	≤0,02 (25 В)
КТ685Е	*p-n-p*, ПЭ	0,6 Вт	≥250	30	5	0,6 А	≤0,02 (25 В)
КТ685Ж	*p-n-p*, ПЭ	0,6 Вт	≥250	30	5	0,6 А	≤0,02 (25 В)
КТ686А	*p-n-p*, ПЭ	0,625 (1,4*) Вт	≥100	50* (0)	5	0,8 (1,5*) А	0,1 (45 В)
КТ686Б	*p-n-p*, ПЭ	0,625 (1,4*) Вт	≥100	50* (0)	5	0,8 (1,5*) А	0,1 (45 В)
КТ686В	*p-n-p*, ПЭ	0,625 (1,4*) Вт	≥100	50* (0)	5	0,8 (1,5*) А	0,1 (45 В)
КТ686Г	*p-n-p*, ПЭ	0,625 (1,4*) Вт	≥100	30* (0)	5	0,8 (1,5*) А	0,1 (25 В)
КТ686Д	*p-n-p*, ПЭ	0,625 (1,4*) Вт	≥100	30* (0)	5	0,8 (1,5*) А	0,1 (25 В)
КТ686Е	*p-n-p*, ПЭ	0,625 (1,4*) Вт	≥100	30* (0)	5	0,8 (1,5*) А	0,1 (25 В)
КТ686Ж	*p-n-p*, ПЭ	0,625 (1,4*) Вт	≥100	30* (0)	5	0,8 (1,5*) А	0,1 (25 В)
П701	*n-p-n*, ДС	10*Вт (50 °С)	≥20*	40	2(80 °С)	0,5 А	≤0,1 мА (40 В)
П701А	*n-p-n*, ДС	10*Вт (50 °С)	≥20*	60	2(80 °С)	0,5 А	≤0,1 мА (60 В)
П701Б	*n-p-n*, ДС	10*Вт (50 °С)	≥20*	35	2(80 °С)	0,5 А	≤0,1 мА (35 В)
П702	*n-p-n*, МП	40* Вт (50 °С)	≥4	60	3	2 А	≤5 мА (70 В)
П702А	*n-p-n*, МП	40* Вт (50 °С)	≥4	60	3	2 А	≤5 мА (70 В)
КТ704А	*n-p-n*, МП	15* Вт (50 °С)	≥3	500* (1000 имп.)	4	2,5 (4*) А	≤5* мА (1000 В)
КТ704Б	*n-p-n*, МП	15* Вт (50 °С)	≥3	400* (700 имп.)	4	2,5 (4*) А	≤5* мА (700 В)
КТ704В	*n-p-n*, МП	15* Вт (50 °С)	≥3	400* (500 имп.)	4	2,5 (4*) А	≤5* мА (500 В)
КТ710А	*n-p-n*, МП	50* Вт (50 °С)	—	3000* (0,01 к)	5	5 (7,5*) А	≤2 мА (3000 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, $r^*_{БЭ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
40...120* (10 В; 0,15 А)	⩽15 (10 В)	⩽3; ⩽6,6*	⩽8*	⩽500**	
80...240* (10 В; 0,15 А)	⩽15 (10 В)	⩽3; ⩽6,6*	⩽8*	⩽500**	
40...120* (10 В; 0,15 А)	⩽15 (10 В)	⩽3; ⩽6,6*	⩽8*	⩽500**	
40...120* (10 В; 0,15 А)	⩽15 (10 В)	⩽3; ⩽6,6*	⩽8*	⩽500**	
80...240* (10 В; 0,15 А)	⩽15 (10 В)	⩽3; ⩽6,6*	⩽8*	⩽500**	
160...480* (10 В; 0,15 А)	⩽15 (10 В)	⩽3; ⩽6,6*	⩽8*	⩽500**	
40...250* (2 В; 0,15 А)	⩽50 (10 В)	⩽1	—	—	
40...160* (2 В; 0,15 А)	⩽50 (10 В)	⩽1	—	—	
40...160* (2 В; 0,15 А)	⩽50 (10 В)	⩽1	—	—	
40...120* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽0,26	—	⩽80*	
40...120* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽0,26	—	⩽80*	
100...300* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽0,26	—	⩽80*	
100...300* (10 В; 0,15 А)	⩽8 (10 В)	⩽0,26	—	⩽80*	
70...200* (1 В; 0,15 А)	⩽12 (10 В)	⩽0,2	—	⩽80*	
40...120* (1 В; 0,3 А)	⩽12 (10 В)	⩽0,2	—	⩽150*	
100...300* (1 В; 0,3 А)	⩽12 (10 В)	⩽0,2	—	⩽150*	
100...250* (1 В; 0,1 А)	⩽12 (10 В)	⩽1,4	—	—	
160...400* (1 В; 0,1 А)	⩽12 (10 В)	⩽1,4	—	—	
250...630* (1 В; 0,1 А)	⩽12 (10 В)	⩽1,4	—	—	
100...250* (1 В; 0,1 А)	⩽12 (10 В)	⩽1,4	—	—	
160...400* (1 В; 0,1 А)	⩽12 (10 В)	⩽1,4	—	—	
250...630* (1 В; 0,1 А)	⩽12 (10 В)	⩽1,4	—	—	
100...250* (1 В; 0,1 А)	⩽12 (10 В)	⩽1,4	—	—	
10...40* (10 В; 0,5 А)	—	⩽14	—	—	
15...60* (10 В; 0,2 А)	—	—	—	—	
30...100* (10 В; 0,2 А)	—	—	—	—	
⩾25* (10 В; 1,1 А)	—	⩽2,5	—	—	
⩾10* (10 В; 1,1 А)	—	⩽4	—	—	
10...100* (15 В; 1 А)	⩽50 (20 В)	⩽2,5	—	—	
10...100* (15 В; 1 А)	⩽50 (20 В)	⩽2,5	—	—	
⩾10* (15 В; 1 А)	⩽50 (20 В)	⩽2,5	—	—	
⩾3,5 (10 В; 4 А)	—	⩽0,9	—	⩽30 000*	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К.т\,max}$, $P^{**}_{К.и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{**}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ712А КТ712Б	*p-n-p*, ПЭ *p-n-p*, ПЭ	1,5 (50*) Вт 1,5 (50*) Вт	≥3 ≥3	200 160	5 5	10 (15*) А 10 (15*) А	≤1 мА (200 В) ≤1 мА (160 В)
КТ715А	*n-p-n*, МП	75 Вт (50 °С)	≥0,45	5000	5	2 А	≤1 мА (5000 В)
КТ801А КТ801Б	*n-p-n*, СД *n-p-n*, СД	5 Вт (55 °С) 5 Вт (55 °С)	≥10 ≥10	80* (0,1 к) 60* (0,1 к)	2,5 2,5	2 А 2 А	10* мА (80 В) 10* мА (60 В)
КТ802А КТ803А КТ805А КТ805Б	*n-p-n*, МП *n-p-n*, П *n-p-n*, МП *n-p-n*, МП	50 Вт 60 Вт 30 Вт (50 °С) 30 Вт (50 °С)	≥10; ≥20 ≥20 ≥20 ≥20	150; 180 60* (0,1 к) 60* (160 имп.) 60* (135 имп.)	3; 5 4 5 5	5 А 10 А 5 (8*) А 5 (8*) А	≤60 мА (150 В) ≤5* мА (70 В) ≤15* мА (60 В) ≤15* мА (60 В)
КТ805АМ КТ805БМ КТ805ВМ	*n-p-n*, МП *n-p-n*, МП *n-p-n*, МП	30 Вт (50 °С) 30 Вт (50 °С) 30 Вт (50 °С)	≥20 ≥20 ≥20	60* (160 имп.) 60* (135 имп.) 60* (135 имп.)	5 5 5	5 (8*) А 5 (8*) А 5 (8*) А	≤15* мА (60 В) ≤15* мА (60 В) ≤15* мА (60 В)
КТ807А КТ807Б	*n-p-n*, МП *n-p-n*, МП	10* Вт (70 °С) 10* Вт (70 °С)	≥5 ≥5	100* 100*	4 4	0,5; 1,5* А 0,5; 1,5* А	≤5* мА (100 В) ≤5* мА (100 В)
КТ807АМ КТ807БМ	*n-p-n*, МП *n-p-n*, МП	10 Вт (70 °С) 10 Вт (70 °С)	≥5 ≥5	100* (1 к) 100* (1 к)	4 4	0,5 (1,5*) А 0,5 (1,5*) А	≤5* мА (100 В) ≤5* мА (100 В)
КТ808А	*n-p-n*, МП	50* Вт (50 °С)	≥7,2	120* (250 имп.)	4	10 А	≤3* мА (120 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
⩾500* (5 В; 2 А) ⩾400* (5 В; 2 А)	— —	⩽1 ⩽1	— —	— —	
⩾15 (10 В; 0,2 А)	—	⩽15	—	⩽27 500*	
15...50* (5 В; 1 А) 30...150* (5 В; 1 А)	— —	⩽2 ⩽2	— —	— —	
15* (10 В; 2 А) 10...70* (10 В; 5 А) 15* (10 В; 2 А) 15* (10 В; 2 А)	— ⩽250 (20 В) — —	1 ⩽0,5 ⩽0,5 ⩽1	— — — —	— ⩽190** — —	
⩾15* (10 В; 2 А) ⩾15* (10 В; 2 А) ⩾15* (10 В; 2 А)	— — —	⩽0,5 ⩽1 ⩽1,25	— — —	— — —	
15...45* (5 В; 0,5 А) 30...100* (5 В; 0,5 А)	— —	⩽2 ⩽2	— —	— —	
15...45* (5 В; 0,5 А) 30...100* (5 В; 0,5 А)	— —	⩽2 ⩽2	— —	— —	
10...50* (3 В; 6 А)	⩽500 (10 В)	—	—	⩽2000*	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,т\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ808АМ	*n-p-n*, МП	60* Вт (50 °С)	⩾8	130* (250 имп)	5	10 А	⩽2* мА (120 В)
КТ808БМ	*n-p-n*, МП	60* Вт (50 °С)	⩾8	100* (160 имп)	5	10 А	⩽2* мА (100 В)
КТ808ВМ	*n-p-n*, МП	60* Вт (50 °С)	⩾8	80* (135 имп)	5	10 А	⩽2* мА (150 В)
КТ808ГМ	*n-p-n*, МП	60* Вт (50 °С)	⩾8	70* (80 имп)	5	10 А	⩽2* мА (70 В)
КТ809А	*n-p-n*, МП	40* Вт (50 °С)	⩾5,1	400* (0,01 к)	4	3 А; 5* А	⩽3 мА (400 В)
КТ812А	*n-p-n*, МП	50* Вт (50 °С)	⩾3	400* (0,01 к)	7	8 А; 12* А	⩽5* мА (700 В)
КТ812Б	*n-p-n*, МП	50* Вт (50 °С)	3	300* (0,01 к)	7	8 А; 12* А	⩽5* мА (500 В)
КТ812В	*n-p-n*, МП	50* Вт (50 °С)	⩾3	200* (0,01 к)	7	8 А; 12* А	⩽5* мА (300 В)
КТ814А	*p-n-p*, ПЭ	1 (10*) Вт	⩾3	40*	5	1,5 (3*) А	⩽0,5 мА (40 В)
КТ814Б	*p-n-p*, ПЭ	10* Вт	⩾3	50*	5	1,5 (3*) А	⩽0,5 мА (40 В)
КТ814В	*p-n-p*, ПЭ	10* Вт	⩾3	70*	5	1,5 (3*) А	⩽0,5 мА (40 В)
КТ814Г	*p-n-p*, ПЭ	10* Вт	⩾3	100*	5	1,5 (3*) А	⩽0,5 мА (40 В)
КТ815А	*n-p-n*, МПЭ	10* Вт	⩾3	40* (0,1 к)	5	1,5 (3*) А	⩽0,5 мА (40 В)
КТ815Б	*n-p-n*, МПЭ	10* Вт	⩾3	50* (0,1 к)	5	1,5 (3*) А	⩽0,5 мА (40 В)
КТ815В	*n-p-n*, МПЭ	10* Вт	⩾3	70* (0,1 к)	5	1,5 (3*) А	⩽0,5 мА (40 В)
КТ815Г	*n-p-n*, МПЭ	10* Вт	⩾3	100* (0,1 к)	5	1,5 (3*) А	⩽0,5 мА (40 В)
КТ816А	*p-n-p*, МПЭ	25* Вт	⩾3	40* (1 к)	5	3 (6*) А	⩽0,1 мА (25 В)
КТ816Б	*p-n-p*, МПЭ	25* Вт	⩾3	45* (1 к)	5	3 (6*) А	⩽0,1 мА (45 В)
КТ816В	*p-n-p*, МПЭ	25* Вт	⩾3	60* (1 к)	5	3 (6*) А	⩽0,1 мА (60 В)
КТ816Г	*p-n-p*, МПЭ	25* Вт	⩾3	100* (1 к)	5	3 (6*) А	⩽0,1 мА (100 В)
КТ817А	*n-p-n*, МПЭ	25* Вт	⩾3	40*	5	3 (6*) А	⩽0,1 мА (25 В)
КТ817Б	*n-p-n*, МПЭ	25* Вт	⩾3	45*	5	3 (6*) А	⩽0,1 мА (45 В)
КТ817В	*n-p-n*, МПЭ	25* Вт	⩾3	60*	5	3 (6*) А	⩽0,1 мА (60 В)
КТ817Г	*n-p-n*, МПЭ	25* Вт	⩾3	80*	5	3 (6*) А	⩽0,1 мА (100 В)
КТ818А	*p-n-p*, МПЭ	60* Вт	⩾3	40* (0,1 к)	5	10 (15*) А	⩽1 мА (40 В)
КТ818Б	*p-n-p*, МПЭ	60* Вт	⩾3	50* (0,1 к)	5	10 (15*) А	⩽1 мА (40 В)
КТ818В	*p-n-p*, МПЭ	60* Вт	⩾3	70* (0,1 к)	5	10 (15*) А	⩽1 мА (40 В)
КТ818Г	*p-n-p*, МПЭ	60* Вт	⩾3	90* (0,1 к)	5	10 (15*) А	⩽1 мА (40 В)
КТ818АМ	*p-n-p*, МПЭ	100* Вт	⩾3	40* (0,1 к)	5	15 (20*) А	⩽1 мА (40 В)
КТ818БМ	*p-n-p*, МПЭ	100* Вт	⩾3	50* (0,1 к)	5	15 (20*) А	⩽1 мА (40 В)
КТ818ВМ	*p-n-p*, МПЭ	100* Вт	⩾3	70* (0,1 к)	5	15 (20*) А	⩽1 мА (40 В)
КТ818ГМ	*p-n-p*, МПЭ	100* Вт	⩾3	90* (0,1 к)	5	15 (20*) А	⩽1 мА (40 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{21э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
20...125* (3 В; 2 А)	≤500 (100 В)	≤0,33	—	≤2000*	
20...125* (3 В; 2 А)	≤500 (100 В)	≤0,33	—	≤2000*	
20...125* (3 В; 2 А)	≤500 (100 В)	≤0,33	—	≤2000*	
20...125* (3 В; 2 А)	≤500 (100 В)	≤0,33	—	≤2000*	
15...100* (5 В; 2 А)	≤150 (20 В)	≤0,75	—	≤4* мкс	
≥4* (2,5 В; 8 А)	≤100 (100 В)	≤0,3	—	$t_{сп}$≤1,3 мкс	
≥4* (2,5 В; 8 А)	≤100 (100 В)	≤0,3	—	$t_{сп}$≤1,3 мкс	
≥10* (5 В; 5 А)	≤100 (100 В)	≤0,3	—	$t_{сп}$≤1,3 мкс	
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤60 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤60 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤60 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥30* (2 В; 0,15 А)	≤60 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤60 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤60 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤60 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤60 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥15* (5 В; 5 А)	—	≤0,27	—	—	
≥20* (5 В; 5 А)	—	≤0,27	—	—	
≥15* (5 В; 5 А)	—	≤0,27	—	—	
≥12* (5 В; 5 А)	—	≤0,27	—	—	
≥15* (5 В; 5 А)	—	≤0,27	—	—	
≥20* (5 В; 5 А)	—	≤0,27	—	—	
≥15* (5 В; 5 А)	—	≤0,27	—	—	
≥12* (5 В; 5 А)	—	≤0,27	—	—	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^*_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^*_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ819А	n-p-n, МПЭ	60* Вт	≥3	40*	5	10 (15*) А	≤1 мА (0 В)
КТ819Б	n-p-n, МПЭ	60* Вт	≥3	50*	5	10 (15*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819В	n-p-n, МПЭ	60* Вт	≥3	70*	5	10 (15*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819Г	n-p-n, МПЭ	60* Вт	≥3	100*	5	10 (15*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819АМ	n-p-n, МПЭ	100* Вт	≥3	40*	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819БМ	n-p-n, МПЭ	100* Вт	≥3	50*	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819ВМ	n-p-n, МПЭ	100* Вт	≥3	70*	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819ГМ	n-p-n, МПЭ	100* Вт	≥3	100*	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ820А-1	p-n-p, МПЭ	10* Вт	≥3	50* (0,1 к)	5	0,5 (1,5*) А	≤30 (40 В)
КТ820Б-1	p-n-p, МПЭ	10* Вт	≥3	70* (0,1 к)	5	0,5 (1,5*) А	≤30 (40 В)
КТ820В-1	p-n-p, МПЭ	10* Вт	≥3	100* (0,1 к)	5	0,5 (1,5*) А	≤30 (40 В)
КТ821А-1	n-p-n, МПЭ	10* Вт	≥3	50* (0,1 к)	5	0,5 (1,5*) А	≤30 (40 В)
КТ821Б-1	n-p-n, МПЭ	10* Вт	≥3	70* (0,1 к)	5	0,5 (1,5*) А	≤30 (40 В)
КТ821В-1	n-p-n, МПЭ	10* Вт	≥3	100* (0,1 к)	5	0,5 (1,5*) А	≤30 (40 В)
КТ822А-1	p-n-p, МПЭ	20* Вт	≥3	45* (0,1 к)	5	2 (4*) А	≤50 (40 В)
КТ822Б-1	p-n-p, МПЭ	20* Вт	≥3	60* (0,1 к)	5	2 (4*) А	≤50 (40 В)
КТ822В-1	p-n-p, МПЭ	20* Вт	≥3	100* (0,1 к)	5	2 (4*) А	≤50 (40 В)
КТ823А-1	n-p-n, МПЭ	20* Вт	≥3	45* (0,1 к)	5	2 (4*) А	≤50 (40 В)
КТ823Б-1	n-p-n, МПЭ	20* Вт	≥3	60* (0,1 к)	5	2 (4*) А	≤50 (40 В)
КТ823В-1	n-p-n, МПЭ	20* Вт	≥3	100* (0,1 к)	5	2 (4*) А	≤50 (40 В)
КТ825Г	p-n-p, МП	125* Вт	≥4	90	5	20 (30*) А	≤1* мА (90 В)
КТ825Д	p-n-p, МП	125* Вт	≥4	60	5	20 (30*) А	≤1* мА (60 В)
КТ825Е	p-n-p, МП	125* Вт	≥4	30	5	20 (30*) А	≤1* мА(30 В)
КТ826А	n-p-n, МП	15* Вт (50 °С)	≥6	700* (0,01 к)	5	1 А	≤2 мА (700 В)
КТ826Б	n-p-n, МП	15* Вт (50 °С)	≥6	700* (0,01 к)	5	1 А	≤2 мА (700 В)
КТ826В	n-p-n, МП	15* Вт (50 °С)	≥6	700* (0,01 к)	5	1 А	≤2 мА (700 В)
КТ827А	n-p-n, МП	125* Вт	≥4	100	5	20 (40*) А	≤3* мА (100 В)
КТ827Б	n-p-n, МП	125* Вт	≥4	80	5	20 (40*) А	≤3* мА (80 В)
КТ827В	n-p-n, МП	125* Вт	≥4	60	5	20 (40*) А	≤3* мА (60 В)
КТ828А	n-p-n, МП	50* Вт (50 °С)	≥4	800* (0,01 к)	5	5 (7,5*) А	≤5 мА (1400 В)
КТ828Б	n-p-n, МП	50* Вт	≥4	600* (0,1 к)	5	5 (7,5*) А	≤5 мА (1200 В)
КТ829А	n-p-n, МП	60* Вт	≥4	100	5	8 (12*) А	≤1,5* мА (100 В)
КТ829Б	n-p-n, МП	60* Вт	≥4	80	5	8 (12*) А	≤1,5* мА (80 В)
КТ829В	n-p-n, МП	60* Вт	≥4	60	5	8 (12*) А	≤1,5* мА (60 В)
КТ829Г	n-p-n, МП	60* Вт	≥4	45	5	8 (12*) А	≤1,5* мА (60 В)
КТ834А	n-p-n, МП	100* Вт	≥4	500* (0,1 к)	8	15 (20*) А	≤3* мА (500 В)
КТ834Б	n-p-n, МП	100* Вт	≥4	450* (0,1 к)	8	15 (20*) А	≤3* мА (450 В)
КТ834В	n-p-n, МП	100* Вт	≥4	400* (0,1 к)	8	15 (20*) А	≤3* мА (400 В)
КТ835А	p-n-p, МПЭ	25* Вт	≥1	30	4	3 А	≤0,1 мА (30 В)
КТ835Б	p-n-p, МПЭ	25* Вт	≥1	45	4	7,5 А	≤0,15 мА (45 В)
КТ837А	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥1	80	15	7,5 А	≤0,15 мА (80 В)
КТ837Б	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥1	80	15	7,5 А	≤0,15 мА (80 В)
КТ837В	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥1	80	15	7,5 А	≤0,15 мА (80 В)
КТ837Г	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥1	60	15	7,5 А	≤0,15 мА (60 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{21э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
≥15* (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	
≥20* (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	
≥15* (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	
≥12* (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	
≥15* (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	
≥20* (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—		
≥15* (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	
≥12* (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	—	
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤65 (5 В)	≤1	—	—	
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤65 (5 В)	≤1	—	—	
≥30* (2 В; 0,15 А)	≤65 (5 В)	≤1	—	—	
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤40 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤40 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥30* (2 В; 0,15 А)	≤40 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤115 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤115 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤115 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤75 (5 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤75 (5 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤75 (5 В)	≤0,6	—	—	
750* (10 В; 10 А)	≤600 (10 В)	≤0,4	—	≤4,5**	
750* (10 В; 10 А)	≤600 (10 В)	≤0,4	—	≤4,5**	
750* (10 В; 10 А)	≤600 (10 В)	≤0,4	—	≤4,5**	
10...120* (10 В; 0,1 А)	≤25 (100 В)	≤5	—	$t_{сп}$≤1500	
5...300* (10 В; 0,1 А)	≤25 (100 В)	≤5	—	$t_{сп}$≤700	
5...120* (10 В; 0,1 А)	≤25 (100 В)	≤5	—	$t_{сп}$≤700	
750...18 000* (3 В; 10 А)	≤400 (10 В)	≤0,2	—	≤4,5*	
750...18 000* (3 В; 10 А)	≤400 (10 В)	≤0,2	—	≤4,5*	
750...18 000* (3 В; 10 А)	≤400 (10 В)	≤0,2	—	≤4,5*	
≥2,25* (5 В; 4,5 А)	—	≤0,66	—	≤10*; ≤1,2**	
≥2,25* (5 В; 4,5 А)	—	≤0,66	—	≤10*; ≤1,2**	
≥750* (3 В; 3 А)	—	≤0,57	—	—	
≥750* (3 В; 3 А)	—	≤0,57	—	—	
≥750* (3 В; 3 А)	—	≤0,57	—	—	
≥750* (3 В; 3 А)	—	≤0,57	—	—	
≥150* (5 В; 5 А)	≤100 (150 В)	≤0,13	—	≤1,2**	
≥150* (5 В; 5 А)	≤100 (150 В)	≤0,13	—	≤1,2**	
≥150* (5 В; 5 А)	≤100 (150 В)	≤0,13	—	≤1,2**	
25* (1 В; 1 А)	≤800 (10 В)	≤0,35	—	—	
10...100* (5 В; 2 А)	≤800 (10 В)	≤0,8	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	
20...80* (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{k\,max}$, $P^*_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h\,21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{**}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^*_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ837Д	р-п-р, ЭД	30* Вт	≥1	60	15	7,5 А	≤0,15 мА (60 В)
КТ837Е	р-п-р, ЭД	30* Вт	≥1	60	15	7,5 А	≤0,15 мА (60 В)
КТ837Ж	р-п-р, ЭД	30* Вт	≥1	45	15	7,5 А	≤0,15 мА (45 В)
КТ837И	р-п-р, ЭД	30* Вт	≥1	45	15	7,5 А	≤0,15 мА (45 В)
КТ837К	р-п-р, ЭД	30* Вт	≥1	45	15	7,5 А	≤0,15 мА (45 В)
КТ873Л	р-п-р, ЭД	30* Вт	≥1	80	5	7,5 А	≤0,15 мА (80 В)
КТ837М	р-п-р, ЭД	30* Вт	≥1	80	5	7,5 А	≤0,15 мА (80 В)
КТ837Н	р-п-р, ЭД	30* Вт	≥1	80	5	7,5 А	≤0,15 мА (80 В)
КТ837П	р-п-р, ЭД	30* Вт	≥1	60	5	7,5 А	≤0,15 мА (60 В)
КТ837Р	р-п-р, ЭД	30* Вт	≥1	60	5	75 А	≤0,15 мА (60 В)
КТ837С	р-п-р, ЭД	30* Вт	≥1	60	5	7,5 А	≤0,15 мА (60 В)
КТ837Т	р-п-р, ЭД	30* Вт	≥1	45	5	7,5 А	≤0,15 мА (45 В)
КТ837У	р-п-р, ЭД	30* Вт	≥1	45	5	7,5 А	≤0,15 мА (45 В)
КТ837Ф	р-п-р, ЭД	30* Вт	≥1	45	5	7,5 А	≤0,15 мА (45 В)
КТ838А	п-р-п, МП	12,5* Вт (90 °С)	3	1500 (имп.)	5...7	5 (7,5*)	≤1* мА (1500 В)
КТ839А	п-р-п, МП	50*	5	1500	5	10	≤1 мА (1500 В)
КТ840А	п-р-п, П	60*	≥8	400* (900 имп.)	5	6 (8*)	≤3 мА (900 В)
КТ840Б	п-р-п, П	60*	≥8	350* (750 имп.)	5	6 (8*)	≤3 мА (750 В)
КТ841А	п-р-п, ПЭ	3 (50*) Вт	≥10	600	5	10 (15*) А	≤3 мА (600 В)
КТ841Б	п-р-п, ПЭ	3 (50*) Вт	≥10	400	5	10 (15*) А	≤3 мА (400 В)
КТ841В	п-р-п, ПЭ	3 (50*) Вт	≥10	600	5	10 (15*) А	≤3 мА (400 В)
КТ842А	р-п-р, ПЭ	3 (50*) Вт	≥10	300	5	5 (10*) А	≤1 мА (300 В)
КТ842Б	р-п-р, ПЭ	3 (50*) Вт	≥10	200	5	5 (10*) А	≤1 мА (200 В)
КТ844А	п-р-п, ПЭ	50* Вт (50 °С)	≥7,2	250* (0,01 к)	4	10 (20*) А	≤3 мА (250 В)
КТ845А	п-р-п, МП	40* Вт (50 °С)	≥4,5	400* (0,01 к)	4	5 (7,5*) А	≤3 мА (400 В)
КТ846А	п-р-п, МП	12,5* Вт (90 °С)	2	1500* (0,01 к)	—	5 (7,5*) А	≤1 мА (1500 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{21Э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ; $r'^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; ($t_{сп}$)	Габаритный чертеж корпуса
20...80* (5 В; 2 А)	—	⩽0,3	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	⩽0,3	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	⩽0,25	—	—	
20...80* (5 В; 2 А)	—	⩽0,25	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	⩽0,25	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	⩽0,8	—	—	
20...80* (5 В; 2 А)	—	⩽0,8	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	⩽0,8	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	⩽0,3	—	—	
20...80* (5 В; 2 А)	—	⩽0,3	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	⩽0,3	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	⩽0,25	—	—	
20...80* (5 В; 2 А)	—	⩽0,25	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	⩽0,25	—	—	
⩾4* (5 В; 3,5 А)	170 (10 В)	⩽i,1	—	10* мкс; ⩽(1,5)	
⩾5* (10 В; 4 А)	240 (10 В)	⩽0,375	—	10* мкс; ⩽(1,5) мкс	
10...60* (5 В; 0,6 А)	—	⩽0,75	—	⩽(0,6) мкс	
⩾10* (5 В; 0,6 А)	—	⩽0,75	—	⩽(0,6) мкс	
⩾12* (5 В; 5 А)	⩽300 (10 В)	⩽0,3	—	⩽1000*	
⩾12* (5 В; 5 А)	⩽300 (10 В)	⩽0,3	—	⩽1000*	
⩾12* (5 В; 5 А)	⩽300 (10 В)	⩽0,3	—	⩽1000*	
⩾15* (4 В; 5 А)	250 (10 В)	⩽0,36	—	800*	
⩾15* (4 В; 5 А)	250 (10 В)	⩽0,36	—	800*	
10...50* (3 В; 6 А)	⩽300 (10 В)	⩽0,4	—	⩽2000*	
15...100* (5 В; 2 А)	⩽45 (200 В)	⩽0,75	—	⩽4000	
—	⩽200	⩽0,22	—	⩽12 000*	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ847А	*n-p-n*, МП	125* Вт	⩾15	650* (0,01 к)	8	15 (25*) А	⩽5 мА (650 В)
КТ848А	*n-p-n*, МП	35* Вт	—	400*	15	15 А	⩽3 мА (400 В)
КТ850А	*n-p-n*, П	25 Вт	⩾20	250	5	2 (3*) А	⩽100 (250 В)
КТ850Б	*n-p-n*, П	25 Вт	⩾20	300	5	2 (3*) А	⩽500 (300 В)
КТ850В	*n-p-n*, П	25 Вт	⩾20	180	5	2 (3*) А	⩽500 (180 В)
КТ851А	*p-n-p*, П	25 Вт	⩾20	250	5	2 (3*) А	⩽100 (250 В)
КТ851Б	*p-n-p*, П	25 Вт	⩾20	300	5	2 (3*) А	⩽500 (300 В)
КТ851В	*p-n-p*, П	25 Вт	⩾20	180	5	2 (3*) А	⩽500 (180 В)
КТ852А	*p-n-p*, П	50 Вт	⩾7	100	5	2,5 (4*) А	—
КТ852Б	*p-n-p*, П	50 Вт	⩾7	80	5	2,5 (4*) А	—
КТ852В	*p-n-p*, П	50 Вт	⩾7	60	5	2,5 (4*) А	—
КТ852Г	*p-n-p*, П	50 Вт	⩾7	45	5	2,5 (4*) А	—
КТ853А	*p-n-p*, ПЭ	60 Вт	⩾7	100	5	8 (12*) А	—
КТ853Б	*p-n-p*, ПЭ	60 Вт	⩾7	80	5	8 (12*) А	—
КТ853В	*p-n-p*, ПЭ	60 Вт	⩾7	60	5	8 (12*) А	—
КТ853Г	*p-n-p*, ПЭ	60 Вт	⩾7	45	5	8 (12*) А	—
КТ854А	*n-p-n*, ПЭ	60 Вт	⩾10	600	5	10 (15*) А	⩽3 мА (600 В)
КТ854Б	*n-p-n*, ПЭ	60 Вт	⩾10	400	5	10 (15*) А	⩽3 мА (400 В)
КТ855А	*p-n-p*, ПЭ	40 Вт	⩾5	250	5	5 (8*) А	⩽1000 (250 В)
КТ855Б	*p-n-p*, ПЭ	40 Вт	⩾5	150	5	5 (8*) А	⩽100 (150 В)
КТ855В	*p-n-p*, ПЭ	40 Вт	⩾5	150	5	5 (8*) А	⩽1000 (150 В)
КТ857А	*n-p-n*, ПЭ	60 Вт	⩾10	250	6	7 (10*) А	⩽5 мА (250 В)
КТ858А	*n-p-n*, ПЭ	60* Вт	⩾10	400	6	7 (10*) А	⩽1 мА (400 В)
КТ859А	*n-p-n*, МП	40* Вт	⩾10	800	10	3 (4*) А	⩽1 мА (800 В)
КТ863А	*n-p-n*, МПЭ	50* Вт	⩾4	30	5	10 А	⩽1 мА (30 В)
КТ864А	*n-p-n*, ПЭ	100* Вт	⩾15	200	6	10 (15*) А	⩽100 (200 В)
КТ865А	*p-n-p*, ПЭ	100* Вт	⩾15	200	6	10 (15*) А	⩽100 (200 В)
КТ868А	*n-p-n*, ПЭ	70* Вт	⩾8	900	5	6 (8*) А	⩽3 мА (900 В)
КТ868Б	*n-p-n*, ПЭ	70* Вт	⩾8	750	5	6 (8*) А	⩽3 мА (750 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{21э}$, пФ	$r_{КЭ нас}$, $r^*_{БЭ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r_б^{1*}$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
8...25* (3 В; 15 А)	≤200 (400 В)	≤0,1	—	≤3000*	
≥20* (5 В; 15 А)	—	≤0,2	—	—	
40...200* (10 В; 0,5 А)	≤35 (5 В)	≤2	—	1500*	
≥20* (10 В; 0,5 А)	≤35 (5 В)	≤2	—	1500*	
≥20* (10 В; 0,5 А)	≤35 (5 В)	≤2	—	1500*	
40...200* (10 В; 0,5 А)	40 (5 В)	≤2	—	1400*	
20...200* (10 В; 0,5 А)	40 (5 В)	≤2	—	1400*	
20...200* (10 В; 0,5 А)	40 (5 В)	≤2	—	1400*	
≥500* (4 В; 2 А)	26 (5 В)	0,87*	—	2000**	
≥500* (4 В; 2 А)	26 (5 В)	0,87*	—	2000**	
≥1000* (5 В; 1 А)	26 (5 В)	0,87*	—	2000**	
≥1000* (4 В; 1 А)	26 (5 В)	0,87*	—	2000**	
≥750* (3 В; 3 А)	102 (5 В)	—	—	3300**	
≥750* (3 В; 3 А)	102 (5 В)	—	—	3300**	
≥750* (3 В; 3 А)	102 (5 В)	—	—	3300**	
≥750* (3 В; 3 А)	102 (5 В)	—	—	3300**	
≥20* (4 В; 2 А)	200 (10 В)	≤0,4	—	$t_{сп}$=700	
≥20* (4 В; 2 А)	200 (10 В)	≤0,4	—	$t_{сп}$=700	
≥20* (4 В; 2 А)	200 (10 В)	≤0,5	—	—	
≥20* (4 В; 2 А)	200 (10 В)	≤0,5	—	—	
≥15* (4 В; 2 А)	200 (10 В)	≤0,5	—	—	
≥7,5* (1 В; 3 А)	—	≤0,33		≤2500*	
≥10* (5 В; 5А)	—	≤0,2	≤0,24**	≤2500*	
≥10* (10 В; 1 А)	—	≤1,5	≤1,4**	≤3500*	
≥100* (2 В; 5 А)	—	≤0,06	—	—	
40...200* (4 В; 2 А)	≤300 (5 В)	≤0,3	—	—	
40...250* (4 В; 2 А)	≤300 (5 В)	≤0,3	—	—	
10...60* (5 В; 0,6 А)	≤100 (80 В)	≤0,75	—	≤3500*	
10...100* (5 В; 0,6 А)	≤100 (80 В)	≤0,75	—	≤3500*	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^*_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^*_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ872А	*n-p-n*, МП	100* Вт	7	700*	6	8 (15*) А	⩽1 мА (1500 В)
КТ872Б	*n-p-n*, МП	100* Вт	7	700*	6	8 (15*) А	⩽1 мА (1500 В)
КТ878А	*n-p-n*, ПЭ	150*Вт	—	900* (0,01 к)	5	25 (50*) А	—
КТ892А	*n-p-n*, ПЭ	175*Вт	—	350* (0,01 к)	5	15 (30*) А	—
КТ892Б	*n-p-n*, ПЭ	175*Вт	—	400* (0,01 к)	5	15 (30*) А	—
КТ902А	*n-p-n*, Д	30* Вт (50 °С)	⩾35	65 (110 имп.)	5	5 А	⩽10 мА (70 В)
КТ902АМ	*n-p-n*, Д	30* Вт (50 °С)	⩾35	65 (110 имп.)	5	5 А	⩽10 мА (70 В)
КТ903А	*n-p-n*, МП	30* (60**) Вт	⩾120	60 (80 имп.)	4	3 (5*) А	⩽10* мА (70 В)
КТ903Б	*n-p-n*, МП	30* (60**) Вт	⩾120	60 (80 имп.)	4	3 (5*) А	⩽10* мА (70 В)
КТ904А	*n-p-n*, ПЭ	5* Вт (40 °С)	⩾350	60	4	0,8 (1,5*) А	⩽15* мА (60 В)
КТ904Б	*n-p-n*, ПЭ	5* Вт (40 °С)	⩾300	60	4	0,8 (1,5*) А	⩽15* мА (60 В)
КТ907А	*n-p-n*, ПЭ	13,5* Вт	⩾350	60	4	1 (3*) А	⩽3* мА (60 В)
КТ907Б	*n-p-n*, ПЭ	13,5* Вт	⩾300	60	4	1 (3*) А	⩽3* мА (60 В)
КТ908А	*n-p-n*, МП	50* Вт (50 °С)	⩾30	100* (0,01 к)	5	10 А	⩽25* мА (100 В)
КТ908Б	*n-p-n*, МП	50* Вт (50 °С)	⩾30	60* (0,25 к)	5	10 А	⩽50* мА (60 В)
КТ909А	*n-p-n*, ПЭ	27* Вт	⩾350	60* (0,01 к)	3,5	2 (4*) А	⩽30* мА (60 В)
КТ909Б	*n-p-n*, ПЭ	54* Вт	⩾500	60* (0,01 к)	3,5	4 (8*) А	⩽60* мА (60 В)
КТ909В	*n-p-n*, ПЭ	27* Вт	⩾300	60* (0,01 к)	3,5	2 (4*) А	⩽30* мА (60 В)
КТ909Г	*n-p-n*, ПЭ	54* Вт	⩾450	60* (0,01 к)	3,5	4 (8*) А	⩽60* мА (60 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_{ш}$, дБ, $r_б^{\prime *}$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
— —	≤125 (15 В) ≤125 (15 В)	≤0,22 ≤1,1	— —	≤7500* ≤7500*	
— — —	— — —	≤0,1 ≤0,225 ≤0,225	— — —	≤3000* $t_{сп}$≤4 мкс $t_{сп}$≤4 мкс	
≥15* (10 В; 2 А)	≤300 (10 В)	≤1	≥20** (10 МГц)	—	
≥15* (10 В; 2 А)	≤300 (10 В)	≤1	≥20** (10 МГц)	—	
15...70* (10 В; 2 А) 40...180* (10 В; 2 А)	≤180 (30 В) ≤180 (30 В)	≤1,25 ≤1,25	≥10** (50 МГц) ≥10** (50 МГц)	— —	
10* (5 В; 0,25 А) 10* (5 В; 0,25 А) 10* (5 В; 0,4 А) 10* (5 В; 0,4 А)	≤12 (28 В) ≤12 (28 В) ≤20 (30 В) ≤20 (30 В)	≤5 ≤5 ≤4 ≤4	≥3** (400 МГц) ≥2,5** (400 МГц) ≥8** (400 МГц) ≥6** (400 МГц)	— — — —	
8...60* (2 В; 10 А) ≥20* (4 В; 4 А)	≤700 (10 В) ≤700 (10 В)	≤0,15 ≤0,25	— —	— —	
— — — —	≤30 (28 В) ≤60 (28 В) ≤35 (28 В) ≤60 (28 В)	— — — —	20** (500 МГц) 40** (500 МГц) 15** (500 МГц) ≥30** (500 МГц)	≤20 ≤20 ≤30 ≤30	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h\,21б}$, $f^{**}_{h\,21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ9101АС	*n-p-n*, ПЭ	128* Вт	⩾350	50	4	7 А	⩽80 мА (50 В)
КТ9104А	*n-p-n*, ПЭ	10** Вт	⩾600	50	4	1,5 А	⩽10 (50 В)
КТ9104Б	*n-p-n*, ПЭ	23** Вт	⩾600	50	4	5 А	⩽20 (50 В)
КТ9105АС	*n-p-n*, ПЭ	133* Вт	⩾660	50* (10 Ом)	4	16 А	⩽120* мА (50 В)
КТ9116А	*n-p-n*, ПЭ	46* Вт	⩾240	55* (0,01 к)	4	4 А	⩽30 мА (55 В)
КТ9116Б	*n-p-n*, ПЭ	76,7* Вт	⩾230	55* (0,01к)	4	10 А	⩽100 мА (55 В)
КТ9120А	*p-n-p*, ПЭ	50* Вт	⩾50	45* (0,1 к)	5	12 (30*) А	⩽0,1 мА (45 В)
КТ911А	*n-p-n*, ПЭ	3* Вт	⩾750	55	3	0,4 А	⩽5 мА (55 В)
КТ911Б	*n-p-n*, ПЭ	3* Вт	⩾600	55	3	0,4 А	⩽5 мА (55 В)
КТ911В	*n-p-n*, ПЭ	3* Вт	⩾750	40	3	0,4 А	⩽5 мА (40 В)
КТ911Г	*n-p-n*, ПЭ	3* Вт	⩾600	40	3	0,4 А	⩽5 мА (40 В)
КТ912А	*n-p-n*, П	30* Вт (85 °С)	⩾90	70* (0,01 к)	5	20 А	⩽50* мА (70 В)
КТ912Б	*n-p-n*, П	30* Вт (85 °С)	⩾90	70* (0,01 к)	5	20 А	⩽50* мА (70 В)
КТ913А	*n-p-n*, ПЭ	4,7* Вт (55 °С)	⩾900	55	3,5	0,5 (1*) А	⩽25* мА (55 В)
КТ913Б	*n-p-n*, ПЭ	8* Вт (70 °С)	⩾900	55	3,5	1 (2*) А	⩽50* мА (55 В)
КТ913В	*n-p-n*, ПЭ	12* Вт	⩾900	55	3,5	1 (2*) А	⩽50 * мА (55 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{21э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
—	⩽150 (28 В)	—	⩾100** (0,7 ГГц)	⩽45	
— —	⩽20 (28 В) ⩽40 (28 В)	— —	⩾5** (0,7 ГГц) ⩾20** (0,7 ГГц)	⩽20 ⩽20	
—	⩽240 (28 В)	—	⩾100** (0,5 ГГц)	⩽12	
— —	⩽55 (28 В) ⩽155 (28 В)	— —	⩾5** (225 МГц) ⩾15** (225 МГц)	⩽25 ⩽30	
⩾40* (1 В; 4 А)	⩽1900 (10 В)	⩽0,75	—	⩽500*	
— — — —	⩽10 (28 В) ⩽10 (28 В) ⩽10 (28 В) ⩽10 (28 В)	⩽5 ⩽5 ⩽5 ⩽5	⩾1** (1,8 ГГц) ⩾1** (1 ГГц) ⩾0,8** (1,8 ГГц) ⩾0,8** (1 ГГц)	⩽25 ⩽25 ⩽50 ⩽100	
10...50* (10 В; 5 А) 20...100* (10 В; 5 А)	⩽200 (27 В) ⩽200 (27 В)	⩽0,12 ⩽0,12	⩾70** (30 МГц) ⩾70** (30 МГц)	— —	
⩾10* (10 В; 50,5 А) ⩾10* (10 В; 0,5 А) ⩾10* (10 В; 0,5 А)	⩽6 (28 В) ⩽12 (28 В) ⩽14 (28 В)	⩽1,1 ⩽1,1 ⩽1,1	⩾3** (1 ГГц) ⩾5** (1 ГГц) ⩾10** (1 ГГц)	⩽15 ⩽15 ⩽15	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21Б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max} МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ914А	*p-n-p*, ПЭ	7* Вт	⩾300	65	4	0,8 (1,5*) А	2* (65 В)
КТ916	*n-p-n*, ПЭ	30* Вт	⩾1100	55* (0,01 к)	3,5	2 (4*) А	⩽25 мА (55 В)
КТ918А КТ918Б	*n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ	2,5* Вт 2,5* Вт	⩾800 ⩾1000	30 30	2,5 2,5	250 250	⩽2 мА (30 В) ⩽2 мА (30 В)
КТ919А КТ919Б КТ919В КТ919Г	*n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ	10* Вт 5* Вт 3,25* Вт 10* Вт	⩾1350 ⩾1350 ⩽1350 ⩾1350	45 45 45 45	3,5 3,5 3,5 3,5	0,7 (1,5*) А 0,35 (0,7*) А 0,2 (0,4*) А 0,7 (1,5*) А	⩽10 мА (45 В) ⩽5 мА (45 В) ⩽2 мА (45 В) ⩽10 мА (45 В)
КТ920А КТ920Б КТ920В КТ920Г	*n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ *n-p-n*, ПЭ	5* (50 °С) 10* (50 °С) 25* Вт (50 °С) 25* Вт (50 °С)	⩾400 ⩾400 ⩾400 ⩾350	36 36 36 36	4 4 4 4	0,25 (1*) А 1 (2*) А 3 (7*) А 3 (7*) А	⩽2* мА (36 В) ⩽4* мА (36 В) ⩽7,5* мА (36 В) ⩽7,5* мА (36 В)
КТ921А КТ921Б	*n-p-n*, П *n-p-n*, П	12,5 Вт (75 °С) 12,5 Вт (75 °С)	⩾90 ⩾90	65* (0,1 к) 65* (0,1 к)	4 4	3,5 А 3,5 А	⩽10* (70 В) ⩽10* (70 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{21э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ $r'^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
10...50* (5 В; 0,25 А)	⩽12 (28 В)	12	⩾2,5** (400 МГц)	⩽20	[drawing]
35* (5 В; 0,25 А)	⩽20 (30 В)	0,8	⩾20** (1 ГГц)	⩽10	[drawing]
— —	⩽4,2 (15 В) ⩽4,2 (15 В)	— —	⩾0,25** (3 ГГц) ⩾0,5** (3 ГГц)	⩽15 ⩽4	[drawing]
— — — —	⩽10 (28 В) ⩽6,5 (28 В) ⩽5 (28 В) ⩽12 (28 В)	— — — —	⩾3,5** (2 ГГц) ⩾1,6** (2 ГГц) ⩾0,8** (2 ГГц) ⩾3** (2 ГГц)	⩽2,2 ⩽2,2 ⩽2,2 ⩽2,2	[drawing]
— — — —	⩽15 (10 В) ⩽25 (10 В) ⩽75 (10 В) ⩽75 (10 В)	— — — —	2** (175 МГц) 5** (175 МГц) 20** (175 МГц) 15** (175 МГц)	⩽2,0 ⩽2,0 ⩽2,0 ⩽2,0	[drawing]
⩾10* (10 В; 1 А) ⩾10* (10 В; 1 А)	50 (20 В) 50 (20 В)	⩽1,8 ⩽1,8	⩾12,5** (60 МГц) ⩾12,5** (60 МГц)	⩽22 ⩽22	[drawing]

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ922А	n-p-n, ПЭ	8* (40 °С)	⩾300	65* (0,1 к)	4	0,8 (1,5*) А	⩽5* мА (65 В)
КТ922Б	n-p-n, ПЭ	20* Вт (40 °С)	⩾300	65* (0,1 к)	4	1,5 (4,5*) А	⩽20* мА (65 В)
КТ922В	n-p-n, ПЭ	40* Вт (40 °С)	⩾300	65* (0,1 к)	4	3 (9*) А	⩽40* мА (65 В)
КТ922Г	n-p-n, ПЭ	20* Вт (40 °С)	⩾300	65* (0,1 к)	4	1,5 (4,5*) А	⩽20* мА (65 В)
КТ922Д	n-p-n, ПЭ	20* Вт (40 °С)	⩾250	65* (0,1 к)	4	3 (9*) А	⩽40* мА (65 В)
КТ925А	n-p-n, ПЭ	5,5 Вт (40 °С)	⩾500	36* (0,1 к)	4	0,5 (1*) А	⩽7 мА (36 В)
КТ925Б	n-p-n, ПЭ	11 Вт (40 °С)	⩾500	36* (0,1 к)	4	1 (3*) А	⩽12 мА (36 В)
КТ925В	n-p-n, ПЭ	25 Вт (40 °С)	⩾450	36* (0,1 к)	3,5	3,3 (8,5*) А	⩽30 мА (36 В)
КТ925Г	n-p-n, ПЭ	25 Вт (40 °С)	⩾450	36* (0,1 к)	3,5	3,3 (8,5*) А	⩽30 мА (36 В)
КТ926А	n-p-n, МП	50 Вт (50 °С)	⩾51	150* (0,01 к)	5	15 (25*) А	⩽25 мА (150 В)
КТ926Б	n-p-n, МП	50 Вт (50 °С)	⩾51	150* (0,01 к)	5	15 (25*) А	⩽25 мА (150 В)
КТ927А	n-p-n, ПЭ	83,3 Вт (75 °С)	⩾105	70* (0 к)	3,5	10 (30*) А	40* мА (70 В)
КТ927Б	n-p-n, ПЭ	83,3 Вт (75 °С)	⩾105	70* (0 к)	3,5	10 (30*) А	40* мА (70 В)
КТ927В	n-p-n, ПЭ	83,3 Вт (75 °С)	⩾105	70* (0 к)	3,5	10 (30*) А	40* мА (70 В)
КТ928А	n-p-n, ПЭ	0,5 Вт (36*)	⩾250	60	5	0,8 (1,2*) А	⩽1 (60 В)
КТ928Б	n-p-n, ПЭ	0,5 Вт (36*)	⩾250	60	5	0,8 (1,2*) А	⩽1 (60 В)
КТ929А	n-p-n, ПЭ	6 Вт (40 °С)	⩾700	30* (0,1 к)	3	0,8 (1,5*) А	⩽5* мА (30 В)
КТ930А	n-p-n, ПЭ	75 Вт (40 °С)	⩾450	50* (0,1 к)	4	6 (10*) А	⩽20* мА (50 В)
КТ930Б	n-p-n, ПЭ	120 Вт (40 °С)	⩾600	50* (0,1 к)	4	6 (10*) А	⩽100* мА (50 В)
КТ931А	n-p-n, ПЭ	150 Вт (40 °С)	⩾250	60* (0,01 к)	4	15 А	⩽20* мА (60 В)
КТ932А	p-n-p, ПЭ	20* Вт (50 °С)	⩾40	80	4,5	2 А	⩽1,5* мА (80 В)
КТ932Б	p-n-p, ПЭ	20* Вт (50 °С)	⩾60	80	4,5	2 А	⩽1,5* мА (60 В)
КТ932В	p-n-p, ПЭ	20* Вт (50 °С)	⩾40	40	4,5	2 А	⩽1,5* мА (40 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{21э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, $r^*_{БЭ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'^*_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
—	≤15 (28 В)	—	5** (175 МГц)	≤20	
—	≤35 (28 В)	—	20** (175 МГц)	≤20	
—	≤65 (28 В)	—	40** (175 МГц)	≤25	
—	≤35 (28 В)	—	17** (175 МГц)	≤20	
—	≤65 (28 В)	—	35** (175 МГц)	≤25	
8* (5 В; 0,2 А)	≤15 (12,6 В)	—	2** (320 МГц)	≤20	
	≤30 (12,6 В)	—	5** (320 МГц)	≤35	
17* (5 В; 0,2 А)	≤60 (12,6 В)	—	20** (320 МГц)	≤40	
—	≤60 (12,6 В)	—	15** (320 МГц)	≤40	
10...60* (7 В; 15 А)	—	≤0,17	—	—	
10...60* (7 В; 15 А)	—	≤0,25	—	—	
≥15* (6 В; 5 А)	≤190 (28 В)	≤0,07	≥75** (20 МГц)	—	
≥25* (6 В; 5 А)	≤190 (28 В)	≤0,07	≥75** (20 МГц)	—	
≥40* (6 В; 5 А)	≤190 (28 В)	≤0,07	≥75** (20 МГц)	—	
20...100* (5 В; 150 мА)	≤12 (10 В)	≤3,3	—	≤250*	
50...200* (5 В; 150 мА)	≤12 (10 В)	≤3,3	—	≤250*	
≥25* (5 В; 0,7 А)	≤20 (8 В)	—	≥2** (175 МГц)	≤25	
40* (5 В; 0,5 А)	≤80 (28 В)	—	≥40** (400 МГц)	8	
50* (5 В; 0,5 А)	≤170 (28 В)	—	≥75** (400 МГц)	11	
25* (5 В; 0,5 А)	≤240 (28 В)	0,18	≥80** (175 МГц)	18	
≥15* (3 В; 1,5 А)	≤300 (20 В)	≤1	—	—	
≥30* (3 В; 1,5 А)	≤300 (20 В)	≤1	—	—	
≥40* (3 В; 1,5 А)	≤300 (20 В)	≤1	—	—	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ933А КТ933Б	p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ	5* Вт (50 °С) 5* Вт (50 °С)	⩾75 ⩾75	80 60	4,5 4,5	0,5 А 0,5 А	⩽0,5 мА (80 В) ⩽0,5 мА (60 В)
КТ934А	n-p-n, ПЭ	7,5 Вт	⩾500	60* (0,01 к)	4	0,5 А	⩽7,5 мА (60 В)
КТ934Б	n-p-n, ПЭ	15 Вт	⩾500	60* (0,01 к)	4	1 А	⩽15 мА (60 В)
КТ934В	n-p-n, ПЭ	30 Вт	⩾500	60* (0,01 к)	4	2 А	⩽30 мА (60 В)
КТ934Г	n-p-n, ПЭ	15 Вт	⩾450	60* (0,01 к)	4	1 А	⩽15 мА (60 В)
КТ934Д	n-p-n, ПЭ	30 Вт	⩾450	60* (0,01 к)	4	2 А	⩽30 мА (60 В)
КТ935А	n-p-n, МПЭ	60*Вт (50 °С)	⩾51	80* (0,01 к)	5	20 (30*) А	⩽30 мА (80 В)
КТ936А	n-p-n, ПЭ	28 Вт (75 °С)	—	60	3,5	3,3 А	⩽10 мА (60 В)
КТ936Б	n-p-n, ПЭ	83,3*Вт (75 °С)	—	60	3,5	10 А	⩽30 мА (60 В)
КТ937А-2 КТ937Б-2	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	3,6 Вт 7,4 Вт	6500 6500	25 25	2,5 2,5	250 450	⩽2 мА (25 В) ⩽5 мА (25 В)
КТ938А-2 КТ938Б-2	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	1,5 Вт 1,5 Вт	⩾2000 ⩾1800	28 28	2,5 В 2,5 В	180 180	⩽1 мА (28 В) ⩽1 мА (28 В)
КТ939А КТ939Б	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	4 Вт 4 Вт	⩾2500 ⩾1500	30* (0,01 к) 30* (0,01 к)	3,5 3,5	400 400	⩽2 мА (30 В) ⩽2 мА (30 В)
КТ940А	n-p-n, ПЭ	1,2 (10*) Вт	⩾90	300* (10 к)	5	0,1 (0,3*) А	⩽0,05 мА (250 В)
КТ940Б	n-p-n, ПЭ	1,2 (10*) Вт	⩾90	250* (10 к)	5	0,01 (0,3*) А	⩽0,05 мА (200 В)
КТ940В	n-p-n, ПЭ	1,2 (10*) Вт	⩾90	160* (10 к)	5	0,1 (0,3*) А	⩽0,05 мА (100 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ $r'^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
⩾15* (3 В; 0,4 А) ⩾30* (3 В; 0,4 А)	⩽70 (20 В) ⩽70 (20 В)	⩽3,75 ⩽3,75	— —	— —	
50* (5 В; 0,1 А) 50* (5 В; 0,15 А) 50* (5 В; 0,25 А) — —	⩽9 (28 В) ⩽16 (28 В) ⩽32 (28 В) ⩽16 (28 В) ⩽32 (28 В)	2 1 0,5 — —	⩾3** (400 МГц) ⩾12** (400 МГц) ⩾25** (400 МГц) ⩾10** (400 МГц) ⩾20** (400 МГц)	⩽20 ⩽20 ⩽20 ⩽25 ⩽25	
20...100* (4 В; 15 А)	⩽800 (10 В)	⩽0,066	—	⩽700**	
⩾6* (3 В; 0,1 А)	—	—	—	—	
⩾6* (3 В; 0,1 А)	—	—	—	—	
— —	⩽5,5 (20 В) ⩽7,5 (20 В)	— —	⩾1,6** (5 ГГц) ⩾3,2** (5 ГГц)	0,78 0,6	
— —	⩽4 (20 В) ⩽4,5 (20 В)	— —	⩾1** (5 ГГц) ⩾1** (5 ГГц)	⩽2 ⩽2	
40...200* (12 В; 0,2 А) 20...200* (12 В; 0,2 А)	⩽5,5 (12 В) ⩽6 (12 В)	— —	— —	⩽9 ⩽10	
⩾25* (10 В; 30 мА) ⩾25* (10 В; 40 мА) ⩾25* (10 В; 30 мА)	4,2 (30 В) 4,2 (30 В) 4,2 (30 В)	⩽33 ⩽33 ⩽33	— — —	— — —	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ942В	*n-p-n*, ПЭ	25* Вт	⩾1950	45	3,5	1,5 (3*) А	⩽25 мА (45 В)
КТ943А	*n-p-n*, МП	25* Вт	⩾30	45	5	2 (6*) А	⩽0,1 мА (45 В)
КТ943Б	*n-p-n*, МП	25* Вт	⩾30	60	5	2 (6*) А	⩽0,1 мА (60 В)
КТ943В	*n-p-n*, МП	25* Вт	⩾30	100	5	2 (6*) А	⩽0,1 мА (100 В)
КТ943Г	*n-p-n*, МП	25* Вт	⩾30	100	5	2 (6*) А	⩽1 мА (100 В)
КТ943Д	*n-p-n*, МП	25* Вт	⩾30	100	5	2 (6*) А	⩽1 мА (100 В)
КТ944А	*n-p-n*, ПЭ	55 Вт (90 °С)	⩾105	100* (0,01 к)	5	12,5 (20*) А	⩽80 мА (100 В)
КТ945А	*n-p-n*, Э	50* Вт (50 °С)	⩾51	150* (10 Ом)	5	15 (25*)	25 мА (150 В)
КТ946А	*n-p-n*, ПЭ	37,5** Вт	⩾720	50	3,5	2,5 (5*) А	⩽50 мА (50 В)
КТ947А	*n-p-n*, ПЭ	200* Вт (50 °С)	⩾75	100* (0,01 к)	5	20 (50*) А	⩽100* мА (100 В)
КТ948А	*n-p-n*, ПЭ	40 Вт	⩾1950	45	2	2,5 (5*) А	⩽35 мА (45 В)
КТ948Б	*n-p-n*, ПЭ	20 Вт	⩾1950	45	2	1,25 (2,5*) А	⩽15 мА (45 В)
КТ955А	*n-p-n*, ПЭ	20 Вт (100 °С)	⩾100	70* (0,01 к)	4	6 А	⩽10 мА (60 В)
КТ956А	*n-p-n*, ПЭ	70** Вт (100 °С)	⩾100	100* (0,01 к)	4	15 А	⩽80* мА (100 В)
КТ957А	*n-p-n*, ПЭ	100** Вт (100 °С)	⩾100	60* (0,01 к)	4	20 А	⩽100* мА (60 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ нас}$, $r^*_{БЭ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
—	⩽25 (28 В)	—	⩾8** (2 ГГц)	⩽3	
40...200* (2 В; 0,15 А)	—	⩽0,6	—	—	
40...160* (2 В; 0,15 А)	—	⩽0,6	—	—	
40...120* (2 В; 0,15 А)	—	⩽0,6	—	—	
20...60* (2 В; 0,15 А)	—	⩽1,2	—	—	
30...100* (2 В; 0,15 А)	—	⩽1,2	—	—	
10...60* (5 В; 10 А)	⩽350 (28 В)	⩽0,25	⩾100** (30 МГц)	—	
10...80* (7 В; 15 А)	⩽200 (30 В)	⩽0,17	—	⩽1,1*	
—	⩽50 (10 В)	—	⩾27** (1 ГГц)	—	
10...80* (5 В; 20 А)	⩽850 (27 В)	—	⩾250** (1,5 МГц)	—	
— —	⩽30 (28 В) ⩽17 (28 В)	— —	⩾15** (2 ГГц) ⩾8** (2 ГГц)	— —	
10...80* (5 В; 1 А)	⩽75 (28 В)	—	⩾20** (30 МГц)	—	
10...80* (5 В; 1 А)	⩽400 (28 В)	—	⩾100** (30 МГц)	—	
10...80* (5 В; 5 А)	⩽600 (28 В)	—	⩾125** (30 МГц)	—	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21э}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ958А	*n-p-n*, ПЭ	85** Вт (40 °С)	⩾300	36* (0,01 к)	4	10 А	⩽15 мА (36 В)
КТ960А	*n-p-n*, ПЭ	70** Вт (40 °С)	⩾600	36* (0,01 к)	4	7 А	⩽20* мА (36 В)
КТ961А	*n-p-n*, П	1 (12,5*) Вт	⩾50	100* (1 к)	5	1,5 (2*) А	⩽10 (60 В)
КТ961Б	*n-p-n*, П	1 (12,5*) Вт	⩾50	80* (1 к)	5	1,5 (2*) А	⩽10 (60 В)
КТ961В	*n-p-n*, П	1 (12,5*) Вт	⩾50	60* (1 к)	5	1,5 (2*) А	⩽10 (60 В)
КТ962А	*n-p-n*, ПЭ	17** Вт (40 °С)	⩾750	50	4	1,5 А	⩽20 мА (50 В)
КТ962Б	*n-p-n*, ПЭ	27** Вт (40 °С)	⩾750	50	4	2,5 А	⩽20 мА (50 В)
КТ962В	*n-p-n*, ПЭ	66** Вт (40 °С)	⩾600	50	4	4 А	⩽30 мА (50 В)
КТ965А	*n-p-n*, ПЭ	32 Вт	⩽100	36* (0,01 к)	4	4 А	⩽10* мА (36 В)
КТ966А	*n-p-n*, ПЭ	64 Вт	⩾100	36* (0,01 к)	4	8 А	⩽23* мА (36 В)
КТ967А	*n-p-n*, ПЭ	100** Вт	⩾180	36* (0,01 к)	4	15 А	⩽20* мА (36 В)
КТ969А	*n-p-n*, П	1 (6*) Вт	⩾60	300	5	100 (200*)	⩽0,05 (200 В)
КТ970А	*n-p-n*, ПЭ	170** Вт	600	50* (0,01 к)	4	13 А	100* мА (50 В)
КТ971А	*n-p-n*, ПЭ	200** Вт	⩾220	50* (0,01 к)	4	17 А	⩽60* мА (50 В)
КТ972А	*n-p-n*, ПЭ	8 Вт	⩾200	60* (1 к)	5	4 А	⩽1* мА (60 В)
КТ972Б	*n-p-n*, ПЭ	8 Вт	⩾200	45* (1 к)	5	4 А	⩽1* мА (45 В)
КТ973А	*p-n-p*, ПЭ	8 Вт	⩾200	60* (1 к)	5	4 А	⩽1* мА (60 В)
КТ973Б	*p-n-p*, ПЭ	8 Вт	⩾200	45* (1 к)	5	4 А	⩽1* мА (60 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'_Б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
⩾10* (8 В; 0,5 А) —	⩽180 (12 В) ⩽120 (12 В)	0,16 0,16	⩾40** (175 МГц) ⩽40** (400 МГц)	12 12,5	
40...100* (2 В; 0,15 А) 63...160* (2 В; 0,15 А) 100...250* (2 В; 0,15 А)	— — —	⩽1 ⩽1 ⩽1	— — —	— — —	
— — —	⩽20 (28 В) ⩽35 (28 В) ⩽50 (28 В)	— — —	⩾10** (1 ГГц) ⩾20** (1 ГГц) ⩾40** (1 ГГц)	⩽15 ⩽14 ⩽11	
10...60* (5 В; 1 А)	⩽100 (12,6 В)	—	⩾20** (30 МГц)	—	
—	⩽250 (12,6 В)	—	⩾40** (30 МГц)	—	
10...100* (5 В; 5 А)	⩽500 (12,6 В)	—	⩾90** (30 МГц)	—	
50...250* (10 В; 15 мА)	⩽1,8 (30 В)	⩽60	—	—	
— —	180 (28 В) ⩽330 (28 В)	—	100** (400 МГц) ⩾150** (175 МГц)	25 ⩽40	
⩾750* (3 В; 1 А) ⩾750* (3 В; 1 А) ⩾750* (3 В; 1 А) ⩾750* (3 В; 1 А)	— — — —	⩽3 ⩽3 ⩽3 ⩽3	— — — —	⩽200* ⩽200* ⩽200* ⩽200*	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^*_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^*_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ976А	*n-p-n*, ПЭ	75** Вт (40 °С)	≥750	50	4	6 А	≤60 мА (50 В)
КТ977А	*n-p-n*, ПЭ	200** Вт (85 °С)	≥600	50	3	8* А	≤25 мА (50 В)
КТ981А	*n-p-n*, ПЭ	70 Вт	—	36* (0,01 к)	4	10 А	≤50** мА (36 В)
КТ983А	*n-p-n*, ПЭ	8,7 Вт	≥1200	40* (0,01 к)	4	0,5 А	≤5* мА (40 В)
КТ983Б	*n-p-n*, ПЭ	13 Вт	≥900	40* (0,01 к)	4	1 А	≤8* мА (40 В)
КТ983В	*n-p-n*, ПЭ	22,5 Вт	≥750	40* (0,01 к)	4	2 А	≤18* мА (40 В)
КТ984А	*n-p-n*, ПЭ	1,4 Вт	≥720	65	4	7* А	≤30 мА
КТ984Б	*n-p-n*, ПЭ	4,7 Вт	≥720	65	4	16* А	≤80 мА
КТ985АС	*n-p-n*, ПЭ	105* Вт	≥660	50*	4	17 А	≤120* мА
КТ991АС	*n-p-n*, ПЭ	67* Вт	≥600	50	4	3,7 А	≤50 мА
КТ997А	*n-p-n*, ПЭ	50* Вт	≥51	45	5	10 (20*) А	≤10 мА (45 В)
КТ997Б	*n-p-n*, ПЭ	50* Вт	≥51	45	5	10 (20*) А	≤10 мА (45 В)
КТ999А	*n-p-n*, ПЭ	5 Вт	≥60	250	5	50	≤0,1

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$С_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^{1*}_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
—	⩽70 (28 В)	—	⩾60** (1 ГГц)	⩽25	
—	—	—	⩾50** (1,5 ГГц)	—	
10...90* (5 В; 5 А)	⩽400 (12,6 В)	—	⩾50** (80 МГц)	—	
— — —	⩽8 (28 В) ⩽12 (28 В) ⩽24 (28 В)		⩾0,5** (860 МГц) ⩾1** (860 МГц) ⩾3,5** (860 МГц)	— — —	
—	⩽35 (30 В) ⩽80 (30 В)	—	75** (820 МГц) 250** (820 МГц)	⩽20 ⩽20	
—	⩽270 (28 В)	—	⩾125** (0,4 ГГц)	21	
—	—	—	55** (0,7 ГГц)	⩽6,8	
⩾40* (1 В; 4 А) ⩾20* (1 В; 4 А)	⩽270 (10 В) ⩽270 (10 В)	⩽0,125 ⩽0,125	— —	⩽500* ⩽500*	
⩾50	—	⩽66	—	—	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТС303А-2	*n-p-n*, *p-n-p*, ПЭ	500 (50 °С)	⩾300	45* (10 к)	—	100 (500)*	⩽0,5 (45 В)
КТС3103А	*p-n-p*, П	300 (55 °С)	⩾600	15* (15 к)	5	20 (50*)	⩽200 (15 В)
КТС3103Б	*p-n-p*, П	300 (55 °С)	⩾600	15* (15 к)	5	20 (50*)	⩽200 (15 В)
КТС393А	*p-n-p*, ПЭ	20 (45 °С)	⩾500	10* (10 к)	4	10 (20*)	⩽0,1 (10 В)
КТС393Б	*p-n-p*, ПЭ	20 (45 °С)	⩾500	15* (10 к)	4	10 (20*)	⩽0,2 (15 В)
КТС394А-2	*p-n-p*, ПЭ	300*	⩾300	45* (10 к)	4	100	⩽0,5 (45 В)
КТС394Б-2	*p-n-p*, ПЭ	300*	⩾300	45* (10 к)	4	100	⩽0,5 (45 В)
КТС395А-1	*n-p-n*, ПЭ	30	⩾300	45* (10 к)	4	20	⩽0,5 (45 В)
КТС395В-1	*n-p-n*, ПЭ	30	⩾300	10* (10 к)	4	20	⩽0,5 (10 В)
КТС395А-2	*n-p-n*, ПЭ	150 (500**)	⩾300	45* (10 к)	4	100	⩽0,5 (45 В)
КТС395Б-2	*n-p-n*, ПЭ	150 (500**)	⩾300	45* (10 к)	4	100	⩽0,5 (45 В)
КТС395В-2	*n-p-n*, ПЭ	150 (500**)	⩾300	10* (10 к)	4	100	⩽0,5 (10 В)
КТС398А-1	*n-p-n*, ПЭ	30 (85 °С)	⩾1000	10* (10 к)	4	10 (20*)	⩽0,5 (10 В)
КТС398Б-1	*n-p-n*, ПЭ	30 (85 °С)	⩾1000	10* (10 к)	4	10 (20*)	⩽0,5 (10 В)
КТС613А	*n-p-n*, ПЭ	800 (50 °С)	⩾200	60	4	400 (800*)	⩽8 (60 В)
КТС613Б	*n-p-n*, ПЭ	800 (50 °С)	⩾200	60	4	400 (800*)	⩽8 (60 В)
КТС613В	*n-p-n*, ПЭ	800 (50 °С)	⩾200	40	4	400 (800*)	⩽8 (40 В)
КТС613Г	*n-p-n*, ПЭ	800 (50 °С)	⩾200	40	4	400 (800*)	⩽8 (40 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $h_{21э1}/h^*_{21э2}$, $\Delta U^{**}_{эб}$, мВ	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
40...180 (5 В; 1 мА)	⩽8 (5 В)	⩽20	⩾0,7*	⩽80	
40...200 (1 В; 1 мА) 40...200 (1 В; 1 мА)	⩽2,5 (5 В) ⩽2,5 (5 В)	⩽60 ⩽60	⩽5 (60 МГц) ⩾0,9* ⩽5 (60 МГц) ⩾0,8*	⩽80 ⩽80	
40...180 (1 В; 1 мА) 30...140 (1 В; 1 мА)	⩽2 (5 В) ⩽2 (5 В)	⩽60 ⩽60	⩽6 (60 МГц) ⩾0,9* ⩽6 (60 МГц) ⩾0,8*	⩽80 ⩽80	
40...120 (5 В; 1 мА) 10...300 (5 В; 1 мА)	⩽8 (10 В) ⩽8 (10 В)	⩽30 ⩽30	⩽10** —	— —	
40...120 (5 В; 1 мА) ⩾350 (5 В; 1 мА)	⩽8 (10 В) ⩽8 (10 В)	⩽30 ⩽30	⩽10** —	— —	
40...120 (5 В; 1 мА) 100...300 (5 В; 1 мА) ⩾350 (5 В; 1 мА)	⩽8 (10 В) ⩽8 (10 В) ⩽8 (10 В)	⩽30 ⩽30 ⩽30	⩽10** — —	— — —	
40...250 (1 В; 1 мА) 40...250 (1 В; 1 мА)	⩽1,5 (5 В) ⩽1,5 (5 В)	— —	0,8...1,25* ⩽1,5** 0,9...1,1*⩽3**	⩽50 ⩽50	
25...100* (5 В; 0,2 А) 40...200* (5 В; 0,2 А) 20...120* (5 В; 0,2 А) 50...300* (5 В; 0,2 А)	⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В) ⩽15 (10 В)	⩽2,5 ⩽2,5 ⩽2,5 ⩽2,5	— — — —	⩽100* ⩽100* ⩽100* ⩽100*	1,6,7,12–Э; 5,2,8,11–К 3,4,9,10–Б I, II, III, IV – единые транзисторные структуры

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К.т\,max}$, $P^{**}_{К.и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$K_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К.и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТС622А	p-n-p, ПЭ	0,4 (10**) Вт	⩾200	45* (1 к)	4	400 (600*)	⩽10 (45 В)
КТС622Б	p-n-p, ПЭ	0,4 (10**) Вт	⩾200	35* (1 к)	4	400 (600*)	⩽20 (35 В)
КТС631А	n-p-n, ПЭ	4 Вт (55 °С)	⩾350	30	4	1 (1,3*) А	⩽200 (30 В)
КТС631Б	n-p-n, ПЭ	4 Вт (55 °С)	⩾350	30	4	1 (1,3*) А	⩽50 (30 В)
КТС631В	n-p-n, ПЭ	4 Вт (55 °С)	⩾200	60	4	1 (1,3*) А	⩽50 (60 В)
КТС631Г	n-p-n, ПЭ	4 Вт (55 °С)	⩾200	60	4	1 (1,3*) А	⩽200 (60 В)
К1НТ251	n-p-n, ПЭ	400 (50 °С)	⩾200	45* (1 к)	4	400 (800*)	⩽6 мА (45 В)
К1НТ661А	n-p-n, ПЭ	100 (50 °С)	—	300	—	5 (10*)	⩽30 (250 В)
К129НТ1А-1	n-p-n, ПЭ	15 (85 °С)	⩾250	15	4	10 (40*)	⩽0,2 (15 В)
К129НТ1Б-1	n-p-n, ПЭ	15 (85 °С)	⩾250	15	4	10 (40*)	⩽0,2 (15 В)
К129НТ1В-1	n-p-n, ПЭ	15 (85 °С)	⩾250	15	4	10 (40*)	⩽0,2 (15 В)
К129НТ1Г-1	n-p-n, ПЭ	15 (85 °С)	⩾250	15	4	10 (40*)	⩽0,2 (15 В)
К129НТ1Д-1	n-p-n, ПЭ	15 (85 °С)	⩾250	15	4	10 (40*)	⩽0,2 (15 В)
К129НТ1Е-1	n-p-n, ПЭ	15 (85 °С)	⩾250	15	4	10 (40*)	⩽0,2 (15 В)
К129НТ1Ж-1	n-p-n, ПЭ	15 (85 °С)	⩾250	15	4	10 (40*)	⩽0,2 (15 В)
К129НТ1И-1	n-p-n, ПЭ	15 (85 °С)	⩾250	15	4	10 (40*)	⩽0,2 (15 В)
К159НТ1А	n-p-n, ПЭ	50	⩾200	20	4	10 (40*)	⩽0,2 (20 В)
К159НТ1Б	n-p-n, ПЭ	50	⩾200	20	4	10 (40*)	⩽0,2 (20 В)
К159НТ1В	n-p-n, ПЭ	50	⩾200	20	4	10 (40*)	⩽0,2 (20 В)
К159НТ1Г	n-p-n, ПЭ	50	⩾200	20	4	10 (40*)	⩽0,2 (20 В)
К159НТ1Д	n-p-n, ПЭ	50	⩾200	20	4	10 (40*)	⩽0,2 (20 В)
К159НТ1Е	n-p-n, ПЭ	50	⩾200	20	4	10 (40*)	⩽0,2 (20 В)
КР159НТ1А	n-p-n, ПЭ	50	⩾200	20	4	10 (40*)	⩽0,2 (20 В)
КР159НТ1Б	n-p-n, ПЭ	50	⩾200	20	4	10 (40*)	⩽0,2 (20 В)
КР159НТ1В	n-p-n, ПЭ	50	⩾200	20	4	10 (40*)	⩽0,2 (20 В)
КР159НТ1Г	n-p-n, ПЭ	50	⩾200	20	4	10 (40*)	⩽0,2 (20 В)
КР159НТ1Д	n-p-n, ПЭ	50	⩾200	20	4	10 (40*)	⩽0,2 (20 В)
КР159НТ1Е	n-p-n, ПЭ	50	⩾200	20	4	10 (40*)	⩽0,2 (20 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, $r^*_{БЭ\,нас}$, Ом	$K_ш$, дБ; $h_{21э1}/h^*_{21э2}$; $\Delta U^{**}_{эб}$, мВ	$\tau_к$, пс; $t^*_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
25...150* (5 В; 0,2 А) ≥10* (5 В; 0,2 А)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤3,25 ≤3,25	— —	≤120* ≤200*	
20...115* (1 В; 0,3 А)	≤15 (10 В)	≤2,8	—	≤40; ≤30*	1,6,7,12-Э; 5,2,8,11-К; 3,4,9,10-Б I, II, III, IV – единые транзисторные структуры
20...125* (1 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤12	—	≤40; ≤30*	
20...125* (1 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤12	—	≤40; ≤60*	
20...115* (1 В; 0,3 А)	≤15 (10 В)	≤2,8	—	≤40; ≤60*	
≥10* (5 В; 0,2 А)	≤15 (10 В)	≤5	—	≤200*	
≥5* (5 В; 10 мА)	—	≤1000	—	—	
20...80 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,85*; ≤3**	—	
60...80 (5 В; 1 мА)	≤4 (В)	—	≥0,85*; ≤3**	—	
≥80 (5 В; 50 мкА)	≤4 (5 В)	—	≥0,85*; ≤3**	—	
20...80 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,75*; ≤15**	—	
60...80 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,75*; ≤15**	—	
≥80 (5 В; 50 мкА)	≤4 (5 В)	—	≥0,75*; ≤15**	—	
40...160 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,85*; ≤3**	—	
40...160 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,75*; ≤15**	—	
20...80 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,85*; ≤3**	—	
60...180 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,85*; ≤3**	—	
≥80 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,85* (50 мкА); ≤3**	—	
20...80 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,75* (1 мА); ≤15**	—	
60...180 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,75* (1 мА); ≤15**	—	
≥80 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,75* (50 мкА); ≤15**	—	
20...80 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,85* (1 мА); ≤3**	—	
60...80 (50 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,85* (1 мА); ≥3**	—	
≥80 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,85* (50 мкА); ≤3**	—	
20...80 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,75* (1 мА); ≤15**	—	
60...180 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,75* (1 мА); ≤15**	—	
≥80 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≥0,75* (50 мкА); ≤15**	—	

3.5. Полевые транзисторы

Принцип действия полевых транзисторов основан на использовании эффекта внешнего электрического поля для управления проводимостью. Их еще называют униполярными, так как перенос тока осуществляется носителями заряда одного типа (в отличие от биполярных транзисторов).

Особенностью полевых транзисторов является высокое входное сопротивление, малые шумы, повышенная температурная стабильность, квадратичность переходной (проходной) характеристики, что позволяет получить малый уровень перекрестных и модуляционных помех по сравнению с биполярными транзисторами.

Полевые транзисторы по принципу действия подразделяются на транзисторы с управляющим *p-n* переходом и МДП-транзисторы (в частности, МОП-транзисторы, имеющие структуру металл — окисел — полупроводник). Управляющим электродом служит затвор.

В транзисторах с управляющим переходом затвор отделен от канала между стоком и истоком *p-n* переходом. В МОП-транзисторах (их называют также транзисторами с изолированным затвором) затвор отделен от канала исток — сток тонким слоем диэлектрика. В качестве диэлектрика используются пленки двуокиси кремния, нитрида кремния и окиси алюминия.

В зависимости от типа исходного материала полевые транзисторы имеют каналы *n*-типа или *p*-типа. Например, МОП-транзисторы с каналом *n*-типа основаны на электронной проводимости (носители зарядов электроны), а с каналом *p*-типа — на дырочной проводимости. У *n*-канальных приборов ток канала тем меньше, чем меньше потенциал затвора, а к выводу истока прикладывается больший отрицательный потенциал, чем к выводу стока (т. е. полярность напряжения стока положительная), а у *p*-канальных — наоборот.

Существуют два основных режима работы полевых транзисторов: обеднения (проводимость канала может быть увеличена или уменьшена в зависимости от полярности приложенного напряжения $U_{ЗИ}$ и обогащения (проводимость канала может быть увеличена в результате приложенного напряжения $U_{ЗИ}$ определенной полярности). У транзисторов обедненного типа при напряжении на затворе $U_{ЗИ}=0$ протекает небольшой ток, а транзисторы обогащенного типа закрыты при значениях $U_{ЗИ}$, близких к нулю. Такие приборы соответственно называются нормально открытыми и нормально закрытыми. В частности, полевые транзисторы с управляющим *p-n* переходом являются нормально открытыми, они закрываются (т. е. ток стока имеет минимальное значение) при определенном напряжении, называемом напряжением отсечки.

По конструктивно-технологическим признакам полевые транзисторы подразделяются на приборы с встроенным и индуцированным каналами. Встроенный канал создается технологическими приемами, а индуцированный канал наводится в поверхностном слое полупроводника в результате воздействия поперечного электрического поля.

В транзисторах со встроенным каналом (например, КП305, КП313) уменьшение тока на выходе осуществляется подачей на затвор напряжения с полярностью, соответствующей знаку носителей заряда в канале (для *p*-канала $U_{ЗИ}>0$, для *n*-канала $U_{ЗИ}<0$), что вызывает обеднение канала носителями заряда. При изменении полярности напряжения на затворе произойдет обогащение канала носителями и выходной ток увеличится. Такие приборы могут работать в режимах обеднения и обогащения.

В транзисторах с индуцированным каналом при $U_З=0$ канал отсутствует и только при напряжении, равном пороговому, образуется (индуцируется) канал. Такие приборы работают только в режиме обогащения (нормально закрытый прибор).

В полевых транзисторах с управляющим *p-n* переходом канал существует только при $U_З=0$, т. е. они имеют встроенный канал, но могут работать только в режиме обеднения носителями заряда (нормально открытый прибор).

Выходные вольт-амперные характеристики полевых транзисторов (зависимость тока стока от напряжения на стоке при различных напряжениях на затворе) подобны характеристикам усилительных пентодов.

В отличие от транзисторов с управляющим *p-n* переходом МДП-транзисторы сохраняют высокое входное сопротивление при любом значении напряжения на затворе, которое ограничено напряжением пробоя изолятора затвора.

В графических обозначениях транзисторы с индуцированным каналом имеют штриховую линию в обозначении канала, а со встроенным каналом — сплошную, стрелки определяют тип канала: направлена к каналу — канал *n*-типа, от канала — канал *p*-типа.

Графические обозначения полевых транзисторов

Тип канала	Класс прибора	С *p-n* переходом	С изолированным затвором	
		нормально открытый (с обеднением)	нормально открытый (с обеднением)	нормально закрытый (с обогащением)
n-канал	Транзистор с одним затвором			
	Транзистор с двумя затворами (тетрод)			
p-канал	Транзистор с одним затвором			
	Транзистор с двумя затворами (тетрод)			

В МОП-транзисторах иногда делается четвертый вывод (кроме выводов истока, стока и затвора) от подложки, которая, как и затвор, может выполнять управляющие функции, но от канала она отделена только *p-n* переходом. Обычно вывод подложки соединяется с выводом истока. Если же требуется иметь два управляющих электрода, то используются МОП-транзисторы с двумя затворами (МОП-тетроды, например, транзисторы КП322, КП327, КП346, КП350). Они имеют малую емкость обратной связи, не требуют цепей нейтрализации и более устойчивы к паразитным колебаниям. Транзистор КП306 имеет нормированную квадратичность переходной характеристики менее 2,5 В при ослаблении комбинированных составляющих третьего порядка не менее 80 дБ.

Слой окисла между затвором и подложкой очень тонкий, поэтому МОП-транзисторы чувствительны к действию статического электричества, которое может привести к их пробою. Для их защиты между затворами и подложкой иногда включают защитные диоды (стабилитроны). МОП-транзисторы имеют более высокий коэффициент шума на низких частотах по сравнению с полевыми транзисторами с *p-n* переходом, поэтому они используются в малошумящих усилителях на высоких частотах.

Среди мощных полевых транзисторов с управляющим *p-n* переходом необходимо отметить транзисторы со статической индукцией (например, КП801). Они имеют выходные характеристики, подобные ламповому триоду; хорошие параметры переключения и линейность в области токов, используемых в усилителях звуковой частоты; у них отсутствует тепловая нестабильность, так как при больших токах стока температурный коэффициент имеет отрицательное значение; низкий уровень шумов; низкое выходное сопротивление, что хорошо согласуется энергетически с низкоомной нагрузкой.

Рассмотрим назначение некоторых конкретных типов полевых транзисторов.

КП101 (Г—Е) — малошумящие диффузионно-планарные (ДП) полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *p*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КП103 (Е—М) — малошумящие диффузионно-планарные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *p*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —55...+85 °С.

КП201 (Е—Л-1) — бескорпусные (с гибкими выводами) малошумящие диффузионно-планарные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *p*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением в составе гибридных интегральных микросхем. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

КП202 (Д—Е-1) — бескорпусные (с гибкими выводами) малошумящие эпитаксиально-планарные (ЭП) полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением в составе гибридных интегральных микросхем. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

КП301 (Б—Г) — малошумящие планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом *p*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей и нелинейных малосигнальных каскадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+70 °С.

КП302 (А—Г, АМ—ГМ) — высокочастотные малошумящие планарные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения в широкополосных усилителях на частотах до 150 МГц, в переключающих и коммутирующих устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+100 °С.

КП303 (А—И) — высокочастотные малошумящие эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей с высоким входным сопротивлением (КП303Г — в зарядочувствительных усилителях и других устройствах ядерной спектрометрии). Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85°С.

КП304А — диффузионно-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом *p*-типа. Предназначены для применения в переключающих и усилительных каскадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...85 °С.

КП305 (Д—И) — высокочастотные малошумящие диффузионно-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом *n*-типа. Предназначены для применения в усилителях высокой и низкой частоты с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С.

КП306 (А—В) — малошумящие СВЧ диффузионно-планарные полевые транзисторы с двумя изолированными затворами и каналом *n*-типа. Предназначены для применения в преобразовательных и усилительных каскадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С.

КП307 (А—Ж) — малошумящие эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей высокой и низкой частот с высоким входным сопротивлением (КП307Ж — в зарядочувствительных усилителях и устройствах ядерной спектроскопии). Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

КП308 (А—Д) — бескорпусные (с гибкими выводами) малошумящие эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения: КП308 (А — В) — во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока, КП308 (Г — Д) — в коммутаторах переключающих устройств с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+85 °С.

КП310 (А—Б) — малошумящие СВЧ диффузионно-планарные полевые транзисторы с изоли-

рованным затвором и каналом *n*-типа. Предназначены для применеиия в приемно-передающих устройствах СВЧ диапазона. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С.

КП312 (А, Б) — малошумящие СВЧ эпитаксиальио-планарные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных усилителях и преобразовательных каскадах СВЧ диапазона. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+100 °С.

КП313 (А—В) — малошумящие СВЧ диффузионно-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом *n*-типа. Предназначены для применения в усилительных каскадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45... ...+85 °С.

КП314А — малошумящие планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения в охлаждаемых каскадах предварительных усилителей устройств ядерной спектрометрии. Диапазон рабочих температур окружающей среды —170...+85 °С.

КП322А — малошумящие планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с двумя затворами на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для работы в усилительных и смесительных каскадах высокочастотного диапазона. Диапазои рабочих температур окружающей среды —60...+85 °С.

КП323 (А-2, Б-2) — бескорпусные (на керамическом кристаллодержателе) с полосковыми выводами и приклеиваемой керамической крышкой эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для работы в малошумящих усилительных каскадах на частотах до 400 МГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+70 °С.

КП327 (А, Б) — кремниевые планарные полевые транзисторы с двумя изолированными затворами (МДП-тетрод), защитными диодами и каналом *n*-типа. Предназначеиы для работы в селекторах телевизоров метрового и дециметрового диапазонов для улучшения чувствительиости, избирательности и глубины регулироваиия сигналов с малыми перекрестными искажениями. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КП329 (А, Б) — высокочастотные малошумящие полевые транзисторы на основе *p-n* перехода с каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей на частотах до 200 МГц и в переключательных и коммутирующих устройствах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...100 °С.

КП341 (А, Б) — малошумящие планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С.

КП346 (А9, Б9) — малошумящие СВЧ планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с двумя изолированными затворами и каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей. Транзисторы имеют корпус КТ-48, предназначенный для поверхностного монтажа. Диапазои рабочих температур окружающей среды —60...+85 °С.

КП350 (А — В) — диффузионно-планарные полевые транзисторы с двумя изолированными затворами и каналом *n*-типа. Предназначены для применения в усилительных, генераторных и преобразовательных каскадах СВЧ (на частотах до 700 МГц). Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КП601 (А, Б) — сверхвысокочастотные малошумящие средней мощности планарные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для работы во входных и выходных каскадах усилителей, генераторах и преобразователях высокой частоты. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+85 °С.

КП801 (А—Г) — мощные эпитаксиально-планарные со статической индукцией транзисторы (СИТ) с затвором на осиове *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Имеют характеристики, подобные ламповому триоду. Предназначены для работы в выходных каскадах усилителей звуковоспроизводящей аппаратуры. По сравнению с МДП-транзисторами СИТ характеризуются более высокой линейностью и крутизной и низким сопротивлением насыщения. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

КП802 (А, Б) — мощные высоковольтные эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с каналом *n*-типа. Предназначены для работы в преобразователях постоянного напряжения, ключевых и линейных устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60... +85 °С.

КП901 (А, Б) — мощные планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом *n*-типа. Предназначены для работы в усилительных и генераторных каскадах в диапазоне коротких и ультракоротких длин волн. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С.

КП902 (А—В) — мощные планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом *n*-типа. Предназначены для работы в приемно-передающих устройствах на частотах до 400 МГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КП903 (А—В) — мощные планарно-эпитаксиальные транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для работы в приемно-передающих устройствах на частотах до 30 МГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+100 °С.

КП904 (А, Б) — мощные планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом *n*-типа. Предназначены для работы в усилительных, преобразовательных и генераторных каскадах в диапазонах коротких и ультракоротких волн. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С.

КП905 (А, Б) — мощные СВЧ планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом *n*-типа. Предназначены для работы в усилительных и генераторных каскадах на частотах до 1,5 ГГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

КП907 (А, Б) — мощные СВЧ полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом *n*-типа. Предназначены для работы в усилительиых и генераторных каскадах на частотах до 1,5 ГГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

КП921А — мощный эпитаксиально-планарный полевой транзистор с изолированным затво-

ром и индуцированным каналом n-типа. Предназначен для применения в быстродействующих переключающих устройствах.

Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КП928 (А, Б) — мощные генераторные СВЧ эпитаксиально-планарные полевые МДП-транзисторы. Предназначены для работы в генераторах и усилителях мощности сигналов на частотах до 400 мГц, а также в импульсных и быстродействующих переключающих устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С.

КПС104 (А—Е) — сдвоенные планарно-эпитаксиальные ионно-легированные полевые транзисторы с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах малошумящих дифференциальных и операционных усилителей низкой частоты и усилителей постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45... ...+85 °С.

КПС202 (А-2—Г-2) — сдвоенные бескорпусные планарно-эпитаксиальные ионно-легированные малошумящие полевые транзисторы с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей, дифференциальных и операционных усилителей низкой частоты, а также усилителей постоянного тока с высоким входным сопротивлением (например, в медико-биологической аппаратуре и малошумящих балансных каскадах).

При монтаже транзисторов не допускается использование материалов, вступающих в химическое взаимодействие с защитным покрытием. Должна быть исключена возможность соприкосновения выводов с кристаллом (минимальное расстояние от места изгиба выводов до кристалла 1 мм, радиус закругления не менее 0,5 мм). При монтаже тепловое сопротивление кристалл — корпус должно быть не более 3 °С/мВт. При пайке выводов (на расстоянии не менее 1 мм) и при заливке компаундами нагрев кристалла не должен превышать +125 °С.

Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+70 °С.

КПС203 (А-1—Г-1) — сдвоенные бескорпусные с гибкими выводами без кристаллодержателя малошумящие планарно-диффузионные полевые транзисторы с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах высокоточных и малошумящих дифференциальных и операционных усилителей и малошумящих балансных каскадах с высоким входным сопротивлением. При монтаже и пайке расстояние от края транзистора до места изгиба должно быть не менее 1 мм, радиус изгиба — не менее 0,5 мм, расстояние до места пайки — не менее 1,5 мм. Не допускается нагрев транзисторов свыше +125 °С.

Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КПС315 (А, Б) — сдвоенные планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах дифференциальных усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60... ...+100 °С.

КПС316 (Д-1 — И-1) — сдвоенные бескорпусные с гибкими выводами без кристаллодержателя планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах дифференциальных усилителей и балансных каскадов с высоким входным сопротивлением. Типономинал прибора указывается на индивидуальной или групповой таре. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

3.6. Буквенные обозначения параметров полевых транзисторов

Буквенные обозначения параметров полевых транзисторов в соответствии со стандартом МЭК (публикация 747-8, 1984 г.) приводятся ниже.

Буквенное обозначение по ГОСТ 19095—73: отечественное	Буквенное обозначение по ГОСТ 19095—73: международное	Параметр
$I_з$	I_G	Ток затвора (постоянный)
$I_{З\ отс}$	I_{GSX}	Ток отсечки затвора
$I_{З\ пр}$	I_{GF}	Прямой ток затвора
$I_{З\ ут}$	I_{GSS}	Ток утечки затвора
$I_{ЗИО}$	I_{GSO}	Обратный ток перехода затвор — исток
$I_{ЗСО}$	I_{GDO}	Обратный ток перехода затвор — сток
$I_И$	I_S	Ток истока (постоянный)
$I_{И\ нач}$	I_{SDS}	Начальный ток истока
$I_{И\ ост}$	I_{SDX}	Остаточный ток истока
$I_С$	I_D	Ток стока (постоянный)
$I_{С\ нагр}$	I_{DSR}	Ток стока при нагруженном затворе
$I_{С\ нач}$	I_{DSS}	Начальный ток стока
$I_{С\ ост}$	I_{DSX}	Остаточный ток стока
$I_П$	I_B, I_U	Ток подложки
$U_{ЗИ}$	U_{GS}	Напряжение затвор — исток (постоянное)
$U_{ЗИ\ обр}$	U_{GSR}	Обратное напряжение затвор — исток (постоянное)
$U_{ЗИ\ отс}$	$U_{GS\ (OFF)}$, $U_{GS\ off}$	Напряжение отсечки транзистора — напряжение между затвором и истоком (полевого транзистора с p-n переходом и с изолированным затвором, работающего в режиме обеднения), при котором ток стока достигает заданного низкого значения

Буквенное обозначение по ГОСТ 19095—73		Параметр
отечественное	международное	
$U_{ЗИ\ пор}$	U_{GST}, $U_{GS\ (th)}$, $U_{GS\ (TO)}$	Пороговое напряжеиие транзистора — напряжение между затвором и истоком (у полевого траизистора с изолированным затвором, работающего в режиме обогащения), при котором ток стока достигает заданного низкого значения
$U_{ЗИ\ пр}$	U_{GSF}	Прямое напряжение затвор — исток (постоянное)
$U_{З\ проб}$	$U_{(BR)\ GSS}$	Пробивное напряжение затвора — иапряжение пробоя затвор — исток при замкнутых стоке и истоке
$U_{ЗП}$	U_{GB}, U_{GU}	Напряжеиие затвор — подложка (постоянное)
$U_{ЗС}$	U_{GD}	Напряжение затвор — сток (постояииое)
$U_{ИП}$	U_{SB}, S_{SU}	Напряжеиие исток — подложка (постоянное)
$U_{СИ}$	U_{DS}	Напряжение сток — исток (постоянное)
$U_{СП}$	U_{DB}, U_{DU}	Напряжеиие сток — подложка (постоянное)
$U_{З1}$—$U_{З2}$	U_{G1}—U_{G2}	Напряжение затвор — затвор (для приборов с несколькими затворами)
$P_{СИ}$	P_{DS}	Рассеиваемая мощность сток — исток (постоянная)
$P_{СИ,\ т\ max}$	—	Максимальиая рассеиваемая мощность сток — исток с теплоотводом (постоянная)
S	g_{ms}	Крутизна характеристики
$R_{ЗИ}$	r_{GS}, r_{gs}	Сопротивление затвор — исток
$R_{ЗС}$	r_{GD}, r_{gd}	Сопротивление затвор — сток
$R_{ЗС0}$	r_{GSS}, r_{gss}	Сопротивление затвора (при $U_{DS}=0$ или $U_{ds}=0$)
$R_{СИ}$	r_{DS}, r_{ds}	Сопротивлеиие сток — исток
$R_{СИ\ отк}$	$r_{DS\ (ON)}$, $r_{ds\ (on)}$, $r_{DS\ on}$	Сопротивление сток — исток в открытом состоянии — сопротивление между стоком и истоком в открытом состоянии траизистора при заданном напряжении сток — исток, меньшем напряжения насыщения
$R_{СИ\ закр}$	$r_{DS\ (OFF)}$, $r_{ds\ (off)}$, $r_{DS\ off}$	Сопротивление сток — исток в закрытом состояиии — сопротивление между стоком и истоком в закрытом состоянии транзистора при заданном напряжеиии сток — исток
$C_{ЗИО}$	C_{gso}	Емкость затвор — исток — емкость между затвором и истоком при разомкнутых по переменному току остальных выводах
$C_{ЗСО}$	C_{gdo}	Емкость затвор — сток — емкость между затвором — истоком при разомкнутых по перемеиному току остальиых выводах
$C_{СИО}$	C_{dso}	Емкость сток — исток — емкость между стоком и истоком при разомкнутых по переменному току остальных выводах
$C_{11и}$, $C_{вх,\ и}$	C_{iss}, C_{11ss}	Входная емкость транзистора — емкость между затвором и истоком при коротком замыкаиии по переменному току на выходе в схеме с общим стоком
$C_{12и}$	C_{rss}, C_{12ss}	Емкость обратной связи в схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе по переменному току
$C_{22и}$	C_{oss}, C_{22ss}	Выходная емкость транзистора — емкость между стоком и истоком при коротком замыкании по переменному току на выходе в схеме с общим истоком
$C_{22с}$	C_{ods}, C_{22ds}	Выходная емкость в схеме с общим стоком при коротком замыкании на входе (при коротком замыкании цепи затвор — сток по переменному току)
$g_{11и}$	g_{iss}, g_{11s}	Активная составляющая входной проводимости транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на выходе)
$g_{22и}$	g_{oss}, g_{22s}	Активная составляющая выходной проводимости транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе)
$y_{11и}$	y_{is}, y_{11s}	Полная входиая проводимость транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на выходе)
$y_{12и}$	y_{rs}, y_{12s}	Полная проводимость обратной передачи транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе)
$y_{21и}$	y_{fs}, y_{21s}	Полиая проводимость прямой передачи транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на выходе; $y_{fs}=g_{fs}+jb_{fs}=I_D/U_{GS}$; на НЧ $\|y_{fs}\|=g_{fs}$)
$y_{22и}$	y_{os}, y_{22s}	Полная выходная проводимость транзистора (при коротком замыкании на входе)
$K_{y,\ P}$	G_P	Коэффициент усиления по мощности
$f_{y\ 21и}$	f_{yfs}	Частота отсечки в схеме с общим истоком
$E_ш$	U_n	Шумовое напряжение траизистора
$K_ш$	F	Коэффициент шума транзистора
—	α_{ID}	Температурный коэффициент тока стока
—	α_{rds}	Температуриый коэффициент сопротивления сток — исток
$t_{вкл}$	t_{on}	Время включения транзистора
$t_{выкл}$	t_{off}	Время выключения транзистора
$t_{зд\ вкл}$	$t_{d\ (on)}$	Время задержки включения
$t_{зд.\ выкл}$	$t_{d\ (off)}$	Время задержки выключения
$t_{нр}$	t_r	Время нарастания
$t_{сп}$	t_f	Время спада

Буквенное обозначение по ГОСТ 19095—73		Параметр
отечественное	международное	
		Для сдвоенных полевых транзисторов:
$I_{З(ут)1}—I_{З(ут)2}$	$I_{GSS1}—I_{GSS2}$	Разность токов утечки затвора (для полевых транзисторов с изолированным затвором) и разность токов отсечки затвора (для полевых транзисторов с *p-n* переходом)
$I_{С\,нач1}/I_{С\,нач2}$	I_{DSS1}/I_{DSS2}	Отношение токов стока при нулевом напряжении затвор — исток
$U_{ЗИ1}—U_{ЗИ2}$	$U_{GS1}—U_{GS2}$	Разиость иапряжений затвор — исток
$\|\Delta(U_{ЗИ1}—U_{ЗИ2})\|_{\Delta T}$	$\|\Delta(U_{GS1}—U_{GS2})\|_{\Delta T}$	Изменение разности напряжений затвор — исток между двумя зиачениями температуры
$g_{22и1}—g_{22и2}$	$g_{os1}—g_{os2}$	Разность выходных проводимостей в режиме малого сигнала в схеме с общим истоком
$g_{22и1}/g_{21и2}$	g_{fs1}/g_{fs2}	Отношение полных проводимостей прямой передачи в режиме малого сигнала в схеме с общим истоком

3.7. Параметры полевых транзисторов

Тип прибора	Технология, структура	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^*_{СИ,\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_{С\,max}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
КП101Г	ДП, с *p-n* переходом и *p*-каналом	50	5	10	10	2	0,15...2
КП101Д		50	6	10	10	5	0,3...4
КП101Е		50	6	10	10	5	0,5...5
КП103Е	ДП, с *p-n* переходом и *p*-каналом	7	0,4...1,5	10	—	—	0,3...2,5
КП103Ж		12	0,5...2,2	10	—	—	0,35...3,8
КП103И		21	0,8...3	12	—	—	0,8...1,8
КП103К		38	1,4...4	10	—	—	1...5,5
КП103Л		66	2...6	12	—	—	1,8...6,6
КП103М		120	2,8...7	10	—	—	3...12
КП103ЕР1	ДП, с *p-n* переходом и *p*-каналом	7	0,4...1,5	10	—	—	0,3...2,5
КП103ЖР1		12	0,5...2,2	10	—	—	0,35...3,8
КП103ИР1		21	0,8...3	12	—	—	0,8...1,8
КП103КР1		38	1,4...4	10	—	—	1...5,5
КП103ЛР1		66	2...6	12	—	—	1,8...6,6
КП103МР1		120	2,8...7	10	—	—	3...12
КП201Е-1	ДП, с *p-n* переходом и *p*-каналом	60	⩽1,5	10; 15*	15	—	0,3...0,65
КП201Ж-1		60	⩽2,2	10; 15*	15	—	0,55...1,2
КП201И-1		60	⩽3	10; 15*	15	—	1...2,1
КП201К-1		60	⩽4	10; 15*	15	—	1,7...3
КП201Л-1		60	⩽6	10; 15*	15	—	3...6
КП202Д-1	ЭП с *p-n* переходом и *n*-каналом	60	0,4...2	15; 20*	0,5	—	⩽1,5
КП202Е-1		60	1...3	15; 20*	0,5	—	1,1...3
КП301Б	Планарные с изолированным затвором, с индуцированным *p*-каналом	200	2,7...5,4*	20	30	15	⩽0,5 мкА
КП301В		200	2,7...5,4*	20	30	15	⩽0,5 мкА
КП301Г		200	2,7...5,4*	20	30	15	⩽0,5 мкА
КП302А	Планарные с *p-n* переходом и *n*-каналом	300	1,0...5	20	12; 10	24	⩽24; 6,0*
КП302Б		300	2,5...7	20	12; 10	43	⩽43; 6,0*
КП302В		300	3,0...10	20	20; 12	—	⩽33; 6,0*
КП302Г		300	2,0...7	20	12; 10	—	⩽65; 6,0*

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у,P}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс f^{**}, МГц $\Delta T_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Габаритный чертеж корпуса
⩾0,15	⩽10; ⩽0,4**	—	⩽4 (1 кГц)	—	
⩾0,4	⩽10; ⩽0,4**	—	⩽7 (1 кГц)	—	
⩾0,3	⩽10; ⩽0,4**	—	⩽7 (1 кГц)	—	
0,4...2,4	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	3**	
0,5...2,8	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	3**	
0,8...2,6	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	3**	
1...3	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	3**	
1,8...3,8	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	3**	
1,3...4,4	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	3**	
0,4...2,4	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	—	
0,5...2,8	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	—	
0,8...2,6	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	—	
1...3	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	—	
1,8...3,8	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	—	
1,3...4,4	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	—	
⩾0,4	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	—	
⩾0,7	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	—	
⩾0,8	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	—	
⩾1,4	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	—	
⩾1,8	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	—	
⩾0,65	⩽6; ⩽2*	—	—	—	
⩾1	⩽6; ⩽2*	—	—	—	
1...2,6	⩽3,5; ⩽1,0*; ⩽3,5**	—	⩽9,5 (100 МГц)	100**	
2...3,0	⩽3,5; ⩽1,0*; ⩽3,5**	—	⩽9,5 (100 МГц)	100*	
0,5...1,6	⩽3,5; ⩽1,0*; ⩽3,5**	—	9,5 (100 МГц)	100**	
5...12	⩽20; ⩽8*	—	⩽3 (1 кГц)	⩽4; ⩽5*	
7...14	⩽20; ⩽8*	⩽150	—	⩽4; ⩽5*	
—	⩽20; ⩽8*	⩽100	—	⩽4; ⩽5*	
7...14	⩽20; ⩽8*	⩽150	—	⩽4; ⩽5*	

Тип прибора	Технология, структура	$P_{СИ\ max}$, $P^*_{СИ,\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С\ max}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП302АМ	Планарные с *p-n* переходом и *n*-каналом	300	1,0...5	20	12; 10	24	≤24; 6,0*
КП302БМ		300	2,5...7	20	12; 10	43	≤43; 6,0*
КП302ВМ		300	3,0...10	20	20; 12	—	≤33; 6,0*
КП302ГМ		300	2,0...7	20	12; 10	—	≤65; 6,0*
КП303А	ЭП, с *p-n* переходом и *n*-каналом	200	0,5...3	25; 30*	30	20	≤2,5; 5,0*
КП303Б		200	0,5...3	25; 30*	30	20	≤2,5; 5,0*
КП303В		200	1,0...4	25; 30*	30	20	≤5; 5,0*
КП303Г		200	≤8	25; 30*	30	20	≤12; 5,0*
КП303Д		200	≤8	25; 30*	30	20	≤9; 5,0*
КП303Е		200	≤8	25; 30*	30	20	≤20; 5,0*
КП303Ж		200	0,3...3	25; 30*	30	20	<3; 5,0*
КП303И		200	0,5...2	25; 30*	30	20	≤5; 5,0*
КП304А	ДП, с изолированным затвором и индуцированным *p*-каналом	200	≥5*	25; 30*	30	30 (60*)	≤0,2 мкА
КП305Д	ДП, с изолированным затвором и *n*-каналом	150	≥6	15; ±15*	±15	15	—
КП305Е		150	≥6	15; ±15*	±15	15	—
КП305Ж		150	≥6	15; ±15*	±15	15	—
КП305И		150	≥6	15; ±15*	±15	15	—
КП306А	ДП, с двумя изолированными затворами и *n*-каналом	150	≤4	20	20	20	—
КП306Б		150	≤4	20	20	20	—
КП306В		150	≤6	20	20	20	—
КП307А	ЭП, с *p-n* переходом и *n*-каналом	250	0,5...3	25; 27*	27	25	≤9
КП307Б		250	1,0...5	25; 27*	27	25	≤15
КП307В		250	1...5	25; 27*	27	25	≤15
КП307Г		250	1,5...6	25; 27*	27	25	24
КП307Д		250	1,5...6	25; 27*	27	25	8...24
КП307Е		250	≤2,5	25; 27*	27	25	≤5
КП307Ж		250	≤7	25; 27*	27	25	≤25
КП308А-1	ЭП, с *p-n* переходом и *n*-каналом	60	0,2...1,2	25; 30*	30	20	≤1
КП308Б-1		60	0,3...1,8	25; 30*	30	20	≤1,6
КП308В-1		60	0,4...2,4	25; 30*	30	20	≤3
КП308Г-1		60	1...6	25	30	20	—
КП308Д-1		60	1...3	25	30	20	—
КП310А	ДП, с изолированным затвором и *n*-каналом	80	—	8; 10*	10	20	≤5; ≤0,1*
КП310Б		80	—	8; 10*	10	20	≤5; ≤0,1*

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{***}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у,P}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U^{*}_ш$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс f^{**}, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Габаритный чертеж корпуса
5...12	≤20; ≤8*	—	≤3 (1 кГц)	≤4; ≤5*	
7...14	≤20; ≤8*	≤150	—	≤4; ≤5*	
—	≤20; ≤8*	≤100	—	≤4; ≤5*	
7...14	≤20; ≤8*	≤150	—	≤4; ≤5*	
1,0...4	≤6; ≤2,0*	—	≤30** (20 Гц)	—	
1,0...4	≤6; ≤2,0*	—	≤20** (1 кГц)	—	
2,0...5	≤6; ≤2*	—	≤20** (1 кГц)	—	
3,0...7	≤6; ≤2,0*	—	≤$(6\cdot10^{-17})$***	—	
≥2,6	≤6; ≤2,0*	—	≤4 (100 МГц)	—	
≥4	≤6; ≤2,0*	—	≤4 (100 МГц)	—	
1,0...4	≤6; ≤2,0*	—	≤100** (1 кГц)	—	
2,0...6	≤6; ≤2,0*	—	≤100** (1 кГц)	—	
≥4	≤9; ≤2*; ≤6**	≤100	—	—	
5,2...10,5	≤5; ≤0,8*	>13* (250 МГц)	≤7,5 (250 МГц)	—	
4...8	≤5; ≤0,8*	—	—	—	
5,2...10,5	≤5; ≤0,8*	≥13* (250 МГц)	≤7,5 (250 МГц)	—	
4...10,5	≤5; ≤0,8*	—	—	—	
4...3 ($U_{З_2И}$=10 В)	≤5; ≤0,07*	—	≤6 (200 МГц, $U_{З_2И}$=10 В)	800***	
4...8 ($U_{З_2И}$=10 В)	≤5; ≤0,07*	—	≤6 (200 МГц)	800**	
4...8 ($U_{З_2И}$=10 В)	≤5; ≤0,07*	—	≤6 (200 МГц)	800**	
4...9,0	≤5; ≤1,5*	—	≤20** (1 кГц)	—	
5...10	≤5; ≤1,5*	—	≤2,5** (100 кГц)	—	
5...10	≤5; ≤1,5*	—	≤2,5** (100 кГц)	—	
6...12	≤5; ≤1,5*	—	≤6 (400 МГц)	—	
6...12	≤5; ≤1,5*	—	≤6 (400 МГц)	—	
3...8	≤5; ≤1,5*	—	≤20** (1 кГц)	—	
4...14	≤5; ≤1,5*	—	≤$(0,4\cdot10^{-16})$***	—	
1...4	≤6; ≤2**	—	≤20** (1 ц)	—	
1...4	≤6; ≤2**	—	≤20** (1 кГц)	—	
2...6,5	≤6; ≤2**	—	≤20** (1 кГц)	—	
—	≤6; ≤2**	—	—	≤20; ≤20*	
—	≤6; ≤2**	—	—	≤20; ≤20*	
3...6	≤2,5; ≤0,5*	—	≤6 (1 ГГц)	—	
3...6	≤2,5; ≤0,5*	—	≤7 (1 ГГц)	—	

Тип прибора	Технология, структура	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^*_{СИ,\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_{С\,max}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
КП312А	ЭП, с *p-n* переходом и *n*-каналом	100	2...8	20; 25*	25	25	⩽25
КП312Б		100	0,8...6	20; 25*	25	25	⩽7
КП313А	ДП, с изолированным затвором и *n*-каналом	75	⩾6	15; 15*	10	15	—
КП313Б		75	⩾6	15; 15*	10	15	—
КП313В		75	⩾6	15; 15*	10	15	—
КП314А	ЭП, с *p-n* переходом и *n*-каналом	200	—	25	30	20	2,5 20
КП322А	ЭП, с двумя затворами, *p-n* переходом и *n*-каналом	200	2,2...12	20	20	—	⩽42
КП323А-2	ЭП, с *p-n* переходом и *n*-каналом	100	0,74...6	20	25	12	12
КП323Б-2		100	0,74...6	20	25	12	12
КП327А	П, с двумя изолированными затворами и *n*-каналом	200	⩽2,7	18	6	—	⩽10
КП327Б		200	⩽2,7	18	6	—	⩽10
КП329А	ЭП, с *p-n* переходом и *n*-каналом	250	⩾1,5	50	45	—	⩾1
КП329Б		250	⩾1,5	40	35	—	⩾1
КП341А	ЭП, с *p-n* переходом и *n*-каналом	150 (60 °С)	⩽3	15; 15*	10	—	⩽20
КП341Б		150 (60 °С)	⩽3	15; 15*	10	—	⩽30

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у,P}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс f^{**}, МГц $U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Габаритный чертеж корпуса
4...5,8	⩽4; ⩽1*	⩾2* (400 МГц)	⩽4 (400 МГц)	—	
2...5	⩽4; ⩽1*	⩾2* (400 МГц)	⩽6 (400 МГц)	—	
4,5...10,5	⩽7; ⩽0,9*	⩾10* (250 МГц)	⩽7,5 (250 МГц)	300**	
4,5...10,5	⩽7; ⩽0,9*	⩾10* (250 МГц)	⩽7,5 (250 МГц)	300***	
4,5...10,5	⩽7; ⩽0,9*	⩾10* (250 МГц)	⩽7,5 (250 МГц)	300**	
4	⩽6; ⩽2*	—	⩽(1,32·10^{-17})***	⩾100**	
3,2...6,3	⩽6; ⩽0,2*	—	⩽6 (250 МГц)	—	
4...5,8	⩽4; ⩽1,2*	—	⩽5**	400**	
4...5,8	⩽4; ⩽1,2*	—	⩽5**	400**	
⩾11	⩽2,5	⩾12* (0,8 ГГц)	⩽4,5	—	
⩾11	⩽2,5	⩾18* (250 МГц)	⩽3	—	
⩾3	⩽6	⩽1500	⩽20**	200**	
⩾1	⩽6	⩽1500	⩽20**	200**	
15...30	⩽5; 1*; 1,6**	—	2,8 (400 МГц) ⩽1,2** (100 кГц)	—	
18...32	⩽5; 1*; 1,6**	—	1,8 (200 МГц) ⩽1,2** (100 кГц)	—	

Тип прибора	Технология, структура	$P_{СИ\ max}$, мВт, $P^*_{СИ.т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С\ max}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП346А9	ЭП, с двумя изолированными затворами и *n*-каналом	200	—	14; 16*	10	30	2...20
КП346Б9		200	—	14; 16*	10	30	⩽20
КП346В9		200	—	14; 16*	10	30	2...20
КП350А	ДП, с двумя изолированными затворами и встроенным *n*-каналом	200	0,07 6	15	15	30	⩽3,5
КП350Б		200	0,07 6	15	15	30	⩽3,5
КП350В		200	0,07 6	15	15	30	⩽3,5
КП601А	П, с *p-n* переходом и *n*-каналом	500; 2* Вт	4...9	20	15	—	⩽400
КП601Б		500; 2* Вт	6...12	20	15	—	⩽400
КП801А	ЭП, с *p-n* переходом *n*-каналом	60* Вт	—30	75; 110*	—35	5 А	—
КП801Б		60* Вт	—30	75; 90*	—35	5 А	—
КП801В		100* Вт	—30	110; 150*	—40	8 А	—
КП801Г		100* Вт	—30	140; 180*	—40	8 А	—
КП802А	ЭП, с *p-n* переходом *n*-каналом	40* Вт	—25	500; 535*	35	2,5 А	—
КП802Б		40* Вт	—28	450; 480*	30	2,5 А	—
КП901А	Планарные с изолированным затвором и индуцированным *n*-каналом	20* Вт	—	70; 85*	30	4 А	200; 50*
КП901Б		20* Вт	—	70; 85*	30	4 А	200; 50*
КП902А	Планарные с изолированным затвором и *n*-каналом	3,5* Вт	—	50	30	200	10; 0,5*
КП902Б		3,5* Вт	—	50	30	200	10; 0,5*
КП902В		3,5* Вт	—	50	30	200	10; 0,5*

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^*_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^*_{у,р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U^*_ш$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^*_{выкл}$, нс f^{**}, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$ мкВ/°С	Габаритный чертеж корпуса
⩾12	⩽2,6; ⩽0,035* ⩽1,3**	⩾15* (0,8 ГГц)	⩽3,5 (0,8 ГГц)	—	
⩾10	⩽3; ⩽0,035* ⩽1,5**	⩾13 (0,8 ГГц)	⩽4,5 (100 МГц)	—	
⩾12	⩽2,6; ⩽0,035* ⩽1,3**	⩾21 (200 МГц)	⩽1,9 (МГц)	—	
⩾6	⩽6, ⩽0,07* ⩽6**	—	⩽6 (400 МГц)	—	
⩾6	⩽6; ⩽0,07* ⩽6**	—	⩽6 (100 МГц)	—	
⩾7	⩽6; ⩽0,07** ⩽6**	—	<8 (400 МГц)	—	
40...87	⩽6*	—	⩽6 (400 МГц)	—	
40...87	⩽6*	—	⩽6 (400 МГц)	—	
⩾600	—	⩽2,2	—	—	
⩾450	—	⩽4,4	—	—	
⩾800	—	—	—	—	
⩾600	—	—	—	—	
⩾800	—	⩽3	—	⩽30*	
⩾800	—	⩽3	—	⩽30*	
50...160	100	⩾7* (100 МГц)	—	—	
	10*	⩾10** (100 МГц)	—	—	
60...170	10*	⩾6,7** (100 МГц)	—	—	
10...25	11; 0,6*; 11**	⩾6,6* (250 МГц)	6 (250 МГц)	—	
10...25	11; 0,6*; 11**	⩾0,8** (60 МГц)	—	—	
10...25	11; 0,8*; 11**	⩾0,8** (60 МГц)	8,0 (250 МГц)	—	

Тип прибора	Технология, структура	$P_{СИ\,max}$, мВт; $P^*_{СИ,\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_{С\,max}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
КП903А	ЭП, с *p-n* переходом и *n*-каналом	6* Вт	5...12	20; 20*	15	700	700
КП903Б		6* Вт	1...6,5	20; 20*	15	700	480
КП903В		6* Вт	1...10	20; 20*	15	700	600
КП904А	Планарные, с изолированным затвором и индуцированным *n*-каналом	75* Вт	—	70; 90*	30	10 А	350; 200*
КП904Б		75* Вт	—	70; 90*	30	5 А	350; 200*
КП905А	Планарные с изолированным затвором и *n*-каналом	4* Вт	—	60; 70*	±30	350	20; 1*
КП905Б		4* Вт	—	60; 70*	±30	350	20; 1*
КП905В		4* Вт	—	60; 70*	±30	350	20; 1*
КП907А	Планарные, с изолированным затвором и *n*-каналом	11,5* Вт	—	60; 70*	±30	2,7 А	100
КП907Б		11,5* Вт	—	60; 70*	±30	1,7 А	100
КП907В		11,5* Вт	—	60; 70*	±30	1,3 А	100
КП921А	ЭП, с индуцированным *n*-каналом	15* Вт	—	45	40 (имп)	10 А	⩽2,5
КП928А	ЭП, с изолированным затвором и *n*-каналом	250* Вт	—	50; 60*	25	21 А	150
КП928Б		250* Вт	—	50; 60*	25	16 А	150
КПС104А	ЭП, сдвоенные с *p-n* переходом и *n*-каналом	45	0,2...1	25; 30*	30	—	⩽0,8
КПС104Б		45	0,2...1	25; 30*	30	—	⩽0,8
КПС104В		45	0,4...2	25; 30*	30	—	⩽1,5
КПС104Г		45	0,4...2	25; 30*	30	—	⩽3
КПС104Д		45	0,8...3	25; 30*	30	—	⩽3
КПС104Е		45	0,8...3	25; 30*	30	—	⩽3

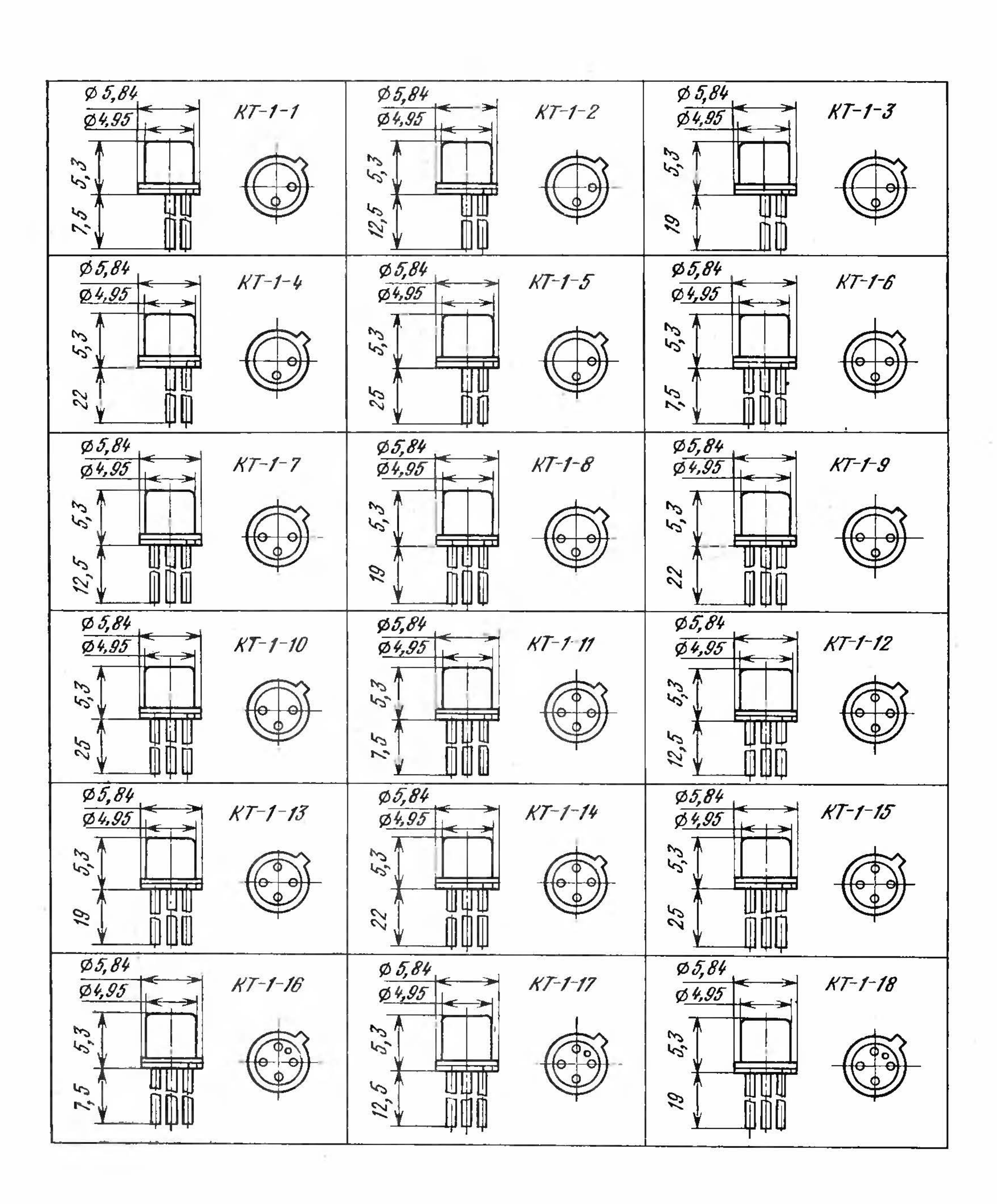
S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом; $K^{*}_{у}$, P, дБ; $P^{**}_{вых}$, Вт; $U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ; $U^{*}_{ш}$, мкВ; $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$; Q***, Кл	$t_{вкл}$, нс; $t^{*}_{выкл}$, нс; f**, МГц; $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T$***, мкВ/°С	Габаритный чертеж корпуса
85...140	18	⩾0,09** (30 МГц) 10	⩽5** (100 кГц)	—	
50...130	18	⩾0,09* (30 МГц) 10	⩽5** (100 кГц)	—	
60...140	18	⩾0,09** (30 МГц) 10	⩽5** (100 кГц)	—	
250...510	300 (30 В)	50** (60 МГц)	—	—	
250...510	300 (30 В)	30** (60 МГц)	—	—	
18	7; 0,6*; 4**	⩾1** ⩾8* (1 ГГц)	—	—	
18	11; 0,6; 4**	⩾6* (1 ГГц)	6,5 (1000 МГц)	—	
18	13; 0,8*; 6**	⩾4* (1 ГГц)	—	—	
110...200	⩽3*	⩾4** (1 ГГц)	—	⩽2	
100...200	⩽3*	⩾3** (1 ГГц)	—	⩽2	
80...110	⩽3*	⩾5** (0,4 ГГц)	—		
800...1500	—	⩽0,03	—	—	
1800	530 (10 В) 50*	⩽0,4 ⩾220** (0,4 ГГц)	—	—	
1800	530 (10 В) 50*	⩽0,4 ⩾220** (0,4 ГГц)	—	—	
⩾0,35	⩽4,5; ⩽1,5*	⩽30	⩽0,4*	50***	
⩾0,35	⩽4,5; ⩽1,5*	⩽30***	⩽1*	150***	
⩾0,65	⩽4,5; ⩽1,5*	⩽50***	⩽5*	150***	
⩾1	⩽4,5; ⩽1,5*	⩽50***	⩽1*	100***	
⩾1	⩽4,5; ⩽1,5*	—	⩽5*	150***	
⩾0,65	⩽4,5; ⩽1,5*	⩽20***	—	20***	

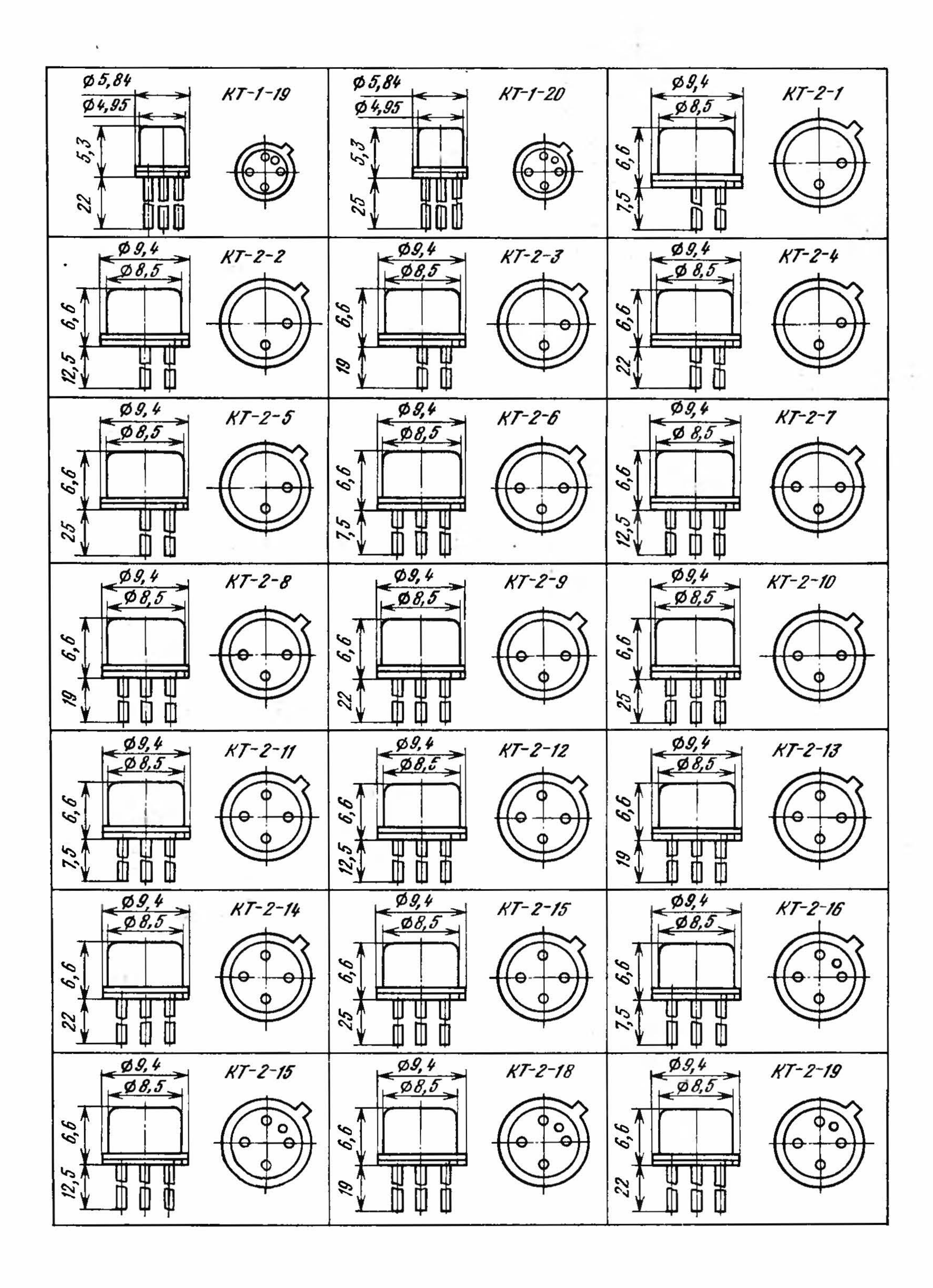
Тип прибора	Технология, структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С\ max}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КПС202А-2	ЭП, сдвоенные с *p-n* переходом и *n*-каналом	60	0,4...2	15; 20*	0,5	—	⩽1,5
КПС202Б-2		60	0,4...2	15; 20*	0,5	—	⩽1,5
КПС202В-2		60	0,4...2	15; 20*	0,5	—	⩽1,5
КПС202Г-2		60	1...3	15; 20*	0,5	—	⩽3
КПС203А-1	ПД, сдвоенные с *p-n* переходом и *n*-каналом	30 (55 °С)	0,2...2	15; 20*	0,5	—	0,25...1,5
КПС203Б-1		30 (55 °С)	0,2...2	15; 20*	0,5	—	0,25...1,5
КПС203В-1		30 (55 °С)	0,4...2	15; 20*	0,5	—	0,35...1,5
КПС203Г-1		30 (55 °С)	1...3	15; 20*	0,5	—	1,1...3
КПС315А	ЭП, сдвоенные с *p-n* переходом и *n*-каналом	300	1...5	25; 30*	30	—	1...20
КПС315Б		300	0,4...2	25; 30*	30	—	1...20
КПС316Д-1	ЭП, сдвоенные с *p-n* переходом и *n*-каналом	60	0,3...2,2	25; 25*	25	—	—
КПС316Е-1		60	0,3...2,2	25; 25*	25	—	—
КПС316Ж-1		60	1,4...4	25; 25*	25	—	—
КПС316И-1		60	2,5...6	25; 25*	25	—	—

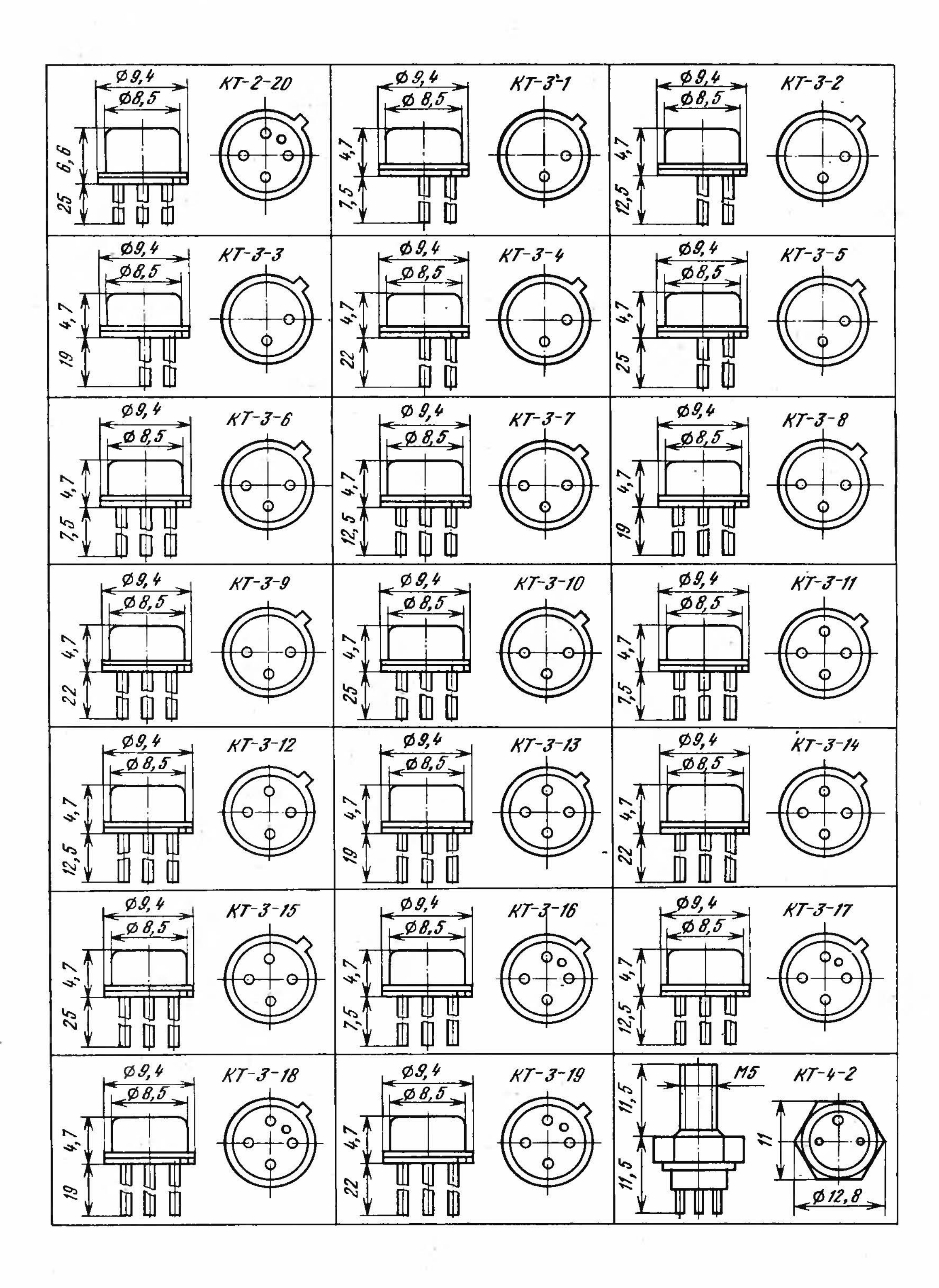
S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у}$, P, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс f^{**}, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$ мкВ/°С	Габаритный чертеж корпуса
⩾0,5 ⩾0,5 ⩾0,65 ⩾1	⩽6; ⩽2* ⩽6; ⩽2* ⩽6; ⩽2* ⩽6; ⩽2*	⩽10*** ⩽10*** ⩽30*** ⩽30***	— — — —	— — — —	
⩾0,5 ⩾0,5 ⩾0,65 ⩾1	⩽6 (10 В); ⩽2* ⩽6 (10 В); ⩽2* ⩽6 (10 В); ⩽2* ⩽6 (10 В); ⩽2*	⩽10*** ⩽10*** ⩽30*** ⩽30***	⩽2,5* (10 Гц) ⩽12* (10 Гц) — —	⩽40*** ⩽40*** ⩽150*** ⩽150***	
⩾2,8 ⩾1...5	⩽8 (10 В) ⩽8 (10 В)	⩽30*** ⩽30***	— —	60** ⩽30*** 60** ⩽30***	
⩾0,5 ⩾0,5 ⩾0,5 ⩾0,5	⩽6 (10 В); ⩽2* ⩽6 (10 В); ⩽2* ⩽6 (10 В); ⩽2* ⩽6 (10 В); ⩽2*	⩽50*** ⩽50*** ⩽50*** ⩽50***	— — — —	⩽40*** ⩽40*** ⩽40*** ⩽40***	

3.8. Стандартизованные корпуса отечественных транзисторов

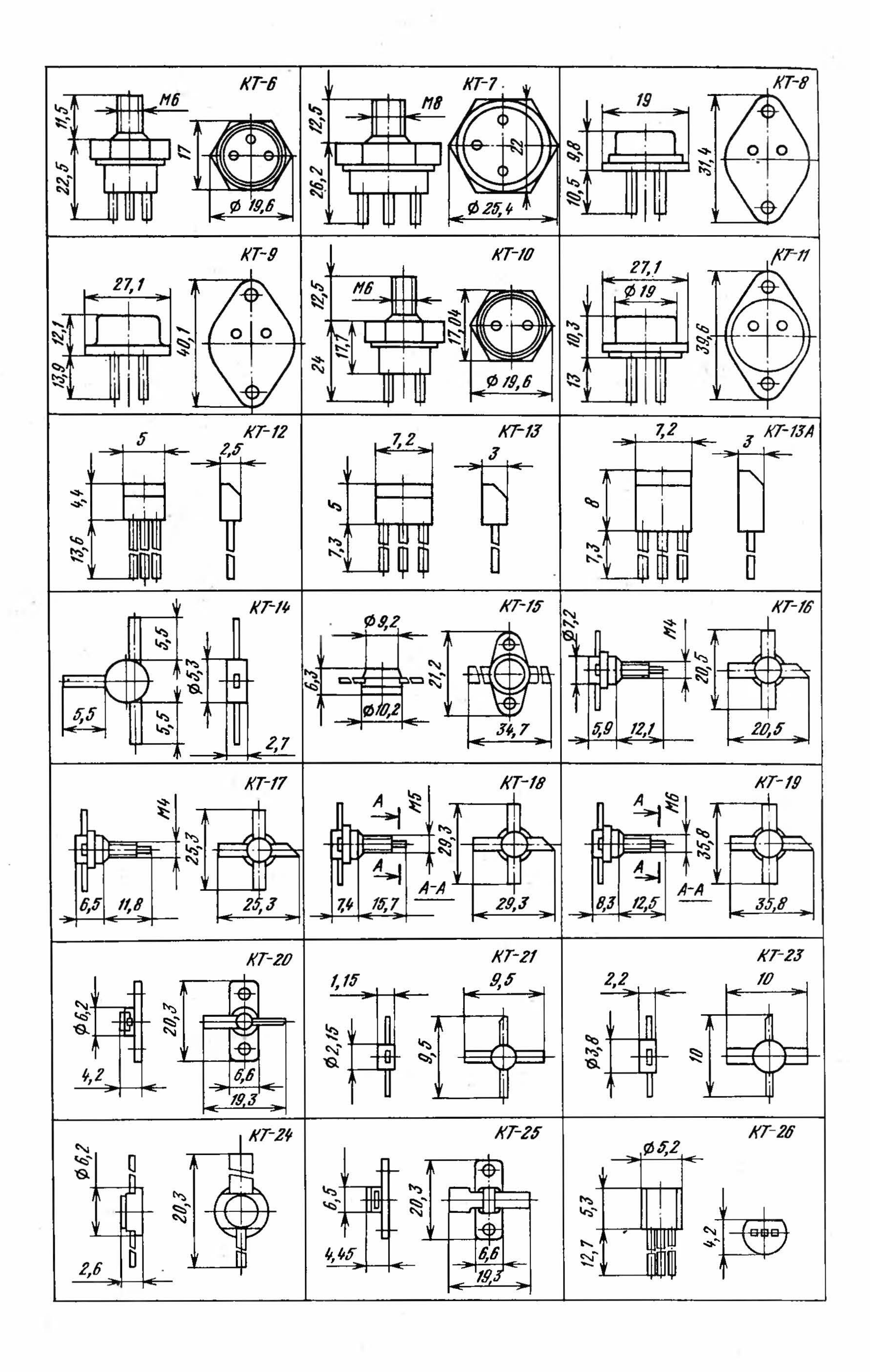
Ниже приводятся габаритные чертежи корпусов транзисторов, выпускаемых отечественной промышленностью, соответствующие ГОСТ 18472—88.

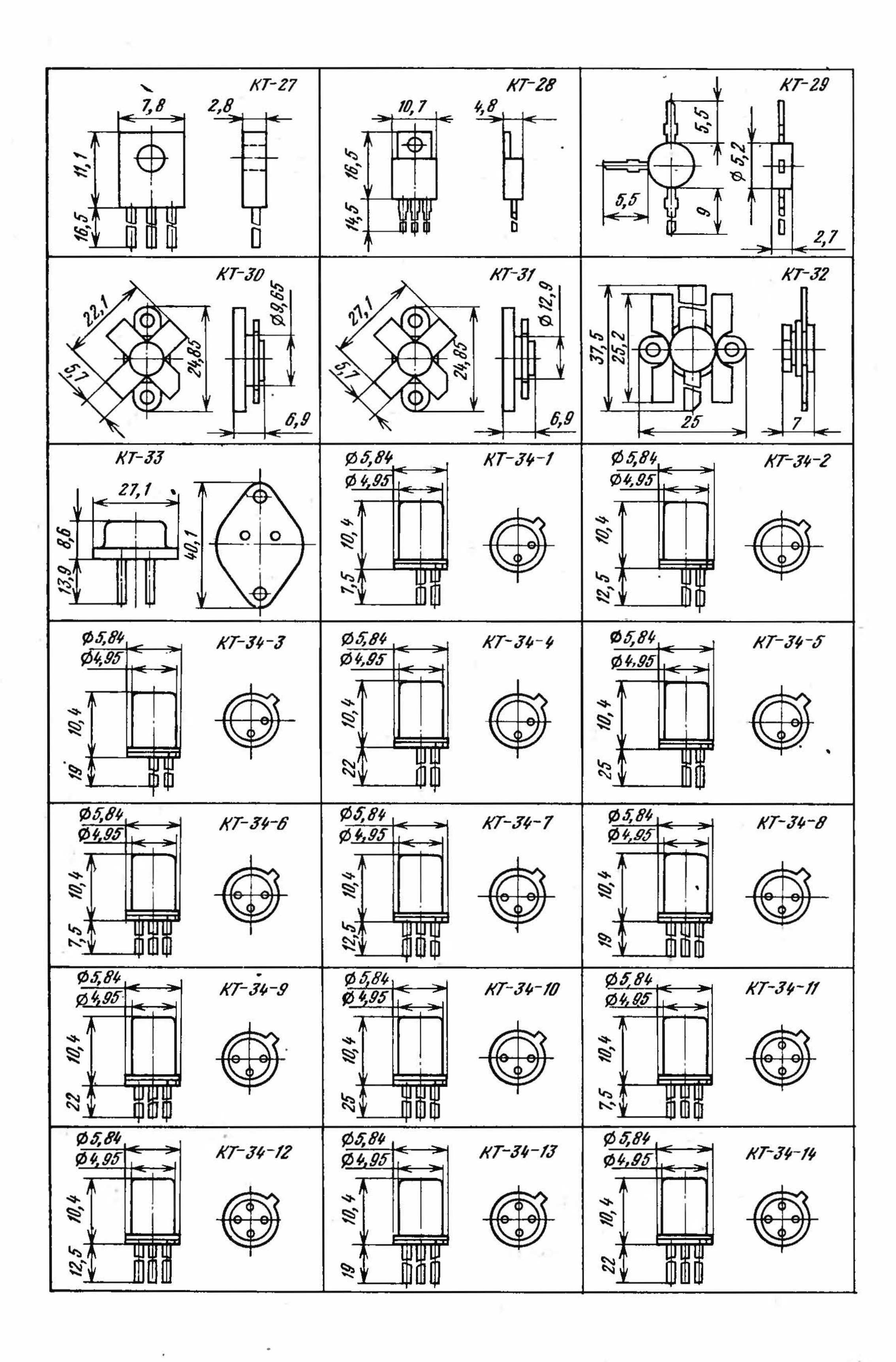



КТ-1-19
Ø5,84
Ø4,95
5,3
22
КТ-1-20
Ø5,84
Ø4,95
5,3
25
КТ-2-1
Ø9,4
Ø8,5
6,6
7,5
КТ-2-2
Ø9,4
Ø8,5
6,6
12,5
КТ-2-3
Ø9,4
Ø8,5
6,6
19
КТ-2-4
Ø9,4
Ø8,5
6,6
22
КТ-2-5
Ø9,4
Ø8,5
6,6
25
КТ-2-6
Ø9,4
Ø8,5
6,6
7,5
КТ-2-7
Ø9,4
Ø8,5
6,6
12,5
КТ-2-8
Ø9,4
Ø8,5
6,6
19
КТ-2-9
Ø9,4
Ø8,5
6,6
22
КТ-2-10
Ø9,4
Ø8,5
6,6
25
КТ-2-11
Ø9,4
Ø8,5
6,6
7,5
КТ-2-12
Ø9,4
Ø8,5
6,6
12,5
КТ-2-13
Ø9,4
Ø8,5
6,6
19
КТ-2-14
Ø9,4
Ø8,5
6,6
22
КТ-2-15
Ø9,4
Ø8,5
6,6
25
КТ-2-16
Ø9,4
Ø8,5
6,6
7,5
КТ-2-15
Ø9,4
Ø8,5
6,6
12,5
КТ-2-18
Ø9,4
Ø8,5
6,6
19
КТ-2-19
Ø9,4
Ø8,5
6,6
22

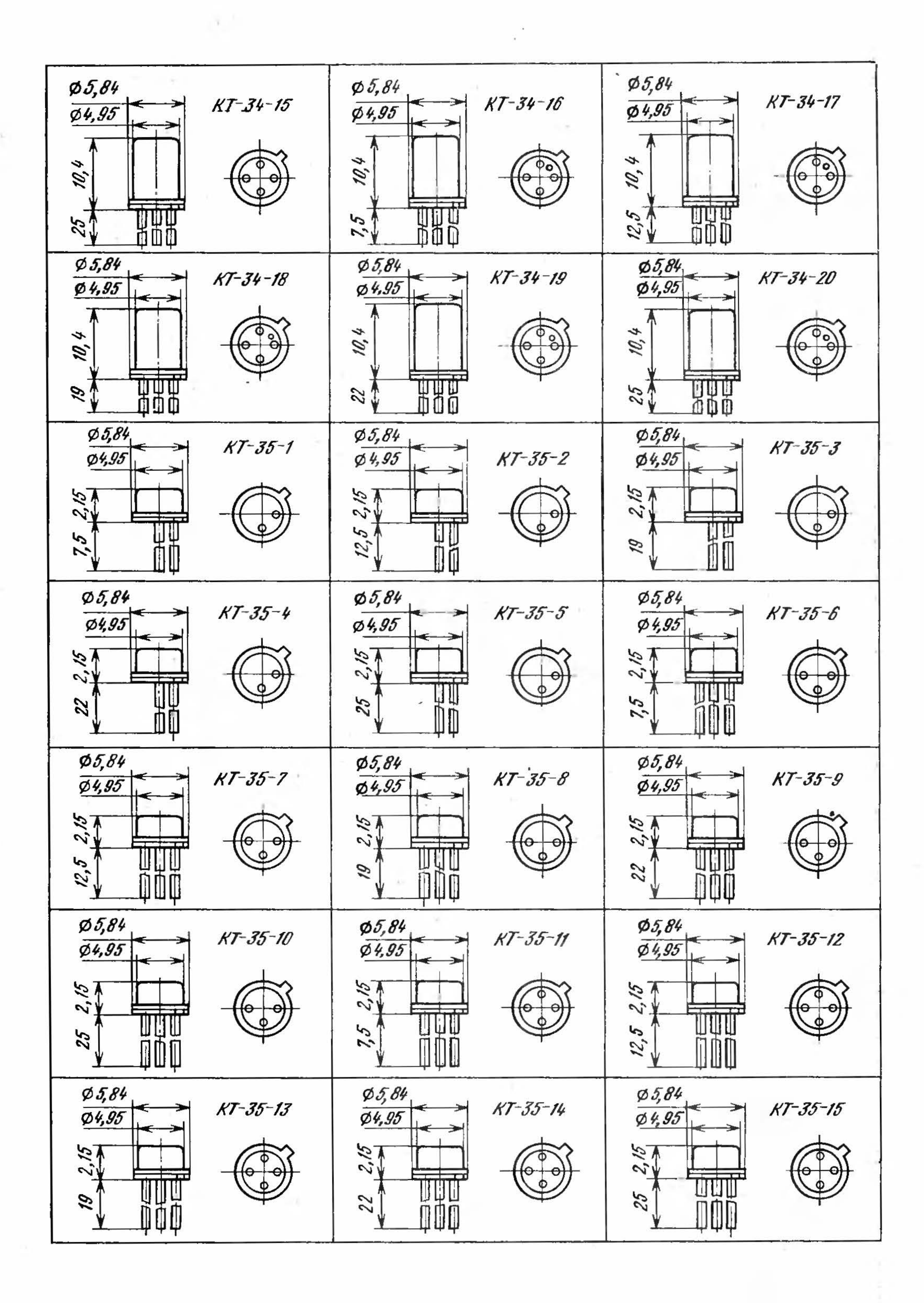


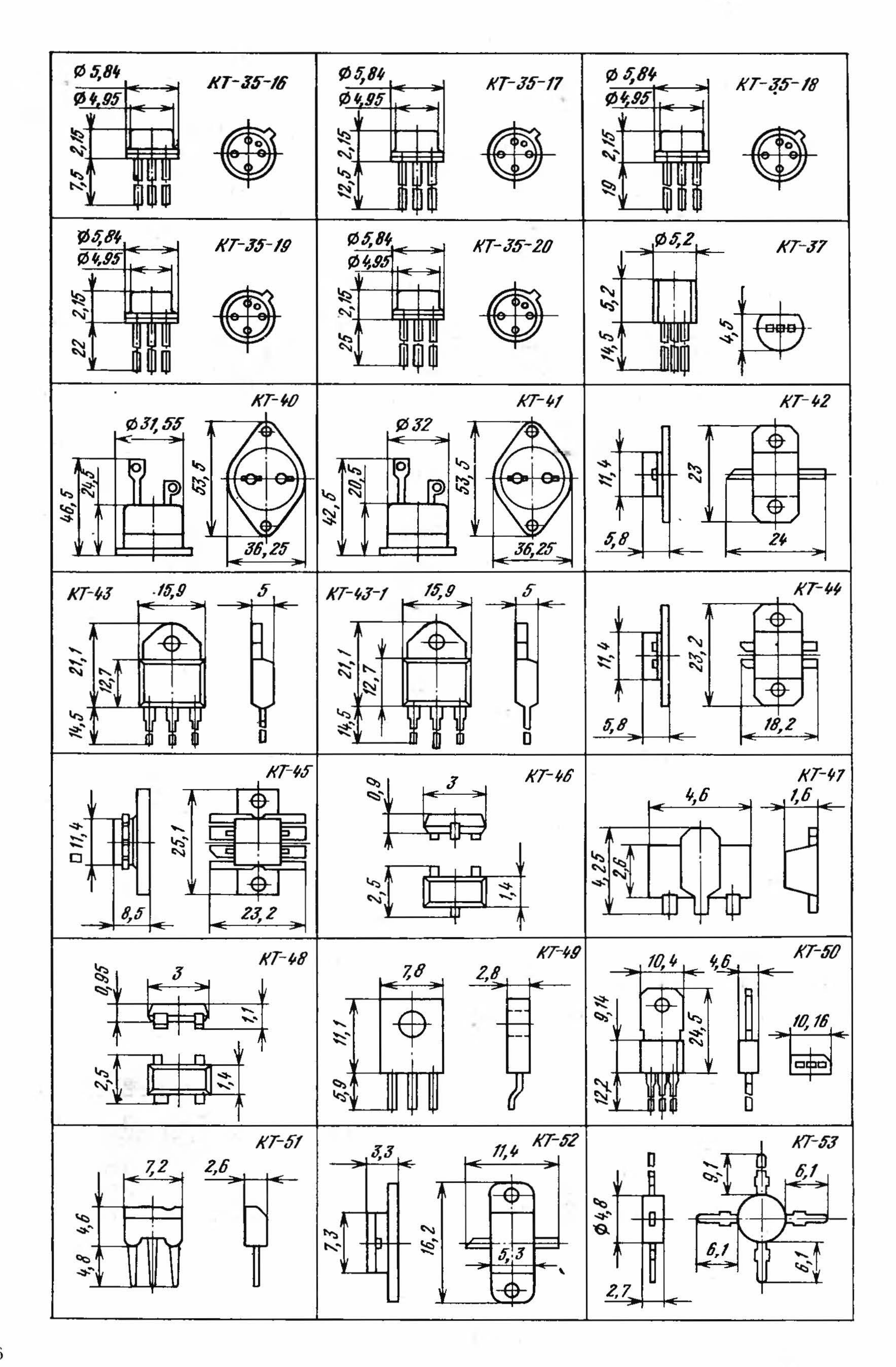
КТ-2-20
КТ-3-1
КТ-3-2
КТ-3-3
КТ-3-4
КТ-3-5
КТ-3-6
КТ-3-7
КТ-3-8
КТ-3-9
КТ-3-10
КТ-3-11
КТ-3-12
КТ-3-13
КТ-3-14
КТ-3-15
КТ-3-16
КТ-3-17
КТ-3-18
КТ-3-19
КТ-4-2
Ø9,4
Ø8,5
M5
Ø12,8

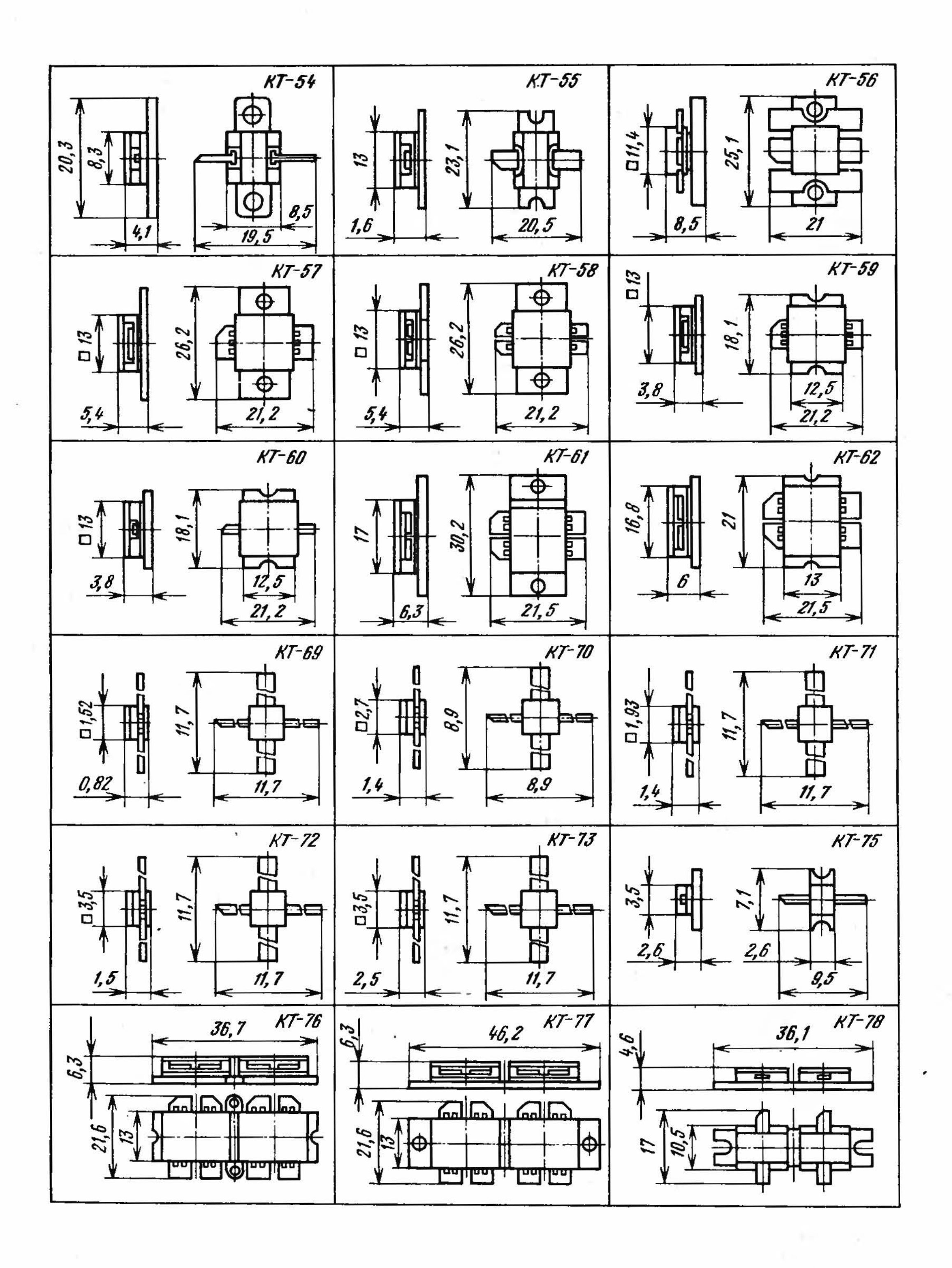

КТ-6
КТ-7
КТ-8
КТ-9
КТ-10
КТ-11
КТ-12
КТ-13
КТ-13А
КТ-14
КТ-15
КТ-16
КТ-17
КТ-18
КТ-19
КТ-20
КТ-21
КТ-23
КТ-24
КТ-25
КТ-26



КТ-27
7,8
2,8
11,1
16,5
КТ-28
10,7
4,8
16,5
14,5
КТ-29
5,5
ϕ 5,2
5,5
9
2,7
КТ-30
22,1
ϕ9,65
24,85
5,7
6,9
КТ-31
27,1
ϕ 12,9
24,85
5,7
6,9
КТ-32
37,5
25,2
25
7
КТ-33
27,1
8,6
13,9
40,1
КТ-34-1
ϕ 5,84
ϕ 4,95
10,4
7,5
КТ-34-2
ϕ 5,84
ϕ 4,95
10,4
12,5
КТ-34-3
ϕ 5,84
ϕ 4,95
10,4
19
КТ-34-4
ϕ 5,84
ϕ 4,95
10,4
22
КТ-34-5
ϕ 5,84
ϕ 4,95
10,4
25
КТ-34-6
ϕ 5,84
ϕ 4,95
10,4
7,5
КТ-34-7
ϕ 5,84
ϕ 4,95
10,4
12,5
КТ-34-8
ϕ 5,84
ϕ 4,95
10,4
19
КТ-34-9
ϕ 5,84
ϕ 4,95
10,4
22
КТ-34-10
ϕ 5,84
ϕ 4,95
10,4
25
КТ-34-11
ϕ 5,84
ϕ 4,95
10,4
7,5
КТ-34-12
ϕ 5,84
ϕ 4,95
10,4
12,5
КТ-34-13
ϕ 5,84
ϕ 4,95
10,4
19
КТ-34-14
ϕ 5,84
ϕ 4,95
10,4
22


Ø5,84
Ø4,95
10,4
25
КТ-34-15
Ø5,84
Ø4,95
10,4
7,5
КТ-34-16
Ø5,84
Ø4,95
10,4
12,5
КТ-34-17
Ø5,84
Ø4,95
10,4
19
КТ-34-18
Ø5,84
Ø4,95
10,4
22
КТ-34-19
Ø5,84
Ø4,95
10,4
25
КТ-34-20
Ø5,84
Ø4,95
2,15
7,5
КТ-35-1
Ø5,84
Ø4,95
2,15
12,5
КТ-35-2
Ø5,84
Ø4,95
2,15
19
КТ-35-3
Ø5,84
Ø4,95
2,15
22
КТ-35-4
Ø5,84
Ø4,95
2,15
25
КТ-35-5
Ø5,84
Ø4,95
2,15
7,5
КТ-35-6
Ø5,84
Ø4,95
2,15
12,5
КТ-35-7
Ø5,84
Ø4,95
2,15
19
КТ-35-8
Ø5,84
Ø4,95
2,15
22
КТ-35-9
Ø5,84
Ø4,95
2,15
25
КТ-35-10
Ø5,84
Ø4,95
2,15
7,5
КТ-35-11
Ø5,84
Ø4,95
2,15
12,5
КТ-35-12
Ø5,84
Ø4,95
2,15
19
КТ-35-13
Ø5,84
Ø4,95
2,15
22
КТ-35-14
Ø5,84
Ø4,95
2,15
25
КТ-35-15


КТ-35-16
Ø 5,84
Ø 4,95
2,15
7,5
КТ-35-17
Ø 5,84
Ø 4,95
2,15
12,5
КТ-35-18
Ø 5,84
Ø 4,95
2,15
19
КТ-35-19
Ø 5,84
Ø 4,95
2,15
22
КТ-35-20
Ø 5,84
Ø 4,95
2,15
25
КТ-37
Ø 5,2
5,2
14,5
4,5
КТ-40
Ø 31,55
46,5
24,5
53,5
36,25
КТ-41
Ø 32
42,6
20,5
53,5
36,25
КТ-42
11,4
23
5,8
24
КТ-43
15,9
5
21,1
12,7
14,5
КТ-43-1
15,9
5
21,1
12,7
14,5
КТ-44
11,4
23,2
5,8
18,2
КТ-45
□ 11,4
25,1
8,5
23,2
КТ-46
0,9
3
2,5
1,4
КТ-47
4,6
1,6
4,25
2,6
КТ-48
0,95
3
1,1
2,5
1,4
КТ-49
7,8
2,8
11,1
5,9
КТ-50
10,4
4,6
9,14
24,5
10,16
12,2
КТ-51
7,2
2,6
4,6
4,8
КТ-52
3,3
11,4
7,3
16,2
5,3
КТ-53
9,1
6,1
Ø 4,8
6,1
6,1
2,7



КТ-54
20,3
8,3
4,1
19,5
8,5
КТ-55
13
23,1
1,6
20,5
КТ-56
□11,4
25,1
8,5
21
КТ-57
□13
26,2
5,4
21,2
КТ-58
□13
26,2
5,4
21,2
КТ-59
□13
18,1
3,8
12,5
21,2
КТ-60
□13
18,1
3,8
12,5
21,2
КТ-61
17
30,2
6,3
21,5
КТ-62
16,8
21
6
13
21,5
КТ-69
□1,52
11,7
0,82
11,7
КТ-70
□2,7
8,9
1,4
8,9
КТ-71
□1,93
11,7
1,4
11,7
КТ-72
□3,5
11,7
1,5
11,7
КТ-73
□3,5
11,7
2,5
11,7
КТ-75
3,5
7,1
2,6
2,6
9,5
КТ-76
36,7
6,3
21,6
13
КТ-77
6,3
46,2
21,6
13
КТ-78
4,6
36,1
17
10,5

ЗАРУБЕЖНЫЕ ДИОДЫ И ИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ

Тип диода	Приближенный отечественный аналог
A15A	КД202В
A15F	КД202А
A100	Д229Ж
A121-1T	КД208А
A132-1T	КД208А
A168-1T	КД208А
A2A4	КД204В
A2C4	КД205Г
A2D1	Д229К
A2D5	КД205В
A2D9	КД205В
A2E1	Д229Л
A2E3	Д229Л
A2E4	КД205Б
A2E5	Д229Л
A2E9	Д229Л
A2F4	КД205А
A3C1	КД205Л
A3C3	КД205Л
A3C5	КД205Л
A3C9	КД205Л
A3D1	Д229К
A3D3	Д229К
A3D5	Д229К
A3D9	Д229К
A3E1	Д246Б
A3E5	Д246Б
A3E9	Д246Б
A14B	КЦ412В
A114A	КЦ412Б
A115	КЦ410В
A300	Д229К
AA112	Д10
AA112P	Д10
AA113Г	Д101
AA114E	КД411В
AA130 (2)	Д10А
AA137	Д9В
AAУ32	Д311
AD150	Д223Б
AE3A	КЦ410А
AE150	Д223Б
AAZ15	Д312А
AM12	Д229В
AM42	Д229Е
AM030	Д229В
AM410	Д229К
AS3A	КЦ410А
AS3C	КЦ409Д
AS3C	КЦ409Е
AZ6,8	КС168В
B2D1	Д229К
B2D5	Д229К
B2D9	Д229К
B2E1	Д229Л
B2E5	Д229Л
B3E9	Д229Л
B2B5	Д229Ж
B3B9	Д229Ж
B3C1	КД205Л
B3E1	Д246Б
B3E5	Д246Б
B3E9	Д246Б
B5C1	Д302
B5C5	Д302
B5C9	Д302
B80C300	КД204Б
B250C300	КД205И
B587-85	КД105Д
B587-70	КД105Г
BA128	КД103А
BA145	МД226А
BA147/220	Д207
BA147/300	Д208
BA179	Д102
BA180	ГД511 (А—В), КД922В
BA5H5	КД411 (А, АМ)
BAS70	ГД113А
BAW14	Д226В
BAW14TF24	Д226В
BAW56GT	КДС627А, КДС111А
BAW56G	КДС523 (А—Г), КДС523 (АМ—ГМ)
BAW62	КД521А
BAW63A	КД521Г
BAW101	КДС627А, КДС628А, КДС111 (А—В)
BAX53	КД906 (А—В)
BAX54	КД906 (А—В)
BAX61	КДС526Б, КД914В
BAX63	КДС526Б
BAX63A	КД521Г
BAX80	КД509А
BAX91C/TE102	КД521А
BAX95/TF600	КД521А
BAY21	Д226В
BAY38	КД509А
BAY45	КД407А, КД409А
BAY46	КД109Б
BAY63	КД509А
BAY74	КД509А
BAY89	КД105А
BB104	КВС111 (А, Б)
BB109	КВ109 (А—Г)
BB109G	КВ121 (А, Б)
BB113	КВС120 (А, В), КВС120А1, КВ127 (А—Г), КВ142 (А, Б)
BB205	КВ122 (А—В)
BB209	КВ123А, КВ126А5, КВ126АГ-5
BB309	КВ130А
BB404	КВ107В
BB405	КВ109 (А—Г)
BB503	КВ109 (А—Г)
BB505	КВ109 (А—Г)
BBY31	КВ109 (А—В)
BC619	КВ110 (А—Е)
BHC0003	Д231, Д231А
BLYA168	КС168А
BLY168B	КС168А
BLYA468	КС168А
BLYA468A	КС168А
BLYA468B	КС168А
BCA71	КД509А
BR22	КД205Г
BR24	КД205Б
BR42	КД205Л
BR44	Д246Б
BRB1D	КД208А
BR101A	Д242
BR102A	Д243
BR104A	Д246Б
BR106A	КД206В
BR205	КД204В
BYY67	Д245
BYY68	Д245
BY118	Д245Б
BY157	КД105Г
BYW17-100	КД213Г
BYW17-100	КД244 (А, Б)
BYW17-200	КД213 (А—Г)
BZX55C100B	КС600А
BZX55C120B	КС620А
BZX78C51	КС55А1
BZX79B12	Д813
BYX42/300	Д245
BYX42/600	КД206В
BYX60-400	Д229Е
BZX46C3V3	КС133А
BZX55C3V3	КС133А
BZX83C3V3	КС133А
BZY85B3V3	КС133А
BZY83C4V7	КС147А
BZY83D4V7	КС147А
BZY85C4V7	КС447А
BZY2924V7	КС447А
BZX85C4V7	КС456А
BZX29C35V6	Д246
C4010	Д102
C6041	КС107А
C6041M	КС107А
C6042	КС115А
CA50	Д102
CA100	Л223А
CB100	Д223А
CB150	Д102
CD21	КД922Б
CER69	КД205Г
CER69C	КД105В
CER70	КД105В
CER71B	КД105В
CER72C	КД205Е
CER500B	КД205Е
G6HZ	КД206В, КД210Б
GD72E3	Д9В
GD72E4	Д9В
GPM2NA	Д9В
GSA30E	КД202К
G129	Д219С, Д220С, Д223С
G1010	Д242
CD4156	Д2В
CDLL200	АД110А
CDLL300	Д2 (Г, Д)
CDLL400	Д2Е
CDLL4157	АД110А
CDLL5540	КД220Ж
CT23	Д206
CT33	Д206
CT163	Д2Ж
CG84H	КД503В
COD1531	Д222Ж
COD1555	КД205Е

Тип диода	Приближенный отечественный аналог	Тип диода	Приближенный отечественный аналог	Тип диодов	Приближенный отечественный аналог
COD1556	КД105В	E6N3	КД210Б	HP9	Д818А
COD16044	КС119А	E6G3	КД412Г	HS6 (1)	КЦ106В
CRG20	КЦ106Ж	E6C3	Д215, Д215А,	HS2039	КС139А
CRG40	КЦ106А		КЦ109А	HS7033	КС133А
CRG60	КЦ106Б	EG100	КД205Б	HS9010	КД521Г
CTN100	КД208А	ER405	КД411ВМ	HS9501	КД521А
CTP100	КД208А	EQA03-09B	Д809	HS9504	КД521А
CV7	Д808	EQA01-06	КС468А	HS9507	КД521А
CV836	КВ107Г	END400	КД205Б	H6010	КД206В
CV1930	КВ128А, КВ128АК	ERD600	КД205Ж	JE2	КД205Л
CV40	Д246Б	FSA2510M	КД919А	HS033A	КС133А
D2D	Д101	ESP5100	Д304	HS033B	КС133А
D25C	КД205Г	ESP5300	Д245Б	HVC40	КЦ201Б
D60H	КЦ201В	F2C3	КД509А	HV03SS	КЦ111А
D80H	КЦ201Г	FD100	Д245Б	1DMB10	КДС627А
D100	Д229Ж	F1E3	КД2997В	1DMB20	КДС628А
DA106K	КДС526А	F2A3	Д242	K1C5	Д2375
DA203	КД914Б, КДС526В	F2B3	Д242	K2C5	Д237А
DA203X	Д2Б	F2H3	КД206Б	KVF10	КЦ201Д
DA204X	Д2Б	F1K3	Д248Б, Д234Б	KLR10	КС106Г
DAN202K	КДС523 (А—Г),	F2M3	КД203Г	LAC2002	КС147А
	КДС523 (АМ—ГМ)	F2N3	КД210Б	LD2A	КД109А
DAN235K	КД906 (Г—Е)	FD600	КД521А	LDD5	КД521Б
DAN401	КД914А	FDN600	КД521А	LDD10	КД521Б
DAN403	КДС526А,	FPZ5V6	К2456А	LDD15	КД521Б
	КДС906 (Г—Е)	FSA2563M	КД903 (А, Б)	LDD50	КД521Б
DAN801	КД909А	G65HZ	Д248Б	LD4RA	КД109А
	КД903 (А, Б)	G233	КВ117 (А, Б)	LFD8	КД106В
DAP201	КДС526В	G1010	Д424	LR33H	КС133А
DAP202KVA	КДС523 (А—Г),	G1502	КД213 (А—В)	M4E9	КЦ409В
	КДС523 (АМ—ГМ)	G3010	Д425	M101P04	Д231Б
DAP203	КДС526В	G4010	Д426Б	M14	Д229В
DAP209	КДС523 (А—Г),	G8010	КД210Б	M1B1	КД208А
	КДС523 (АМ—ГМ)	GD3E	Д104А	M1B5	КД208А
DAP401	КДС526А	GD11E	Д10А	M1B9	КД208А
DAP801	КД903 (А—В),	GD72E5	Д103	M4HZ	Д229Е
	КД908А, КД909А	GP330	КД521Г	M500B	КД205Е
D226	Д37Б	GP350	КД509А	M500C	КД205А
DD003	КД205Г	GP360	КД521Б	M68	Д229Ж
DD006	КД205Б	GPP1J	КД411Б	M69C	КД205Г
DD056	КД205Б	GSA30E	КД202К	M70B	Д7Ж
DD236	Д246Б	GV3SY	КД212 (В, Г)	M70C	КЦ407А, КД205Б
DD266	Д246Б	GV35Z	КД221Б	M72B	КД105В
DD4521	Д242	HD4101	КД519 (А, Б)	MA27W	КС115А
DD4526	Д246Б	HD5000	КД514А,	MA56	КД923А
DE112	КД922Б		ГД508 (А, Б)	MA161	КД513А
DFC10	КД411Б	HDS901	КД521Г	MA166	КД513Б
DK751	Д229К, Д205Л	HDS9009	КД509А	MA215	КД205В
DK752	КВ119А	HS3 (2)	КЦ106А	MA231	Д242
DKV6516	КВ116А-1	HV035S	КЦ111А	MA232	Д243
DKV6517	Д226В	HMG626A	Д220	MA240	Д243
DT230H	Д209	HMG662	Д220Б	MA1120	Д813
DP695	Д208	HMG662A	Д220Б	MA4303	КД509А
DP698	Д209	HMG663	Д220Б	MA4304	КД509А
DP699	Д208	HMG844	Д220Б	MA4305	КД509А
DS866	КЦ201Д	HMG904	КД521Г	MA4306	КД509А
E1M3	КД411А,	HMG904A	КД521Г	MA4307	КД512А
	КД411 (АМ, БМ)	HMG907	КД521Г	MA4308	КД512А
E2M3	КД409БМ	HMG907A	КД521Г	MA4761	КВ113Б
E3B3	Д304	HMG3064	КД521А	MAD1130C	КД919А
E3E	Д245Б	HMG3596	КД521Г	MAD1108C	КД917А
E3H3	Д247Б	HMG3598	КД521А	MAD1108P	КД917А
E3K3	Д248Б, Д234Б	HMG3600	КД509А	MA4KO72-184	КВ115 (А—В)
E5A3	Д305	HMG3873	КД509А	MA4KO72-975	КВ115 (А—В)
E6B3	Д242	HMG4150	КД509А	MB236	КД208А
E6E3	Д245	HMG4319	КД521А	MB253	Д229К
E6M3	КД203Г	HMG4322	КД509А	MB254	Д229Л

Тип диода	Приближенный отечественный аналог	Тип диода	Приближенный отечественный аналог	Тип диода	Приближенный отечественный аналог
MB258	Д229Ж	MT050	КД205А	PD6045	КС139А
MB259	КД205Г	MT050A	КД205А	PD6047	КС147А
MB260	КД205Л	MT060	КД205Ж	PD6051	КС168А
MB261	КД205В	MTO60A	КД205Ж	PD6056	Д811
MB262	Д229К	MT14	Д229В	PD6202	КС147А
MB263	КД205Б	MT44	Д229Е	PD6206	КС168А
MB264	Д229Л	MT206	КД109В	PE10	Д304
MB265	КД205А	MT458	Д223Б	PE20	Д243Б
MB267	КД205Ж	MT462A	КД103А	PE40	Д246Б
MB270	Д229Ж	MT705	КД512Б	PE60	Д248Б
MB271	КД205Л	MT482B	КД522Б	PFF2	КЦ412В
MB272	Д229К	MT2061	КД109В	PR103	КД226А
MB336	КД106А	MT5140	КД109А	PS120	КД205Г
MB273	Д229Л	MV1656	КВ116А-1	PS130	КД205В
MC030	Д226В	MZ4A	КС147А	PS140	КД205Б
MCO30A	Д226В	MZ6A	КС168А	PS150	КД205А
MC51	Д226В	MZ1009	Д818А	PS160	КД205Ж
MC52	КД521А	MZ4622	КС139А	PS440	Д229Е
MC53	КД521Г	MZ4624	КС147А	PS632	Д226В
MC55	КД521Б	MZC3	КС133А	PS633	Д226В
MC58	КД509А	NC47	КС547В	PS2415	Д211
MC59	КД521Б	N5465C	КС112А-1,	PS2416	МД217
MC60	КД401Б		КВ112Б-1	PS2417	МД218
MC108	КД509А	0A91A	Д104	PS5301	Д204
MC433	КД521А	1M5	КД410Б	PS5302	Д205
MC461A	КД522А	P2K5	Д210	PS5303	КЦ40А1
MC903	КД509А	P2M5	Д211	PT520	КД205Л
MC905	КД521Г	P4F5	КД204Б, МД226А	PT530	Д229К
MCO905A	КД521Г	P4H5	Д7Ж, МД226	PT540	Д229Л
MC906	КД521Г	P4HZ	Д246Б	PH1217	КВ107А
MC906A	КД521Г	P6HZ	КД206В	PH1237	КВ107Б
MC908	КД509А	P8HZ	КД210Б	PK236	КС162А
MC908A	КД509А	P4K5	КД205Е	PV003	КВ103 (А, Б)
MC5321	КД521Г	P4M5	КД105В	PV008	КВ106 (А, Б)
MC6010A	КД168А	P5D5	Д229В	PV1505-15	КВ101
MC6015A	Д811	P6F6	КД205Г	PX50	Д220
MCPD521A	КД521Б	P6K5	КД205А	PX100	Д2206
MCPD521B	КД521Б	P6M5	КД205Ж	Q12-200A	КД521Д
MCPD521C	КД521Б	P7G5	Д229К	Q12-200	КД521Д
MGD73	КД521А	P7H5	Д246Б	Q12-200T	КД521Д
MGDA39 (A, B)	КС139А	P100A	Д229Ж	Q12-300	КД521Д
MHD611	КД521А	P100B	КД208А	Q12-300A	КД521Д
MHD612	КД521А	P150B	КД208А	Q12-300B	КД521Д
MHD614	КД521А	P200A	КД205Л	R040	КД411Г
MHD615	КД521А	P205	Д206	R250C	КД412Б
MHD616	КД509А	P400A	Д229Л	R421	Д243
MK39C-H	КС139А	P665	КД205В	R602	Д243Б
MMBD511	АД110А	P1010	Д242	R604	Д246
MM1001	КД521А	P2010	Д243	R606	КД206В
MMC1002	КД521А	P3010	Д245	R612	Д243
MMC1003	КД5214	P5010	КД206Б	R614	Д246Б
MMC1004	КД521А	P8010	КД210Б	R616	КД206В
MMC1005	КД521А	PA05	Д305	R704	КД416А
MMC1007	КД521А	PC116	Д901 (А—Е)	R3400606	КД412В
MR47C-H	КС147А	PD116	МД218	R3400806	КД412Б
MR80	МД217	PD126	Д220Б	RD30EC	КД531В
MR90	МД218	PD127	Д312А	RD264	Д10
MR100	МД218	PD133	Д101	RD91MB1	Д809
MR1337-2	Д229Ж	PD911	Д210	RD7AN	КС482А
MR1337-4	Д229К	PD912	Д211	RL252	Д103, Д103А
MR1337-5	Д229Л	PD914	МД217	RLS4450	КД504А
MS5	Д305	PD916	МД218	RM15TC40	КД529 (А, В, Г)
MT020A	КД205Г	PD915	МД218	RZ18	КС218Ж
MT030	КД205В	PD6004A	КС139А	RZ22	КС222Ж
MT030A	КД205Б	PD5006A	КС147А	RZZ11	КС211Ж
MT040	КД205В	PD6010	КД206В	SC5100	КД509А
MT040A	КД205Б	PD6010A	КС168А	S1R60	КД109В

Тип диода	Приближенный отечественный аналог
S1RBA60	КД109В
S1,5-0,1	КД208А
S2A-12	Д243
S2E60	КД205Ж
S4M	Д232, Д232А
S5A1	Д304
S5A2	Д243Б
S5A3	Д245Б
S5A6	Д248Б
S5AN12	КД206 (Б—Г)
S8A12	КД210Б
S10VB60	Д233Б
S15	КД205А
S17	КД205Г
S18	КД205А
S18A	КД205А
S19	Д7Ж
S20-06	Д248Б
S23A	КД205Ж
S26	Д229К
S28	КД105Г
S30	КД205Ж
S31	КД205В
S35A32OFR	Д215, Д215А
S83	Д229К
S92A	КД205Л
S101	КД205Г
S106	Д7Ж
S125	КД206В
S205	Д210
S206	Д211
S208	МД217
S210	МД218
S219	Д7Ж
S222	КД205Г
S223	КД205В
S234	КД105Г
S252	КД205Г
S253	КД205В
S256	КД105Ж
S427	КД210Б
S65250	КД509А
S2E20	КД205Г
SA283	Д202
SJ104 (Е, К)	Д242
SD11F	Д101
SD1A	КД205Ж
SD17	КД205Г
SD91A	Д229Ж
SD92A	КД205Л
SE05B	КД205Ж
SED107	Д10
SD93	Д229К
SDA113B	КД226А
SDA113C	КД226Б
SDA113D	КД226В
SDA113E	КД226Г
SDA113P	КД226Д
SD4756A	КС547В
SDR3008	КЦ401Г
SFD83	КД521Г
SED107	Д10
SE05	КД205Г
SE1,5	КД208А
SHVM15	КЦ201Е
SV31	КД109Б
SJ103 (Е, к)	Д304
SJ304 (Е, К)	Д243
SV134	Д811
SVM9021	Д818А
SP6	КЦ106Б
SG211 (1)	Д105, Д106
SG5200	КД521А
SG5260	КД521А
SJ203 (Е, К)	Д243Б
SRS360	КД202Р
SR712F	КД416Б
SR714F	КД416А
SPG100	КЦ106Г
SM20	КД205Л
SM230	Д229К
SM400	КЦ412А
SL3	Д245Б
SL92	МД226Е
SPD5817	АД516 (А, Б)
SN3142B	КС119А
ST23	Д219С, Д220С, Д223С
STB2	КС113А
SW05B	КД206Ж
SW05	КД205Г
SW1SS	КД205Л, Д229Ж
SV131	Д818А
SVC151	КВ135А
SVC252	КВ132А
SVM905	Д818А
SVM91	Д818А
SVM9010	Д818А
SVM9011	Д818А
SVM9020	Д818А
SZ3-120-5-25	КС620Н
SZ3-120-20-25	КС620А
SZ3-130-10-25	КС630А
SZ3-150-20-25	КС650А
SZ3-180-20-25	КС680А
SZP5-20-20-1	КС220Ж
SZ9	Д818А
SZ11	Д811
TF24	Д226В
TK20	КД205Л
TK40	Д229Л
TM7	КД202АП
TM17	КД202В
TM37	КД202Ж
TM47	КД202К
TM57P	КД202М
TM64	КД202Р
TR251	КД2994А
TR251	КД2994 (Б—Г), КД2999А
TSZ6.2	КС162А
TMD45	Д207
TS1	Д229Ж
TS2	КД205Л
TS4	Д229Л
UC1610	КД917А
UP12069	КД205Л
UP12070	Д229Л
UTX3105	АД516А
UTX3105	АД516Б
P12070A	Д229Л
UR215	Д303
UT112	Д229Ж
UT113	КД205Л
UT114	Д229К
UT115	Д229Л
UT212	Д229К
UT213	Д229Л
UT3020	КД226Г
UT3040	Д304
URE100X	Д304
URF100X	Д304
URG100X	КЦ109А
US60A	Д902
V10	КЦ409А
V346	Д902
V910	КВ114А
VLA-722	КВ114Б, КВ139А
VC556V	КВ139А
VC885D	КВ110А
VVC861	КВ110 (Б—Е), КВ113А
VVC898	КВ104А
VVC901	КВ104 (Б—Е), КВ105А
VVC1027	КВ105Б, КВ117А
VVC1638	КВ117Б, КВ102А
WC925	КВ102 (Б—Д), КЦ105В
X60C	Д229Ж
XS10	КД205Л
XS17	КЦ201Г
Z80F	КС156А
Z1500	КС156А
Z1555	КС156А
Z1560	КС156А
Z1565	КС156А
Z1570	КС156А
Z1A5,6	КС156А
Z1A6,8	КС168А
Z1A11	Д811
ZF3,3	КС113А
ZMM5257	КС533А
Z4B68	КС568В
ZC833	КВ134А, КВ117 (А,В)
ZRY82	КС591А
ZR936-50	Д810
ZR937-50	Д810
ZD13	КС515А
ZP151	КС551А
Z4A15	КС551А
0102	КД102А
0112	КД102А
0502	Д226В
0507	КД105Г
0604	КД206В
10PM2	Д243
10PM4	Д246Б
10PM6	КД206В
11R2S	Д243
11R3S	Д245
11R4S	Д246Б
16P2	Д2Г

Продолжение

Тип диода	Приближенный отечественный аналог
19R2	КД922В
100R48	КД411Г
100R5B	КД411ГМ
1N34AS	КД401А
1N74	Д101
1N75	Д104, Д104А
1N87	Д9В
1N137A	КД519 (А, Б)
1N138A	ГД511А
1N204	ГД402Б
1N210	Д102
1N211	Д102
1N212	Д101
1N213	Д101
1N215	Д2И
1N219	КД104А
1N220	КД104А
1N248	КД2997А
1N249	КД2999Б
1N250	Д243
1N259X	Д9В
1N300	ГД402 (А, Б)
1N300B	КД922А, КД923А
1N302	Д2В
1N320	КД205Е
1N324	Д229В
1N327	КЦ401А
1N332	Д229Е
1N339	Д229В
1N341	Д229Е
1N344	Д103А
1N348	Д229В
1N354	КД104А
1N358	КС212Ж
1N365	МД218
1N388	Д102
1N391	Д101
1N393	Д2И
1N401AM	КД522А
1N440B	Д229Ж
1N441	КД204Б, Д237А
1N441B	КД205Л
1N442B	Д229К
1N443	Д7Ж
1N444	КД205Е
1N445	КД105В
1N458	Д223Б
1N462M	КД401А
1N483	КД103А
1N485	Д207
1N486	Д207
1N487A	Д226В
1N488	Д209
1N531	КД204Б
1N527	Д103А
1N533	КД205Б
1N534	КД205Е
1N535	КД105В
1N537	Д229Ж
1N538	КД205Л
1N539	Д229К
1N551	КД205Г
1N552	КД205В
1N553	КД205Б, Д237ЛС
1N554	КД205А, КЦ401Г
1N555	КД205Ж
1N560	КД105Г
1N602	КД204Б
1N602A	КД204Б
1N604	Д7Ж, Д237Ж
1N605	КД205Е
1N605A	КД205Е
1N606A	КД105В
1N616	Д10Б
1N625	КД413 (А, Б), КД417А
1N627	Д312А, ГД313А
1N647	Д229Е
1N662	Д220Б
1N662A	Д220Б
1N663	Д220Б
1N667	Д229В
1N573	Д229Е
1N679	Д203
1N695	Д310
1N770	Д310
1N777	Д312А
1N844	Д220Б
1N866	КД410А
1N873	Д210
1N874	Д211
1N876	МД217
1N878	МД218
1N885	КД410Б
1N899	Д105А, Д106А
1N903A	КД509А
1N903AM	КД509А
1N903M	КД509А
1N904	КД521Г
1N905A	КД521Г
1N905AM	КД521Г
1N905M	КД521Г
1N906A	КД521Г
1N906AM	КД521Г
1N906M	КД521Г
1N907	КД521Г
1N908A	КД509А
1N908AM	КД509А
1N913	Д220С, Д223С
1N914A	КД521А
1N914B	КД521А
1N914M	КД521А
1N916A	КД521А
1N916B	КД521А
1N932	Д237Е
1N942	КС212Е
1N993	КД520А, ГД507А, КД413 (А, Б), КД417А
1N994	ГД107 (А, Б)
1N999	Д310
1N1031	КД205Г
1N1032	КД205В
1N1033	КД205Б
1N1041	КЦ412Б
1N1053	КД208А
1N1059	Д304
1N1061	Д243Б
1N1062	Д245Б
1N1063	Д246Б, Д232Б
1N1067	Д243Б
1N1068	Д245Б
1N1069	Д246Б, Д232Б
1N1073	Д243Б
1N1075	КД246Б, Д232Б
1N1079	КД416Б
1N1081A	Д229Ж
1N1082A	КД205Л
1N1083	КД205В
1N1083A	Д229К
1N1084	КД205Б
1N1085	КД208А
1N1090	Д243Б
1N1091	Д245Б
1N1092	Д246Б, Д232Б
1N1092A	Д246Б
1N1115	КД208А
1N1124	КД212 (А, Б)
1N1126	КД209А
1N1126A	КД411БМ
1N1128	КД209Б
1N1169A	КД205Б
1N1251	КД204В
1N1253	КД205Г
1N1254	КД205В
1N1255	КД205Б
1N1256	КД205Е
1N1257	КД105В
1N1258	КД205И
1N1259	КД105Г
1N1407	МД217
1N1440	КД205Л
1N1441	Д229К
1N1446	КД208А
1N1450	КД208А
1N1487	Д229Ж
1N1488	КД205Л
1N1489	КД205Л
1N1490	Д229Л
1N1520A	КС456А
1N1557	КД205Л
1N1558	Д229К
1N1559	Д229Л
1N1563	КД208А
1N1582	КЦ410Б
1N1584	КД2020, Д304
1N1613	Д304
1N1613A	Д243Б
1N1614A	Д246Б
1N1615A	Д248Б
1N1616	КД208А
1N1616A	Д242
1N1617	Д248Б
1N1621	Д245
1N1623	Д246Б
1N1624	КД412Г, КД104А
1N1632	Д229Ж
1N1645	КД205Л
1N1647	Д229К

Тип диода	Приближенный отечественный аналог
1N1649	Д229Л
1N1651	Д229К
1N1694	Д229Л
1N1695	АД112А
1N1701	КД204Б
1N1703	КД205Е
1N1706	КД205Г
1N1709	КД205В
1N1710	КД205В
1N1711	КД205А
1N1712	КД205А
1N1764	КД411В
1N1764А	КС456А
1N1765	КС456А
1N1765А	КС600А
1N1795	Д102
1N1844	Д2Е
1N1846	Д2Ж
1N1847	КД104А
1N1849	КС596В
1N1888	КС139А
1N1927	Д814А
1N1931	КС168В
1N1984	КС168В
1N1984А	КС182А
1N1985	КС182А
1N1985А	КС210Б
1N1985В	КС210Б
1N1986	КС210Б
1N1986А	КС215Ж
1N1986В	КС215Ж
1N1988	КС215Ж
1N1988А	КС218Ж
1N1988Б	КС218Ж
1N1989	КС218Ж
1N1898А	КС218Ж
1N1989Б	КС218Ж
1N1990	КС222Ж
1N1990А	КС222Ж
1N1990В	КС222Ж
1N2022	КД2999А
1N2023	Д245
1N2025	Д246
1N2034	КС482А
1N2069	КД205Л
1N2070	Д229Л
1N2070А	Д229Л
1N2073	Д229Ж
1N2080	КД204В
1N2082	КД205Г
1N2083	КД205В
1N2084	КД205Б
1N2085	КД205А
1N2086	КД205Ж
1N2091	Д229Ж
1N2092	КД205Л
1N2093	Д229К
1N2094	Д229Л
1N2104	Д229Ж
1N2105	КД205Л
1N2106	Д229К
1N2107	Д229К
1N2230	Д243Б
1N2230А	Д243Б
1N2231	Д243Б
1N2232	Д245Б
1N2232А	Д245Б
1N2233А	Д245Б
1N2234	Д246Б
1N2234А	Д246Б
1N2235	Д246Б
1N2235А	Д246Б
1N2236	Д247Б
1N2237	Д247Б
1N2237А	Д247Б
1N2238	Д248Б
1N2238А	Д248Б
1N2239	Д248Б
1N2239А	Д248Б
1N2246	Д305
1N2246А	Д305
1N2247А	Д305
1N2248	Д242, Д214А, Д214
1N2248А	Д242
1N2249	Д242
1N2249А	Д214А, Д242
1N2250	Д243
1N2250А	Д243
1N2251	Д243
1N2251А	Д243
1N2252	Д245
1N2252А	Д245
1N2253	Д245
1N2253А	Д245
1N2254	Д246Б
1N2254А	Д246Б
1N2255	Д246Б
1N2255А	Д246Б
1N2256	КД206Б
1N2256	Д233
1N2256А	КД206Б
1N2257	КД206Б, Д233
1N2257А	КД206Б
1N2258	КД206В
1N2258А	КД206В
1N2259	КД206В
1N2259А	КД206В
1N2260	КД210Б
1N2260А	КД210Б
1N2261	КД210Б
1N2289	КД208А
1N2289А	КД208А
1N2290	Д304
1N2350	Д303
1N2349	КД221А
1N2350	Д303
1N2373	Д211
1N2374	МД218
1N2391	КД208А
1N2400	КД208А
1N2409	КД208А
1N2418	КД208А
1N2482	КД205Л
1N2483	Д229Л
1N2487	Д229Л
1N2505	КД105Г
1N2559	КД412А
1N2571	КД412В
1N2574	КД412А
1N2598	КД999В
1N2610	Д229Ж
1N2611	КД205Л
1N2613	Д229Л
1N2638	КД208А
1N2705	КЦ410В
1N2708	КЦ409Г
1N2786	Д243
1N2793	Д305
1N2847	КД208А
1N2859	Д229Ж
1N2860	КД205Л
1N2862	Д229Л
1N2878	КД205И
1N2879	КД205И
1N2063	КД521А
1N3020А	КС510А
N13030В	КС527А
1N3064	КД521А
1N3064М	КД521А
1N3065	КД509А
1N3067	КД521Г
1N3082	КД205Г
1N3083	КД205Б
1N3097	КД407 (А, Л)
1N3121	Д220
1N3184	КД205А
13193	КД205Л
1N3194	Д229Л
1N3228	КД205Г
1N3229	КД205А
1N3238	Д229Ж
1N3239	КД205Л
1N3253	КД205Л
1N3254	Д229Л
1N3270	Д246Б
1N3277	КД205Л
1N3278	Д229Л
1N3282	МД218
1N3359	КД212 (В, Г), КД106А, КД221А, КД226А
1N3361	КД212 (А, Б)
1N3367	КД209В
1N3545	КД205Г
1N3547	Д229
1N3575	КД522Б
1N3600	КД509А
1N3604	КД521А
1N3606	КД521А
1N3607	КД521А
1N3639	КД205Л
1N3640	Д229Л
1N3656	КД205Л
1N3748	КД205Г
1N3749	КД205Б
1N3750	КД205Ж
1N3827	КС456А
1N3827А	КС456А
1N3873	КД509А
1N3981	КД221Б
1N3982	КД209А, КД211В
1N3983	КД209Б, КД221Г
1N3894	Д205
1N3873Н	КД509А
1N3954	КД509А
1N4005С	КД411ВМ
1N4008	МД3Б, КД503А
1N4099	КС168А
1N4142	КЦ409В
1N4147	КД503А

Тип диода	Приближенный отечественный аналог	Тип диода	Приближенный отечественный аналог	Тип диода	Приближенный отечественный аналог
1N4148	КД521А	1S231	КС518А	5Е3	КД205В
1N4149	КД521А	1S307	Д18	5Е4	КД205ВБ
1N4153	КД521А	1S313	КД205В	5Е5	КД205А
1N4305	КД521А	1S314	КД205Б	5Е6	КД205Ж
1N4364	Д229Ж	1S315	КД205А	5J6	КД205Ж
1N4365	КД205Л	1S421	Д243	5МА4	Д246Б
1N4366	Д229К	1S423	Д246Б	5РМ4	Д246Б
1N4367	Д229Л	1S410 (1)	КД213Г,		
1N4437	Д246Б		КД244 (А, Б)	5Е1	Д229Ж
1N4438	КД206В	1S411 (1)	КД213 (А—В)	5Е2	КД205Г
1N4439	КД210Б	1S421	КД2997А	5МА2	КД205Л
1N4446	КД521А	1S426	Д10, Д10Б	5РМ6	Д248Б
1N4447	КД521А	1S1618	КВ129А	60АS	КД205Ж
1N4448	КД521А	1S1619	КВ129А	60F5	Д248Б
1N4449	КД521А	1S4716	КВ129А	60LF	Д248Б
1N4450	КД504А	1S427	КД210Б	60М	КД205Ж
1N4454	КД521А	1S431	КЦ410	60S5	КД205Ж
1N4531	КД521А	1S743	Д811	367К	КД206Б
1N4542	Д205	1S544	КД210Б	367М	КД206В
1N4622	КС139А	1S558	КД205А	3Т504	КД205Б
1N4624	КС147А	1S559	КД205В	3Т505	КД205А
1N4655	КС456А	1S1219	КД521Г	40109	Д242
1N4661	КС510А	1S1220	КД521Г	40110	Д243
1N4686	КС139А	1S1230	КД205Б	40111	Д245
1N4688	КС147А	1S1231	КД205А	40112	Д246
1N4721	КД202Д	1S1232	КД205Ж	40113	КД206Б
1N4724	КД202В	1S1473	КД521Г	40114	КД206В
1N4734	КС456А	1S1660	Д303	40115	КД210Б
1N4748А	КД522А	1S1763	КД205Б	407К	Д247Б
1N4762	К5С591А	1S1943	КД205Б	407М	Д248Б
1N4817	КД208А	1S1944	КД205Ж	408К	КД206В
1N4835В	КС515А	1RM40	КЦ201Б	408М	КД206В
1N5209	Д233Б	1RM150	КЦ201Е	408Р	КД203Г
1N5216	КД205Б	1RN60	КЦ201В	408S	КД210Б
1N5217	КД205Ж	1SR19-100	КД2997Б	40АS	КД206Б
1N5318	КД521А	1Z16	КС518А	40S5	КД205Б
1N5392	КД208А	1Т504	КД205Б	4D4	Д229Е
1N5216	КЦ407А	1Т505	КД205А	4G8	Д229Л
1N5405	КЦ409Б	2Т502	КД205Г	4Т503	КД205В
1N5406	КД202Р	2Т504	КД205Б	4Т504	КД205Б
1N5446В	КВ136А,	2Т505	КД205А	4Т505	КД205А
	КВ138 (А, Б)	2Т506	КД205Ж	4Т506	КД205Ж
1N5448	КВ138 (А—Б),	3С15	Д303	50АS	КД205А
	КВ136Б	3Е2	КЦ409Д	10SP04	Д231Б
1N5466В	КВ136В	3Е2	КЦ409Е	10SP06	Д223Б
1N5466С	КВ136Г	3Е2	КЦ409Е	10S20	КЦ106Д
1N5466D	КВ136Г	3А500	КД202М	101Р02	Д215Б
1N5720	КД503А	3Т502	КД205Г	10L60	КЦ105В
1N5770	КД908А	4Т502	КД205Г	14Р2	Д232Б
1N5997	Д808	6А1	КЦ409 (Ж, И)	20S5	КД205Г
1N6007В	КС520В	6Д100	КЦ409 (Ж, И)	24J2	Д223Б
1N6478	КЦ412А	7J1	Д229Ж	75R2В	КД205Л
1Р644	Д229В	7J2	КД205Л	100D10	МД218
1Р647	Д229Е	7Е1	Д229Ж	100К10	МД218
1GSPO2	Д215Б	10А400	Д232, 232А	2G8	КД205Л
1Т502	КД205Г	10F5	Д304	366D	Д234Б
1S032	КД205Л	10R6В	Д211	367В	Д242
1S034	Д229Л	10R10В	МД218	616С	Д102
1S41	КД205Л	10SR01	Д214Б	618С	Д101
1S43	Д229Л	50J2Р	КД206Б	30АS	КД205В
1S101	КД205Л	50F5	Д247Б	30F5	Д245Б
1S103	Д229Л	50J2Р	КД206Б	30S5	КД205В
1S113	Д229Е	5J3	КД205В	366М	Д248Б
1S136 (1)	Д237В	5J4	КД205Б	366F	Д245Б
1S148	Д229К	5L85	КЦ105Д	366Н	Д246Б
1S162	Д243	50LF	Д247Б	366К	Д247Б
1S163	Д245	50L70	КЦ105Г	367D	Д243
1S164	Д246Б	50S5	КД205А	367Н	Д246
1S165	КД206Б	5D4	К246Б	11R4S	Д246

ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ И ИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус	
AC107	R-9	ГТ115А
AC116	X-9	МП25А
AC117	X-9	ГТ402И
AC121	TO-1	МП20А
AC122	R-60	ГТ115Г
AC124	TO-1	ГТ403И
AC125	TO-1	МП20Б
AC126	TO-1	МП20Б
AC127	TO-1	ГТ404Б
AC128	TO-1	ГТ402И
AC132	TO-1	МП20Б, ГТ402Е
AC138	TO-1	ГТ402И
AC139	TO-1	ГТ402И
AC141	TO-1	ГТ404Б
AC141B	TO-1	ГТ404Б
AC142	TO-1	ГТ402И
AC150	TO-1	МГТ108Д
AC152	TO-1	ГТ402И
AC160	R-60	П28
AC170	R-60	МГТ108Г
AC171	R-60	МГТ108Г
AC176	TO-1	ГТ404А
AC181	R-134	ГТ404Б
AC182	R-134	МП20Б
AC183	TO-1A	МП36А, МП38А
AC184	R-134	ГТ402И
AC185	TO-11	ГТ404Г
AC187	TO-1	ГТ404Б
AC188	TO-1	ГТ402Е
AC540	TO-58	МП39Б
AC541	TO-58	МП39Б
AC542	TO-58	МП39Б, МП41А
ACY24	TO-18	МП26Б
ACY33	TO-1	ГТ402И
AD130	TO-3	П217
AD131	TO-3	П217
AD132	TO-3	П217
AD138	TO-3	П216
AD139	MD-11	П213
AD142	TO-3	П210Б
AD143	TO-3	П210В
AD145	TO-3	П210В, П216В
AD148	MD-23	ГТ703В
AD149	TO-3	ГТ703В
AD150	TO-3	ГТ703Г
AD152	MD-11	ГТ403Б
AD155	MD-11	ГТ403Е
AD161	MD-17	ГТ705Д
AD162	MD-17	ГТ703Г
AD163	TO-3	П217
AD164	MD-11	ГТ403Б
AD169	MD-11	ГТ403Е
AD262	SOT-9	П213
AD263	SOT-9	П214А
AD301	TO-3	ГТ703Г
AD302	TO-3	П216
AD303	TO-3	П217
AD304	TO-3	П217
AD312	TO-3	П216
AD313	TO-3	П217
AD314	TO-3	П217, ГТ701А
AD325	TO-3	П210Б, ГТ701А
AD431	TO-3	П213
AD436	TO-3	П213
AD438	TO-3	П214А
AD439	TO-3	П215
AD457	TO-3	П214А
AD465	TO-3	П213Б
AD467	TO-3	П214А
AD469	TO-3	П215
AD542	TO-3	П217, ГТ701А
AD545	TO-3	П210Б
AD1202	TO-3	П213Б
AD1203	TO-3	П214Б
ADP665	TO-66	ГТ403Б
ADP666	TO-66	ГТ403Г
ADP670	TO-3	П201АЭ
ADP671	TO-3	П201АЭ
ADP672	TO-3	П202Э
ADY27	TO-3	ГТ703В
AF106	TO-72	ГТ328Б
AF106A	TO-72	ГТ328В
AF109R	TO-72	ГТ328А
AF139	TO-72	ГТ346Б
AF178	TO-12	ГТ309Б
AF200	TO-72	ГТ328А
AF201	TO-72	ГТ328А
AF202	TO-72	ГТ328А
AF239	TO-72	ГТ346А
AF239S	TO-72	ГТ346А
AF240	TO-72	ГТ346Б
AF251	MM-12	ГТ346А
AF252	MM-12	ГТ346А
AF253	MM-12	ГТ328А
AF256	MM-12	ГТ328Б
AF260	TO-18	П29А
AF261	TO-18	П30
AF266	TO-18	МП42Б, МП20А
AF271	TO-18	ГТ322В
AF272	TO-18	ГТ322В
AF275	TO-18	ГТ322Б
AF279	TO-50	ГТ330Ж
AF280	TO-50	ГТ330И
AF426	TO-18	ГТ322Б
AF427	TO-18	ГТ322Б
AF428	TO-18	ГТ322Б
AF429	TO-18	ГТ322Б
AF430	TO-18	ГТ322В
AFY11	TO-5	ГТ313А
AFY12	TO-72	ГТ328Б
AFY13	TO-18	ГТ305В
AFY15	TO-18	П30
AFY29	TO-18	ГТ305Б
AFZ11	TO-72	ГТ309Б
AL100	TO-3	ГТ806В
AL102	TO-3	ГТ806А
AL103	TO-3	ГТ806Б
ASX11	TO-5	МП42Б
ASX12	TO-5	МП42Б
ASY26	TO-5	МП42А, МП20А
ASY31	R-9	МП42А
ASY33	TO-5	МП42А, МП20А
ASY34	TO-5	МП42А, МП20А
ASY35	TO-5	МП425, МП20А
ASY70	TO-1	МП42
ASY76	TO-5	ГТ403Б
ASY77	TO-5	ГТ403Г
ASY80	TO-5	ГТ403Б
ASZ15	TO-3	П217А, ГТ701А
ASZ16	TO-3	П217А
ASZ17	TO-3	П217А
ASZ18	TO-3	П217В, ГТ701А

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
ASZ1015	TO-3	П217В	BC170B	X-64	КТ375В
ASZ1016	TO-3	П217В	BC171A	TO-92	КТ373А
ASZ1017	TO-3	П217В	BC171B	TO-92	КТ373Б
ASZ1018	TO-3	П217В	BC172A	TO-92	КТ373А
AT270	TO-1	МП42Б, МП20А	BC172B	TO-92	КТ373Б
AT275	TO-1	МП42Б, МП20А	BC172C	TO-92	КТ373В
AU103	TO-3	ГТ810А	BC173B	TO-92	КТ373В
AU104	TO-3	ГТ810А	BC173C	TO-92	КТ373В
AU107	TO-3	ГТ810А	BC177AP	X-55	КТ3107А
AU108	TO-3	ГТ806Б	BC177V1P	X-55	КТ3107Б
AU110	TO-3	ГТ806Д	BC178A	TO-18	КТ349В
AU113	TO-3	ГТ810А	BC178AP	X-55	КТ3107В
AUY10	TO-3	П608А, ГТ905А	BC178BP	X-55	КТ3107Д
AUY18	TO-8	П214А	BC178V1P	X-55	КТ3107В
AUY19	TO-3	П217	BC179AP	X-55	КТ3107Е
AUY20	TO-3	П217	BC179BP	X-55	КТ3107Ж
AUY21	TO-41	П210Б	BC182A	TO-92	КТ3102А
AUY21A	TO-3	П210Б	BC182B	TO-92	КТ3102Б
AUY22	TO-41	П210Б	BC182C	TO-92	КТ3102Б
AUY22A	TO-3	П210Б	BC183A	TO-92	КТ3102А
AUY28	TO-3	П217	BC183B	TO-92	КТ3102Б
AUY35	TO-3	ГТ806А	BC183C	TO-92	КТ3102Б
AUY38	TO-3	ГТ806В	BC183C	TO-92	КТ3102Г
BC100	TO-5	КТ605А	BC184A	X-55	КТ3102Д
BC101	TO-18	КТ301Е	BC184B	X-55	КТ3102Е
BC107A	TO-18	КТ342А	BC192	TO-92	КТ351Б
BC107AP	X-55	КТ3102А	BC212A	TO-92	КТ3107Б
BC107BP	X-55	КТ3102Б	BC212B	TO-92	КТ3107И
BC107B	TO-18	КТ342Б	BC212C	TO-92	КТ3107К
BC108A	TO-18	КТ342А	BC213A	TO-92	КТ3107Б
BC108AP	X-55	КТ3102В	BC213B	TO-92	КТ3107И
BC108B	TO-18	КТ342Б	BC213C	TO-92	КТ3107К
BC108BP	X-55	КТ3102В	BC216	TO-18	КТ351А
BC108C	TO-18	КТ342В	BC216A	TO-18	КТ351А
BC108CP	TO-18	КТ3102Г	BC218	TO-18	КТ340Б
BC109B	TO-18	КТ342Б	BC218A	TO-18	КТ340Б
BC109BP	X-55	КТ3102Д	BC226	TO-18	КТ351Б
BC109C	TO-18	КТ342В	BC226A	TO-18	КТ351Б
BC109CP	X-55	КТ3102Е	BC234	TO-18	КТ342А
BC119	TO-39	КТ630Д	BC234A	TO-18	КТ342А
BC139	TO-39	КТ933Б	BC235	TO-18	КТ342Б
BC140	TO-39	КТ630Г	BC235A	TO-18	КТ342Б
BC141	TO-39	КТ630Г	BC237A	TO-92	КТ3102А
BC142	TO-39	КТ630Г	BC237B	TO-92	КТ3102Б
BC143	TO-39	КТ933Б	BC238A	TO-92	КТ3102А
BC146-01	SOT-42	КТ373А	BC238A	TO-92	КТ3102В
BC146-02	SOT-42	КТ373Б	BC238B	TO-92	КТ3102В
BC146-03	SOT-42	КТ373В	BC238C	TO-92	КТ3102Г
BC147A	MM-10	КТ373А	BC239B	TO-92	КТ3102Д
BC147B	MM-10	КТ373Б	BC239C	TO-92	КТ3102Е
BC148A	MM-10	КТ373А	BC250A	TO-92	КТ361А
BC148B	MM-10	КТ373Б	BC250B	TO-92	КТ361Б
BC148C	MM-10	КТ373В	BC285	TO-18	П308
BC149B	MM-10	КТ373Б	BC286	TO-39	КТ630Г
BC149C	MM-10	КТ373В	BC300	TO-5	КТ630Б
BC157	MM-13	КТ361Г	BC307A	TO-92	КТ3107Б
BC158A	MM-10	КТ349В	BC307B	TO-92	КТ3107И
BC160-6	TO-39	КТ933Б	BC308A	TO-92	КТ3107Г
BC161-6	TO-39	КТ933А	BC308B	TO-92	КТ3107Д
BC167A	TO-92	КТ373А	BC308C	TO-92	КТ3107К
BC167B	TO-92	КТ373Б	BC309B	TO-92	КТ3107Е
BC168A	TO-92	КТ373А	BC309C	TO-92	КТ3107Л
BC168B	TO-92	КТ373Б	BC317	TO-92	КТ3102А
BC168C	TO-92	КТ373В	BC318	TO-92	КТ3102Б
BC169B	TO-92	КТ373Б	BC319	TO-92	КТ3102Е
BC169C	TO-92	КТ373В	BC320A	TO-92	КТ3107Б
BC170A	X-64	КТ375Б	BC320B	TO-92	КТ3107Д

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус	
BC321A	TO-92	КТ3107Б
BC321B	TO-92	КТ3107И
BC321C	TO-92	КТ3107К
BC322B	TO-92	КТ3017Ж
BC322C	TO-92	КТ3107Л
BC355	TO-92	КТ352Б
BC355A	TO-92	КТ352А
BC382B	X-55	КТ3102Б
BC382C	X-55	КТ3102Г
BC383B	X-55	КТ3102Д
BC383C	X-55	КТ3102Е
BC384B	X-55	КТ3102Д
BC384C	X-55	КТ3102Е
BC451	TO-92	КТ3102В
BC452	TO-92	КТ3102Б
BC453	TO-92	КТ3102Д
BC454A	TO-92	КТ3107Б
BC454B	TO-92	КТ3107И
BC454C	TO-92	КТ3107К
BC455A	TO-92	КТ3107Г
BC455B	TO-92	КТ3107Д
BC455C	TO-92	КТ3107К
BC456A	TO-92	КТ3107Е
BC456B	TO-92	КТ3107Ж
BC456C	TO-92	КТ3107Л
BC513	X-55	КТ345А
BC521	TO-92	КТ3102Д
BC521C	TO-92	КТ3102Д
BC526A	TO-92	КТ3107И
BC526B	TO-92	КТ3107И
BC526C	TO-92	КТ3107К
BC527-6	TO-92	КТ644А
BC527-10	TO-92	КТ644Б
BC547A	TO-92	КТ3102А
BC547B	TO-92	КТ3102Б
BC547C	TO-92	КТ3102Г
BC548A	TO-92	КТ3102А
BC548B	TO-92	КТ3102В
BC548C	TO-92	КТ3102Г
BC549A	TO-92	КТ3102Д
BC549B	TO-92	КТ3102Д
BC549C	TO-92	КТ3102Е
BC557	TO-92	КТ361Д
BC557A	TO-92	КТ3107А
BC557B	TO-92	КТ3107И
BC558	TO-92	КТ3107Д
BC558A	TO-92	КТ3107Г
BC558B	TO-92	КТ3107Д
BC559	TO-92	КТ3107Ж
BCF29	SOT-23	КТ3129В9
BCF30	SOT-23	КТ3129Г9
BCF32	SOT-23	КТ3130В9
BCF33	SOT-23	КТ3130Е9
BCF70	SOT-23	КТ3129Г9
BCF81	SOT-23	КТ3130Б9
BCP627A	TO-92	КТ373А
BCP627B	TO-92	КТ373Б
BCP627C	TO-92	КТ373В
BCP628A	TO-92	КТ373А
BCP628B	TO-92	КТ373Б
BCP628C	TO-92	КТ373В
BCV71	SOT-23	КТ3130А9
BCV72	SOT-23	КТ3130Б9
BCW29	SOT-23	КТ3129В9
BCW30	SOT-23	КТ3129Г9
BCW31	SOT-23	КТ3130В9
BCW32	SOT-23	КТ3130В9
BCW33	SOT-23	КТ3130Г9
BCW47	MM-13	КТ373А
BCW48	MM-13	КТ373 (Б, В)
BCW49	MM-13	КТ373 (Б, В)
BCW57	MM-13	КТ361Г
BCW58	MM-13	КТ361Е
BCW60A	SOT-23	КТ3130А9
BCW60B	SOT-23	КТ3130Б9
BCW60C	SOT-23	КТ3130В9
BCW60D	SOT-23	КТ3130Е9
BCW61A	SOT-23	КТ3129В9
BCW61B	SOT-23	КТ3129Г9
BCW61C	SOT-23	КТ3129Г9
BCW69	SOT-23	КТ3129Б9
BCW70	SOT-23	КТ3129Г9
BCW71	SOT-23	КТ3130А9
BCW72	SOT-23	КТ3130Б9
BCW81	SOT-23	КТ3130Б9
BCW89	SOT-23	КТ3129Б9
BCX70G	SOT-23	КТ3130А9
BCX70H	SOT-23	КТ3130Б9
BCX70J	SOT-23	КТ3130В9
BCX70K	SOT-23	КТ3130В9
WSH71G	SOT-23	КТ3129Б9
BCX71H	SOT-23	КТ3129Г9
BCX71J	SOT-23	КТ3129Г9
BCY10	R-8	КТ208Е
BCY11	R-8	КТ208Л
BCY12	R-8	КТ208Д
BCY30	TO-5	КТ208Л
BCY31	TO-5	КТ208М
BCY32	TO-5	КТ208М
BCY33	TO-5	КТ208Г
BCY34	TO-5	КТ208Г
BCY38	TO-5	КТ501Д
BCY39	TO-5	КТ501М
BCY40	TO-5	КТ501Д
BCY42	TO-18	КТ312Б
BCY43	TO-18	КТ312В
BCY54	TO-5	КТ501К
BCY56	TO-18	КТ3102Б
BCY57	TO-18	КТ3102Е
BCY58A	TO-18	КТ342А
BCY58B	TO-18	КТ342Б
BCY58C	TO-18	КТ342Б
BCY58D	TO-18	КТ342В
BCY59-VII	TO-18	КТ3102А
BCY59-VIII	TO-18	КТ3102Б
BCY59-IX	TO-18	КТ3102Б
BCY59-X	TO-18	КТ3102Д
BCY65-VII	TO-18	КТ3102А
BCY65-VIII	TO-18	КТ3102Б
BCY65-IX	TO-18	КТ3102Б
BCY69	TO-18	КТ342В
BCY70	TO-18	КТ3107А
BCY71	TO-18	КТ3107Е
BCY72	TO-18	КТ3107В
BCY78	TO-18	КТ3107Д
BCY79	TO-18	КТ3102Б
BCY90	TO-18	КТ208Е
BCY90B	TO-5	КТ501Г
BCY91	TO-18	КТ208Е
BCY91B	TO-5	КТ501Г
BCY92	TO-18	КТ208Е
BCY93	TO-18	КТ208К
BCY93B	TO-5	КТ501Л
BCY94	TO-18	КТ208К
BCY94B	TO-5	КТ501Л

Продолжение

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус	
BCY95	TO-18	КТ208К
BCY95B	TO-5	КТ501М
BD109	MD-6	КТ805Б
BD115	TO-39	КТ604Б
BD121	TO-3	КТ902А
BD123	TO-3	КТ902А
BD123	TO-3	КТ805Б
BD131	TO-126	КТ943В
BD132	TO-126	КТ932Б
BD135-6	TO-126	КТ943А
BD136	TO-126	КТ626А
BD137-6	TO-126	КТ943Б
BD138	TO-126	КТ626Б
BD139-6	TO-126	КТ943В
BD140	TO-126	КТ626В
BD142	TO-3	КТ819БМ
BD148	MD-17	КТ805Б
BD149	MD-17	КТ805Б
BD165	TO-126	КТ815А
BD166	TO-126	КТ814Б
BD167	TO-126	КТ815Б
BD168	TO-126	КТ814В
BD169	TO-126	КТ815В
BD170	TO-126	КТ814Г
BD175	TO-126	КТ817Б
BD176	TO-126	КТ816Б
BD177	TO-126	КТ817В
BD178	TO-126	КТ816В
BD179	TO-126	КТ817Г
BD180	TO-126	КТ816Г
BD181	TO-3	КТ819БМ
BD182	TO-3	КТ819ВМ
BD183	TO-3	КТ819ГМ
BD201	TO-220	КТ819В
BD202	TO-220	КТ818Б
BD203	TO-220	КТ819Г
BD204	TO-220	КТ818В
BD216	MD-17	КТ809А
BD220	TO-220	КТ817Г
BD221	TO-220	КТ817В
BD222	TO-220	КТ817Г
BD223	TO-220	КТ837Н
BD224	TO-220	КТ837Ф
BD225	TO-220	КТ837С
BD226	TO-126	КТ943А
BD227	TO-126	КТ639Б
BD228	TO-126	КТ943Б
BD229	TO-126	КТ639Д
BD230	TO-126	КТ943В
BD233	TO-126	КТ817Б
BD234	TO-126	КТ816Б
BD235	TO-126	КТ817В
BD236	TO-126	КТ816В
BD237	TO-126	КТ817Г
BD238	TO-126	КТ816Г
BD239	TO-126	КТ817В
BD239A	TO-126	КТ817В
BD239B	TO-126	КТ817Г
BD240	TO-220	КТ816В
BD240A	TO-220	КТ816В
BD240B	TO-220	КТ816Г
BD246	X-86	КТ818 (АМ—ГМ)
BD253	TO-3	КТ809А
BD263	TO-126	КТ829Б
BD263A	TO-126	КТ829А
BD265	TO-220	КТ829Б
BD265	TO-220	КТ829А
BD267	TO-220	КТ829Б
BD267A	TO-220	КТ829А
BD291	SOT-82	КТ819А
BD292	SOT-82	КТ818А
BD293	SOT-82	КТ819Б
BD294	SOT-82	КТ818Б
BD295	SOT-82	КТ819В
BD296	SOT-82	КТ818В
BD331	SOT-82	КТ829В
BD333	SOT-82	КТ829Б
BD335	SOT-82	КТ829А
BD375	TO-126	КТ943А
BD377	TO-126	КТ943Б
BD379	TO-126	КТ943В
BD386	TO-202	КТ644Б
BD433	TO-126	КТ817А
BD434	TO-126	КТ816А
BD435	TO-126	КТ817А
BD436	TO-126	КТ816А
BD437	TO-126	КТ817Б
BD438	TO-126	КТ816Б
BD439	TO-126	КТ817В
BD440	TO-126	КТ816В
BD441	TO-126	КТ817Г
BD442	TO-202	КТ816Г
BD533	TO-220	КТ819Б
BD534	TO-220	КТ818Б
BD535	TO-220	КТ819В
BD536	TO-220	КТ818В
BD537	TO-220	КТ819Г
BD538	TO-220	КТ818Г
BD611	TO-202	КТ817А
BD612	TO-202	КТ816А
BD613	TO-202	КТ817А
BD614	TO-202	КТ816А
BD615	TO-202	КТ817Б
BD616	TO-202	КТ816Б
BD617	TO-202	КТ817В
BD618	TO-202	КТ816В
BD619	TO-202	КТ817Г
BD620	TO-202	КТ816Г
BD643	TO-220	КТ829В
BD645	TO-220	КТ829Б
BD647	TO-220	КТ829А
BD663	TO-220	КТ819А
BD664	TO-220	КТ818Б
BD675	TO-126	КТ829Г
BD675A	TO-126	КТ829Г
BD677	TO-126	КТ829В
BD677A	TO-126	КТ829В
BD679	TO-126	КТ829Б
BD679A	TO-126	КТ829Б
BD681	TO-126	КТ829А
BD705	TO-220	КТ819А
BD706	TO-220	КТ818Б
BD707	TO-220	КТ819В
BD708	TO-220	КТ818В
BD709	TO-220	КТ819Г
BD710	TO-220	КТ818Г
BD711	TO-220	КТ819Г
BD712	TO-220	КТ818Г
BD813	SOT-128	КТ815А
BD814	SOT-128	КТ814А
BD815	SOT-128	КТ815Б
BD816	SOT-128	КТ814В
BD817	SOT-128	КТ815В

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус	
BD818	SOT-128	КТ814Г
BD825	SOT-128	КТ646А
BD826	SOT-128	КТ639Б
BD827	SOT-128	КТ646А
BD828	SOT-128	КТ639Д
BD840	SOT-128	КТ639В
BD842	SOT-128	КТ639Д
BD933	TO-220	КТ817Б
BD934	TO-220	КТ816Б
BD935	TO-220	КТ817В
BD936	TO-220	КТ816В
BD937	TO-220	КТ817Г
BD938	TO-220	КТ816Г
BD944	TO-220	КТ837Ф
BD946	TO-220	КТ837Ф
BD948	TO-220	КТ837Ф
BD949	TO-220	КТ819Б
BD950	TO-220	КТ818Б
BD951	TO-220	КТ819В
BD952	TO-220	КТ818В
BD953	TO-220	КТ819Г
BD954	TO-220	КТ819Г
BDT91	TO-220	КТ819Б
BDT92	TO-220	КТ818Б
BDT93	TO-220	КТ819В
BDT94	TO-220	КТ818В
BDT95	TO-220	КТ819Г
BDT96	TO-220	КТ818Г
BDV91	SOT-93	КТ819Б
BDV92	SOT-93	КТ818Б
BDV93	SOT-93	КТ819В
BDV94	SOT-93	КТ818В
BDV95	SOT-93	КТ819Г
BDV96	SOT-93	КТ818Г
BDW21	TO-3	КТ819АМ
BDW21A	TO-3	КТ819БМ
BDW21B	TO-3	КТ819ВМ
BDW21C	TO-3	КТ819ГМ
BDW22	TO-3	КТ818БМ
BDW22A	TO-3	КТ818ВМ
BDW22B	TO-3	КТ818ГМ
BDW22C	TO-3	КТ818ГМ
BDW23	TO-220	КТ829Г
BDW23A	TO-220	КТ829В
BDW23B	TO-220	КТ829Б
BDW23C	TO-220	КТ829А
BDW51	TO-3	КТ819АМ
BDW51A	TO-3	КТ819ВМ
BDW51B	TO-3	КТ819ГМ
BDW51C	TO-3	КТ819ГМ
BDW52	TO-3	КТ818БМ
BDW52A	TO-3	КТ818ВМ
BDW52B	TO-3	КТ818ГМ
BDW52C	TO-3	КТ818ГМ
BDX10	TO-3	КТ819ГМ
BDX10C	TO-3	КТ819ГМ
BDX13C	TO-3	КТ819БМ
BDX18	TO-3	КТ818ГМ
BDX25	MD-17	КТ802А
BDX25	MD-17	КТ808А
BDX53	TO-220	КТ829Г
BDX53A	TO-220	КТ829В
BDX53B	TO-220	КТ829Б
BDX53C	TO-220	КТ829А
BDX62	TO-3	КТ825Д
BDX62A	TO-3	КТ825Г
BDX62B	TO-3	КТ825Г
BDX63	TO-3	КТ827Б
BDX63A	TO-3	КТ827А
BDX64	TO-3	КТ825Д
BDX64A	TO-3	КТ825Г
BDX64B	TO-3	КТ825Г
BDX65	TO-3	КТ827Б
BDX65A	TO-3	КТ827А
BDX66	TO-3	КТ825Д
BDX66A	TO-3	КТ825Г
BDX66B	TO-3	КТ825Г
BDX67	TO-3	КТ827Б
BDX67A	TO-3	КТ827А
BDX71	TO-220	КТ819В
BDX73	TO-220	КТ819Г
BDX77	TO-220	КТ819Г
BDX78	TO-220	КТ818Г
BDX85	TO-3	КТ827В
BDX85A	TO-3	КТ827В
BDX85B	TO-3	КТ827Б
BDX85C	TO-3	КТ827А
BDX86	TO-3	КТ825Б
BDX86A	TO-3	КТ825Б
BDX86B	TO-3	КТ825Г
BDX86C	TO-3	КТ825Г
BDX87	TO-3	КТ827В
BDX87A	TO-3	КТ827В
BDX87B	TO-3	КТ827Б
BDX87C	TO-3	КТ827А
BDX88	TO-3	КТ825Д
BDX88A	TO-3	КТ825Д
BDX88B	TO-3	КТ825Г
BDX88C	TO-3	КТ825Г
BDX91	TO-3	КТ819БМ
BDX92	TO-3	КТ818БМ
BDX93	TO-3	КТ819БМ
BDX94	TO-3	КТ818ВМ
BDX95	TO-3	КТ819ГМ
BDX96	TO-3	КТ818ГМ
BDY12	MD-17	КТ805Б
BDY13	MD-17	КТ805Б
BDY20	TO-3	КТ819ГМ
BDY23	TO-3	КТ803А
BDY24	TO-3	КТ803А
BDY25	TO-3	КТ812В
BDY34	TO-126	КТ943А
BDY38	TO-3	КТ819ГМ
BDY60	TO-3	КТ805А
BDY61	TO-3	КТ805Б
BDY71	TO-66	КТ808БМ
BDY72	TO-66	КТ802А
BDY73	TO-3	КТ819ГМ
BDY78	TO-66	КТ805Б
BDY79	TO-66	КТ802А
BDY90	TO-3	КТ945А, КТ908А
BDY91	TO-3	КТ945А, КТ908А
BDY92	TO-3	КТ908А, КТ908Б
BDY93	TO-3	КТ704Б, КТ828
BDY94	TO-3	КТ812А, КТ704Б
BDY95	TO-3	КТ704Б
BF111	TO-39	КТ611А
BF114	TO-5	КТ611Г
BF137	TO-39	КТ611Г
BF140A	TO-5	КТ611В
BF173	TO-72	КТ339В
BF177	TO-39	КТ602А
BF178	TO-39	КТ611Г

Продолжение

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус	
BF179B	TO-5	КТ611Б
BF179C	TO-39	КТ618А
BF186	TO-1	КТ611Г
BF197	MM-10	КТ339Г
BF199	TO-92	КТ339АМ
BF208	TO-72	КТ339А
BF223	MM-10	КТ339В
BF240	TO-18	КТ312В
BF254	TO-92	КТ339АМ
BF257	TO-39	КТ611Г
BF258	TO-39	КТ604Б, КТ940Б
BF259	TO-39	КТ604Б
BF273	TO-72	КТ339А
BF291	TO-5	КТ611Г
BF297	X-55	КТ940В
BF298	X-55	КТ940А
BF299	X-55	КТ940А
BF305	TO-39	КТ611Г
BF306	TO-72	КТ339В
BF311	TO-92	КТ339Б
BF330	SOT-25	КТ339В
BF336	TO-5	КТ611Г
BF337	TO-39	КТ604Б
BF338	TO-39	КТ940А
BF457	TO-126	КТ940В
BF458	TO-126	КТ940Б
BF459	TO-126	КТ940А
BF469	TO-126	КТ940Б
BF470	TO-126	КТ940А
BF471	TO-126	КТ605БМ, КТ940А
BF480	SOT-37	КТ3120А
BF615	TO-202	КТ940Б
BF617	TO-202	КТ940А
BF680	TO-50	КТ3109А
BF970	SOT-37	КТ3109В
BF979	SOT-37	КТ3109А
BFJ57	TO-5	КТ602Б
BFJ70	TO-72	КТ339В
BFJ93	TO-18	КТ342Б
BFJ98	TO-5	КТ611Г
BFP177	TO-39	КТ611В
BFP178	TO-39	КТ611Г
BFP179A	TO-39	КТ611Г
BEP179B	TO-39	КТ611Б
BFP179C	TO-39	КТ618А
BFP719	MM-10	КТ315А
BFP720	MM-10	КТ315Б
BFP721	MM-10	КТ315В
BFP722	MM-10	КТ315Г
BFR34	TO-50	КТ372Б
BFR34A	TO-50	КТ372Б
BFR90	SOT-37	КТ371А
BFS62	TO-72	КТ368А
BFW16	TO-39	КТ610А
BFW30	TO-72	КТ399А
BFW45	TO-39	КТ611Г
BFW89	MM-10	КТ351Б
BFW90	MM-10	КТ351Б
BFW91	MM-10	КТ351Б
BFW92	SOT-37	КТ382Б
BFX12	TO-18	КТ326АМ
BFX13	TO-18	КТ326БМ
BFX29	TO-5	КТ933Б
BFX30	TO-5	КТ933Б
BFX44	TO-18	КТ340В
BFX65	TO-18	КТ3102Е
BFX73	TO-72	КТ368А
BFX84	TO-5	КТ630Г
BFX85	TO-5	КТ630Г
BFX86	TO-5	КТ630Д
BFX87	TO-5	КТ933Б
BFX88	TO-5	КТ933Б
BFX89	TO-72	КТ355А
BFX94	TO-18	КТ3117А
BFY19	TO-18	КТ326Б
BFY34	TO-39	КТ630Г
BFY45	TO-39	КТ611Г
BFY46	TO-39	КТ630Д
BFY50	TO-39	КТ630Г
BFY51	TO-39	КТ630Д
BFY52	TO-39	КТ630Д
BFY53	TO-39	КТ630Д
BFY55	TO-39	КТ630Г
BFY56	TO-5	КТ630Г
BFY56A	TO-39	КТ630Г
BFY56B	TO-39	КТ630Г
BFY65	TO-39	КТ611Г
BFY66	TO-18	КТ355А
BFY67A	TO-5	КТ630А
BFY67C	TO-5	КТ630А
BFY68	TO-39	КТ630Е
BFY68A	TO-5	КТ630Б
BFY78	TO-72	КТ368А
BFY80	TO-18	П308, КТ601А
BFY90	TO-72	КТ399А
BLW18	TO-117	КТ920Б
BLW24	TO-117	КТ922Г
BLX92	MT-84	КТ913А
BLX93	MT-84	КТ913Б
BLY47	TO-3	КТ808А
BLY47A	TO-66	КТ808А
BLY48	TO-3	КТ808А
BLY48A	TO-66	КТ808А
BLY49	TO-3	КТ809А
BLY49A	TO-66	КТ809А
BLY50	TO-3	КТ809А
BSW52	TO-39	КТ928Б
BSW61	TO-18	КТ3117А
BSW62	TO-18	КТ3117А
BSW65	TO-39	КТ630Г
BSW66	TO-5	КТ630Г
BSW66A	TO-5	КТ630Г
BSW67	TO-5	КТ630А
BSW67A	TO-5	КТ630А
BSW68	TO-39	КТ630В
BSW68A	TO-39	КТ630В
BSW88A	X-73	КТ375А
BSX21	TO-18	П308
BSX32	TO-39	КТ928Б
BSX38	TO-18	КТ802АМ
BSX38A	TO-18	КТ340А
BSX45	TO-39	КТ630Г
BSX45-6	TO-39	КТ630Г
BSX45-10	TO-39	КТ630Г
BSX45-16	TO-39	КТ630Б
BSX46	TO-39	КТ630Г
BSX46-6	TO-39	КТ630Г
BSX46-10	TO-39	КТ630Г
BSX46-16	TO-39	КТ630Б
BSX47	TO-39	КТ630Б
BSX47-6	TO-39	КТ630А
BSX47-10	TO-39	КТ630Б
BSX51	TO-18	КТ340В

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус	
BSX52	TO-18	KT340B
BLY50A	TO-66	KT809A
BLY63	TO-117	KT920Г
BLY88A	MT-72	KT920Г
BSJ36	TO-18	KT351Б
BSJ63	TO-18	KT340Б
BSS27	TO-5	KT928A
BSS28	TO-5	KT928Б
BSS29	TO-5	KT928A
BSS38	TO-92	KT503E, KT602AM
BSS42	TO-39	KT630A
BSS68	TO-92	KT502E
BSV15-6	TO-39	KT639Г
BSV15-10	TO-39	KT639Д
BSV15-165	TO-39	KT639B
BSV16	TO-39	KT639Д
BSV49A	TO-18	KT351Б
BSV59-VIII	TO-18	KT3117A
BSW19	TO-18	KT343Б
BSW20	TO-92	KT361Г
BSW21	TO-18	KT343Б
BSW27	TO-39	KT928A
BSW36	TO-5	KT603Б
BSW39-6	TO-39	KT630Г
BSW39-10	TO-39	KT630Г
BSW39-16	TO-39	KT630Г
BSW41	TO-18	KT616A
BSW51	TO-39	KT928Б
BSX53A	TO-18	KT340A
BSX59	TO-5	KT928A
BSX60	TO-5	KT928A
BSX61	TO-5	KT928A
BSX62	TO-39	KT801Б
BSX63	TO-39	KT801A
BSX66	TO-18	KT306Д, KT306A
BSX67	TO-18	KT306Д, KT306A
BSX72	TO-5	KT630Д
BSX75	TO-18	KT3117A
BSX79A	TO-18	KT342A, KT3117A
BSX79B	TO-18	KT342Б
BSX80	MM-11	KT375Б
BSX81A	MM-11	KT375A
BSX89	TO-18	KT616A
BSX97	TO-18	KT3117A
BSXP59	TO-39	KT928A
BSXP60	TO-39	KT928A
BSXP61	TO-39	KT928A
BSXP87	TO-18	KT340B
BSY17	TO-18	KT616Б
BSY18	TO-18	KT616Б
BSY26	TO-18	KT340B
BSY27	TO-18	KT340B
BSY34	TO-39	KT608A
BSY38	TO-18	KT340B
BSY39	TO-18	KT340Б
BSY40	TO-18	KT343A
BSY41	TO-18	KT343Б
BSY51	TO-39	KT630Д
BSY52	TO-39	KT630E
BSY53	TO-39	KT630Г
BSY54	TO-39	KT630Г
BSY55	TO-39	KT630A
BSY56	TO-39	KT630Б
BSY58	TO-39	KT608A
BSY62	TO-18	KT616Б
BSY72	TO-18	KT352A
BSY73	TO-18	KT312Б
BSY79	TO-18	П309
BSY95	TO-18	KT340B
BSY95A	TO-18	KT340B
BSYP62	TO-18	KT340B
BSYP63	TO-18	KT340B
BSZ10	TO-18	KT104Б
BSZ11	TO-18	KT104Б
BSZ12	TO-18	KT203A
BU106	TO-3	KT812Б
BU108	TO-3	KT839A
BU120	TO-3	KT809A
BU123	TO-3	KT802A
BU126	TO-3	KT704Б, KT828A
BU129	TO-3	KT809A
BU132	TO-3	KT704A
BU133	TO-3	KT704Б, KT828A
BU204	TO-3	KT838A
BU205	TO-3	KT838A
BU207	TO-3	KT838A
BU207A	TO-3	KT838A
BU208A	TO-3	KT838A
BU326	TO-3	KT840A
BU326A	TO-3	KT828A
BU409	TO-3	KT812Б
BU606	TO-3	KT840A
BU607	TO-3	KT840Б
BU608	TO-3	KT848A
BUX77	TO-66	KT908A
BUX82	TO-3	KT812A
BUX83	TO-3	KT812A
BUX97	TO-3	KT828A
BUX97A	TO-3	KT828A
BUX97B	TO-3	KT828A
BUY18	TO-3	KT840A
BUY43	MD-17	П702
BUY46	MD-17	П702A
BUY55	TO-3	KT808A
BUYP52	TO-3	KT802A
BUYP53	TO-3	KT802A
BUYP54	TO-3	KT802A
D41D1	X-51	KT626A
D41D4	X-51	KT626Б
D41D7	X-51	KT626B
EFT212	TO-3	П216
EFT213	TO-3	П216
EFT214	TO-3	П217
EFT250	TO-3	П217
EFT306	TO-1	МП40
EFT307	TO-1	МП40
EFT308	TO-18	KT208Б
EFT311	TO-1	МП20A
EFT312	TO-1	МП20A
EFT313	TO-1	МП20Б
EFT317	TO-1	П401
EFT319	TO-1	П401
EFT320	TO-1	П401
EFT321	TO-1	МП20A

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
EFT322	TO-1	МП20А	GF504	TO-18	ГТ313А
EFT323	TO-1	МП20Б	GF505	TO-72	ГТ328Б
EFT331	TO-1	МП20А	GF506	TO-72	ГТ328Б
EFT332	TO-1	МП20А	GF507	TO-72	ГТ346Б
EFT333	TO-1	МП20Б	GF514	TO-72	ГТ322А
EFT341	TO-1	МП21Д	GF514	TO-72	ГТ313Б
EFT342	TO-1	МП21Д	GF515	TO-72	ГТ322А
EFT343	TO-1	МП21Д	GF516	TO-72	ГТ322А
GC100	A-1	ГТ109А	GF517	TO-72	ГТ322Б
GC101	A-1	ГТ109А	GFY50	TO-7	ГТ322Б
GC112	A-1	МП26А	GS109	A-1	МП42А
GC116	A-1	МГТ108Д	GS111	A-1	МП42Б
GC117	A-1	МГТ108Д	GS112	A-1	МП25А
GC118	A-1	МГТ108Д	GS121	A-1	МП42
GC121	A-2	МП20А	KC147	MM-10	КТ373А, КТ373Б
GC121	A-2	МП39Б	KC148	MM-10	КТ373А, КТ373Б
GC122	A-2	МП20А	KC149	MM-10	КТ373Б, КТ373В
GC123	A-2	МП21Г	KC507	TO-18	КТ342Б
GC500	A-6	ГТ402Д	KC508	TO-18	КТ342Б
GC501	A-6	ГТ402Е	KC509	TO-18	КТ342Б
GC502	A-6	ГТ402И	KD601	TO-3	КТ803А
GC507	A-6	МП20А	KD602	TO-3	КТ808А
GC508	A-6	МП20Б	KF173	TO-72	КТ339В
GC509	A-6	МП21Г	KF503	TO-5	КТ602Б
GC510K	A-7	ГТ403Е	KF504	TO-5	КТ611Г
GC512K	A-7	ГТ403Е	KF507	TO-5	КТ617А
GC515	A-6	МП20А	KSA539R	TO-92	КТ502В
GC516	A-6	МП20А	KSA539O	TO-92	КТ502Г
GC517	A-6	МП20Б	KSA539Y	TO-92	КТ502Г
GC518	A-6	МП20Б	KSA545R	TO-92	КТ502Д
GC519	A-6	МП20Б	KSA545O	TO-92	КТ502(Г, Д)
GC525	A-6	МП36А	KSA545Y	TO-92	КТ502(Г, Д)
GC525	A-6	МП35А	KSC853R	TO-92	КТ503(Г, Д)
GC526	A-6	МП36А, МП37А	KSC853O	TO-92	КТ503Г
GC527	A-6	МП36А, МП38А	KSC853Y	TO-92	КТ503Г
GCN55	A-6	МП20А	KSD227O	TO-92	КТ503Б
GCN56	A-6	МП21Г	KSD227Y	TO-92	КТ503Б
CD160	SOT-9	П213Б	KSY21	TO-18	КТ616Б
GD170	SOT-9	П213Б	KSY34	TO-5	КТ608А
GD175	SOT-9	П213Б	KSY62	TO-18	КТ606Б
GD180	SOT-9	П214А	KSY63	TO-18	КТ616Б
GD240	SOT-9	П213	KSY81	TO-18	КТ347Б
GD241	SOT-9	П213	KU601	TO-3	КТ801Б
GD242	SOT-9	П214А	KU602	TO-3	КТ801А
GD243	SOT-9	П214А	KU605	TO-3	КТ812В
GD244	SOT-9	П215	KU606	TO-3	КТ808А
GD607	SOT-9	ГТ404Г	KU607	TO-3	КТ812В
GD608	SOT-9	ГТ404Б	KU611	SOT-9	КТ801Б
GD609	SOT-9	ГТ404Б	KU612	SOT-9	КТ801А
GD617	SOT-9	П201АЭ	KUY12	TO-3	КТ812В
GD618	SOT-9	П201АЭ	MA909	TO-5	МП26А
GD619	SOT-9	П203Э	MA910	TO-5	МП26А
GF126	A-3	ГТ309Г	MJ420	TO-5	КТ618А
GF128	A-3	ГТ309Б	MJ480	TO-3	КТ803А
GF130	A-3	ГТ309Д	MJ481	TO-3	КТ803А
GF145	A-4	ГТ346А	MJ2500	TO-3	КТ825Д
GF147	A-4	ГТ346А	MJ2501	TO-3	КТ825Г
GF501	TO-18	ГТ313Б	MJ3000	TO-3	КТ827В
GF502	TO-18	ГТ313А	MJ3001	TO-3	КТ827Б
GF503	TO-18	ГТ313Б	MJ3480	TO-3	КТ839А
			MJ3520	TO-3	КТ827В
			MJ3521	TO-3	КТ827А
			MJ4030	TO-3	КТ825Д
			MJ4031	TO-3	КТ825Г
			MJ4032	TO-3	КТ825Г
			MJ4033	TO-3	КТ827В
			MJ4034	TO-3	КТ827Б
			MJ4035	TO-3	КТ827А

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
MJE3055	TO-220	КТ819Б	OC35	TO-3	П217
MM404	TO-18	МП42Б	OC41	R-8	П29
MM1748	TO-52	КТ316А	OC42	R-8	П29А
MM3000	TO-39	КТ602А	OC57	R-19	ГТ109А
MM3001	TO-39	КТ611В	OC58	R-19	ГТ109Б
MM3375	TO-60	КТ904Б	OC59	R-19	ГТ109В
MM8006	TO-72	КТ399А	OC60	R-19	ГТ109В
MM8007	TO-72	КТ399А	OC70	R-9	МП40А
MMT2857	SOT-37	КТ382Б	OC71	R-9	МП40А
MM8015	SOT-37	КТ382А	OC75	R-9	МП40А, МП41А
MPS404	TO-92	КТ209Е	OC76	R-8	МП40А
MPS404A	TO-92	КТ209К	OC77	R-8	МП26Б
MPS706	TO-92	КТ645А	OC169	TO-7	ГТ322Б
MPS706A	TO-92	КТ375А	OC170	TO-7	ГТ309Г, ГТ322Б
MPS834	TO-92	КТ306ВМ	OC171	TO-7	ГТ309Г
MPS2711	TO-92	КТ503А	OC200	R-8	КТ104Г
MPS2712	TO-92	КТ503Б	OC201	R-8	КТ104Б
MPS2713	TO-92	КТ306БМ	OC202	R-8	КТ104В
MPS2714	TO-92	КТ306БМ	OC203	R-8	КТ203А
MPS3638	TO-92	КТ351А	OC204	R-8	КТ208Г
MPS3638A	TO-92	КТ351А	OC205	R-8	КТ208Л
MPS3639	TO-92	КТ357А	OC206	R-8	КТ208Г
MPS3640	TO-92	КТ347Б	OC207	R-8	КТ208А
MPS3702	TO-92	КТ3107Д	OC1016	TO-3	ГТ703В
MPS3703	TO-92	КТ3107А	OC1044	TO-1	ГТ109Е
MPS3705	TO-92	КТ645А	OC1045	TO-1	ГТ109Д
MPS3707	TO-92	КТ3102Д	OC1070	TO-1	МП40А
MPS3708	TO-92	КТ3102В	OC1071	TO-1	МП40А, МП39Б
MPS3709	TO-92	КТ3102А	OC1072	TO-1	МП41А, МП39Б
MPS3710	TO-92	КТ3102В	OC1074	TO-1	МП20А
MPS3711	TO-92	КТ3102Г	OC1075	TO-1	МП41А, МП39Б
MPS6512	TO-92	КТ3102Д	OC1076	R-8	МП42Б, МП20А
MPS6513	TO-92	КТ3102Д	OC1077	TO-1	МП21Г
MPS6514	TO-92	КТ3102Д	OC1079	TO-1	МП20А
MPS6515	TO-92	КТ3102Д	PBC107A	TO-98	КТ373А
MPS6516	TO-92	КТ3107Е	PBC107B	TO-98	КТ373Б
MPS6517	TO-92	КТ3107Е	PBC108A	TO-98	КТ373А
MPS6518	TO-92	КТ3107Ж	PBC108B	TO-98	КТ373В
MPS6519	TO-92	КТ3107Л	PBC108C	TO-98	КТ373В
MPS6530	TO-92	КТ645А	PBC109B	TO-98	КТ373Б
MPS6532	TO-92	КТ645А	PBC109C	TO-98	КТ373В
MPS6562	TO-92	КТ350А	PN2484	TO-92	КТ3102(Б, Д)
MPS6563	TO-92	КТ350А	ПТ6670	TO-129	КТ909Г
MPS6565	TO-92	КТ645А	PT6680	TO-129	КТ909В
MPS6566	TO-92	КТ645А	RFD401	TO-60	КТ606Б
MPS6571	TO-92	КТ3102Г	RFD410	TO-129	КТ913А
MPSA09	TO-92	КТ3102Б	RFD420	TO-129	КТ913Б
MPS-H37	TO-92	КТ339АМ	RFD421	TO-60	КТ904А
MPSL07	TO-92	КТ363А	SC206D	A-5	КТ373А
MPSL08	TO-92	КТ363А	SC206E	A-5	КТ373Б
MPSU01	X-81	КТ807Б	SC206F	A-5	КТ373В
MPSU01A	X-81	КТ807Б	SC207D	A-5	КТ373А
MPSU05	X-81	КТ807Б	SC207E	A-5	КТ373Б
MPSU06	X-81	КТ807Б	SC207F	A-5	КТ373Б
MPSU07	X-81	КТ807А	SD1300	TO-72	КТ399А
MPSU51	X-81	КТ639Б	SD1301	TO-72	КТ399А
MPSU51A	X-81	КТ639Б	SDN6000	TO-3	КТ834В
MPSU55	X-81	КТ639Г	SDN6001	TO-3	КТ834Б
MPSU56	X-81	КТ639Б, КТ626Б	SDN6002	TO-3	КТ834А
MSA7505	TO-60	КТ907А	SDN6251	TO-3	КТ834В
NE1010E	TO-128	КТ913Б	SDN6252	TO-3	КТ834Б
NKT11	TO-1	МГТ108Г	SDN6253	TO-3	КТ834А
NKT73	TO-1	МГТ108Б	SDT3207	TO-61	КТ908Б
OC25	TO-3	П216	SDT3208	TO-61	КТ908А
OC26	TO-3	ГТ703Д	SDT7012	TO-61	КТ908Б
OC27	TO-3	ГТ703Г	SDT7013	TO-61	КТ908А
OC28	TO-3	П217	SF21	TO-5	КТ617А
OC30	MD-11	П201Э	SF22	TO-5	КТ617А

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
SF121A	TO-5	КТ617А	SFT352	TO-1	МП39Б
SF121B	TO-5	КТ617В	SFT353	TO-1	МП39Б
SF122A	TO-5	КТ617А	SFT354	TO-44	П422
SF122B	TO-5	КТ617А	SFT357	TO-44	П422
SF123A	TO-5	КТ602В	SFT358	TO-44	П423
SF123B	TO-5	КТ602Г	SFT377	TO-1	ГТ404Ж
SF123C	TO-5	КТ602Г	SS106	TO-18	КТ340В
SF126A	TO-5	КТ617А	SS108	TO-18	КТ340В
SF126B	TO-5	КТ617А	SS109	TO-18	КТ340В
SF126C	TO-5	КТ617А	SS125	TO-5	КТ617А
SF128A	TO-5	КТ630Г	SS126	TO-5	КТ608А
SF128B	TO-5	КТ630Г	SS216	A-5	КТ375Б, КТ340Г
SF128C	TO-5	КТ630Г	SS218	A-5	КТ375Б, КТ349Г
SF128D	TO-5	КТ630Г	SS219	A-5	КТ375Б, КТ340Г
SF129A	TO-5	КТ630А	SSY20	TO-5	КТ617А
SF129B	TO-5	КТ630А	T241	TO-1	МП20А
SF129C	TO-5	КТ630А	T242	TO-1	МП21В
SF129D	TO-5	КТ630Б	T243	TO-1	МП21Г
SF131E	A-4	КТ3102В	T316H	TO-1	П402, П416А
SF131F	A-4	КТ3102Г	T317	TO-1	П401
SF132E	A-4	КТ3102Б	T319	TO-1	П401
SF132F	A-4	КТ3102Г	T320	TO-1	П401
SF136D	TO-18	КТ342А	T321N	TO-1	МП38, МП37А
SF136E	TO-18	КТ342Б	T322N	TO-1	МП37Б
SF136F	TO-18	КТ342В	T323N	TO-1	МП38А
SF137D	TO-18	КТ342А	T354H	TO-1	П403, П416А
SF137E	TO-18	КТ342Б	T357H	TO-1	П403А
SF137F	TO-18	КТ342В	T358H	TO-1	П403
SF150B	TO-5	КТ611Г	TCH98	TO-18	КТ208Е
SF150C	TO-5	КТ611Г	TCH98B	TO-5	КТ501К
SF215C	A-5	КТ375Б, КТ373А	TCH99	TO-18	КТ208К
SF215D	A-5	КТ373А	TCH99B	TO-5	КТ501М
SF215E	A-5	КТ373Б	TG2	TO-18	МГТ108А
SF216C	A-5	КТ375А, КТ373Г	TG3A	TO-18	МГТ108В
SF216D	A-5	КТ373А	TG3F	TO-18	МГТ108Г
SF216E	A-5	КТ373Б	TG4	TO-18	МГТ108А
SFT124	R-13	КТ501Е	TG5	TO-18	ГТ115Б
SFT125	R-13	КТ501Е	TG5E	TO-18	ГТ115А, П27
SFT130	R-13	КТ501Е	TG50	TO-5	МП20А
SFT131	R-13	КТ501Е	TG51	TO-5	МП21Г
SFT143	R-13	КТ501Ж	TG52	TO-5	МП20А
SFT144	R-13	КТ501И	TG53	TO-5	МП20А
SFT145	R-13	КТ501Ж	TG55	TO-5	МП20А
SFT146	R-13	КТ501И	T1P29	TO-220	КТ815А
SFT163	TO-44	П423	T1P29A	TO-220	КТ815Б
SFT187	TO-5	КТ602А	T1P29B	TO-220	КТ815В
SFT212	TO-3	ГТ703Г	T1P29C	TO-220	КТ815Г
SFT213	TO-3	ГТ703Г	T1P30	TO-220	КТ814А
SFT214	TO-3	П217	T1P30A	TO-220	КТ814Б
SFT223	TO-5	МП20Б	T1P30B	TO-220	КТ814В
SFT238	TO-3	П216	T1P30C	TO-220	КТ814Г
SFT239	TO-3	П217	T1P31	TO-220	КТ817А
SFT240	TO-3	П217	T1P31A	TO-220	КТ817Б
SFT250	TO-3	П217, ГТ701А	T1P31B	TO-220	КТ817В
SFT251	TO-5	МП20А, МП39Б	T1P31C	TO-220	КТ817Г
SFT252	TO-5	МП20А, МП39Б	T1P32	TO-220	КТ816А
SFT253	TO-5	МП20А, МП39Б	T1P32A	TO-220	КТ816Б
SFT306	TO-1	МП39Б	T1P32B	TO-220	КТ816В
SFT307	TO-1	КТ208В	T1P32C	TO-220	КТ816Г
SFT308	TO-1	КТ208В	T1P41	TO-220	КТ819А
SFT316	T-44	П422	T1P41A	TO-220	КТ819Б
SFT319	TO-1	П416	T1P41B	TO-220	КТ819В
SFT320	TO-1	П416	T1P41C	TO-220	КТ819Г
SFT321	TO-1	МП20А	T1P61	TO-220	КТ815А
SFT322	TO-1	МП20Б	T1P61A	TO-220	КТ815Б
SFT323	TO-1	МП20Б	T1P61B	TO-220	КТ815В
SFT325	X-47	ГТ402И	T1P61C	TO-220	КТ815Г
SFT351	TO-1	МП39Б	T1P62	TO-220	КТ814А

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
T1P62A	TO-220	КТ814Б	2N445A	TO-5	МП37
T1P62B	TO-220	КТ814В	2N456	TO-3	П210В
T1P62C	TO-220	КТ814Г	2N457	TO-3	П210Б
T1XM101	TO-72	ГТ341А	2N458	TO-3	П210Б
T1XM103	X-60	ГТ362А	2N497	TO-5	КТ630Д
T1XM104	X-60	ГТ341В	2N498	TO-5	КТ630Г
T1X3024	U-26	ГТ341Б	2N499A	TO-1	ГТ305А
ZT2475	R-64	КТ316Б	2N501	TO-1	ГТ305А
2N43	R-32	МП25Б	2N502A	TO-9	ГТ313А
2N44	R-32	МП25Б	2N502B	TO-9	ГТ313А
2N44A	R-32	МП40А	2N503	TO-9	ГТ310Б
2N45	TO-29	МП40А	2N506	TO-22	ГТ115Б
2N45A	TO-29	МП40А	2N535A	TO-23	ГТ115В
2N59	TO-5	МП20А, МП20Б	2N535B	TO-23	ГТ115В
2N59A	TO-5	МП20А, МП20Б	2N536	TO-23	ГТ115Г
2N59B	TO-5	МП21Д	2N554	TO-3	П216В
2N59C	TO-5	МП21Д	2N555	TO-3	П216В
2N60	TO-5	МП20Б	2N560	TO-29	П307В
2N60A	TO-5	МП21В	2N581	TO-5	МП42А
2N60B	TO-5	МП21Д	2N591	TO-1	ГТ115Г
2N60C	TO-5	МП21Г	2N602	TO-5	П416
2N61	TO-5	МП20А	2N603	TO-5	П416
2N61A	TO-5	МП20В	2N604	TO-5	П416А
2N61B	TO-5	МП21Д	2N653	TO-5	МП20А
2N61C	TO-5	МП21Г	2N654	TO-5	МП20А
2N65	OV-4	МП20А	2N655	TO-5	МП20Б
2N77	TO-2	ГТ109Б	2N656	TO-5	КТ630Д
2N94	TO-2	МП38	2N657	TO-5	КТ630Г
2N104	TO-40	МП40А	2N696	TO-5	КТ630Д
2N105	TO-2	ГТ109Б	2N697	TO-39	КТ630Д
2N107	R-31	ГТ115А	2N698	TO-39	КТ630А
2N109	TO-40	МП20Б	2N699	TO-39	КТ630А
2N123	R-32	МП42Б	2N700	TO-72	ГТ313Б, ГТ376А
2N128	TO-24	ГТ310Д	2N700A	TO-17	ГТ376А
2N130	TO-5	МГТ108А	2N702	TO-18	КТ312А
2N131	TO-5	МГТ108Б	2N703	TO-5	КТ312В
2N131A	OV-16	МГТ108Б	2N705	TO-18	ГТ320В
2N132	TO-5	МГТ108В	2N706A	TO-18	КТ340В
2N132A	OV-16	МГТ108В	2N708	TO-18	КТ340В
2N133	TO-5	МГТ108Б	2N709	TO-18	КТ316Б
2N139	TO-40	ГТ109Е	2N709A	TO-18	КТ316Б
2N175	TO-40	П27	2N710	TO-18	КТ320В
2N178	TO-3	П216Б	2N711	TO-18	ГТ320В
2N186A	R-32	МП25Б, МП20А	2N711A	TO-18	ГТ320Б
2N189	R-32	МП25А	2N711B	TO-18	ГТ320Б
2N190	R-32	МП25А	2N726	TO-18	КТ349А
2N191	R-32	МП25Б	2N727	TO-18	КТ349Б
2N193	TO-22	МП38	2N728	TO-18	КТ312В
2N206	TO-5	МГТ108А	2N729	TO-18	КТ312Б
2N207	TO-5	МГТ108Г	2N734	TO-18	П307, КТ601А
2N207A	TO-5	МГТ108Г	2N735	TO-18	П307А, КТ601А
2N207B	TO-5	МГТ108Г	2N735	TO-18	КТ601А, П307А
2N215	TO-1	МП40А	2N738	TO-18	П309
2N218	TO-1	ГТ109Е	2N739	TO-18	П308
2N220	TO-1	П27А	2N741	TO-18	ГТ313В
2N237	TO-22	МП40А	2N741A	TO-18	ГТ313А
2N265	R-32	МГТ108Г	2N743	TO-18	КТ340В
2N273	TO-5	МП39А	2N744	TO-18	КТ340В
2N283	R-8	МП40А	2N753	TO-18	КТ340Б
2N326	TO-3	ГТ705В	2N754	TO-18	П307В
2N331	TO-5	МП39Б	2N755	TO-18	П308
2N368	TO-5	МП40А	2N780	TO-18	КТ312Б
2N369	TO-22	МП41А	2N784A	TO-18	КТ340В
2N404	TO-5	МП42Б	2N797	TO-18	ГТ308А
2N405	TO-40	МП39А	2N795	TO-18	ГТ308А
2N406	TO-1	МП39А	2N796	TO-18	ГТ308Б
2N444	TO-5	МП35	2N797	TO-18	ГТ311И
2N444A	TO-5	МП35	2N834	TO-18	КТ340В
2N445	TO-5	МП38			

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
2N835	TO-18	КТ340В	2N1565	TO-5	КТ601А
2N842	TO-18	КТ301Д	2N1566	TO-5	П307Б, КТ602Г
2N843	TO-18	КТ301 (В, Ж)	2N1566A	TO-5	КТ602Б
2N844	TO-18	П307В, КТ601А	2N1572	TO-5	П309
2N845	TO-18	П308, КТ601А	2N1573	TO-5	П308
2N869	TO-18	КТ352А	2N1574	TO-5	П308
2N869A	TO-18	КТ347А	2N1585	TO-5	ГТ311Ж
2N914	TO-18	КТ616Б	2N1613	TO-5	КТ630Г,
2N915	TO-18	КТ342Г	2N1643	TO-5	КТ104А
2N916	TO-18	КТ342А	2N1681	TO-5	МП42Б
2N917	TO-72	КТ368Б	2N1683	TO-5	ГТ308Б
2N918	TO-72	КТ368А	2N1700	TO-5	КТ801Б
2N919	TO-18	КТ340В	2N1701	TO-8	П702
2N920	TO-18	КТ340В	2N1702	MD-6	КТ803А
2N923	TO-18	КТ203Б	2N1711	TO-5	КТ603 (Е, Г)
2N924	TO-18	КТ203Б	2N1714	TO-5	П701А
2N929	TO-18	КТ342А	2N1716	TO-5	П701А
2N930	TO-18	КТ342А	2N1726	TO-9	П417А
2N943	TO-18	КТ203Б	2N1727	TO-9	П417
2N944	TO-18	КТ203Б	2N1728	TO-9	П417А
2N955	TO-18	ГТ311И	2N1742	TO-9	ГТ313Б
2N955A	TO-18	ГТ311И	2N1743	TO-9	ГТ313А
2N978	TO-18	КТ350А	2N1745	TO-9	ГТ305Б
2N979	TO-18	ГТ305А	2N1746	TO-9	П417
2N980	TO-18	ГТ305А	2N1747	TO-9	П417
2N987	R-38	ГТ322Б	2N1748	TO-9	ГТ305В
2N990	TO-72	ГТ322В	2N1752	TO-9	П417
2N991	TO-72	ГТ322В	2N1754	TO-9	ГТ305А
2N993	TO-72	ГТ322В	2N1785	TO-9	П417А
2N995	TO-18	КТ352А	2N1786	TO-9	П417
2N996	TO-18	КТ352А	2N1787	TO-9	П417
2N1024	TO-5	КТ104Б	2N1838	TO-5	КТ617А
2N1027	TO-5	КТ104Б	2N1839	TO-5	КТ617А
2N1028	TO-5	КТ104А	2N1840	TO-5	КТ617А
2N1051	TO-5	КТ601А	2N1854	TO-5	ГТ308Б
2N1175	TO-5	МП20Б	2N1864	TO-9	П417
2N1204	TO-39	КТ312Г	2N1865	TO-9	П417Б
2N1204A	TO-39	КТ312Г	2N1889	TO-39	КТ630Г
2N1218	TO-3	ГТ705Г	2N1890	TO-39	КТ630Б
2N1219	TO-5	КТ104Г	2N1893	TO-5	КТ630А
2N1220	TO-5	КТ104А	2N1924	TO-5	МП21Г
2N1221	TO-5	КТ104Г	2N1925	TO-5	МП21Г
2N1222	TO-5	КТ104А	2N1926	TO-5	МП21Д
2N1223	TO-5	КТ104А	2N1958	TO-5	КТ608А
2N1292	TO-3	ГТ205В	2N1959	TO-5	КТ608Б
2N1300	TO-5	ГТ308А	2N2020	TO-18	КТ3117А
2N1301	TO-5	ГТ308А	2N2048	TO-9	ГТ308Б
2N1303	TO-39	МП20А	2N2048A	TO-9	ГТ308Б
2N1321	TO-10	ГТ705В	2N2089	TO-7	П403, П416А
2N1329	TO-13	ГТ705В	2N2102	TO-39	КТ630А
2N1353	TO-5	МП42А	2N2102A	TO-39	КТ630А
2N1354	TO-5	МП42Б	2N2137	TO-3	ГТ701А
2N1384	TO-11	ГТ321Д	2N2138A	TO-3	ГТ701А
2N1387	TO-5	КТ301Б	2N2142A	TO-3	ГТ701А
2N1390	TO-5	КТ301Д	2N2143	TO-3	ГТ701А
2N1413	TO-5	МП39Б, МП20А	2N2147	TO-3	ГТ905А
2N1414	TO-5	МП39Б, МП20А	2N2148	TO-3	ГТ905Б
2N1415	TO-5	МП39Б, МП20А	2N2192	TO-39	КТ630Е
2N1420	TO-30	КТ630Е	2N2192A	TO-39	КТ630Е
2N1494A	TO-31	ГТ321Г	2N2193	TO-39	КТ630Г
2N1499A	TO-3	ГТ305А	2N2193A	TO-39	КТ630Г
2N1499B	TO-9	ГТ305Б	2N2194	TO-39	КТ630Д
2N1500	TO-9	ГТ305Г	2N2194A	TO-39	КТ630Д
2N1507	TO-5	КТ630Е	2N2195	TO-5	КТ630Д
2N1524	TO-1	П422	2N2199	TO-9	ГТ305А
2N1526	TO-1	П422	2N2200	TO-9	ГТ305Б
2N1564	TO-5	КТ601А	2N2217	TO-5	КТ928А

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус	
2N2218	TO-5	КТ928Б
2N2218A	TO-5	КТ928Б
2N2219	TO-5	КТ928Б
2N2219A	TO-5	КТ928Б
2N2221	TO-18	КТ3117А
2N2221A	TO-18	КТ3117А
2N2222	TO-18	КТ3117А
2N2224	TO-5	КТ608Б
2N2236	TO-5	КТ617А
2N2237	TO-5	КТ603Б
2N2237	TO-5	КТ608Б
2N2242	TO-18	КТ340В
2N2243	TO-5	КТ630А
2N2243A	TO-5	КТ630А
2N2270	TO-39	КТ630Д
2N2273	TO-18	ГТ305Б
2N2274	TO-18	КТ203Б
2N2275	TO-18	КТ203Б
2N2276	TO-18	КТ203В
2N2277	TO-18	КТ203В
2N2297	TO-5	КТ630Г
2N2360	TO-12	ГТ376А
2N2361	TO-12	ГТ376А
2N2372	TO-18	КТ203В
2N2373	TO-18	КТ203В
2N2400	TO-18	ГТ308Б
2N2405	TO-39	КТ630Б
2N2410	TO-5	КТ928А
2N2411	TO-18	КТ352А
2N2412	TO-18	КТ352А
2N2415	TO-72	ГТ376А
2N2416	TO-72	ГТ376А
2N2428	TO-1	МП41А
2N2432	TO-18	КТ201Б
2N2432A	TO-18	КТ201Б
2N2475	R-64	КТ316Б
2N2482	TO-18	ГТ311И
2N2483	TO-18	КТ3102Б
2N2484	TO-92	КТ3102Д
2N2537	TO-5	КТ928Б
2N2538	TO-5	КТ928Б
2N2539	TO-18	КТ3117А
2N2615	TO-18	КТ325А
2N2616	TO-18	КТ325Б
2N2617	R-8	КТ201А
2N2635	TO-18	ГТ320В
2N2659	R-122	П214А
2N2660	R-122	П215
2N2661	R-122	П215
2N2665	R-122	П214А
2N2666	R-122	П214А
2N2667	R-122	П215
2N2696	TO-18	КТ351А
2N2708	TO-72	КТ325Б
2N2711	R-67	КТ315Ж
2N2712	R-67	КТ315Б
2N2784	TO-18	КТ316Б
2N2811	MT-29	КТ908Б
2N2813	MT-29	КТ908А
2N2835	MD-17	П213
2N2836	TO-3	ГТ703Д
2N2857	TO-72	КТ399А
2N2868	TO-39	КТ630Д
2N2890	TO-5	КТ801А
2N2891	TO-5	КТ801А
2N2894	TO-18	КТ347Б
2N2906	TO-18	КТ313А
2N2906A	TO-18	КТ313А
2N2907	TO-18	КТ313Б
2N2907A	TO-18	КТ313Б
2N2947	TO-3	КТ903А
2N2948	TO-3	КТ903А
2N2958	TO-5	КТ608Б
2N2987	TO-5	КТ630Г
2N2988	TO-5	КТ630В
2N2989	TO-5	КТ630Г
2N2990	TO-5	КТ630В
2N2999	TO-72	ГТ341В
2N3010	TO-18	КТ316Б
2N3012	TO-18	КТ347Б
2N3015	TO-5	КТ928А
2N3019	TO-39	КТ630В
2N3020	TO-39	КТ630В
2N3053	TO-5	КТ630Д
2N3053	TO-5	КТ608Б
2N3054	TO-66	КТ805Б
2N3054A	TO-66	КТ803А
2N3055	TO-3	КТ819ГМ
2N3055E	TO-3	КТ819ГМ
2N3107	TO-5	КТ630Б
2N3108	TO-5	КТ630Г
2N3109	TO-5	КТ630Б
2N3110	TO-5	КТ630Г
2N3114	TO-5	КТ611Г
2N3121	TO-18	КТ315А
2N3127	TO-72	ГТ328А, ГТ376А
2N3209	TO-18	КТ347А
2N3210	TO-18	КТ616Б
2N3248	TO-18	КТ351А
2N3249	TO-18	КТ345Б
2N3250	TO-18	КТ313Б
2N3250A	TO-18	КТ313Б
2N3267	TO-72	ГТ376А
2N3279	TO-72	ГТ328А
2N3280	TO-72	ГТ328А
2N3281	R-96	ГТ328Б
2N3282	R-96	ГТ328В
2N3283	TO-72	ГТ328А
2N3284	TO-72	ГТ328Б
2N3286	TO-72	ГТ328Б
2N3299	TO-5	КТ608Б
2N3301	TO-18	КТ3117А
2N3302	TO-18	КТ3117А
2N3304	TO-18	КТ337А
2N3375	TO-60	КТ904А
2N3390	TO-98	КТ373В
2N3391	TO-98	КТ373Б
2N3392	TO-98	КТ373А
2N3393	TO-98	КТ373А
2N3394	TO-98	КТ373Г
2N3397	TO-98	КТ315Е
2N3399	TO-72	ГТ346Б
2N3440S	TO-39	КТ940А
2N3441	TO-66	КТ802А
2N3442	TO-3	КТ945А
2N3451	TO-18	КТ337А
2N3545	TO-18	КТ343Б
2N3546	TO-18	КТ363А
2N3570	TO-72	КТ399А
2N3571	TO-72	КТ399А
2N3572	TO-72	КТ399А
2N3576	TO-18	КТ347А
2N3583	TO-66	КТ704В
2N3584	TO-66	КТ809А
2N3585	TO-66	КТ704А
2N3585	TO-66	КТ704Б

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
2N3600	TO-72	КТ368А	2N4899	TO-66	КТ932Б
2N3605	R-67	КТ375Б	2N4900	TO-66	КТ932А
2N3606	R-67	КТ375Б	2N4910	TO-66	П702А
2N3607	TO-92	КТ375Б	2N4911	TO-66	П702
2N3611	TO-3	ГТ701А	2N4912	TO-66	П702
2N3613	TO-3	ГТ701А	2N4913	TO-3	КТ808А
2N3702	TO-92	КТ345Б	2N4914	TO-3	КТ808А
2N3709	TO-92	КТ358А, КТ373А	2N4915	TO-3	КТ808А
2N3710	TO-92	КТ358В, КТ373А	2N4924	TO-39	КТ611Г
2N3711	TO-92	КТ3102В	2N4925	TO-39	КТ611Г
2N3712	TO-5	КТ611Г	2N4926	TO-39	КТ604Б
2N3722	TO-5	КТ608Б	2N4927	TO-39	КТ604Б
2N3724	TO-39	КТ608Б	2N4960	TO-5	КТ928Б
2N3730	TO-3	ГТ810А	2N4976	TO-129	КТ911А
2N3732	TO-3	ГТ905А	2N5031	TO-72	КТ399А
2N3733	TO-60	КТ907А	2N5032	TO-72	КТ399А
2N3738	TO-66	КТ809А	2N5043	TO-72	ГТ329Б
2N3739	TO-66	КТ809А	2N5044	TO-72	ГТ329А
2N3740	TO-66	КТ932Б	2N5050	TO-66	КТ802А
2N3741	TO-66	КТ932 (А, К)	2N5051	TO-66	КТ802А
2N3742	TO-5	КТ604Б	2N5052	TO-66	КТ802А
2N3766	TO-66	КТ805Б	2N5056	TO-18	КТ347Б
2N3767	TO-66	КТ805Б	2N5067	TO-3	КТ803А
2N3839	TO-72	КТ399А	2N5068	TO-3	КТ803А
2N3878	TO-66	КТ908А	2N5069	TO-3	КТ803А
2N3879	TO-66	КТ908А	2N5070	TO-60	КТ912А
2N3880	TO-72	КТ399А	2N5090	TO-60	КТ606А
2N3883	TO-5	ГТ320Б	2N5177	MD-36	КТ909А
2N3903	TO-92	КТ375А	2N5178	MD-36	КТ909Б
2N3904	TO-92	КТ375 (А, Б)	2N5179	TO-72	КТ399А
2N3905	TO-92	КТ361Г	2N5188	TO-39	КТ603Б
2N3906	TO-92	КТ361Г	2N5190	TO-126	КТ817А
2N3964	TO-18	КТ3107Л	2N5191	TO-126	КТ817В
2N4030	TO-5	КТ933Б	2N5192	TO-126	КТ817Г
2N4031	TO-5	КТ933А	2N5193	TO-126	КТ816А, КТ818А
2N4034	TO-18	КТ326Б	2N5194	TO-126	КТ816В, КТ818В
2N4034	TO-18	КТ347А	2N5195	TO-126	КТ816Г, КТ818Г
2N4036	TO-39	КТ933А	2N5202	TO-66	КТ908А
2N4037	TO-39	КТ933Б	2N5209	TO-92	КТ3102Д
2N4046	TO-5	КТ608Б	2N5210	TO-92	КТ3102Е
2N4077	MD-6	ГТ705Д	2N5219	TO-92	КТ375Б
2N4123	TO-92	КТ3102А	2N5221	TO-92	КТ351А
2N4124	TO-92	КТ3102Д	2N5223	TO-92	КТ375Б
2N4125	TO-92	КТ361Б	2N5226	TO-92	КТ350А
2N4126	TO-92	КТ3107Ж	2N5228	TO-92	КТ357А
2N4127	MT-59	КТ922Г	2N5239	TO-3	КТ812Б
2N4128	MT-59	КТ922Д	2N5240	TO-3	КТ812А
2N4138	TO-46	КТ201Б	2N5313	TO-61	КТ908А
2N4207	TO-18	КТ337Б	2N5315	TO-61	КТ908А
2N4208	TO-18	КТ337Б	2N5317	TO-61	КТ908А
2N4209	TO-18	КТ363А	2N5319	TO-61	КТ908А
2N4231	TO-66	П702	2N5354	TO-98	КТ351А
2N4232	TO-66	П702	2N5365	TO-98	КТ351А
2N4233	TO-66	П702	2N5366	TO-98	КТ351Б
2N4237	TO-5	КТ801А	2N5427	TO-66	КТ808А
2N4238	TO-5	КТ801Б	2N5429	TO-66	КТ808А
2N4239	TO-5	КТ801А	2N5447	X-55	КТ345Б
2N4240	TO-66	КТ704 (А, Б)	2N5481	MT-74	КТ911А
2N4260	TO-72	КТ363А	2N5490	TO-220	КТ819Б
2N4261	TO-72	КТ363Б	2N5492	TO-220	КТ819В
2N4301	TO-61	КТ908А	2N5494	TO-220	КТ819В
2N4314	TO-39	КТ933А	2N5496	TO-220	КТ819Г
2N4400	TO-92	КТ645А	2N5641	MT-71	КТ922А
2N4429	MT-59	КТ911Б	2N5642	MT-72	КТ922Б
2N4430	TO-129	КТ913А	2N5643	MT-72	КТ922В
2N4431	TO-129	КТ913Б	2N5652	TO-72	КТ372В
2N4440	TO-60	КТ907Б	2N5681	TO-39	КТ630Г
2N4898	TO-66	КТ932В	2N5682	TO-39	КТ630А

Продолжение

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус	
2N5764	MT-77	KT913A
2N5765	MT-77	KT913Б
2N5771	TO-92	KT363AM
2N5838	TO-3	KT840Б
2N5839	TO-3	KT840Б
2N5840	TO-3	KT840A
2N5842	TO-72	KT355A
2N5845	TO-92	KT645A
2N5851	TO-72	KT355A
2N5852	TO-72	KT355A
2N5887	TO-66	ГТ701А, П216
2N5888	TO-66	ГТ701А, П216
2N5889	TO-66	ГТ701А, П216
2N5890	TO-66	ГТ701А, П216Г
2N5891	TO-66	ГТ701А, П217
2N5995	MT-78	KT920Г
2N5996	MT-78	KT920Г
2N6011	R-203	KT825Б
2N6050	TO-3	KT825Д
2N6051	TO-3	KT825Г
2N6052	TO-3	KT825Г
2N6057	TO-3	KT827B
2N6058	TO-3	KT827Б
2N6059	TO-3	KT827A
2N6077	TO-66	KT812Б
2N6078	TO-66	KT812Б
2N6079	TO-66	KT812A
2N6080	MT-72	KT920Б
2N6081	MT-72	KT920Г
2N6093	MT-67	KT912Б
2N6099	TO-220	KT819B
2N6101	TO-220	KT819Г
2N6107	TO-220	KT818Г
2N6109	TO-220	KT818B
2N6111	TO-220	KT818A
2N6121	TO-220	KT817A
2N6122	TO-220	KT817B
2N6123	TO-220	KT817Г
2N6124	TO-220	KT839Ф
2N6125	TO-220	KT839C
2N6126	TO-220	KT839H
2N6129	TO-220	KT819Б
2N6130	TO-220	KT819B
2N6131	TO-220	KT819Г
2N6132	TO-220	KT818Б
2N6133	TO-220	KT818B
2N6134	TO-220	KT818Г
2N6135	X-110	KT610A
2N6178	X-109	KT943Д
2N6179	X-109	KT943Б
2N6180	TO-126	KT932A
2N6181	TO-126	KT932A
2N6246	TO-3	KT818BM
2N6247	TO-3	KT818ГM
2N6248	TO-3	KT818ГM
2N6253	TO-3	KT819БM
2N6260	TO-66	KT805Б
2N6263	TO-66	KT802A
2N6264	TO-66	KT802A
2N6282	TO-3	KT827B
2N6283	TO-3	KT827Б
2N6284	TO-3	KT827A
2N6285	TO-3	KT825Д
2N6286	TO-3	KT825Г
2N6287	TO-3	KT825Г
2N6288	TO-220	KT819A
2N6289	TO-220	KT819A
2N6290	TO-220	KT819B
2N6291	TO-220	KT819B
2N6292	TO-220	KT819Г
2N6293	TO-220	KT819Г
2N6304	TO-72	KT399A
2N6305	TO-72	KT399A
2N6371	TO-3	KT819БM
2N6372	TO-66	KT808ГM
2N6373	TO-66	KT808ГM
2N6374	TO-66	KT808БM
2N6469	TO-3	KT818БM
2N6470	TO-3	KT819БM
2N6471	TO-3	KT819BM
2N6472	TO-3	KT819ГM
2SA40	TO-1	ГТ124Б
2SA49	TO-1	ГТ109Е
2SA50	TO-1	П30
2SA52	TO-1	ГТ109Е
2SA53	TO-1	ГТ109Д
2SA58	TO-44	ГТ322Б
2SA60	TO-44	ГТ322Б
2SA65	TO-1	ГТ125В
2SA69	TO-1	ГТ309Е
2SA70	TO-1	ГТ309Е
2SA71	TO-1	ГТ309Е
2SA72	TO-44	ГТ322В
2SA73	TO-44	ГТ322В
2SA78	TO-44	ГТ321Д
2SA92	TO-44	ГТ322Б
2SA93	TO-44	ГТ322В
2SA101	TO-1	ГТ322В
2SA102	TO-1	ГТ322В
2SA103	TO-72	ГТ322В
2SA104	TO-1	ГТ322Б
2SA105	TO-44	ГТ310Е
2SA106	TO-44	ГТ310Е
2SA107	TO-44	ГТ310Д
2SA108	TO-44	П422
2SA109	TO-44	П422
2SA110	TO-44	П422
2SA111	TO-44	П422
2SA112	TO-44	П422
2SA116	TO-44	ГТ310В
2SA117	TO-44	ГТ310Д
2SA118	TO-44	ГТ310Д
2SA173	TO-5	ГТ125Б
2SA174	TO-5	ГТ125Б
2SA195	TO-1	ГТ124А
2SA204	TO-5	ГТ125Б
2SA205	TO-5	ГТ125Д
2SA206	TO-5	ГТ125Б
2SA211	TO-5	ГТ125А
2SA212	TO-5	ГТ125А
2SA219	TO-44	ГТ322В
2SA221	TO-44	ГТ322Б
2SA223	TO-44	ГТ322В
2SA229	TO-17	ГТ313А
2SA230	TO-17	ГТ313А
2SA234	TO-44	ГТ309Б
2SA235	TO-44	ГТ309Б
2SA236	TO-44	ГТ322В
2SA237	TO-44	ГТ322В
2SA246	TO-44	ГТ305В
2SA254	R-18	ГТ109Е
2SA255	R-18	ГТ109Д
2SA256	TO-18	ГТ322Б
2SA257	TO-18	ГТ322В
2SA258	TO-18	ГТ322В

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус	
2SA259	TO-18	ГТ322В
2SA260	TO-17	ГТ310А
2SA266	TO-1	ГТ309Г
2SA267	TO-1	ГТ309Г
2SA268	TO-1	ГТ309Д
2SA269	TO-1	ГТ309Д
2SA270	TO-1	ГТ309Г
2CA271	TO-1	ГТ309Г
2SA272	TO-1	ГТ309А
2SA277	TO-5	ГТ124В
2SA279	TO-7	П416Б, ГТ305Б
2SA282	TO-5	ГТ125 (В, Г)
2SA285	TO-44	ГТ322Б
2SA286	TO-44	ГТ322Б
2SA287	TO-44	ГТ322Б
2SA321	TO-44	ГТ322В
2SA322	TO-44	ГТ322В
2SA338	TO-18	ГТ322В
2SA339	TO-18	ГТ322Б
2SA340	TO-72	ГТ322Б
2SA341	TO-72	ГТ322Б
2SA342	TO-72	ГТ322Б
2SA343	TO-7	ГТ309Б
2SA350	TO-1	П422
2SA351	TO-1	П422
2SA352	TO-1	П422
2SA354	TO-1	П422
2SA355	TO-1	П422
2SA374	TO-5	П609А
2SA391	TO-5	ГТ125В
2SA396	TO-5	ГТ125Г
2SA400	TO-1	ГТ309Г
2SA412	TO-1	ГТ308Б
2SA414	TO-5	ГТ125Б
2SA416	TO-3	П605А
2SA422	TO-17	ГТ346Б
2SA440	R-146	ГТ313А
2SA467	R-67	КТ351Б
2SA490	TO-220	КТ816Б
2SA494G	R-67	КТ349В
2SA495	R-67	КТ357Г
2SA495G	R-67	КТ357Г
2SA496	TO-126	КТ639Б
2SA500	TO-18	КТ352А
2SA504	TO-39	КТ933А
2SA505	TO-126	КТ639Д
2SA522	TO-18	КТ326Б
2SA530	TO-18	КТ313Б
2SA537	TO-39	КТ933Б
2SA555	X-20	КТ361Е
2SA556	X-20	КТ361Е
2SA559	TO-18	КТ352А
2SA564	TO-92	КТ3107Д
2SA564A	TO-92	КТ3107И
2SA568	TO-92	КТ345В
2SA603	TO-18	КТ313Е
2SA628	TO-92	КТ357Г
2SA640	TO-92	КТ3107 (К, И)
2SA641	TO-92	КТ3107Л
2SA670	TO-220	КТ816В
2SA671	TO-220	КТ816Б
2SA673	TO-92	КТ350А
2SA715B	TO-126	КТ639В
2SA715C	TO-126	КТ639В
2SA715D	TO-126	КТ639В
2SA718	TO-18	КТ313Б
2SA733	TO-92	КТ3107И
2SA738B	TO-126	КТ639В
2SA738C	TO-126	КТ639В
2SA738D	TO-126	КТ639В
2SA741H	TO-18	КТ352А
2SA743	TO-126	КТ639Г
2SA743A	TO-126	КТ639Г
2SA750	TO-92	КТ3107К
2SA755A	TO-220	КТ932Б
2SA755B	TO-220	КТ932Б
2SA768	TO-220	КТ816В
2SA769	TO-220	КТ816Г
2SA779K	TO-202	КТ639В
2SA780AK	TO-202	КТ639Д
2SA781K	TO-92	КТ345Б
2SA811C5	SOT-23	КТ3129Б9
2SA811C6	SOT-23	КТ3129Г9
2SA812M4	SOT-23	КТ3129Б9
2SA812M5	SOT-23	КТ3129Б9
2SA815	TO-220	КТ814Г
2SA844C	TO-92	КТ3107И
2SA844D	TO-92	КТ3107И
2SA876H	TO-18	КТ313Б
2SA962A	TO-202	КТ639Д
2SA999	TO-92	КТ3107И
2SA999L	TO-92	КТ3107И
2SA1015	TO-92	КТ3107Б
2SA1029B	TO-92	КТ3107Г
2SA1029C	TO-92	КТ3107Д
2SA1029D	TO-92	КТ3107И
2SA1030B	TO-92	КТ3107Б
2SA1030C	TO-92	КТ3107Д
2SA1031B	TO-92	КТ3107Г
2SA1031C	TO-92	КТ3107Ж
2SA1031D	TO-92	КТ3107Ж
2SA1033B	TO-92	КТ3107Г
2SA1033C	TO-92	КТ3107Д
2SA1033D	TO-92	КТ3107К
2SA1052B	TO-236	КТ3129Б9
2SA1052C	TO-236	КТ3129Г9
2SA1052D	TO-236	КТ3129Г9
2SA1090	TO-18	КТ313Б
2SA1356	SOT-82	КТ626А
2SB12	TO-1	ГТ124А
2SB13	TO-1	ГТ124А
2SB15	TO-1	ГТ125А
2SB32	TO-1	МП39А
2SB33	TO-1	МП41А
2SB37	TO-1	МП41А
2SB39	TO-1	ГТ115А
2SB40	TO-1	МП42Б
2SB43	TO-1	ГТ125В
2SB44	TO-1	ГТ124В
2SB47	TO-1	МГТ108 (Д, Г)
2SB48	TO-5	ГТ125Б
2SB49	TO-5	ГТ125В
2SB54	TO-1	ГТ124Г
2SB55	TO-1	ГТ125Г
2SB56	TO-1	ГТ125Г
2SB57	R-55	МГТ108Б
2SB60	TO-1	МП41А
2SB61	TO-1	МП41А
2SB75	TO-1	ГТ125В
2SB90	TO-1	ГТ109Г
2SB97	TO-1	ГТ109В
2SB110	TO-1	ГТ124А
2SB111	TO-1	ГТ124Б
2SB112	TO-1	ГТ124В
2SB113	TO-1	ГТ124В
2SB114	TO-18	ГТ124Б
2SB115	TO-1	ГТ124В
2SB116	TO-1	ГТ124Г

Продолжение

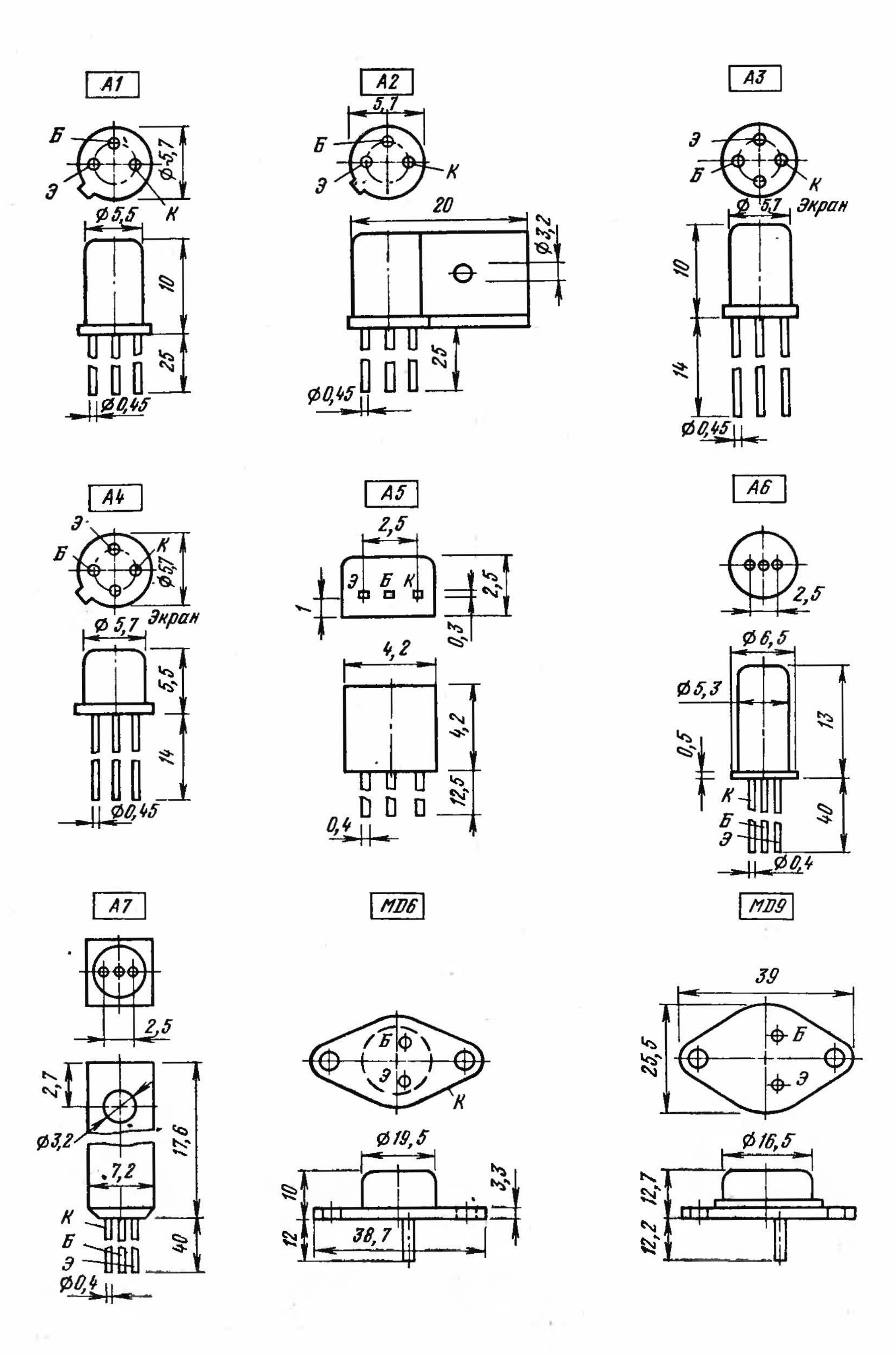
Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус	
2SB117	TO-1	ГТ124Г
2SB120	TO-1	МП41А
2SB130	MD-11	П201АЭ
2SB135	TO-1	ГТ124В
2SB136	TO-1	МП25А, МП20Б
2SB136A	TO-1	МП25А, МП20Б
2SB170	TO-1	МП39А, МП40А
2SB171	TO-1	МП40А
2SB172	TO-1	МП20А, МП25Б
2SB173	TO-1	МП39А
2SB175	TO-1	МП41А
2SB176	TO-1	МП25Б, МП20Б
2SB180A	TO-8	П201АЭ
2SB181A	TO-8	П202Э
2SB200	R-10	МП25Б, МП20А
2SB201	TO-5	МП25Б, МП20А
2SB261	R-18	ГТ115А
2SB262	R-18	ГТ115В
2SB263	TO-1	МП25Б
2SB302	TO-1	ГТ109Е
2SB303	TO-1	ГТ115Г
2SB335	R-18	МГТ108В
2SB336	R-18	МГТ108В
2SB361	TO-3	ГТ806А
2SB362	TO-3	ГТ806Б
2SB367	TO-66	П201АЭ
2SB368	TO-66	П201АЭ
2SB400	TO-1	МГТ108Г
2SB434	TO-220	КТ837Р
2SB434G	TO-220	КТ837Р
2SB435	TO-220	КТ837У
2SB435G	TO-220	КТ837Р
2SB439	TO-1	МП41А, МП39Б
2SB440	TO-1	МП41А, МП39Б
2SB443A	TO-1	МГТ108Г
2SB443B	TO-1	МГТ108Г
2SB444A	TO-1	МГТ108Г
2SB444B	TO-1	МГТ108Г
2SB448	MD-11	П201АЭ
2SB456	TO-8	П202Э
2SB466	MD-10	П201АЭ
2SB467	MD-10	П202Э
2SB468	TO-3	ГТ810А
2SB473	MD-9	П201АЭ
2SB481	MD-9	П201АЭ
2SB497	R-18	МГТ108Б
2SB551H	TO-66	КТ932Б
2SB553	TO-220	КТ818В
2SB558	TO-3	КТ818ГМ
2SB595	TO-220	КТ816Г
2SB596	TO-220	КТ816Г
2SB650H	TO-3	КТ825Г
2SB693H	TO-3	КТ825Г
2SB709	SOT-23	КТ3129Д9
2SB709A	SOT-23	КТ3129Г9
2SB754	TO-220	КТ818Б
2SB834	TO-220	КТ835Б, КТ837В
2SB906	TO-220	КТ835Б, КТ837В
2SB996	TO-220	КТ816Г
2SB1016	TO-220	КТ818Г
2SB1017	TO-220	КТ818Г
2SB1018	TO-220	КТ818Г
2SB1019	TO-220	КТ818В
2SC33	TO-5	КТ312Б
2SC40	TO-18	КТ316Г
2SC41	TO-3	КТ802А
2SC42	TO-3	КТ802А
2SC43	TO-3	КТ802А
2SC44	TO-3	КТ803А
2SC64	TO-5	КТ601А
2SC65	TO-5	КТ611В
2SC66	TO-5	КТ611Г
2SC67	TO-18	КТ340В
2SC68	TO-18	КТ340В
2SC101A	TO-66	КТ902А
2SC105	TO-18	КТ312Б
2SC108A	TO-39	КТ630Г
2SC109A	TO-39	КТ928Б
2SC131	TO-18	КТ616Б
2SC132	TO-18	КТ616Б
2SC133	TO-18	КТ616Б
2SC134	TO-18	КТ616А
2SC135	TO-18	КТ616А
2SC137	TO-18	КТ616Б
2SC151H	TO-39	КТ603А
2SC170	TO-18	КТ306Д
2SC171	TO-18	КТ306Д
2SC172	TO-18	КТ306Д
2SC188	TO-5	КТ617А
2SC247	TO-39	КТ602Г
2SC249	TO-39	КТ602Б
2SC253	TO-72	КТ325А
2SC281	TO-1	КТ312В
2SC282	TO-1	КТ312В
2SC306	TO-5	КТ630Д
2SC307	TO-5	КТ630Г
2SC308	TO-5	КТ630Г
2SC309	TO-5	КТ630А
2SC310	TO-5	КТ630В
2SC366G	TO-92	КТ645А
2SC367G	TO-92	КТ645А
2SC370	R-67	КТ375Б
2SC371	R-67	КТ375Б
2SC372	R-67	КТ375Б
2SC390	TO-72	КТ368А
2SC395A	TO-18	КТ616А
2SC400	TO-18	КТ306В
2SC401	R-37	КТ358В
2SC402	R-37	КТ358В
2SC403	R-37	КТ358Б
2SC404	R-37	КТ358В
2SC454B	TO-92	КТ3102В
2SC454C	TO-92	КТ3102В
2SC454D	TO-92	КТ3102В
2SC458	TO-92	КТ3102В
2SC458LGB	TO-92	КТ3102Д
2SC458LGC	TO-92	КТ3102Д
2SC458LGD	TO-92	КТ3102Д
2SC458KB	TO-92	КТ3102В
2SC458KC	TO-92	КТ3102В
2SC458KD	TO-92	КТ3102В
2SC481	TO-39	КТ630Д
2SC482	TO-5	КТ617А
2SC493	TO-3	КТ803А
2SC497	TO-39	КТ630Б
2SC498	TO-39	КТ630Б
2SC503	TO-39	КТ630Г
2SC504	TO-39	КТ630Г
2SC505	TO-39	КТ618А
2SC506	TO-39	КТ611Б
2SC507	TO-39	КТ611Г
2SC508	TO-66	КТ802А
2SC510	TO-39	КТ630В
2SC512	TO-39	КТ630Г
2SC517	TO-37	КТ903А
2SC519A	TO-3	КТ802А
2SC520A	TO-3	КТ802А
2SC521A	TO-3	КТ803А

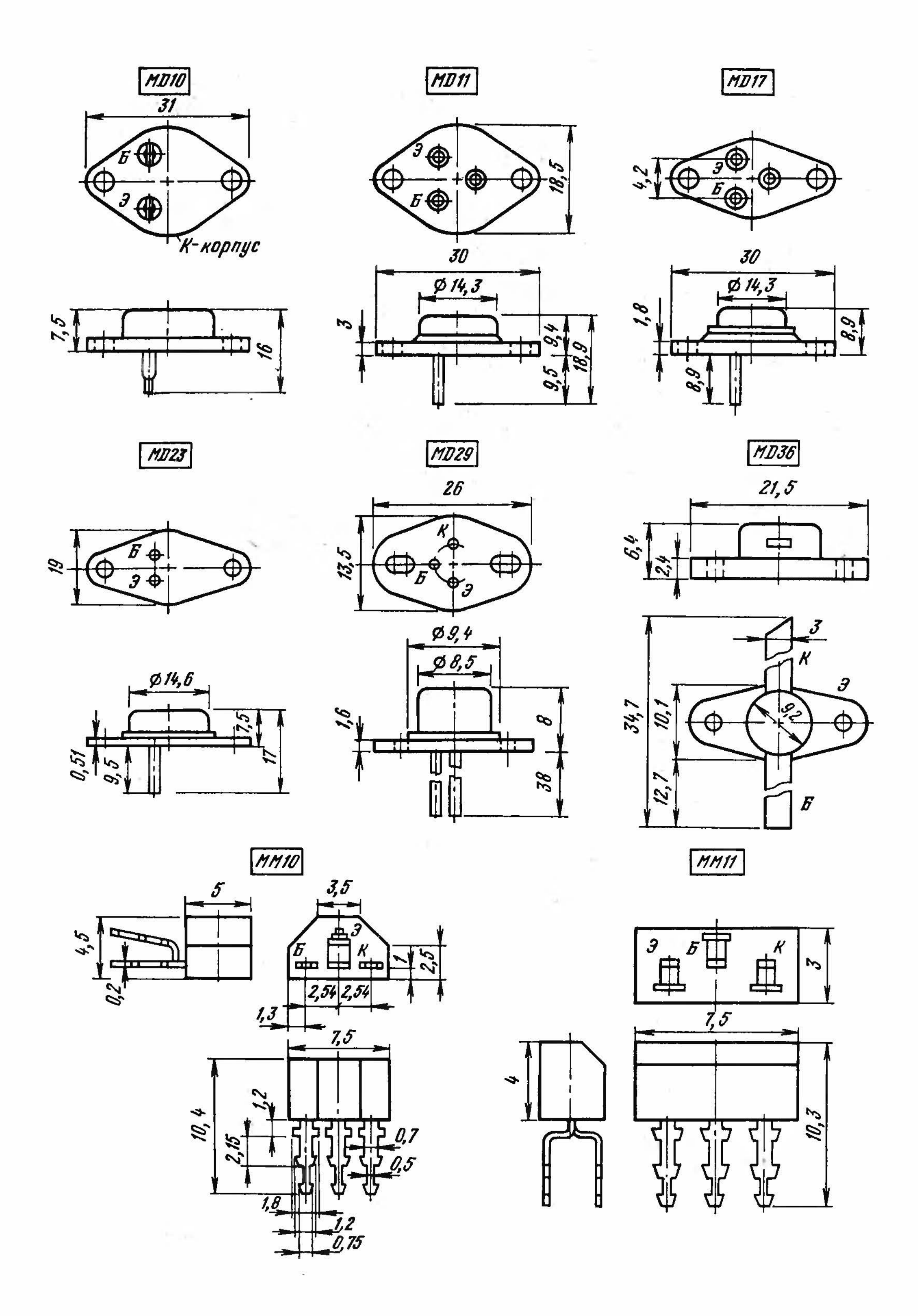
Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
2SC525	MT-29	П701А	2SC1619A	TO-3	КТ808А
2SC538	TO-92	КТ3102Г	2SC1622D6	SOT-23	КТ3130Б9
2SC538A	TO-92	КТ3102Б	2SC1622D7	SOT-23	КТ3130Б9
2SC543	TO-60	КТ907Б	2SC1623L	SOT-23	КТ3130А9
2SC549	TO-60	КТ904Б	2SC1624	TO-220	КТ943В
2SC553	TO-60	КТ907Б	2SC1625	TO-220	КТ943В
2SC563	TO-72	КТ339Г	2SC1815	TO-92	КТ3102Б
2SC583	TO-72	КТ368Б	2SC1826	TO-220	КТ817Г
2SC594	TO-39	КТ608А	2SC1827	TO-220	КТ817Г
2SC598	TO-60	КТ904А	2SC1828	TO-66	КТ828А
2SC601	TO-18	КТ306Б	2SC1846	TO-92	КТ645А
2SC612	TO-72	КТ325В	2SC1894	TO-3	КТ839А
2SC618	TO-72	КТ325А	2SC1895	TO-3	КТ839А
2SC620	TO-92	КТ375А	2SC1896	TO-3	КТ839А
2SC633	R-37	КТ315Б	2SC2036	TO-126	КТ646А
2SC634	R-37	КТ315Г	2SC2068	TO-202	КТ940А
2SC635	TO-60	КТ904Б	2SC2121	TO-3	КТ828А
2SC641	MM-12	КТ315Г	2SC2137	TO-3	КТ812А КТ828Б
2SC642	TO-60	КТ904А	2SC2138	TO-3	КТ812А
2SC712	TO-92	КТ375Б	2SC2231	TO-202	КТ940В
2SC727	TO-18	П307Б	2SC2231A	TO-202	КТ940В
2SC752GTM	TO-92	КТ645А	2SC2242	TO-220	КТ940А
2SC779	TO-66	КТ809А	2SC2258	TO-126	КТ940Б
2SC788	TO-5	КТ618А	2SC2404	SOT-23	КТ3130Г9
2SC790	TO-220	КТ817Б	2SC2405	SOT-23	КТ3130Г9
2SC793	TO-3	КТ803А	2SC2431	TO-3	КТ945А
2SC796	TO-5	КТ603А	2SC2456	TO-126	КТ940А
2SC809	TO-72	КТ325В	2SC2562	TO-220	КТ805АМ
2SC815	TO-92	КТ645А	2SC2611	TO-126	КТ604БМ
2SC825	TO-66	КТ809А	2SC2790	TO-3	КТ828А
2SC828	TO-92	КТ3102В	2SC2790A	TO-3	КТ828А
2SC828A	TO-92	КТ3102Б	2SC2791	TO-3	КТ828А
2SC829	TO-92	КТ358Б	2SC2794	TO-126	КТ943Б
2SC893	MT-29	П701А	2SC3335	TO-126	КТ940Б
2SC900	TO-92	КТ3102Г	2SC3419	TO-126	КТ646А
2SC923	TO-92	КТ3102Г	2SC3422	SOT-82	КТ940В
2SC945	TO-92	КТ3102Д	2SC3423	SOT-82	КТ940В
2SC959S	TO-39	КТ630Б	2SC3424	SOT-82	КТ940Б
2SC976	MT-83	КТ911Г	2SD31	TO-1	МП35
2SC977	MT-83	КТ913А	2SD32	TO-1	МП38А
2SC978	MT-83	КТ913Б	2SD33	TO-1	МП38А
2SC1000GTM	TO-92	КТ3102Б	2SD37	TO-1	МП37А
2SC1008	TO-39	КТ630Д	2SD47	TO-3	КТ908А
2SC1008A	TO-39	КТ630Б	2SD68	TO-3	КТ902А
2SC1044	TO-72	КТ355А	2SD72	TO-1	ГТ404И
2SC1056	TO-5	КТ605Б	2SD75	TO-1	МП38, МП36А
2SC1090	U-78	КТ372А	2SD75A	TO-1	МП37А, МП36А
2SC1111	TO-3	КТ802А	2SD127	TO-1	ГТ404Е
2SC1112	TO-3	КТ802А	2SD127	TO-1	ГТ404Б
2SC1113	TO-66	КТ808А	2SD128	TO-1	ГТ404И
2SC1114	TO-3	КТ812Б	2SD128A	TO-1	ГТ404И
2SC1145	TO-3	КТ809БМ	2SD146	MD-10	П702А
2SC1172	TO-3	КТ839А	2SD147	MD-10	П702
2SC1172A	TO-3	КТ839А	2SD148	MD-10	П702
2SC11172B	TO-3	КТ839А	2SD195	TO-1	МП38А
2SC1173	TO-220	КТ943А	2SD201	TO-3	КТ808А
2SC1260	TO-72	КТ399А	2SD202	TO-3	КТ808А
2SC1317	TO-92	КТ645А	2SD203	TO-3	КТ808А
2SC1440	TO-3	КТ945А	2SD234	TO-220	КТ817А
2SC1454	TO-3	КТ812Б	2SD235	TO-220	КТ817Б
2SC1504	TO-3	КТ809А	2SD292	TO-66	КТ817В
2SC1550	TO-126	КТ940Б	2SD526	TO-220	КТ817Г
2SC1566	TO-202	КТ940Б	2SD601	SOT-23	КТ3130В9
2SC1569	TO-220	КТ940А	2SD601A	SOT-23	КТ3130Б9
2SC1576	TO-3	КТ812А, КТ828Б	2SD605	TO-3	КТ834А
2SC1617	TO-3	КТ812Б	2SD640	TO-3	КТ828Б
2SC1618	TO-3	КТ808А	2SD668	TO-126	КТ611БМ
2SC1619	TO-3	КТ808А	2SD668A	TO-126	КТ611БМ

Окончание

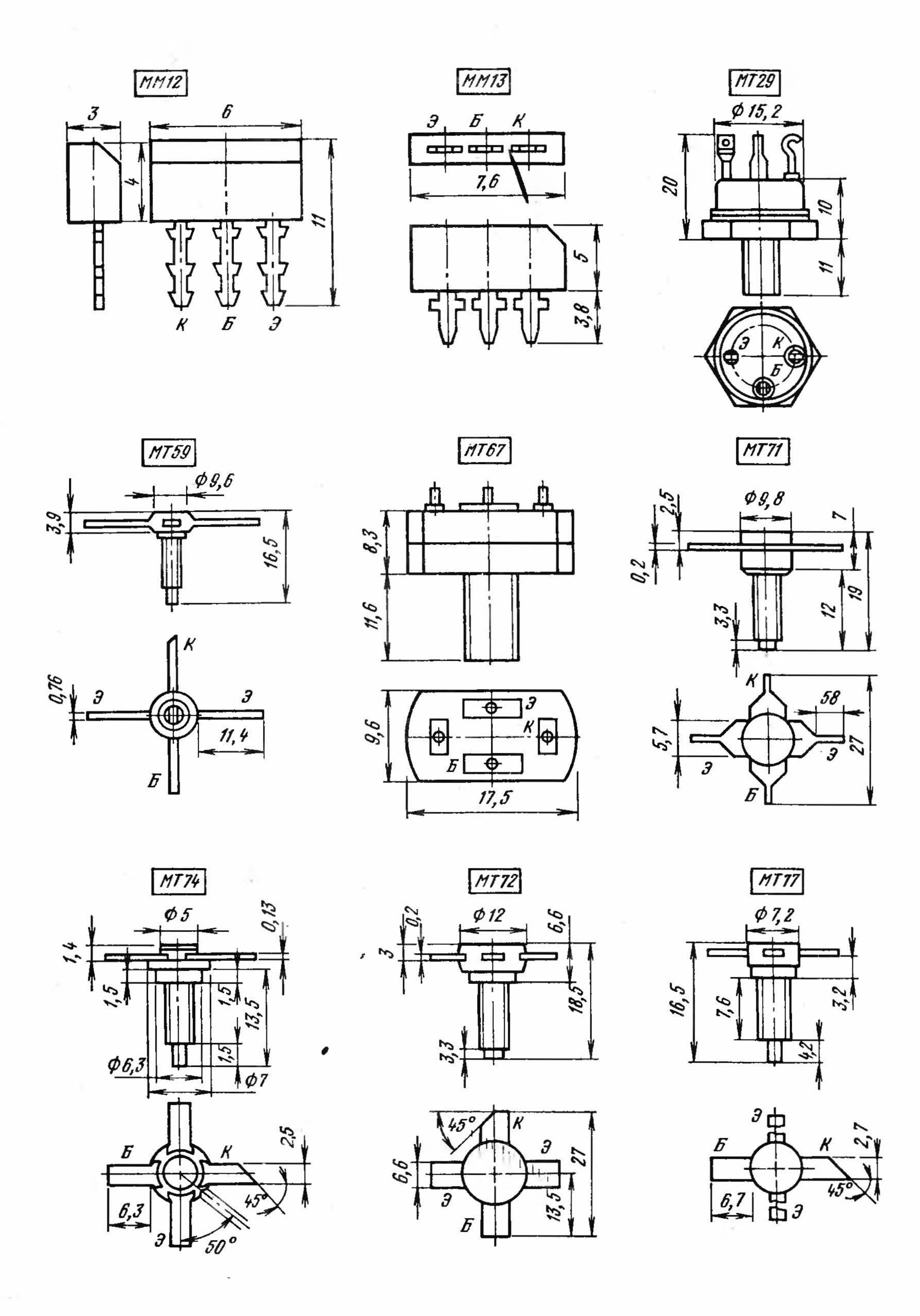
Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
2SD675A	TO-3	КТ945А	2NU73	TO-3	ГТ703Б
2SD685	TO-3	КТ834А	2NU74	TO-3	ГТ701А, П210А
2SD686	TO-220	КТ829А	3NU73	TO-3	ГТ703Г
2SD691	TO-220	КТ829А	3NU74	TO-3	ГТ701А, П201А
2SD692	TO-220	КТ829А	40675	MT-67	КТ912Б
2SD716	TO-202	КТ819ГМ	4NU73	TO-3	ГТ703Д
2SD820	TO-3	КТ839А	4NU74	TO-3	ГТ701А, П210А
2SD821	TO-3	КТ839А	5NU73	TO-3	П213
2SD822	TO-3	КТ839А	5NU74	TO-3	ГТ701А, П210А
2SD843	TO-3	КТ819ГМ	6NU73	TO-3	П215
2SD867	TO-3	КТ808АМ	6NU74	TO-3	П210Б, ГТ701А
2SD877	TO-66	КТ802А	7NU73	TO-3	П215
2SD880	TO-220	КТ817В	7NU74	TO-3	П210Б, ГТ701А
2SD1279	TO-3	КТ839А	101NU70	A-6	МП35
2SD1354	TO-202	КТ817В	102NU70	A-6	МП35
2SD1356	TO-202	КТ817Г	103NU70	A-6	МП37
2SD1406	TO-202	КТ817В	104NU70	A-6	МП36А
2SD1408	TO-202	КТ817Г	105NU70	A-6	МП36А
2T3531	TO-5	П308, КТ602А	106NU70	A-6	МП36А
2T3532	TO-5	П308, КТ602А	106NU70	A-6	МП37А
2T3674	TO-72	КТ355А	107NU70	A-6	МП36А, МП38А
2T3841	TO-18	КТ343А	152NU70	A-6	МП36А, МП38
2NU72	SOT-9	ГТ403Б	153NU70	A-6	МП36А
3NU72	SOT-9	ГТ403Б	154NU70	A-6	МП38
4NU72	SOT-9	ГТ403Б	155NU70	A-6	МП38А
5NU72	SOT-9	ГТ403Е			

КОРПУСА ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

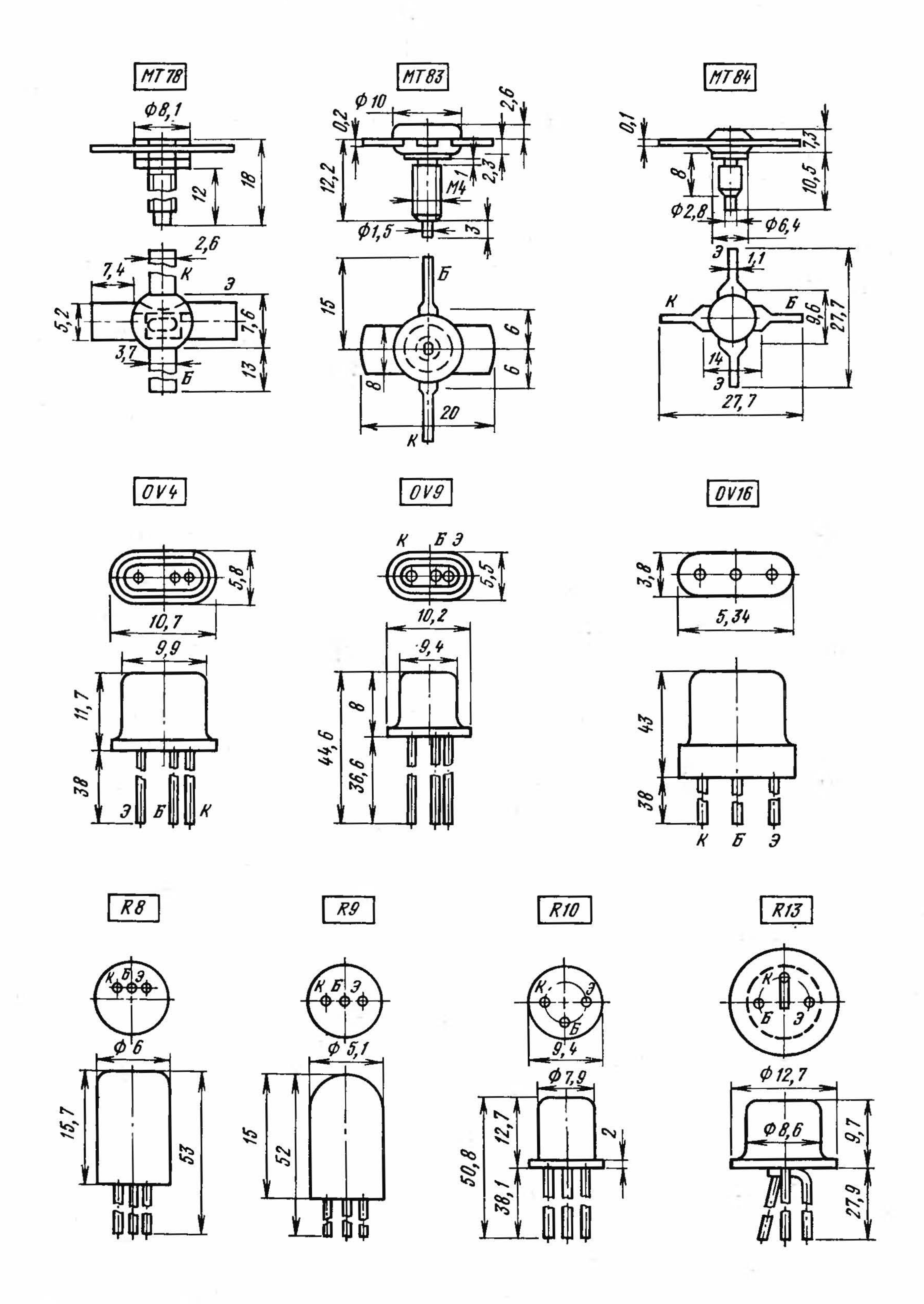


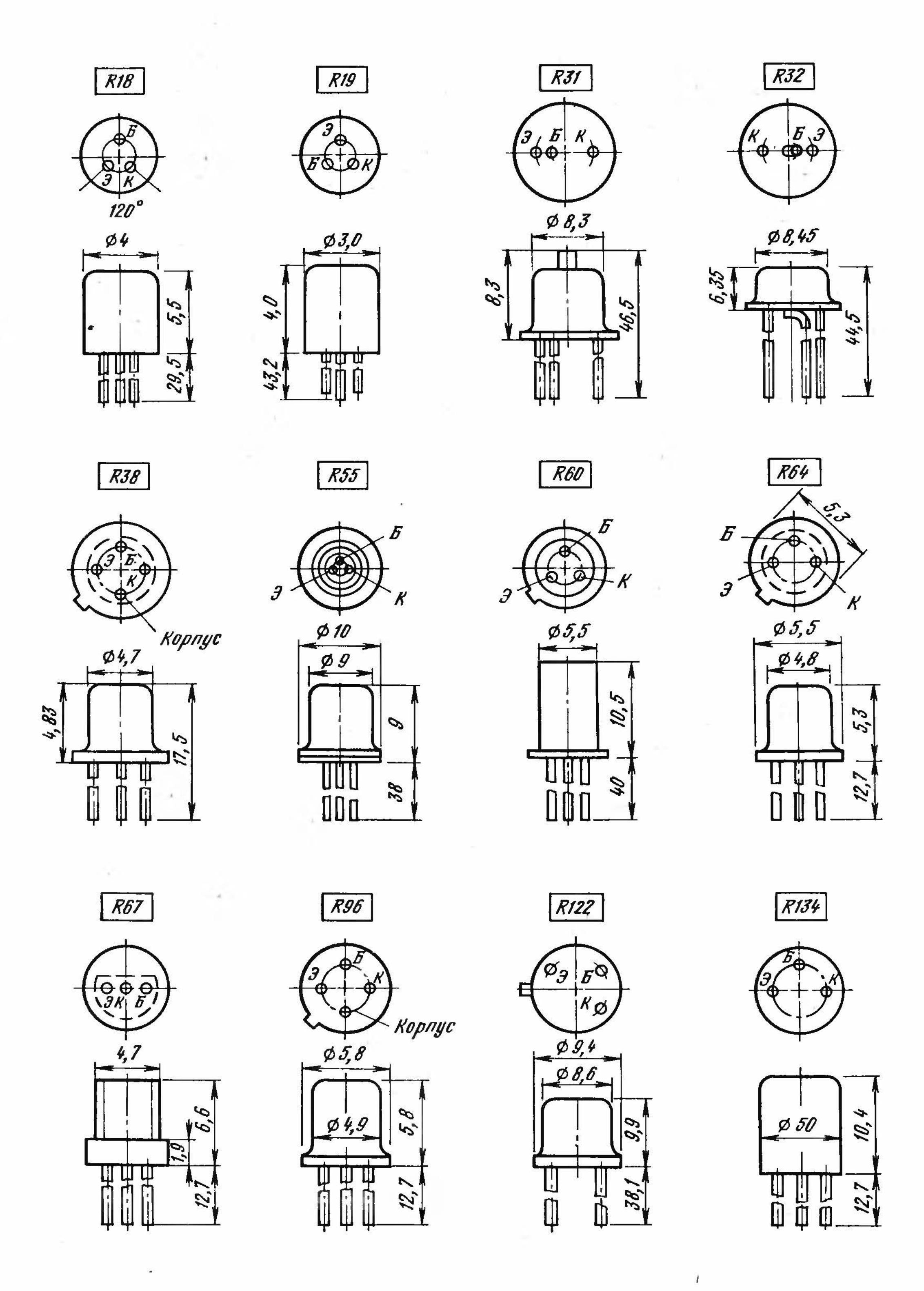


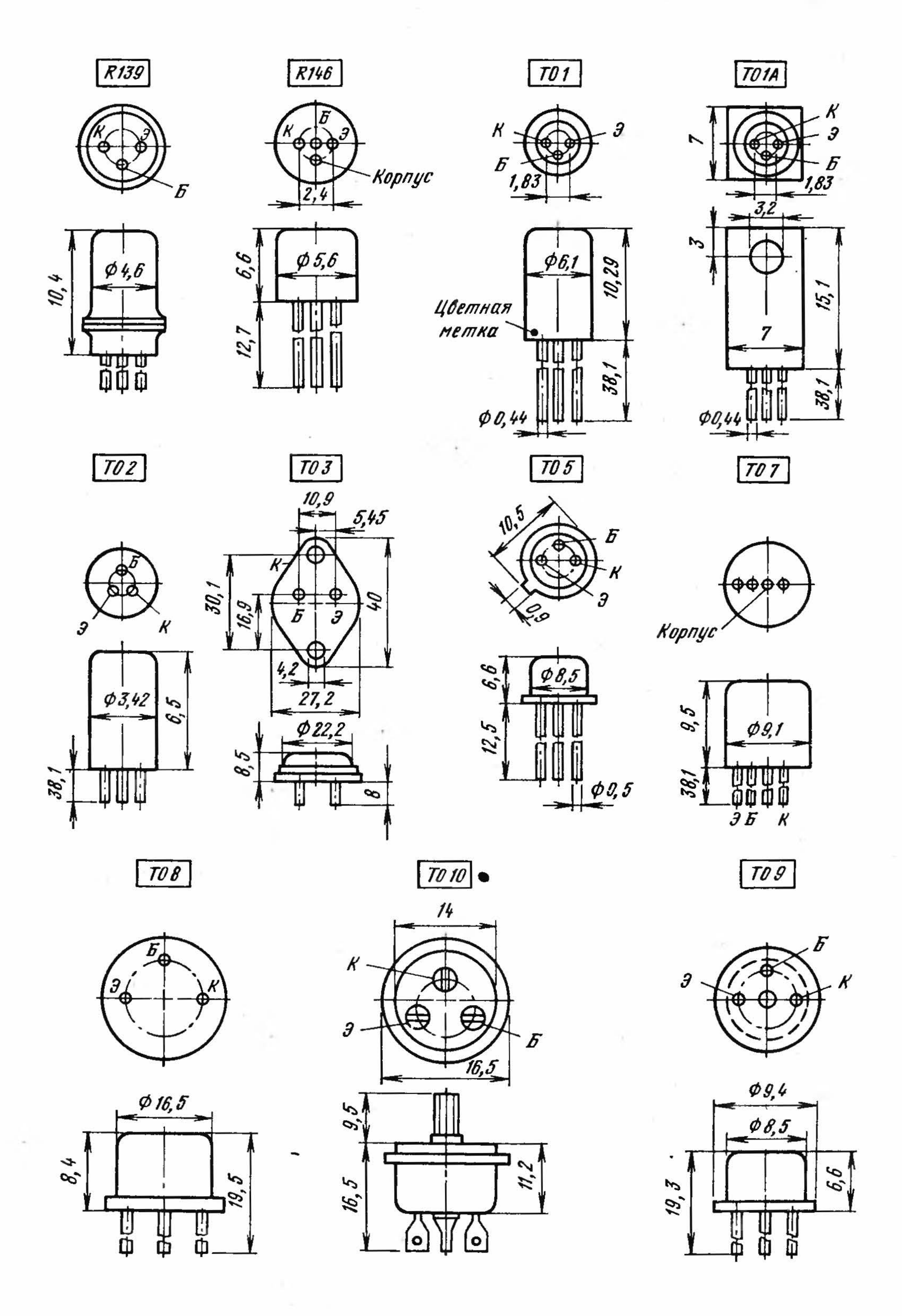
MD10
31
Б
Э
К-корпус
7,5
16
MD11
Э
Б
18,5
30
Ø 14,3
3
9,4
18,9
9,5
MD17
4,2
Э
Б
30
Ø 14,3
1,8
8,9
8,9
MD23
19
Б
Э
Ø 14,6
7,5
17
0,51
9,5
MD29
26
К
13,5
Б
Э
Ø 9,4
Ø 8,5
1,6
8
38
MD36
21,5
6,4
2,4
3
К
Э
34,7
10,1
9,2
12,7
Б
MM10
5
4,5
0,2
3,5
Э
Б
К
1
2,5
2,54
2,54
1,3
7,5
10,4
1,2
2,15
0,7
0,5
1,8
1,2
0,75
MM11
Э
Б
К
3
7,5
4
10,3

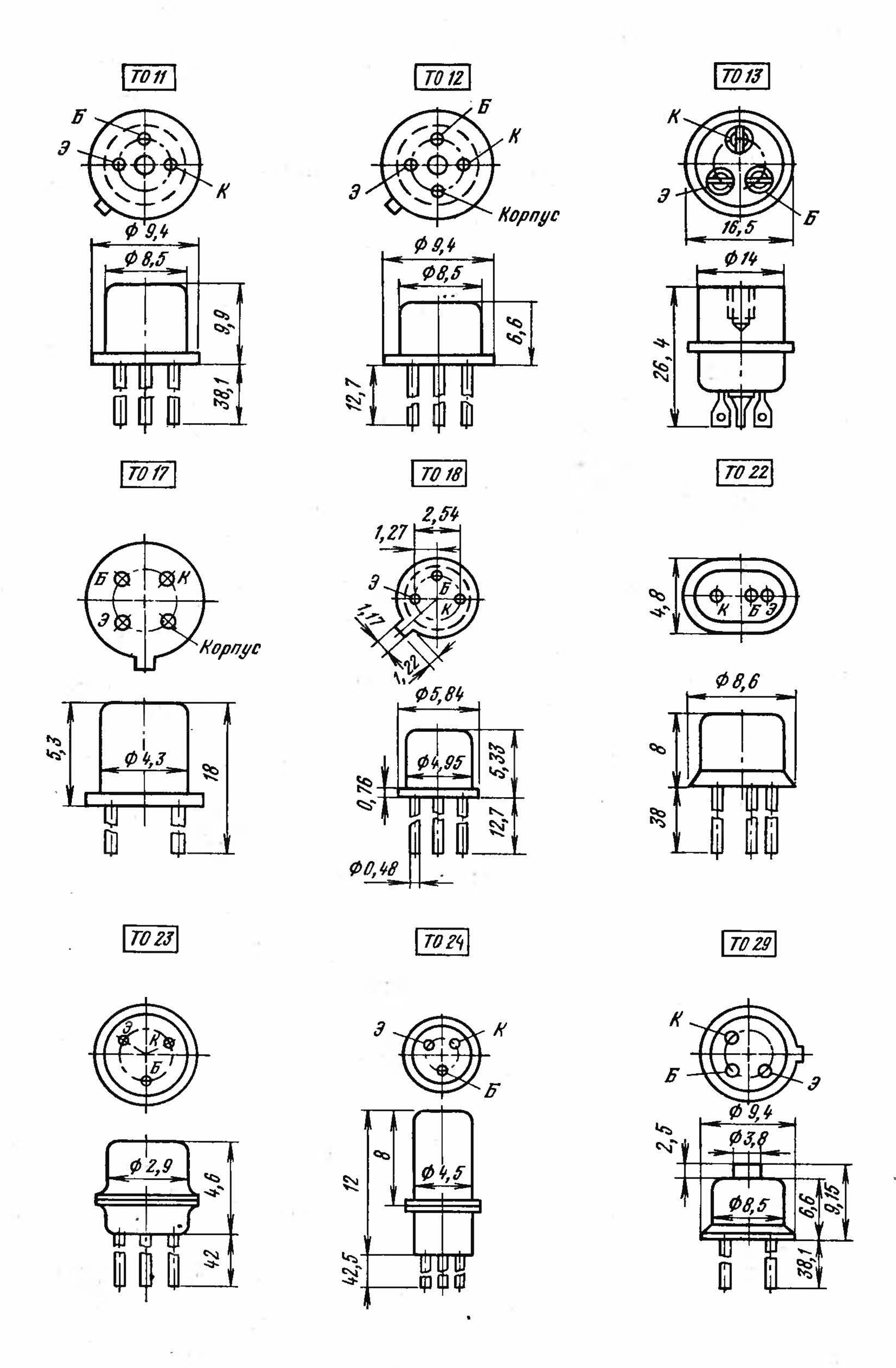


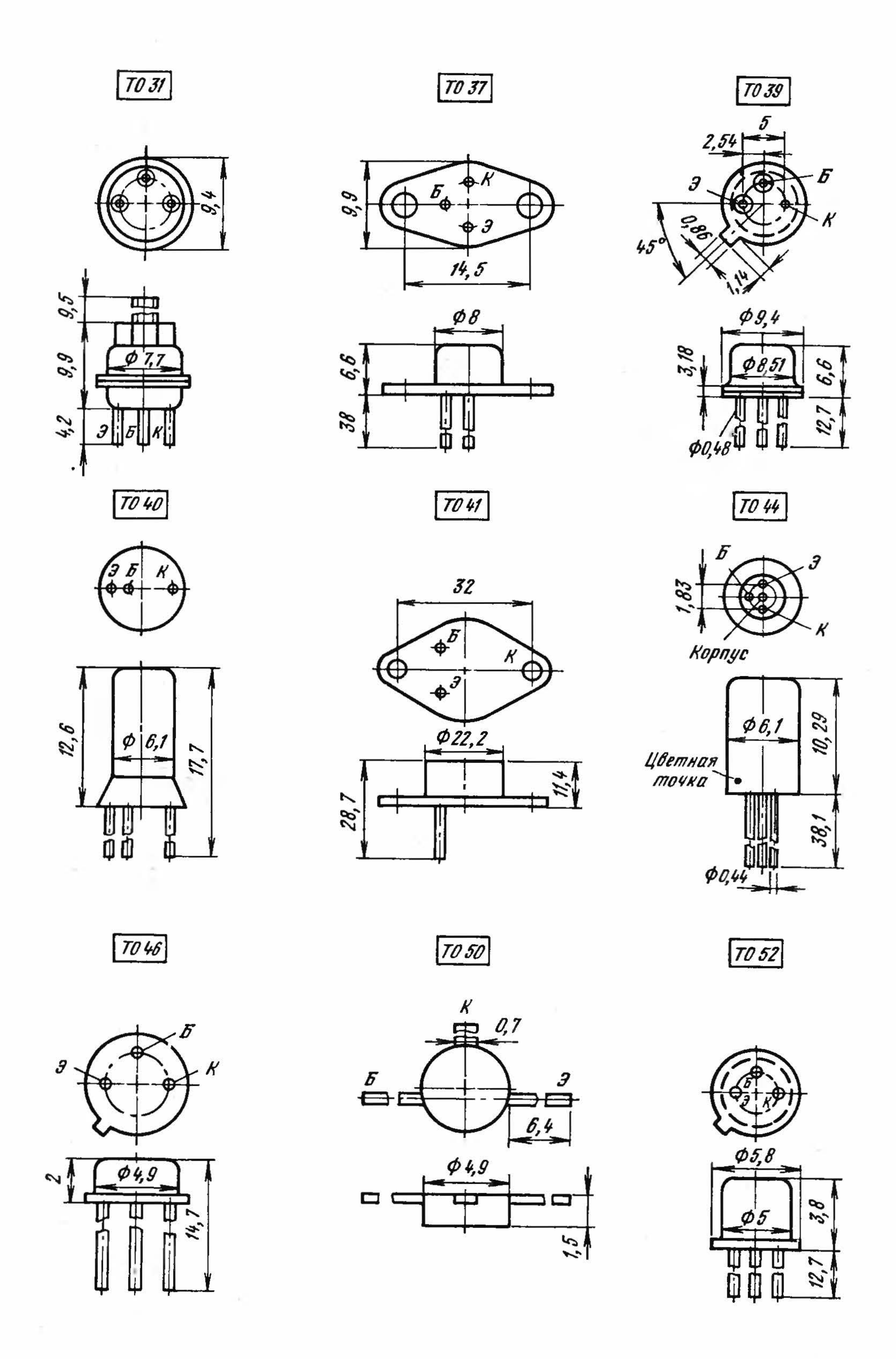
ММ12
3
6
4
11
К
Б
Э
ММ13
Э
Б
К
7,6
5
3,8
МТ29
Ф 15,2
20
10
11
Э
К
Б
МТ59
Ф 9,6
3,9
16,5
К
0,76
Э
Э
11,4
Б
МТ67
8,3
11,6
9,6
Э
К
Б
17,5
МТ71
Ф 9,8
2,5
7
0,2
19
12
3,3
К
58
5,7
27
Э
Э
Б
МТ74
Ф 5
0,13
1,4
1,5
1,5
13,5
1,5
Ф6,3
Ф7
Б
К
2,5
6,3
45°
Э
50°
МТ72
Ф 12
0,2
6,6
3
18,5
3,3
45°
К
6,6
Э
27
Э
13,5
Б
МТ77
Ф 7,2
16,5
7,6
3,2
4,2
Э
Б
К
2,7
45°
6,7
Э

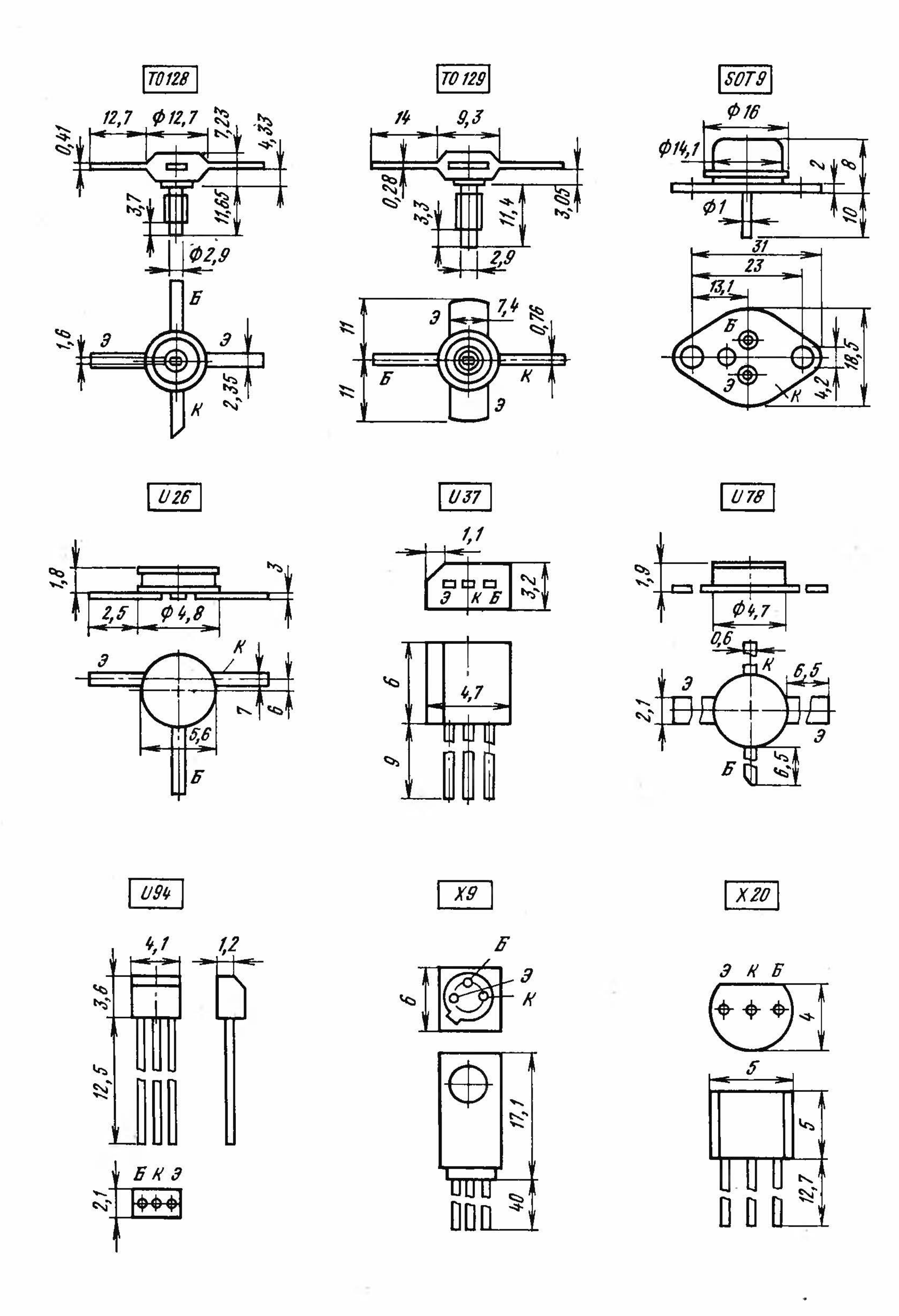

MT78
Φ8,1
18
12
2,6
7,4
К
Э
5,2
7,6
3,7
13
Б
MT83
Φ 10
2,6
0,2
12,2
2,3
М4
Φ1,5
3
Б
15
6
6
8
20
К
MT84
0,1
7,3
8
10,5
Φ2,8
Φ6,4
Э
1,1
К
Б
9,6
27,7
14
Э
27,7
OV4
5,8
10,7
9,9
11,7
38
Э
Б
К
OV9
К
Б
Э
5,5
10,2
9,4
8
44,6
36,6
OV16
3,8
5,34
43
38
К
Б
Э
R8
К
Б
Э
Φ 6
15,7
53
R9
К
Б
Э
Φ 5,1
15
52
R10
К
Э
Б
9,4
Φ 7,9
50,8
12,7
2
38,1
R13
К
Б
Э
Φ 12,7
Φ 8,6
9,7
27,9

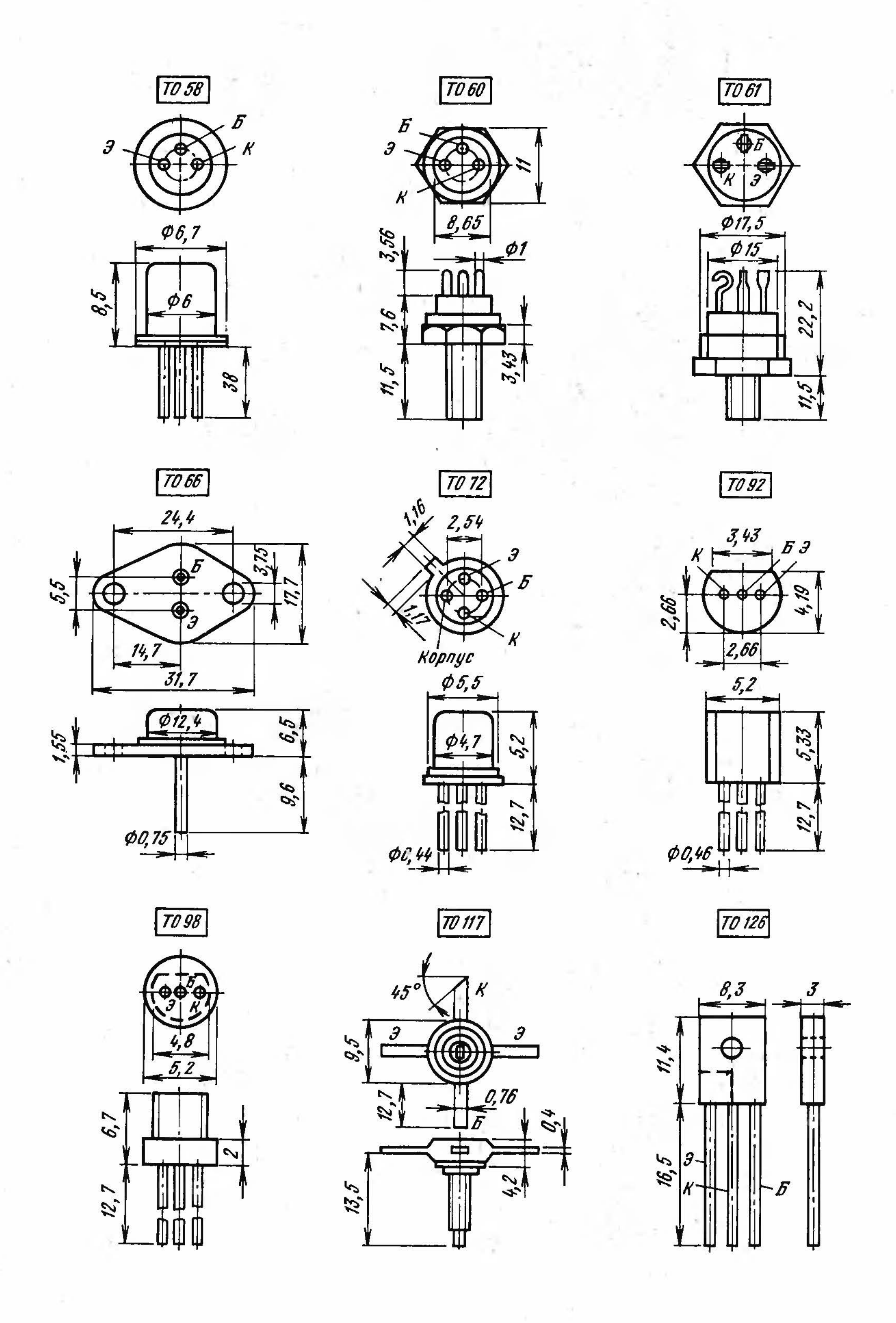

R18
Б
Э
К
120°
Ø 4
5,5
29,5
R19
Э
Б
К
Ø 3,0
4,0
43,2
R31
Э
Б
К
Ø 8,3
8,3
46,5
R32
К
Б
Э
Ø 8,45
6,35
44,5
R38
Э
Б
К
Корпус
Ø 4,7
4,83
17,5
R55
Б
Э
К
Ø 10
Ø 9
9
38
R60
Б
Э
К
Ø 5,5
10,5
40
R64
5,3
Б
Э
К
Ø 5,5
Ø 4,8
5,3
12,7
R67
Э
К
Б
4,7
6,6
1,9
12,7
R96
Б
Э
К
Корпус
Ø 5,8
Ø 4,9
5,8
12,7
R122
Э
Б
К
Ø 9,4
Ø 8,6
9,9
38,1
R134
Б
Э
К
Ø 50
10,4
12,7


R139
К
Э
Б
10,4
ф 4,6
R146
Б
К
Э
Корпус
2,4
6,6
ф 5,6
12,7
ТО 1
К
Э
Б
1,83
ф6,1
10,29
Цветная
метка
38,1
ф 0,44
ТО1А
К
Э
Б
7
1,83
3,2
3
15,1
7
38,1
ф0,44
ТО 2
Б
Э
К
ф3,42
6,5
38,1
ТО 3
10,9
5,45
К
30,1
16,9
Б
Э
40
4,2
27,2
ф 22,2
8,5
8
ТО 5
10,5
Б
К
Э
0,9
6,6
ф 8,5
12,5
ф 0,5
ТО 7
Корпус
9,5
ф 9,1
38,1
Э Б К
ТО 8
Б
Э
К
ф 16,5
8,4
19,5
ТО 10
14
К
Э
Б
16,5
9,5
16,5
11,2
ТО 9
Б
Э
К
ф 9,4
ф 8,5
19,3
6,6

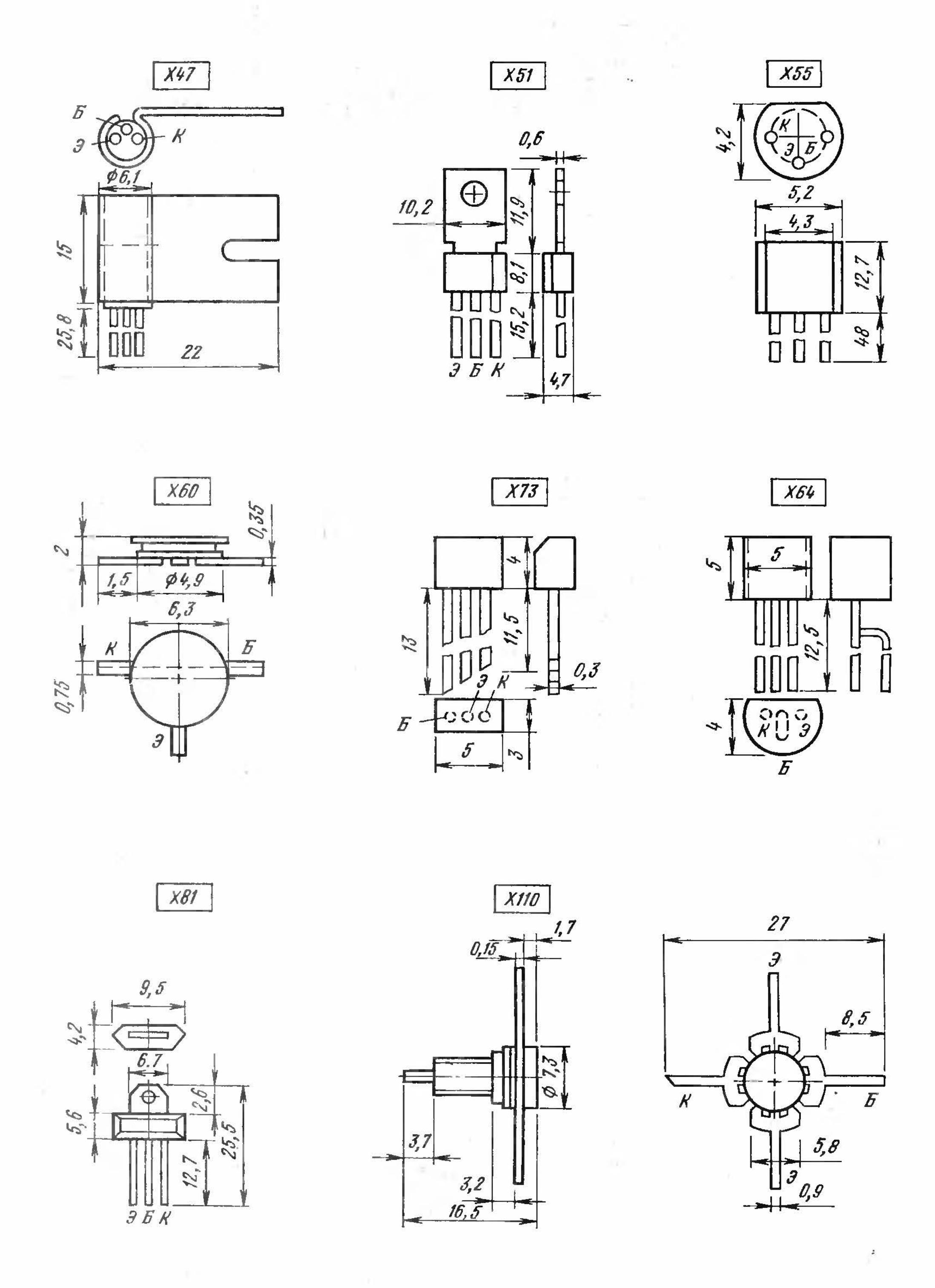

ТО 11
Б
Э
К
Ф 9,4
Ф 8,5
9,9
38,1
ТО 12
Б
К
Э
Корпус
Ф 9,4
Ф 8,5
6,6
12,7
ТО 13
К
Э
Б
16,5
Ф 14
26,4
ТО 17
Б
К
Э
Корпус
5,3
Ф 4,3
18
ТО 18
2,54
1,27
Э
Б
К
1,17
1,22
Ф 5,84
Ф 4,95
5,33
0,76
12,7
Ф 0,48
ТО 22
4,8
К
Б
Э
Ф 8,6
8
38
ТО 23
Э
К
Б
Ф 2,9
4,6
42
ТО 24
Э
К
Б
8
12
Ф 4,5
42,5
ТО 29
К
Б
Э
Ф 9,4
Ф 3,8
2,5
Ф 8,5
6,6
9,15
38,1

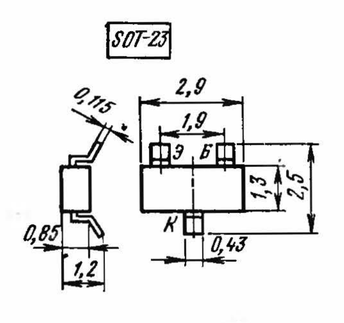

ТО 31
9,4
9,5
9,9
Ф 7,7
4,2
Э Б К
ТО 37
9,9
Б
К
Э
14,5
Ф 8
6,6
38
ТО 39
5
2,54
Э
Б
К
45°
0,86
1,14
Ф 9,4
3,18
Ф 8,51
6,6
12,7
Ф0,48
ТО 40
Э Б К
12,6
Ф 6,1
17,7
ТО 41
32
Б
К
Э
Ф 22,2
28,7
11,4
ТО 44
Б
Э
1,83
К
Корпус
Ф 6,1
10,29
Цветная точка
38,1
Ф0,44
ТО 46
Б
Э
К
2
Ф 4,9
14,7
ТО 50
К
0,7
Б
Э
6,4
Ф 4,9
1,5
ТО 52
Б
Э
К
Ф 5,8
Ф 5
3,8
12,7

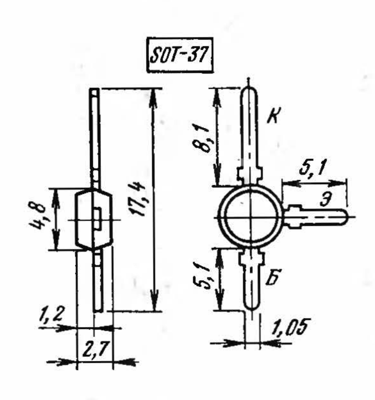

TO128
12,7
Ф12,7
7,23
4,33
0,41
3,7
11,65
Ф2,9
Б
1,6
Э
Э
2,35
К
TO129
14
9,3
0,28
3,05
3,3
11,4
2,9
7,4
0,76
11
11
Э
Б
К
Э
SOT9
Ф16
Ф14,1
2
8
Ф1
10
31
23
13,1
Б
Э
К
18,5
4,2
U26
1,8
3
2,5
Ф4,8
Э
К
7
6
5,6
Б
U37
1,1
3,2
Э К Б
6
4,7
9
U78
1,9
Ф4,7
0,6
К
6,5
Э
2,1
Э
Б
6,5
U94
4,1
1,2
3,6
12,5
Б К Э
2,1
X9
Б
Э
К
6
17,1
40
X20
Э К Б
4
5
5
12,7

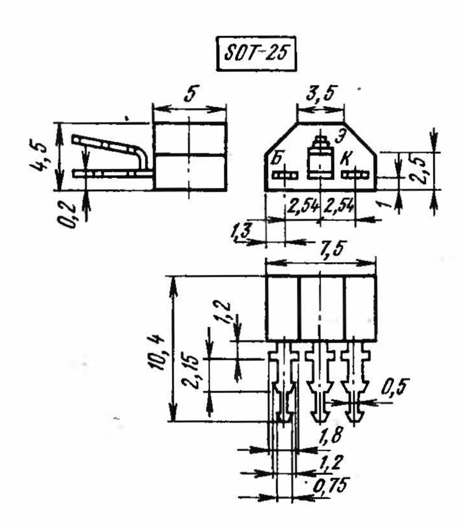


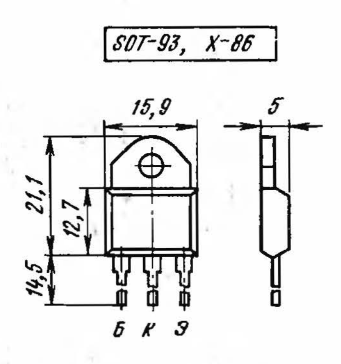
ТО 58
Ф6,7
Ф6
8,5
38
Э
Б
К
ТО 60
Б
Э
К
11
8,65
3,56
Ф1
7,6
11,5
3,43
ТО 61
Б
К
Э
Ф17,5
Ф15
22,2
11,5
ТО 66
24,4
5,5
3,75
17,7
Б
Э
14,7
31,7
Ф12,4
1,55
6,5
9,6
Ф0,75
ТО 72
1,16
2,54
Э
Б
К
1,17
Корпус
Ф5,5
Ф4,7
5,2
12,7
Ф0,44
ТО 92
3,43
К
Б Э
2,66
4,19
2,66
5,2
5,33
12,7
Ф0,46
ТО 98
Б
Э
К
4,8
5,2
6,7
2
12,7
ТО 117
45°
К
Э
Э
9,5
12,7
0,76
Б
0,4
13,5
4,2
ТО 126
8,3
3
11,4
16,5
Э
К
Б

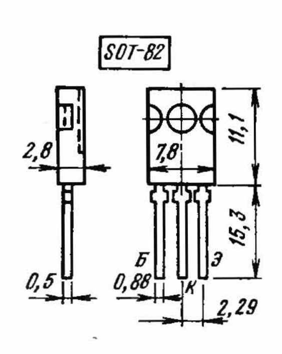

X47
Б
Э
К
Φ6,1
15
25,8
22
X51
0,6
10,2
11,9
8,1
15,2
Э Б К
4,7
X55
4,2
К
Э Б
5,2
4,3
12,7
4,8
X60
0,35
2
1,5
Φ4,9
6,3
К
Б
0,75
Э
X73
4
13
11,5
Э К
0,3
Б
5
3
X64
5
5
12,5
4
К Э
Б
X81
9,5
4,2
6.7
5,6
2,6
25,5
12,7
Э Б К
X110
1,7
0,15
Φ 7,3
3,7
3,2
16,5
27
Э
8,5
К
Б
5,8
Э
0,9

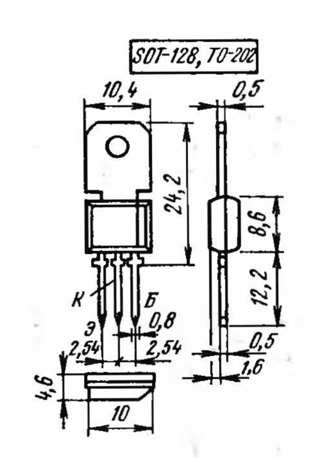

SOT-23
2,9
1,9
0,115
Э
Б
К
1,3
2,5
0,85
1,2
0,43


SOT-37
17,4
4,8
1,2
2,7
8,1
К
5,1
Э
5,1
Б
1,05


SOT-25
5
4,5
0,2
3,5
Э
Б
К
2,5
2,54
2,54
1
1,3
7,5
10,4
1,2
2,15
0,5
1,8
1,2
0,75


SOT-93, X-86
15,9
5
21,1
12,7
14,5
Б К Э


SOT-82
2,8
7,8
11,1
15,3
Б
Э
К
0,5
0,88
2,29


SOT-128, TO-202
10,4
0,5
24,2
8,6
12,2
К
Б
Э
0,8
2,54
2,54
0,5
1,6
4,6
10

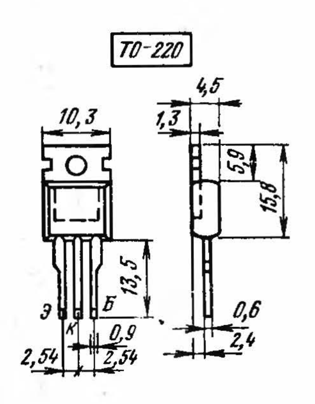

TO-220
10,3
4,5
1,3
5,9
15,8
13,5
Э
Б
К
0,9
2,54
2,54
0,6
2,4

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ КОРПУСОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Отечественное обозначение	Зарубежное обозначение	Отечественное обозначение	Зарубежное обозначение	Отечественное обозначение	Зарубежное обозначение
КТ-1-7	TO-18	КТ-9	TO-3, SOT-9	КТ-35-2	TO-46
КТ-1-12	TO-72	КТ-12*	X-73, U-94	КТ-43-1	SOT-93
КТ-2-7	TO-39	КТ-14*	SOT-37	КТ-46	SOT-23
КТ-2-10	TO-5	КТ-26*	TO-92, R-67	КТ-47	SOT-89
КТ-4-2	TO-60	КТ-27	TO-126	КТ-48	SOT-143
КТ-6	TO-61	КТ-28	TO-220	КТ-49*	TO-126
КТ-8	TO-66	КТ-29	SOT-37	КТ-50	TO-202

* Приближенный аналог

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ДИОДОВ

Обозначение диода	Фирма
A	AI, EII, GDC, GE, IRC, HL, MDP, NJS, SSI, SI
AA	AEI, CSR, ITT, Mist, ML, PEC, SA, SI, STI, Tel, Thom., V
AAP	Unitra
AAY	ML, Unitra
AAZ	EI, Mist., PI, Thom.
AB	SI
AC	SI
AD	SE
AE	AS, ML
AEY	ML
AF	DTC
AGP	GIC
AP	APD
AR	AS, GIC
ARF	AS
AS	ASI
ASZ	SL
AU	HL
AW	HL
AY	EI
AZ	EI
B	BB, EII, FE, MEL, RC, UC
BA	AEI, EI, EII, FE, FSC, SGS, HS, ITT, ML, NAS, PEC, PI, SA, Tel., Thom., V, WDI, Unitra
BAE	Unitra
BAL	SA, Thom.
BAP	Unitra
BAR	EII, SA, Thom, Unitra
BAS	AEI, ML, PEC, RTC, SA, Thom., V
BAT	AEI, ML, PEC, RTC, Thom., V

Обозначение диода	Фирма
BAV	AEI, FEL, FSC, ITT, ML, PEC, RTC, SA, SEC, Tel., Thom., V
BAVP	Unitra
BAW	AEI, FEL, FSC, ML, PEC, RTC, V, SA, SEC, Tel., Thom., Unitra
BAX	FSC, ITT, ML, PEC, RTC, SGS, Thom., V
BAY	FSC, ML, PEC, SA, Tel, Thom., Unitra
BAYP	Unitra
BB	IRC, ITT, HL, PEC, Thom, Unitra
BBP	Unitra
BBY	PEC
BCD	EII
BD	MED, RC
BFW	STI
BH	EDI
BOD	BB
BOV	BB
BP	EI
BPH	RCC
BPHV	RCC
BQ	EI
BR	EII, RL, TRW
BRV	RCC
BS	IRC, LEC
BXY	ML
BXYP	Unitra
BY	AEI, BEL, EDI, EI, FE, ITT, LEC, ML, NAS, PEC, RTC, SA, SGS, Thom., WDI
BYD	PEC
BYM	PEC
BYP	Unitra

Обозначение диода	Фирма
BYQ	PEC
BYR	PEC
BYS	SA
BYT	PEC, Thom.
BYV	ML, PEC, RTC, Tel, Thom., V
BYM	AEI, FEL, ML, PEC, RTC, Tel., Thom., V
BYX	CSD, MED, ML, NAS, PEC, RTC, SCL, Thom., V
BYY	CSD, ML, Tel.
BYYP	Unitra
BZ	AEI, CSD, EI, NJRC, RC, Tel
BZD	PEC, SA
BZP	Unitra
BZT	PEC, RTC
BZV	FEL, ML, PEC, RTC, SA, Thom., V
BZW	PEC, RTC, SA, SGS, Thom., V
BZWP	Unitra
BZX	AEI, CDI, CSD, FE, FEL, ITT, ML, NAS, PEC, RTC, SA, SEC, Tel., Thom., Unitra, V
BZY	AEI, EI, FE, ML, PEC, RTC, SA, SCL, Thom., V
BZYP	Unitra
BZZ	PEC
C	BB, CODI, HL, SCL, UC
CA	RCA
CAX	UC
CAY	ML
CB	EDI
CD	CDI, MSC
CER	SDI, SI
CF	CODI
CFR	CODI

Обозначение диода	Фирма
CG	GIC
CH	SA, Thom
CIL	TCI
CL	CODI
CLR	CODI
CLVA	TRW
CND	CODI
CNM	CODI
COD	CODI
CP	EDI
CR	SCL
CRD	CODI
CRG	CODI
CRHG	SSDI
CRS	CODI
CRT	CODI
CSB	CSD
CSKB	SII
CTM	SE
CTR	MDP
CTU	SE
CTZC	SI
CXY	ML
CY	Thom.
CZ	CSR
D	SEM, SI, TEL, Tel., Thom.
DA	GE, LEC, Rohm, Tel.
DAC	SL
DBA	San.
DB	SL
DCA	San.
DD	CODI, LEC, Tel.
DE	DI, GE
DF	CODI, DI
DFA	San.
DFB	San.
DFC	San.
DG	GIC, Unitra
DHA	San.
DHB	San.
DHD	GE
DHR	Thom.
DI	DI, MEL
DK	Unitra
DL	SDI
DMG	Unitra
DNN	Thom.
DR	BEL, HS, EDI, STI
DRN	Thom.
DRX	BEL
DS	BB, MED, San.
DSA	BB, San.
DSD	BB
DSF	MED
DSH	AI
DSR	TRW
DSZ	MED, TRW
DT	GDC, GE
DTZ	Thom.
DZ	GE, San.
DZG	Unitra
E	EII, STSI
EA	ED
EC	EDI
ED	OEC, SI
EF	EDI
EG	EDI
EGP	GIC
EH	EDI
EK	EDI
EM	ITT
EQ	Thom
EQA	FEC
EQB	FEC
ER	GDC, Thom.
ERA	FEC
ERB	FEC
ERC	FEC
ERD	FEC
ESAB	FEC
ESAC	FEC
ESAD	FEC
ESDA	GSI
ESJA	FEC
ESM	Thom.
ESP	ESPI
ESZ	SL
EV	Thom.
EW	Thom.
EZ	NJRC
F	EII, NEC, Samtech, SDI, STSI, Thom.
FA	FSC
FB	FE
FC	SE
FD	FSC, GS, MEC, PSI
FDC	FSC
FDH	FSC
FE	GIC, GS
FF	GS, Samtech
FG	GS
FH	FSC
FJT	FSC
FM	Samtech
FR	RL
FS	Mist., RCC, Thom.
FSA	FSC
FSN	RCC
FSY	FE
FWL	SI
FWLA	SI
FWLC	SI
FWLD	SI
FZD	Thom.
G	APD, EII, GIC, UC, Thom.
GA	RFT, Tesla
GAY	Tesla
GD	PSI, SA
GEM	ML
GER	GDC, GE
GEX	ML
GFA	San.
GFB	San.
GFD	San.
GFE	San.
GH	SEC
GHV	GSI, SE
GI	GIC
GLA	CODI
GLT	Thom
GM	GIC, SE
GMP	GSI
GP	GIC, RFT
GR	Thom.
GS	Thom.
GSA	San.
GSB	San.
GSD	GSS
GSV	GSI, GSS
GSZ	SL
GU	GPD, SE
GY	RFT
GZ	Thom.
GZA	San.
GZB	San.
H	EII, HL, MDP, SI, VSI
HA	MENA, SI, UC
HAB	EDI
HB	SI
HC	ASI, SDI, SE, SI
HCR	LT
HCV	SDI
HD	PSI, STI
HF	SE
HG	STI
HM	Harris
HMG	Semicoa
HP	CODI, HP
HPA	CODI
HR	CODI
HS	MENA, Tel., UC
HSCH	HP
HSE	HS
HSKE	SII
HSM	HL
HTR	Thom.
HTV	MENA
HV	ASI, HL, MENA, SDI, SE, SI
HVC	SI, STSI
HVE	UC
HVF	UC
HVFS	UC
HVG	GIC
HVH	UC
HVHF	UC
HVHJ	UC
HVHS	UC
HVJX	UC
HVPR	GIC
HVR	SDI, SE
HVRG	CODI
HVS	SE
HVT	SE
HVX	UC
HW	SI
HX	MENA
HZ	HL
ICT	GSI
ICTE	GSI, Mot., Thom.
ID	IDC
IDA	IDC
IDBC	SL
IDCC	SL
IDDC	SL
IN	CD
IRD	IRC
IRWC	SL
IS	QC, San.
ISS	HL
ISV	HL
ITT	ITT
J	ASI, EII, HL, MEL, SDI
JD	PSI
JKV	CSD

Продолжение

Обозначение диода	Фирма	Обозначение диода	Фирма	Обозначение диода	Фирма
K	CODI, EII, MA, MEL	MDA	Mot.	OSM	RTC, V
KA	Tesla	MDD	BB	OSS	RTC, V
KBCTD	GIC	MDX	UC	P	EII, GSI, HL, GIC, PI, SI, Thom.
KBCTP	GIC	ME	Thom.	PAD	TSC
KBF	GIC	MF	MED	PBC	EDI
KBL	GIC	MFE	MED	PBR	EDI
KBP	GIC	MGLA	CODI	PBT	EDI
KBPC	GIC	MH	SDI	PBY	PSDI
KBPS	GIC	MHD	GE	PD	EDI, PI, TRW
KD	EE, PPC, PSI	MHF	BB	PDR	PSDI
KGB	BB	MHO	BB	PE	EDI
KGD	BB	MHV	CODI	PF	SE, Thom.
KHP	EDI	MI	SE	PFC	Thom
KL	CODI	ML	MS	PFG	RI
KLR	CODI	MLNA	CODI	PFR	PSDI, Thom.
KS	FEL	MLV	CODI	PFZ	Thom.
KSA	IRC	MMB	SEC	PFZD	Thom.
KSD	GE	MMD	Mot.	PH	ML, PEC
KSL	IRC	MO	TAG	PHR	PSDI
KU	Thom.	MP	GE, TAG, GIC	PHSD	PEC
KV	EDI, FSI	MPD	GE	PIP	GSI
KVF	EDI	MPI	Mot.	PK	PI
KVP	EDI	MPR	TAG	PKK	PI
KX	UC	MPT	GSI	PL	LEC, Thom.
KXS	UC	MPTE	GSI, Mot.	PLE	Thom.
KY	Tesla	MPZ	Mot.	PLQ	Thom.
KYZ	Tesla	MQ	SCL	PLR	Thom.
KZ	FSI, IRC, STSI, Tesla	MR	CODI, Mot., SE, SI	PM	MED, TRW
KZZ	Tesla	MRD	CODI	PMA	UC
L	HL, Samtech, SCL	MRF	CODI	PMB	UC
LA	IRC, SI, UC	MS	CODI, SDI, UC	PMC	UC
LAA	SI	MSD	Mot., SEC	PMD	RI, UC
LAB	SI	MSK	SII	PME	UC
LAC	SI	MSZ	SL	PMR	LS
LB	IRC	MT	MS, TAG	PR	ITT, PI, SSS, Thom.
LC	IRC, GSI, UC	MTR	TAG	PS,	TRW
LCC	SI	MTZ	MS, Rohm	PSZ	SL
LCD	EDI	MU	Thom.	PT	TAG
LCE	GSI	MUR	Mot.	PTC	MDP
LCS	UC	MV	SDI	PTR	TAG
LD	CODI, IRC	MVAM	Mot.	PTS	TAG
LDD	Amp.	MVS	Mot.	PTSR	TAG
LDZ	Amp.	MX	MS, UC	PW	MEL
LE	IRC	MXS	UC	PY	Thom.
LFD	EDI	MZ	MED, Mot., MS	PZD	Thom.
		MZA	MEC	Q	IDC
LHC	EDI	MZC	Mot.	R	CODI, MEL, Mot, Samtech, SCL, Thom., VSI, WEC
LK	EDI	MZD	Thom.		
LM	NSC, UC	TZL	MEC		
LMS	UC	N	HL		
LMZ	GSI, SI	NBS	NAE	RA	EDI, SE, WEC
LNA	CODI	NCR	NAE	RB	SE
LPM	SI	ND	CODI	RBA	RL
LS	UC	NLA	NEI	RBC	RL
LWA	TRW	NPC	Thom.	RBD	RL
M	EII, MED, Samtech, SDI, TC, Thom.	NS	SDI	RC	RCC, SE
		NSD	SDI	RCD	EDI
MA	MA, MEC, UC	NSR	NAE	RCP	RCC
MB	MED, MS, SE	NSS	NAE	RD	APD, NEC
MBD	Mot.	NTD	EDI	REG	RCC
MBI	Mot.	NV	RCC	RF	EDI, SE
MBR	Mot.	OA	BEL, ME, ML, Mist, PEC, SL, RTC, Tesla, V	RFD	EDI
MC	MS, Thom.			RG	GIC, Thom.
MCL	Mot.	ODB	SL	RGM	GIC
MCLT	Mot.	ODC	SL	RGP	GIC
MCV	SDI	ODD	SL	RH	SE
MD	MEC, OEC, SL, Thom., UC	OF	RTC	RHC	EDI
		OSB	RTC, V	RHR	EDI

Обозначение диода	Фирма
RIB	EDI
RIG	RCC
RK	EDI
RKB	GIC
RKBP	GIC
RKBPC	GIC
RL	EDI, RL
RM	MEC, SE
RN	Thom.
RO	SCL, SE
RP	GIC, SSDI, Thom.
RPP	Thom.
RS	RL
RTD	EDI
RTF	Thom.
RU	SE
RV	EDI
RVP	EDI
RW	GIC
RY	RCC
RZ	Thom.
S	GS, HL, MDP, MED, MEL, SA, SE, Samtech, SI, STSI, WS
SA	GSI, RFT, SE, SL, WS
SAM	RFT
SAX	RFT
SAY	RFT
SAZ	RFT
SB	GIC, RL, SE
SBEA	Samtech
SBEB	Samtech
SBEC	Samtech
SBMA	Samtech
SBMB	Samtech
SBMC	Samtech
SBR	Samtech, SI
SBT	MED
SC	Samtech, SE, SL, SI
SCA	Samtech
SCAJ	Samtech
SCAS	Samtech
SCBA	Samtech
SCBAR	Samtech
SCBH	Samtech
SCBK	Samtech
SCBR	Samtech
SCDA	Samtech
SCDAR	Samtech
SCDAS	Samtech
SCDE	Samtech
SCF	Samtech
SCFC	Samtech
SCH	Samtech
SCHC	Samtech
SCHF	Samtech
SCHJ	Samtech
SCHS	Samtech
SCKV	Samtech
SCM	Samtech
SCMS	Samtech
SCMW	Samtech
SCNA	Samtech
SCNAS	Samtech
SCNE	Samtech
SCPA	Samtech
SCPB	Samtech
SCPD	Samtech
SCPE	Samtech
SCPH	Samtech
SCPN	Samtech
SCPP	Samtech
SCSDF	Samtech
SCSDFF	Samtech
SCSDL	Samtech
SCSDM	Samtech
SCSF	Samtech
SCSFF	Samtech
SCSHF	Samtech
SCSHM	Samtech
SCSM	Samtech
SCSNF	Samtech
SCSNFF	Samtech
SCSNL	Samtech
SCSNM	Samtech
SCSPF	Samtech
SCSPFF	Samtech
SCSPL	Samtech
SCSPM	Samtech
SD	DII, ITT, OEC, PEC, SL, Mot, TRW
SDA	SSDI, SI
SDFF	Samtech
SDH	Samtech
SDR	SSDI, CODI
SER	SSDI
SES	UC
SF	CODI, NAE, SE
SFC	NAE
SFD	Mist., Thom.
SFF	Samtech
SFM	Samtech
SFMS	Samtech
SG	SE
SGA	SE
SGB	SE
SGF	SE
SGM	SE
SH	Samtech, SE, SL
SHVM	Samtech
SI	MDP, Samtech, SI
SIB	FEC
SIST	SMC
SISTE	SMC
Siek	BHP
SIF	Samtech
SIM	ML
SK	SII
SKB	SII
SKBB	SII
SKD	SII
SKE	SII
SKHM	SII
SKKD	SII
SKN	SII
SKNA	SII
SKR	SII
SKS	SII
SKSA	SII
SKV	SII
SKXA	SII
SL	CODI, SI, SSD
SLC	SI
SLCE	SI
SLD	SDI
SLDHV	SDI
SLF	CODI
SLZ	MED
SM	CODI, OEC, Samtech, SL, SI, WS
SMFR	Samtech
SMHF	Samtech
SMHR	Samtech
SN	SII
SNFF	Samtech
SNR	SE
SO	SI
SOD	SDI, SSXI
SODSPC	SDI
SP	CODI
SPC	SDI
SPCHV	SDI
SPD	CODI, SSDI
SPDA	CODI
SPFF	Samtech
SR	MEC, SE, SI, SL
SRB	OEC
SRF	OEC
SRP	GIC
SRS	SSD
SRSFR	SSD
SS	OEC, Samtech, SE, SMC
SSCDA	SSD
SSCNA	SSD
SSCPA	SSD
SSH	SI
SSiB	SA
SSiC	SA
SSiD	SA
SSiE	SA
SSiF	SA
SSiG	SA
SSiK	SA
SSiL	SA
SSiN	SA
SSiP	SA
SSP	SDI
ST	APD, EC, IRC, STSI, Samtech
STB	APD, GE
STF	Samtech
STFF	Samtech
STV	SE
SU	MED
SUES	SI
SV	GIC, NEC, SE, SI, SEM, SMC, Thom., VEC
SVD	TRW
SW	WS
SX	ML, Samtech, UC
SXS	UC
SY	RFT, Samtech, SE
SZ	ML, PS, RFT, SA, SL, SMC
SZL	SA
SZX	RFT
SZY	RFT
T	GS, HL, SDI, SI
TA	SDI
TAV	SDI
TCR	TSC

Окончание

Обозначение диода	Фирма
TD	SE
TFR	TC
THD	SEC
TI	UC
TID	TI, UC
TIDM	TI
TIR	UC
TJ	SDI
TMPD	SEC
TR	EDI
TS	MS, Samtech, SDI
TSC	TSI
TSD	SEC
TSV	SDI
TSZ	SL
TV	Tel., Thom.
TVP	TRW
TVPC	TRW
TVR	TC
TVS	UC
TZ	Rohm, STSI
TZB	SI
TZC	SI
TZV	SI
μPA	NEC
U	HL
UDC	UC
UDE	UC
UDF	UC
UDZ	UC
UES	SI, UC
UF	SE
UFB	UC
UFS	UC
UGB	BB, UC
UGD	UC
UGE	BB
UGF	UC
CHV	CSD
UPI	UPI
UR	UC
US	UC
USB	UC
USD	UC
USR	MS, SA, UC
USS	UC
UT	UC
UTR	UC
UTX	UC
UZ	UC
V	GE, HL, SI, VEC, VSI
VA	VSI
VB	BB, MDP, VSI
VC	VSI
VE	VSI
VF	SI, VSI
VG	VSI
VGB	BB
VGF	BB
VH	VSI
VHE	VSI
VHP	RCC

Обозначение диода	Фирма
VJ	VSI
VK	VSI
VKP	VSI
VL	VSI
VM	VSI
VR	DII, MED, SE, STSI
VRU	SCL
VS	SI, VSI
VSB	VSI
VSF	RFT
VSH	SL
VSK	VSI
VT	VSI
VTA	VSI
VTC	VSI
VTD	VSI
VTE	VSI
VTH	VSI
VX	UC
VXS	UC
VY	VSI
VYA	VSI
VYB	VSI
VYC	VSI
VYD	VSI
VYH	VSI
VZ	MED
W	FE, GIC, HL, VSI
WAC	SL
WBC	SL
WCN	GIC
WG	ITT
WL	FE, GIC
WO	MEL
WZ	NJRC
X	Samtech, SCL, Thom.
XF	RCC
XM	Thom.
XS	SI
Z	IRC, SCL, SMC, TRW
ZA	SI
ZB	MDP, SI
ZBC	SI
ZC	FEL, LEC, SI
ZCC	SI
ZD	ITT
ZDX	FEL
ZE	EI
ZF	EI, Thom.
ZG	EI
ZGP	GIC
ZH	SI
ZJ	TC
ZPD	FE, ITT
ZPU	ITT
ZPY	ITT
ZR	EI, SCL
ZS	FEL, SCL
ZSA	SCL
ZSY	SCL
ZTE	ITT

Обозначение диода	Фирма
ZTK	ITT
ZX	ITT
ZY	ITT
ZZ	FE, ITT
ZZY	ITT
1NZ	Tesla
1P	FE, ITT
1QE	TC
1R	TC
1RM	Thom.
1S	AM, CEIL, FL, FSC, HL MEC, NEC, San., SEM, TC, Rohm
1SF	Samtech
1SM	SL
1SR	Rohm, SE
1SS	FL, HL, HS, NEC, Rohm, TC
1SV	HL, NEC
1SX	SCL
1SZ	NEC, TC
1T	CEIL, SC
1Z	SC
2A	SSDI
2AA	CEIL, Mist., PEC
2AF	IRC
2ASLD	SDI
2B	SSDI, TC
2C	SSDI
2D	TC
2DL	IRC
2DS	LEC
2EZ	MS, SA
2FB	CODI
2G	CEIL, SDI, TC
2KBP	GIC
2KZ	STSI
2L	EII
2OA	Mist.
2R	SSDI
2SB	CODI
2SBF	CODI
2SD	SI
2SF	Samtech
2SFD	Mist
2SFF	Samtech
2SM	SL
2VR	STSI
2W	GIC
3A	SDI
3AF	STSI
3B	TC
3C	SDI
3CC	TC
3CD	TC
3D	TC
3DD	CODI
3DF	CODI
3DH	TC
3DZ	TC
3E	ASI
3EZ	SA
3F	IRC

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Продолжение

Обозначение транзистора	Фирма	Обозначение транзистора	Фирма	Обозначение транзистора	Фирма
A	AEC	BF	AEC, ASI, BEL, FEL, CDI,	BT	RS
AC	BEL, CSD, EI, GPD, ML		CSD, ACR, CSC, EI, IDI,	BU	ASI, CSD, DTC, GTC, HSE,
	PEC, RTC, SA, V, WDI		KRD, IC, HSE, MIS, PEC,		KPD, ML, NEC, PPI, RTC,
ACY	CSD, EI, GPD, HSE, THOM		RFT, RTC, TEL, V, WDI,		SDI, SGS, TEL, THOM,
	SA		UNITRA		UNITRA, V, WDI
AD	ASI, BEL, CSD, EI, GPD,	BFE	UNITRA	BUC	MOT
	ML, PEC, RTC, SA, V, WDI	BFN	RTC, SA	BUP	UNITRA
ADP	UNITRA	BFP	SA, UNITRA, TI	BUR	SGS, SEM
ADY	GPD	BFQ	AEC, FEL, ML, RTC, PEC,	BUS	ML, PEC, RTC, THOM, V
ADZ	CSD, GPD		V	BUT	ML, PEC, RTC, SGS,
AF	EI, GTC, HSE, IDI, ML,	BFR	AEC, ASI, CSD, IC, ML,		TEL, V
	PEC, RTC, UNITRA, V,		PEC, RTC, SA, THOM,	BUV	ML, PEC, RTC, SGS, SDI,
AFY	WDI		UNITRA, V, WDI		TEL, THOM, V
AL	CSD, GPD	BFS	AEC, ASI, FEL, HSE, ML,	BUW	CSD, ML, PEC, RTC, SGS,
AM	AMI		PEC, RTC, THOM,		SDI, THOM, V
AMF	AMI		UNITRA, SA, V, WDI	BUX	CSD, FEL, KPD, ML, PEC,
AP	ACR, ASC	BFT	ASI, FEL, ML, PEC, RTC,		RTC, SGS, SDI, TEL,
ASY	CSD, GPD, UNITRA		SA, SGS, TEL, THOM, V		THOM, UNITRA, UC, V,
ASZ	BEL, CSD, GPD, WDI	BFV	TI		WDI
AT	AI	BFW	AEC, ASI, BEL, CDI, CSC,	BUYP	PPI, UNITRA
AU	CSD, GPD		CSD, ML, PEC, RTC,	BUY	ASI, FEL, CSD, HSE, RTC,
AUY	CSD, GPD, HSE		UNITRA, V, WDI		SGS, SDI, WDI
B	AI, STI, THOM	BFX	ASI, CDI, CSD, CSC, FEL,	BUZ	ML, PEC, RTC, SGS, SA, V
BAL	AI		IDI, HSE, DTC, ML, PEC,	BZW	SA
BAM	AI		RTC, SGS, TEL, V, WDI	C	ASI, ACR, TCI, TI, WDI
BAP	AI	BFY	ASI, CSD, CSC, CDI, HSE,	CA	GPD
BC	AEC, ASI, BEL, CDI, EI,		IDI, FEL, ML, PEC, SGS,	CD	SII
	CSC, CSD, FEL, IDI, ITT,		TEL, V, WDI	CDT	GPD
	KRD, MEL, ML, PEC, RTC,	BGY	ML, PEC, RTC	CF	SII
	SA, SGS, THOM, UNITRA,	BLU	ML, PEC, RTC, V	CIL	CDI
	V	BLV	ML, PEC, RTC, V	CK	STI
BCE	UNITRA	BLW	ML, PEC, RTC, V	CM	TCI
BCF	AEC, ML, PEC, RTC,	BLX	ML, PEC, RTC, SDI, V	CP	TCI
	THOM, V	BLY	HSE, ML, PEC, RTC, V	CQT	GPD
BCP	UNITRA	BM	SII	CS	ASI, NSC, WDI
BCV	AEC, FEL, ML, RTC,	BP	SII	CST	GPD
	THOM, SA, V	BR	MEL, SDI	CT	SEC
BCW	AEC, ASI, CSC, FEL, ML,	BRT	SEM, TRW	CTR	STI, GPD
	PEC, RTC, SEC, SA,	BRY	ML, PEC, RTC, V	CV	SEM
	THOM, UNITRA, V, WDI	BS	ITT, ML, PEC, RTC, V	CX	ASI, WDI
BCX	AEC, ASI, CSD, CSC, FEL,	BSJ	EI	D	ACR, CSC, GE, MOT, NSC,
	ITT, ML, PEC, RTC, SEC,	BSR	AEC, ML, PEC, RTC,		SGS, PPI, STI, TI, WEC
	SA, THOM, V, WDI		THOM, V	DA	GPD, WEC
BCY	AEC, ASI, CSD, CSC, ML,	BSS	AEC, ASI, CSD, FEL, IDI,	DB	WEC
	PEC, RTC, V, WDI		ML, PEC, RTC, SA, V, WDI	DC	DI
BD	ASI, BEL, CSD, CSC, ML,	BST	AEC, ML, PEC, RTC, V	DD	AMS
	PEC, RTC, RFT, SA,	BSV	AEC, CSD, ML, PEC, RTC,	DI	DI
	UNITRA		SA, SGS, FEL, THOM, V,	DM	AMS
BDP	UNITRA		WDI, TEL	DMP	ML, PEC, RTC, V
BDV	ML, PEC, RTC, SGS, V	BSW	AEC, ML, MIS, PEC, RTC,	DN	DI, SI
BDW	CSD, IPS, ML, PEC, RTC,		SGS, TEL, UNITRA, V	DP	DI
	SGS, SSE, SDI	BSX	ASI, CDI, CSC, CSD, EI,	DQN	DI
BDX	BEL, CSC, CSD, FEL, IPS,		HSE, IDI, ML, MIS, PEC,	DT	MED
	ML, SGS, RTC, PEC, V		RTC, SGS, TEL, UNITRA,	DTA	MEC
BDY	IPS, HSE, ML, PEC, RTC,		V, WDI	DTG	ASI, DTC, GPD, STI, WDI
	SDI, TEL, SGS, UNITRA,	BSXP	UNITRA	DTN	DI
	V	BSY	ASI, CDI, CSC, HSE, IDI,	DTS	ASI, CSD, DTC, SPC, SSI,
BE	BE		FEL, ML, PEC, RTC, SGS,		TI, WDI
BEL	BEL		TEL, V	DV	SI
				DVD	SI

Обозначение транзистора	Фирма
E	NSC, SDI, WDI
EC	UA
ED	NSC
EN	ASI, CSD, IDI, STI, WDI
ERS	ETC
ESM	MIS, THOM
ETP	ETC
FC	SEC
FGT	FEL
FMMT	FEL
FM	ACR, NSC
FN	SI
FOS	FS
FT	FS, MOT, STI
FTR	FS
GC	RFT, TESLA
GD	RET, TESLA
GE	CSC, CSD, GE
GET	GE
GF	RET, TESLA
GFY	TESLA
GS	RET, TESLA
GSDB	GSI
GSDS	GSI
GSDU	GSI
GSRU	GSI
GSTU	GSI
GT	GDC, HSE
H	SII
HA	GDC
HEP	MOT
HEPE	MOT
HEPS	MOT
HP	HP
HS	GE, SEC
HSE	HSE
HT	FEL
HV	BEL
IDA	IDI
IDB	IDI
IDC	IDI
IDD	IDI
IDI	IDI
IMF	II, NSC
IR	IR
IRF	FS, IR, MOT, RCA, SGS, SI
IRFD	IR
IRFF	IR
IRFZ	IR
IT	II
ITE	II, NSC
J	IC, II, MOT, NSC, SI, SDI
JA	ITT
JC	ITT
JE	NEC
JH	SDI
JO	TRW
K	ASI, HSE, WDI, KMC
KA	TESLA
KB	WEC
KC	TESLA
KD	KMC, TESLA, WEC
KE	NSC, SDI, WDI, WEC
KF	MAI, TESLA
KFY	TESLA
KJ	MAI

Обозначение транзистора	Фирма
KM	ASI, WDI
KN	KPD
KP	KPD
KS	TESLA, WEC
KSP	PPS
KSY	TESLA
KU	TESLA
KUY	TESLA
L	ASI, WDI
LDA	AEC
LOT	TRW
LS	SI
LT	NSC
M	ASI, II, WDI
MA	ASI, HSE, MEL, MOT, STI, WDI
MC	PI
MD	CSC, MOT, PI
MDS	MOT
MEM	GI, SDI
MEU	MEL
MF	MOT, PI, STI
MFE	CSC, MOT, SDI, SI
MFEC	MOT
MG	TC
MGM	MOT
MGP	MOT
MH	MEL, WDI
MHA	FS
MJ	ASI, CSC, CSD, IDI, GTC, IPS, MOT, PPI, RCA, SGS, STC, STI, TI, WDI
MJE	ASI, CSD, CSC, GTC, IDI, MEC, MOT, NSC, PPI, SGS, STI, THOM, WDI
MJEC	MOT
MJH	MOT
MM	ASI, CSC, HSE, MOT, STI, WDI
MMBA	MOT, SEC
MMBC	MOT, SEC
MMBF	MOT, NSC
MMBPU	MOT
MMBR	MOT
MMBT	MOT, NSC, SEC
MMBTA	MOT, SEC
MMBTH	MOT, NSC
MMBTS	MOT
MMC	MOT
MMCF	MOT
MMFF	MOT
MMCM	MOT
MMT	MOT
MN	STI
MP	GPD, MPS, MEL, STC
MPF	MEL, MOT, NSC, SDI, SI, WDI
MPS	FEL, FS, CSC, SCD, IDI, GE, MOT, NSC, RC, SEC, STI, TI, THOM, WDI
MPSA	FEL, FS, CSD, GE, IDI, MEL, MOT, NSC, RC, SEC, STI, TI, THOM, WDI
MRSC	MOT
MPSD	CSC, CSD, GE, MEL, MOT, RC, SEC, STI, WDI

Обозначение транзистора	Фирма
MPSH	CSC, CSD, FS, GE, IDI, MEL, MOT, NSC, SEC, STI, WDI
MPSK	CSC, SEC
MPSL	CSC, FS, GE, IDI, MOT, NSC, SEC, STI, TI, WDI
MPSU	MOT, SPE, WDI
MPSUC	MOT
MPSW	MOT, NSC
MPU	GE, MOT
MPX	MOT
MRF	DTC, MOT
MRFC	MOT
MS	TI
MSA	FS
MSB	WDI
MSP	HSE, STI
MST	HSE, STI
MT	FS, MEL, PTI
MTA	MOT
MTE	MOT
MTH	MOT
MTM	MOT, SGS
MTP	FS, MOT, SGS
MTS	MOT
MTU	MEL
MU	GE, MOT
N	CHERRY, KPD, TI
NA	NSC
NB	NSC
NDF	NSC
NF	II, MEL, NSC, SI, TS
NKT	HSE
NPC	THOM
NPD	NSC
NR	NSC
NS	NSC
NSD	NSC, WDI
NSDU	NSC
NSE	NSC
NT	NEC
NTM	NEC
OC	GPD, HSE, GTC, STI, TI
ON	ML, PEC, RTC, V
P	CHERRY, NSC, SDI, SI, SSD, WDI
PA	PHILCO
PB	PHILCO
PBM	PHILCO
PC	PHILCO
PD	DI, PHILCO
PE	FS, PHILCO, NSC, PPI
PEC	PPI
PET	STI
PF	NSC
PG	SEC
PH	AEC, ML, PEC, RTC, V
PL	TI
PMD	CSD, LS
PMS	LS
PN	CSD, CSC, FS, MEL, NSC, RC, SSD, SSI
PT	BEL, PTI, SSD, TRW
Q	HSE
R	WDI
RCA	RCA
RCP	STI
RCS	RCA

Обозначение транзистора	Фирма
RFD	FEL
RFH	RCA
REK	RCA
RFL	RCA
RFM	RCA
RFP	RCA
RRF	RCA
RT	RTC
S	ACR, SSD, TC, UA
SC	GPD, RFT, PI
SCA	PI
SD	ML, RFT, RTC, TEL, SI, THOM, V
SDF	SDI
SDG	GPD
SDM	SDI
SDN	STC
SDP	STC
SDT	CSC, GPD, SDI, SSD
SE	ASI, CSD, FS, IDI, GTC, MOT, NSC, SEC, STI, WDI
SFMN	PI, RFT
SFN	SDI
SFT	MIS, PI, THOM
SGS	SGS
SGSP	SGS
SHA	SSI
SK	RCA, STI
SL	PS
SM	RFT
SMBT	SA
SO	THOM
SOR	THOM
SP	RS, SDI
SPC	SPC
SPK	SDI
SPM	SDI
SPT	SSI
SQ	SEM
SQD	SEM
SRF	FEL
SRL	STC
SRLP	STC
SRM	STC
SRS	STC, STI
SS	RFT, SSI
SSP	SSI
SSX	PI
ST	NSC, STI, TC
STA	STC
STC	PTI
STI	STI

Обозначение транзистора	Фирма
STIP	STI
STM	STI
STP	STI
STS	STC
SU	RFT, SGS, TSC
SV	NSC
SVN	SDI
SVT	SDI, SSD, STI, TRW
SWT	SECI
T	SEM
TBC	TC
TBF	TC
TC	MED
TCH	TAG
TCS	TI
TEC	TC
TED	TC
TF	MED
TG	UNITRA
TH	SEC, THOM
THA	THOM
THB	THOM
THX	THOM
THY	THOM
TI	HSE, STI, TI, WDI
TIP	ASI, CSC, CSD, FEL, GTC, IDI, MEC, MEL, MOT, ML, NSC, PPI, PEC, RCA, RTC, SGS, SDI, STI, TI, V, WDI
TIPC	MOT
TIPL	TI
TIS	DIC, IDI, MEL, NSC, SDI, STI, TI, WDI
TIX	TI
TIXM	TI
TIXP	PTI
TIXS	TI
TL	THOM
TMP	SEC
TN	NSC, MEL, SUPERTEX, TCI, TI
TP	SEC
TPE	SEC
TPP	SEC
TPS	SEC
TPV	TPW
TQ	SEC
TR	GDC, HSE, NVS, ME, STI
TRF	TI
TRL	GDC, HSE, STI
TRM	GDC, HVS, HSE, STI
TRS	GDC, HSE, HVS, SSD, STI
TRSP	GDC, HSE, NVS, SSD, STI

Обозначение транзистора	Фирма
TRW	TRW
TS	TI
TSB	TC
TZ	SEC
U	IFC, II, NSC, MOT, SI, SDI, UC, WDI
UC	MOT, SDI
UMIL	ACR
UMT	UC
UPT	UC
UTV	ACR
V	SGS, UA
VAM	ACR
VCR	II, SI
VMIL	ACR
VMOB	ACR
VMP	SI
VN	II, SDI, SI, SUPERTEX
VNM	SDI
VNN	SDI
VNP	SDI
VP	SDI, SUPERTEX
VQ	SUPERTEX
VTV	ACR
W	WDI
WT	WEC
XGS	GSI
XGSA	GSI
XGSQ	GSI
XGSR	GSI
ZDT	FEL
ZT	FEL
ZTX	FEL
ZVN	FEL
2NU	TESLA
3NU	TESLA
4NU	TESLA
5NU	TESLA
6NU	TESLA
7NU	TESLA
101NU	TESLA
102NU	TESLA
103NU	TESLA
104NU	TESLA
105NU	TESLA
106NU	TESLA
107NU	TESLA
152NU	TESLA
153NU	TESLA
154NU	TESLA
155NU	TESLA
156NU	TESLA
2T	EE

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ

Обозначение	Фирма, страна
ACR	ACRIAN, INC., США
AEC	AMPEREX ELECTRONIC CORP., США
AI	AVANTEK, INC.
AMI	AMERICAN MICROSEMICONDUCTOR, INC., США
AMS	AMERICAN MICROSYSTEMS, INC., США
ASI	ADVANCED SEMICONDUCTORS, INC., США
BE	BOEING ELECTRONICS, Швейцария
BEL	BHARAT ELECTRONICS, LTD., Индия
CDI	CONTINENTAL DEVICES INDIA, Индия
CSC	CRIMSON SEMICONDUCTOR CORP., США
CSD	CENTRAL SEMICONDUCTOR DIV, США
CHERRY	CHERRY SEMICONDUCTOR CORP, США
DI	DIONICS, INC., США
DTC	DIODE TRANSISTOR COMP., США
EE	ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ, Болгария
EI	ELEKTRONSKA INDUSTRIJA, Югославия
ETC	ELECTRONIC TRANSISTORS CORP., США
FEL	FERANTI ELECTRONICS, LTD, Англия
FS	FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP., США
GDC	GENERAL DIODE CORP., США
GE	GENERAL ELECTRONIC COMP., США
GPD	GERMANIUM POWER DEVICES CORP., США
GSI	GENERAL SEMICONDUCTOR INDUSTRIES, INC., США
GTC	GENERAL TRANSISTOR CORP., США
HP	HEWLETT PACKARD, США
HSE	HYBRID SEMICONDUCTOR ELECTRONIC, INC., США
HVS	HIGH VOLTAGE SEMICONDUCTOR, США
IC	INTERFET CORP., США
IDI	INTERNATIONAL DEVICES, INC, США
II	INTERSIL, INC., США
IPS	INTERNATIONAL ROWER SEMICONDUCTORS, Индия
IR	INTERNATIONAL RECTIFIER SEMICONDUCTOR, США
ITT	INTERMETALL (DER DEUTSCHE ITT), ФРГ
KMC	KMC SEMICONDUCTOR CORP., США
KPD	KELTRON POWER DEVICES, Индия
LS	LAMBDA SEMICONDUCTOR, США
MAI	MICROWAVE ASSOCIATES, INC., США
MEC	MATSUSHITA ELECTRONICS, CORP., Япония
MED	MARCONI ELECTRONIC DEVICES, LTD, Англия
ME	MITSUBISHI ELECTRIC CORP., Япония
MEL	MICROELECTRONICS LTD., Гонконг
MIS	MISTRAL SPA, Италия
ML	MULLARD LTD., Англия
MOT	MOTOROLA SEMICONDUCTOR PRODUCTS, INC., США
MPS	MICRO POWER SYSTEMS, США
NEC	NIPPON ELECTRIC COMP., Япония
NSC	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP., США
PEC	PHILIPS ELECTRONICS COMP., Нидерланды
PHILCO	PHILCO RADIO TELEVISAO, Бразилия
PI	PIHER INTERNATIONAL CORP., Испания
PPC	PPC PRODUCTS CORP., США
PPI	PECOR PRESIDENT INTERPRISES CORP., США
PS	PLESSEY SEMICONDUCTORS, Англия
PTI	POWER TECH, INC., США
RCA	RCA CORPORATION, США
RTC	RTC LARADIOTECHNIQUE COM., Франция
RFT	RFT, ФРГ
RS	RAYTHEON SEMICONDUCTOR, США
SA	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, ФРГ
SDI	SOLITRON DEVICES INC., США
SEC	SPRAQUE ELECTRIC COMP., США
SEM	SHINDENGEN ELECTRIC MFG., Япония
SGS	SGS — ATES, Италия
SI	SLICONIX, INC., США
SII	SYNTAR INDUSTRIES, INC., США
SPC	SOLID POWER CORP., США
SPE	SPACE POWER ELECTRONICS, INC., США
SSD	SOLID STATE DEVICES, INC., США
SSE	SOLID STATE ELECTRONICS COMP., США
SSI	SOLID STATE INDUSTRIES, INC., США
STC	SILICON TRANSISTOR CORP., США
STI	SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY, INC., США
SUPERTEX	SUPERTEX, INC., США
SECI	SWAMPSCOTT ELECTRONICS COMP., США
TAG	TRANSISTOR AG, Швейцария
TC	TOSHIBA CORP., Япония
TCI	TELEDYNE CRYSTALONICS, INC., США
TEL	TELEFUNKEN ELECTRONIC, ФРГ
TESLA	TESLA, Чехо-Словакия
THOM	THOMSON—CSF, Франция
TI	TEXAS INSTRUMENTS, INC., США
TRW	TRW SEMICONDUCTORS, INC., США
TS	TELEDYNE SEMICONDUCTOR, США
UA	UNITED AIRCRAFT, США
UC	UNITRODE CORP., США
UNITRA	UNITRA, Польша
V	VALVO, ФРГ
WDI	WALBERN DEVICES, INC., США
WEC	WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP., США

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Выпрямительные и импульсные диоды

Тип прибора	Рекомендуется при замене
Д2Б	Д9И
Д2В	Д9Е
Д2Г	Д9Е
Д2Д	Д9Е
Д2Е	Д9Ж
Д2Ж	Д9Ж
Д202	КД204Б
Д203	КД204Б
Д204	КД204А
Д205	КД204А
Д214	Д242
Д214А	Д242А
Д214Б	Д242Б
Д215	Д231, Д243
Д215А	Д243А
Д215Б	Д243Б, КД202Д
МД217	КД209В
МД226	Д226 Д229Б
МД226А	Д226А КД109Б
МД226Е	Д226Е Д229Е
Д7А	КД424А
Д7Б	КД424А
Д7В	КД424А
Д7Г	КД424А
Д7Д	КД424А
Д7Е	КД424А
Д7Ж	КД424А
Д9Б	КД923А, КД419(А—Г), КД424А, КД922(А—В)
Д9В	КД922(А—В), КД419(А—Г), КД923А, КД424А
Д9Г	КД923А, КД419(А—Г), КД424А, КД922(А—В)
Д9Д	КД922(А—В), КД923А, КД419(А—Г), КД424А
Д9Е	КД923А, КД419(А—Г), КД424А, КД922(А—В)
Д9Ж	КД922(А—В), КД424А, КД419(А—Г), КД923А
Д9И	КД923А, КД419(А—Г), КД424А, КД922(А—В)
Д9К	КД923А, КД419(А—Г), КД424А, КД922(А—В)
Д9Л	КД923А, КД922(А—В), КД419(А—Г), КД424Г
Д9М	КД424А, КД419(А—Г), КД923(А—В)
Д101А	КД424А
Д102	КД424А
Д102А	КД424А
Д103	КД424А
Д103А	КД424А
Д104	КД923А
Д104А	КД923А
Д105	КД923А
Д105А	КД923А
Д106	КД923А
Д106А	КД923А
Д206	КД923А
Д207	КД424А
Д208	КД424А
Д209	КД424А
Д210	КД243(Е, Ж)
Д211	КД424А
МД218	КД243(А—Ж)
Д223	КД424А
Д223А	КД424А
Д223Б	КД424А
Д229В	КД226(А—Г)
Д229Г	КД226(А—Г)
Д229Д	КД226(А—Г)
Д229Е	КД226(А—Г)
Д229Ж	КД226(А—Г)
Д229И	КД226(А—Г)
Д229К	КД226(А—Г)
Д229Л	КД226(А—Г)
Д242	КД244 (А, Б), КД206А
Д242А	КД299Б
Д242Б	КД206А
Д243	КД206А
Д243А	КД2999Б
Д243Б	КД206А
Д245	КД2999Б
Д245А	КД206А
Д245Б	КД244(А, Б)
Д246	КД206А
Д246А	КД2999Б
Д246Б	КД206А
Д247	КД2999Б
Д247Б	КД206А
Д248Б	КД244(А, Б)
Д305	КД244(А, Б)
КД102А	КД424А
КД102Б	КД424А
КД103А	КД424А
КД103Б	КД424Б
КД104А	КД424А
КД105Б	КД243 (Е—Ж), КД423 (А—Г)
КД105В	КД243(А—Г)
КД105Г	КД243(А—Г), КД243(Е—Ж)
КД106А	КД247А
КД109А	КД243(А—Ж)
КД109Б	КД243(Е, Ж)
КД109В	КД243(Е, Ж)
АД112А	КД424А
КД204А	КД226(А—Г)
КД204Б	КД226(А—Г)
КД204В	КД226(А—Г)
КД205А	КД243(А—Г), КД243(Е, Ж)
КД205Б	КД243(А—Д)
КД205В	КД243(Е, Э), КД243(А—Д)
КД205Г	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
КД205Д	КД243(Е, Ж), КД243(А—Д)
КД205Е	КД243(Е, Ж), КД243(А—Д)
КД205Ж	КД243(Е, Ж), КД243(А—Д)
КД205И	КД243(Е, Ж), КД243(А—Д)
КД205К	КД243(Е, Ж), КД243(А—Д)
КД205Л	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
КД208А	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
КД209А	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
КД209Б	КД243(Е, Ж), КД243(А—Д)
КД209В	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
КД212А	КД247(А—Г)
КД215Б	КД247(А—Г)
КД212В	КД247(А—Г)
КД212Г	КД247(А—Г)
КД213А	КД244(А, Б)
КД213Б	КД244(А, Б)
КД213В	КД244(А, Б)
КД213Г	КД244(А, Б)
КД221А	КД247А
КД221Б	КД247Б
КД221В	КД247В
КД221Г	КД247Г
КД402А	КД407А
ГД402Б	КД407А, КД409В
КД410А	КЦ114(А, Б)
КД410Б	КЦ114(А, Б)
КД417А	КД413А
КД503А	КД510А КД522Б
КД503	КД522Б, КД510А
КД504А	КД522Б, КД510А
КД509А	КД510А
КД513А	КД522Б
КД518А	КД522Б, КД510А
КД520А	КД522Б
КД521В	КД522Б
КД521Г	КД521А
КД522А	КД522Б

Варикапы

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
КВ109А	КВ122(А9—В9)	КВ121Б	КВ130А9
КВ109Б	КВ122(А9—В9)	КВ122А	КВ122(БТ9, БГ9, ВТ9, АГ9, БГ9, ВГ9, А9—В9)
КВ109В	КВ122(А9—В9)	КВ122Б	КВ122(А9—В9, БТ9, ВГ9, ВТ9, АГ9, АТ9, БГ9)
КВ109Г	КВ122(А9—В9)	КВ122В	КВ122(А9—В9), КВ122(АГ9, АТ9, БГ9, БТ9, ВГ9, ВТ9)
КВС111А	КВ132А	КВ127А	КВ142АТ, КВ142АГ, КВ142А, КВ142АР
КВС111Б	КВ132А	КВ127Б	КВ142АТ, КВ142АГ, КВ142А, КВ142АР
КВ113А	КВ114(А, Б)	КВ127В	КВ142АТ, КВ142АГ, КВ142А, КВ142АР
КВ113Б	КВ114(А, Б)	КВ127Г	КВ142АТ, КВ142АГ, КВ142А, КВ142АР
КВ116А-1	КВ140(А-1, Б-1)	КВ130А	КВ130А9
КВ117А	КВ132А	КВ134А	КВ134А9
КВ117Б	КВ132А	КВ135А	КВ139А
КВ119А	КВ142А	Д902	КВ122(А9—В9)
КВС120А	КВ142Б		
КВС120Б	КВ124Б		
КВС120А1	КВ142Б		
КВ121А	КВ130А9		

Стабилитроны и стабисторы

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
Д219С	КД510А	КС191Р	КС191 (С—Ф)
Д220С	КД510А	КС210Б	КС210Б2
Д223С	КД510А	КС210Е	КС210Ж
Д814А	Д814А1	КС211Б	КС191 (Б, В)
Д814Б	Д814Б1	КС211В	КС191 (Б, В)
Д814В	Д814В1	КС211Г	КС191 (Б, В)
Д814Г	Д814Г1	КС211Д	КС191 (Б, В)
Д814Д	Д814Д1	КС211Е	КС211Ж
КС113А	КС155А	КС212Е	КС212Ж
КС119	КС415А	КС213Б	КС213Б2
КС133Г	КС133А, КС407А	КС213Е	КС213Ж
КС139Г	КС139А, КС407Б	КС433А	КС433А1
КС147Г	КС147А, КС407В	КС439А	КС439А1
КС156Г	КС156А, КС409А	КС447А	КС447А1
КС162А	КС162А2	КС456А	КС456А1
КС168В	КС168В2	КС468А	КС468А1
КС170А	КС162А2, КС213Б2	КС510А	КС510А1
		КС520В	КС520В2
КС175А	КС175А2	КС531В	КС531В2, К1009ЕН1А
КС175Е	КС175Ж		
КС182А	КС182А2	КС533	К1009ЕИ1В
КС182Е	КС182Ж	КС547В	КС547В2
КС191А	КС191А2	КС551А	КС551А1
КС191Е	КС191Ж	КС568В	КС568В2
КС191М	КС191 (С—Ф)	КС591А	КС591А1
КС191Н	КС191 (С—Ф)	КС596В	КС596В2
КС191П	КС191 (С—Ф)	КС600А	КС600А1

Выпрямительные столбы и блоки

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
КЦ105В	КЦ118 (А, Б)	КЦ412Б	КД243 (Е, Ж)		КД704АС9,
КЦ105Г	КЦ118 (А, Б)		КД243 (А—Д)		КД805А,
КЦ106А	КЦ118 (А, Б)	КЦ412В	КД243 (А—Д),		КД629АС9
КЦ106Б	КЦ118 (А, Б)		КД243 (Е, Ж)	КД906Б	КД704АС9,
КЦ106В	КЦ118 (А, Б)	КДС111А	КД424А		КД424А,
КЦ106Г	КЦ118 (А, Б)	КДС111Б	КД424А		КД805А,
КЦ106Д	КЦ118 (А, Б)	КДС111В	КД424А		КД629АС9
КЦ109А	КЦ114 (А, Б)	КДС523А	КДС523АР	КД906В	КД424А,
КЦ201А	КЦ108 (Б, В),	КД523Б	КД523БР		КД704АС9,
	КЦ114 (А, Б)	КДС523В	КДС523ВР		КД805А,
КЦ201Б	КЦ108 (Б, В),	КДС523Г	КДС523ВР		КД629АС9
	КЦ114 (А, Б)	КДС523АМ	КДС523АР	КД906Г	КД704АС9,
КЦ201В	КЦ114 (А, Б),	КДС523БМ	КДС523ВР		КД424А,
	КЦ108 (Б, В)	КДС523ВМ	КДС523 (АР,		КД805А,
КЦ201Г	КЦ108 (Б, В),		ВР)		КД629АС9
	КЦ114 (А, Б)	КДС523ГМ	КДС523 (АР,	КД906Д	КД424А,
КЦ201Д	КЦ114 (А, Б),		ВР)		КД704АС9,
	КЦ108 (Б, В)	КДС627А	КД629АС,		КД805А,
КЦ201Е	КЦ114 (А, Б),		КДС628АМ,		КД629АС9
	КЦ108 (Б, В)		КД704АС,	КД906Е	КД805А,
КЦ407А	КД226В, КД243Г		КД917АМ,		КД629АС9,
КЦ410А	КД202 (А, В, Д)		КД908АМ		КД704АС9,
КЦ410Б	КД202 (А, В, Д)	КДС628А	КДС628АМ		КД424А
КЦ410В	КД202 (А, В, Д)	КД903А	КД908АМ	КД908А	КД908АМ
КЦ412А	КД243 (Е, Ж)	КД903Б	КД908АМ	КД917А	КД917АМ
	КД243 (А—Д)	КД906А	КД424А,	КД919А	КД908АМ

Транзисторы германиевые

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
МП20А	КТ209 (Ж—М),	МП39Б	КТ680А,	ГТ402Г	КТ681А
	КТ209 (А—Е)		КТ209 (Ж—М),	ГТ402Д	КТ681А
МП20Б	КТ209 (Ж—М),		КТ209 (А—Е)	ГТ402Е	КТ681А
	КТ209А (А—Е)	МП40	КТ680А,	ГТ402Ж	КТ681А
МП21В	КТ209 (А—Е),		КТ209 (Ж—М),	ГТ402И	КТ681А
	КТ209 (Ж—М)		КТ209 (А—Е)	П403	КТ363 (АМ, БМ),
МП21Г	КТ209 (А—Е),	МП40А	КТ209 (А—Е),		КТ3126А,
	КТ209 (Ж—М)		КТ209 (Ж—М),		КТ3107 (А—Л)
МП21Д	КТ209 (А—Е),		КТ681А	П403А	КТ3102 (ГМ, ДМ,
	КТ209 (Ж—М)	МП41	КТ681А,		ЕМ), КТ3102
МП21Е	КТ209 (А—Е),		КТ209 (Ж—М),		(БМ, ВМ)
	КТ209 (Ж—М)		КТ209 (А—Е)	ГТ403А	КТ681А
МП21	КТ680А	МП41А	КТ209 (А—Е),	ГТ403Б	КТ681А,
МП25А	КТ680А		КТ681А,		КТ837 (Е—Л),
МП25Б	КТ680А		КТ209 (Ж—М)		КТ837 (А—Д),
МП26	КТ680А	МП42	КТ209 (А—Е),		КТ837 (М—Ф)
МП26А	КТ680А		КТ681А,	ГТ403В	КТ837 (А—Г),
МП26Б	КТ680А		КТ209 (Ж—М)		КТ681А,
П27	КТ209 (А—В)	МП42А	КТ209 (Ж—М),		КТ837 (Т—Ф),
П27А	КТ209 (А—В)		КТ681А,		КТ837 (М—С),
П28	КТ209 (А—В)		КТ209(А—Е)		КТ837 (Е—Л)
П29	КТ681А	МП42Б	КТ681А,	ГТ403Г	КТ837 (А—Д),
П29А	КТ681А		КТ209 (Ж—М),		КТ837 (Е—Л),
П30	КТ681А		КТ209 (А—Е)		КТ837 (Т—Ф),
МП35	КТ680А	ГТ109А	КТ681А		КТ837 (М—С),
МП37А	КТ680А	ГТ109Б	КТ681А		КТ681А
МП37Б	КТ680А	ГТ109В	КТ681А	ГТ403Д	КТ681А,
МП38	КТ680А	ГТ109Г	КТ681А		КТ837 (А—Д),
МП38А	КТ680А	ГТ109Д	КТ681А		КТ837 (Т—Ф),
МП39	КТ681А,	ГТ109Е	КТ681А		КТ837 (Е—Л),
	КТ209 (А—Е),	ГТ109Ж	КТ681А		КТ837 (М—С)
	КТ209 (Ж—М)	ГТ402В	КТ681А	ГТ403Е	КТ837 (М—С),

Продолжение

Тип прибора	Рекомендуется при замене
	КТ837 (Е—Л), КТ837 (А—Д), КТ837 (Т—Ф), КТ681А
ГТ403Ж	КТ681А, КТ837 (М—Ф), КТ837 (Е—Л), КТ837 (А—Д)
ГТ403И	КТ681А, КТ837 (М—Ф), КТ837 (Е—Л), КТ837 (А—Д)
ГТ403Ю	КТ681А, КТ837 (М—Ф), КТ837 (Е—Л), КТ837 (А—Д)
ГТ404А	КТ680А
ГТ404Б	КТ680А
ГТ404В	КТ680А
ГТ404Г	КТ680А
ГТ404Д	КТ680А
ГТ404Е	КТ680А
ГТ404Ж	КТ680А
ГТ404И	КТ680А
ГТ406А	КТ681А
П416	КТ363 (АМ, БМ)
П416А	КТ363 (АМ, БМ)
П416Б	КТ363 (АМ, БМ)
П417	КТ363 (АМ, БМ)
П417А	КТ363 (АМ, БМ)
П417Б	КТ363 (АМ, БМ)
ГТ115А	КТ209М, КТ209 (Е—Л), КТ209 (А—Д)
ГТ115Б	КТ209М
ГТ125И	КТ209 (Е—Л), КТ209 (А—Д)
ГТ115В	КТ209М, КТ209 (А—Д), КТ209 (Е—Л)
ГТ115Г	КТ209М, КТ209 (А—Д), КТ209 (Е—Л)
ГТ122А	КТ201 (АМ, ДМ)
ГТ122Б	КТ201 (АМ, ДМ)
ГТ122В	КТ201 (АМ, ДМ)
ГТ122Г	КТ201 (АМ, ДМ)
ГТ124А	КТ681А
ГТ124Б	КТ681А
ГТ124В	КТ681А
ГТ124Г	КТ681А
ГТ125А	КТ681А
ГТ125Б	КТ681А
ГТ125В	КТ681А
ГТ125Г	КТ681А
ГТ125Д	КТ681А
ГТ125Е	КТ681А
ГТ125Ж	КТ681А
ГТ125К	КТ681А
ГТ125Л	КТ681А
П201Э	КТ816 (Б—Г), КТ818 (Б—Г)
П201АЭ	КТ818 (Б—Г), КТ816 (Б—Г)
П202Э	КТ818 (Б—Г), КТ816 (Б—Г)
П203Э	КТ818 (Б—Г), КТ816 (Б—Г)
П210Б	КТ816 (Б—Г), КТ818 (Б—Г)
П210В	КТ816 (Б—Г), КТ818 (Б—Г)
П213	КТ816 (Б—Г), КТ816 (Б—Г), КТ837 (А—Е), КТ837 (П—Ф)
П213	КТ837 (Ж—Н)
П213А	КТ837 (Ж—Н), КТ837 (А—Е), КТ837 (А—Ф), КТ816 (Б—Г), КТ818 (Б—Г)
П213Б	КТ837 (П—Ф), КТ837 (Ж—Н), КТ837 (А—Е), КТ826 (Б—Г), КТ818 (Б—Г)
П214	КТ837 (Ж—Н), КТ837 (П—Ф), КТ826 (Б—Г), КТ818 (Б—Г), КТ837 (А—Е)
П214А	КТ816 (Б—Г), КТ818 (Б—Г), КТ837 (П—Ф), КТ837 (Ж—Н), КТ837 (А—Е)
П214Б	КТ837 (А—Е), КТ837 (Ж—Н), КТ816 (Б—Г), КТ818 (Б—Г), КТ837 (П—Ф)
П214В	КТ837 (П—Ф), КТ837 (Ж—Н), КТ816 (Б—Г), КТ818 (Б—Г), КТ837 (А—Е)
П214Г	КТ837 (П—Ф), КТ837 (Ж—Н), КТ837 (А—Е), КТ818 (Б—Г), КТ816 (Б—Г)
П215	КТ816 (Б—Г), КТ818 (Б—Г), КТ837 (А—Е), КТ837 (Ж—Н), КТ837 (П—Ф)
П216	КТ837 (А—Е), КТ837 (П—Ф), КТ837 (Ж—Н), КТ816 (Б—Г), КТ818 (Б—Г)
П216А	КТ818 (Б—Г), КТ816 (Б—Г), КТ837 (А—Е), КТ837 (П—Ф), КТ837 (Ж—Н)
П216Б	КТ816 (Б—Г), КТ818 (Б—Г), КТ837 (Ж—Н), КТ837 (А—Е), КТ837 (П—Ф)
П216В	КТ818 (Б—Г), КТ816 (Б—Г), КТ837 (А—Ф)
П216Г	КТ818 (Б—Г), КТ816 (Б—Г), КТ837 (А—Ф)
П216Д	КТ818 (Б—Г), КТ816 (Б—Г), КТ837 (А—Ф)
П217	КТ837 (А—Ф), КТ816 (Б—Г), КТ818 (Б—Г)
П217А	КТ818 (Б—Г), КТ816 (Б—Г)
П217Б	КТ818 (Б—Г), КТ816 (Б—Г)
П217В	КТ818 (Б—Г), КТ816 (Б—Г)
П217Г	КТ818 (Б—Г), КТ816 (Б—Г)
ГТ305А	КТ3126 (А, Б), КТ3117А1
ГТ305Б	КТ3126 (А, Б)
ГТ305В	КТ3117А1
ГТ308А	КТ3109 (А—В), КТ3116 (А, Б), КТ310 (А—Ж)
ГТ308Б	КТ361 (А, Б), КТ310 (А—В), КТ3107 (А—Ж)
ГТ308В	КТ3107 (А—Ж), КТ363 (АМ, БМ)
ГТ309А	КТ3117А1
ГТ309Б	КТ3117А1
ГТ309В	КТ3117А1
ГТ309Г	КТ3117А1
ГТ309Д	КТ3117А1
ГТ309Е	КТ3117А1
ГТ310А	КТ3126А, КТ3127А
ГТ310Б	КТ3127А
ГТ310В	КТ3126А, КТ3127А
ГТ310Г	КТ3127А, КТ3126А
ГТ310Д	КТ3127А, КТ3126А
ГТ310Е	КТ3126А, КТ3127А
ГТ311Е	КТ316ДМ, КТ316 (АМ—ГМ)
ГТ311Ж	КТ316 (АМ—ДМ)
ГТ311И	КТ361 (ГМ, ДМ), КТ316 (АМ—ВМ)
ГТ313А	КТ363 (АМ, БМ), КТ399АМ
ГТ313Б	КТ363 (АМ, БМ), КТ399АМ
ГТ313В	КТ363 (АМ, БМ), КТ399АМ
ГТ320А	КТ363 (АМ, БМ)
ГТ320Б	КТ363 (АМ, БМ)
ГТ320В	КТ363 (АМ, БМ)
ГТ322А	КТ3117А1, КТ3126А
ГТ322Б	КТ3117А1, КТ3126А
ГТ322В	КТ3117А1, КТ3126А
ГТ328А	КТ3128А, КТ3127А

Тип прибора	Рекомендуется при замене
ГТ328Б	КТ3128А, КТ3127А
ГТ328В	КТ3127А, КТ3128А
ГТ338А	ГТ3122 (А, Б)
ГТ338Б	ГТ3122 (А, Б)
ГТ338В	ГТ3122 (А, Б)
ГТ341А	КТ3132 (А-2, Б-2), КТ3132 (В-2, Г-2)
ГТ341Б	КТ3132 (А-2, Б-2), КТ3132 (В-2, Г-2)
ГТ341В	КТ3132 (А-2, Б-2), КТ3132 (В-2, Г-2)
ГТ346А	КТ3109А, КТ3128А
ГТ346Б	КТ3128А, КТ3109А
ГТ346В	КТ3109А, КТ3128А
ГТ362А	КТ399АМ
ГТ362Б	КТ399АМ
П401	КТ3107 (А-1), КТ3126А
П402	КТ3126А, КТ3107 (А—Л)
ГТ402А	КТ680А
ГТ402Б	КТ680А
П422	КТ312А, КТ363 (АМ, БМ)
П423	КТ363 (АМ, БМ), КТ3126А
П605	КТ639 (А—Д)
П605А	КТ639 (А—Д)
П606	КТ639 (А—Д)
П606А	КТ639 (Б—Д), КТ639А
П607	КТ644 (А—Г)
П607А	КТ644 (А—Г)
П608	КТ644 (А—Г)
П608А	КТ644 (А—Г)
П609	КТ644 (А—Г)
П609А	КТ644 (А—Г)
ГТ701А	КТ818 (Б—Г)
ГТ703Б	КТ816 (Б—Г)
ГТ703Б	КТ816 (Б—Г)
ГТ703В	КТ816 (Б—Г)
ГТ703Г	КТ816 (Б—Г)
ГТ705А	КТ817 (Б—Г)
ГТ705Б	КТ817 (Б—Г)
ГТ705В	КТ817 (Б—Г)
ГТ705Г	КТ817 (Б—Г)
ГТ705Д	КТ817 (Б—Г)
ГТ806А	КТ805 (АМ, БМ), КТ840 (А, Б)
ГТ806Б	КТ840 (А, Б), КТ805 (АМ, БМ)
ГТ806В	КТ840 (А, Б)
ГТ806Г	КТ840 (А, Б), КТ805 (АМ, БМ)
ГТ806Д	КТ840 (А, Б)
ГТ810А	КТ945Б, КТ840 (А, Б)
ГТ905А	КТ816 (Б—Г)
ГТ906А	КТ816 (Б—Г)
ГТ906АМ	КТ818 (Б—Г)

Транзисторы кремниевые

Тип прибора	Рекомендуется при замене
КТ104А	КТ681А
КТ104Б	КТ681А
КТ104В	КТ681А
КТ104Г	КТ681А
КТ117А	КТ117 (АМ—ГМ)
КТ117Б	КТ117 (АМ—ГМ)
КТ117В	КТ117 (АМ—ГМ)
КТ117Г	КТ117 (АМ—ГМ)
КТ119А	КТ117 (АМ—ГМ)
КТ119Б	КТ117 (АМ—ГМ)
КТ120А-1	КТ218 (Г9—Е9), КТ218 (А9—В9)
КТ120В-1	КТ120 (Г9—Е9), КТ218 (А9—В9)
КТ201А	КТ202АМ
КТ201Б	КТ201БМ
КТ201В	КТ201ВМ
КТ201Г	КТ201ГМ
КТ201Д	КТ201ДМ
КТ202А-1	КТ218 (А9—В9), КТ218 (Г9—Е9)
КТ202Б-1	КТ218 (Г9—Е9), КТ218 (А9—В9)
КТ202В-1	КТ218 (Г9—Е9), КТ218 (А9—В9)
КТ202Г-1	КТ218 (Г9—Е9), КТ218 (А—В9)
КТ202Д-1	КТ218 (А9—В9), КТ218 (Г9—Е9)
КТ203А	КТ681А
КТ203Б	КТ681А
КТ203В	КТ681А
КТ203АМ	КТ681А
КТ203БМ	КТ681А
КТ203ВМ	КТ681А
КТ206А	КТ3130 (А9—Е9), КТ3151 (А9—Е9)
КТ206Б	КТ313А (А9—Е9), КТ3151 (А9—Е9)
КТ208А	КТ681А
КТ208Б	КТ681А
КТ208В	КТ681А
КТ208Г	КТ681А
КТ208Д	КТ681А
КТ208Е	КТ681А
КТ208Ж	КТ681А
КТ208И	КТ681А
КТ208К	КТ681А
КТ208Л	КТ681А
КТ208М	КТ681А
КТ214А-1	КТ218 (А9—В9), КТ218 (Г9—Е9)
КТ214Б-1	КТ218 (А9—В9), КТ218 (Г9—Е9)
КТ214В-1	КТ218 (Г9—Е9), КТ218 (А9—В9)
КТ214Г-1	КТ218 (Г9—Е9), КТ218 (А9—В9)
КТ214Д-1	КТ218 (А9—Е9)
КТ214Е-1	КТ218 (А9—Е9)
КТ215А-1	КТ3151 (А9—Е9)
КТ215Б-1	КТ3151 (Г9—Е9), КТ3151 (А9—В9)
КТ215В-1	КТ3151 (А9—В9), КТ3151 (Г9—Е9)
КТ215Г-1	КТ3151 (Г9—Е9), КТ3151 (А9—В9)
КТ215Д-1	КТ3151 (А9—В9), КТ3151 (Г9—Е9)
КТ215Е-1	КТ3151 (Г9—Е9), КТ3151 (А9—Б9, Е9)
КТ216А	КТ3129 (Г9, Д9), КТ3129 (А9—В9)
КТ216Б	КТ3129 (Г9, Д9), КТ3129 (А9—В9)
КТ216В	КТ3129 (А9—В9), КТ3129 (Г9, Д9)
КТ301Г	КТ3102 (ГМ—ЕМ), КТ3102 (АМ—ВМ)
КТ301Д	КТ3102 (ГМ—ЕМ), КТ3102 (АМ—ВМ)
КТ301	КТ3102 (ГМ—ЕМ), КТ3102 (АМ—ВМ)
КТ301Ж	КТ3102 (ГМ—ЕМ), КТ3102 (АМ—ВМ)
КТ302А	КТ3102 (АМ—ЕМ), КТ315 (А—Е), КТ315 (Ж, И, Р)
КТ302Б	КТ315 (Ж, И, Р), КТ315 (А—Е), КТ3102 (АМ—ЕМ)
КТ302В	КТ3102 (АМ—ЕМ), КТ315 (А—Е), КТ315 (Ж, И, Р)

Тип прибора	Рекомендуется при замене
КТ302Г	КТ3102 (АМ—ЕМ), КТ315 (А—Е), КТ315 (Ж, И, Р)
КТ306А	КТ368 (АМ, БМ)
КТ306Б	КТ368 (АМ, БМ)
КТ306В	КТ368 (АМ, БМ)
КТ306Г	КТ368 (АМ, БМ)
КТ306Д	КТ368 (АМ, БМ)
П307	КТ683 (А—Г)
П307А	КТ683 (А—Г)
П307В	КТ683 (А—Г)
КТ307А-1	КТ318 (А-1, Г-1)
КТ307Б-1	КТ318 (А-1—В-1), КТ318Г-1
КТ307В-1	КТ318Г-1, КТ318 (А-1—В-1)
КТ307Г-1	КТ318 (А-1—В-1), КТ318Г-1
П308	КТ683 (А—Г)
П309	КТ680А, КТ683 (А—Г)
КТ3101А-2	КТ3121А-6
КТ3102А	КТ3102 (ГМ—ЕМ), КТ3102АМ
КТ3102Б	КТ3102БМ
КТ3102В	КТ3102ВМ
КТ3102Г	КТ3102ГМ
КТ3102Д	КТ3102ДМ
КТ3102Е	КТ3102ЕМ
КТ3114Б-6	КТ3121А-6
КТ3114В-6	КТ3121А-6
КТ3115А-2	КТ3132Э (А-2, Б-2), КТ3132 (В-2, Г-2)
КТ3115В-2	КТ3132 (В-2, Г-2), КТ3132 (А-2, Б-2)
КТ3115Г-2	КТ3132 (А-2, Б-2), КТ3132 (В-2, Г-2)
КТ3117А	КТ3117А1
КТ312А	КТ342 (АМ—ВМ)
КТ312Б	КТ342 (АМ—ВМ)
КТ312В	КТ342 (АМ—ВМ)
КТ3120А	КТ399М
КТ3132А-2	КТ3123 (АМ—ВМ)
КТ3123Б-2	КТ3123 (АМ—ВМ)
КТ3123В-2	КТ3123 (АМ—ВМ)
КТ3139А	КТ3130А9
КТ3139Б	КТ3130Б9
КТ3139В	КТ3130В9
КТ3139Г	КТ3130Г9
КТ3140А	КТ3129 (А9—В9), КТ3129 (Г9—Е9)
КТ3140Б	КТ3129 (А9—В9), КТ3129 (Г9—Е9)
КТ3140В	КТ3129 (А9—В9), КТ3129 (Г9—Е9)
КТ3140Г	КТ3129 (А9—В9), КТ3129 (Г9—Е9)
КТ3145А-9	КТ3151 (А9—Е9), КТ3130 (А9—Ж9)
КТ3145Б-9	КТ3151 (А9—Е9), КТ3130 (А9—Ж9)
КТ3145В-9	КТ3151 (А9—Е9), КТ3130 (А9—Ж9)
КТ3145Г-9	КТ3151 (А9—Е9), КТ3130 (А9—Ж9)
КТ3145Д-9	КТ3151 (А9—Е9) КТ3130 (А9—Ж9)
КТ3146А-9	КТ3129 (А9—Е9)
КТ3146Б-9	КТ3129 (А9—Е9)
КТ3146В-9	КТ3129 (А9—Е9)
КТ3146Г-9	КТ3129 (А9—Е9)
КТ3146Д-9	КТ3129 (А9—Е9)
КТ316А	КТ316АМ
КТ316Б	КТ316БМ
КТ316В	КТ316ВМ
КТ316Г	КТ316ГМ
КТ316Д	КТ316ДМ
КТ317-1	КТ318 (А-1—В-1) КТ318 (Г-1—Е-1)
КТ317А-1	КТ318 (А-1—В-1) КТ318 (Г-1—Е-1)
КТ317Б-1	КТ318 (А-1—В-1) КТ318 (Г-1—Е-1)
КТ317В-1	КТ318 (А-1—В-1) КТ318 (Г-1—Е-1)
КТ324Е-1	КТ324Е-5
КТ325А	КТ325АМ
КТ325Б	КТ325БМ
КТ325В	КТ325ВМ
КТ326А	КТ363 (АМ, БМ)
КТ326Б	КТ363 (АМ, БМ)
КТ326БМ	КТ363 (АМ, БМ)
КТ331А-1	КТ3121А-6
КТ331Б-1	КТ3121А-6
КТ331В-1	КТ3121А-6
КТ331Г-1	КТ3121А-6
КТ332А-1	КТ3121А-6
КТ332Б-1	КТ3121А-6
КТ332В-1	КТ3121А-6
КТ332Г-1	КТ3121А-6
КТ332Д-1	КТ3121А-6
КТ337А	КТ363 (АМ, БМ)
КТ337Б	КТ363 (АМ, БМ)
КТ337В	КТ363 (АМ, БМ)
КТ339А	КТ339АМ
КТ340А	КТ396А-2
КТ340Б	КТ396А-2
КТ340В	КТ396А-2
КТ340Г	КТ396А-2
КТ340Д	КТ396А-2
КТ342А	КТ342АМ
КТ342Б	КТ342БМ
КТ342В	КТ342ВМ
КТ342Г	КТ342ГМ
КТ343А	КТ363 (АМ, БМ)
КТ343Б	КТ363 (АМ, БМ)
КТ3454	КТ685Д КТ644 (А—Г)
КТ345Б	КТ644 (А—Г) КТ685А
КТ345В	КТ644 (А—Г) КТ685А
КТ347А	КТ363 (АМ, БМ)
КТ347Б	КТ363 (АМ, БМ)
КТ347В	КТ363 (АМ, БМ)
КТ349А	КТ3107 (А—Л) КТ363 (АМ, БМ)
КТ349Б	КТ363 (АМ, БМ) КТ3107 (А—Л)
КТ349В	КТ363 (АМ, БМ) КТ3107 (А—Л)
КТ350А	КТ686 (А—Е)
КТ351А	КТ685Е
КТ351Б	КТ685Е
КТ352А	КТ685Ж
КТ352Б	КТ685Ж
КТ355А	КТ368 (АМ, БМ)
КТ357А	КТ368 (АМ, БМ)
КТ357Б	КТ368 (АМ, БМ)
КТ357В	КТ368 (АМ, БМ)
КТ357Г	КТ368 (АМ, БМ)
КТ358А	КТ315 (А—В)
КТ358Б	КТ315 (А—В)
КТ358В	КТ315 (А—В)
КТ360А-1	КТ370 (А9, Б9)
КТ360Б-1	КТ370 (А9, Б9)
КТ360В-1	КТ370 (А9, Б9)
КТ363А	КТ363АМ
КТ363Б	КТ363БМ
КТ368А	КТ368АМ
КТ368Б	КТ368БМ
КТ370А-1	КТ370 (А9, Б9)

Тип прибора	Рекомендуется при замене
КТ370Б-1	КТ370 (А9, Б9)
КТ371А	КТ399АМ
КТ372А	КТ3132 (В-2, Г-2), КТ3132 (А-2, Б-2)
КТ372Б	КТ3132 (В-2, Г-2), КТ3132 (А-2, Б-2)
КТ372В	КТ3132 (В-2, Г-2), КТ3132 (А-2, Б-2)
КТ373А	КТ342 (АМ—ВМ)
КТ373Б	КТ342 (АМ—ВМ)
КТ373В	КТ342 (АМ—ВМ)
КТ373Г	КТ342 (АМ—ВМ)
КТ375А	КТ3102 (АМ—ВМ), КТ3102 (ГМ—ЕМ)
КТ375Б	КТ3102 (АМ—ВМ), КТ3102 (ГМ—ЕМ)
КТ382А	КТ399АМ
КТ382Б	КТ399АМ
КТ388Б-2	КТ3151 (А9—В9) КТ3151 (Г9—Е9)
КТ389Б-2	КТ3151 (А9—В9) КТ3151 (Г9—Е9)
КТ391А-2	КТ3132 (А-2, Б-2), КТ3132 (В-2, Г-2)
КТ391Б-2	КТ3132 (А-2, Б-2), КТ3132 (В-2, Г-2)
КТ391В-2	КТ3132 (А-2, Б-2)
КТ392А-2	КТ3126А9
КТ396А-2	КТ396А-5
КТ399А	КТ399АМ
КТ501А	КТ209 (А-Е), КТ209 (Ж—М)
КТ501Б	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)
КТ501В	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)
КТ501Г	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)
КТ501Д	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)
КТ501Е	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)
КТ501Ж	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)
КТ501И	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)
КТ501К	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)
КТ501Л	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)
КТ501М	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)
КТ502А	КТ681А
КТ502Б	КТ681А
КТ502В	КТ681А
КТ502Г	КТ681А
КТ502Д	КТ681А
КТ502Е	КТ681А
КТ503А	КТ680А
КТ503Б	КТ680А
КТ503В	КТ680А
КТ503Г	КТ680А
КТ503Д	КТ680А
КТ503Е	КТ680А
КТ504А	КТ850 (А—В)
КТ504Б	КТ850 (А—В)
КТ504В	КТ850 (А—В)
КТ505А	КТ851 (А—В)
КТ505Б	КТ851 (А—В)
КТ601А	КТ601АМ
КТ602А	КТ602АМ
КТ602Б	КТ602БМ
КТ602В	КТ602 (АМ, БМ)
КТ602Г	КТ602 (АМ, БМ)
КТ603А	КТ645А
КТ603Б	КТ646А
КТ603В	КТ645А
КТ603Г	КТ645А
КТ603Д	КТ646А
КТ603Е	КТ645А
КТ603И	КТ646А, КТ645А
КТ604А	КТ604АМ
КТ604Б	КТ604БМ
КТ605А	КТ605АМ
КТ605Б	КТ605БМ
КТ607А-4	КТ983Б
КТ607Б-4	КТ983Б
КТ608А	КТ646 (А, Б)
КТ608Б	КТ646 (А, Б)
КТ610А	КТ983А
КТ610Б	КТ934 (А—Д), КТ983Б
КТ611А	КТ611АМ
КТ611Б	КТ611БМ
КТ616А	КТ681А
КТ616Б	КТ681А
КТ617А	КТ644 (А—Г)
КТ618А	КТ644 (А—Г)
КТ620А	КТ644 (А—В), КТ639 (А—И)
КТ620Б	КТ644 (А—В), КТ639 (А—И)
КТ624А-2	КТ3130 (А9—Е9), КТ3153А9
КТ624АМ-2	КТ3130 (А9—Е9), КТ3153А9
КТ625АМ-2	КТ3130 (А9—Е9), КТ3153А9
КТ629АМ-2	КТ3151 (А9—Е9)
КТ630А	КТ683 (А—Г)
КТ630В	КТ683 (А—Г)
КТ630Г	КТ683 (А—Г)
КТ630Д	КТ683 (А—Г)
КТ630Е	КТ683 (А—Г)
КТ633Б	КТ645А
КТ634Б-2	КТ948Б
КТ635Б	КТ646А
КТ637А-2	КТ948Б
КТ637Б-2	КТ948Б
КТ640А-2	КТ948Б
КТ640Б-2	КТ948Б
КТ640В-2	КТ948Б
П701	КТ961В КТ863Д
П701А	КТ961В КТ863Д
П701Б	КТ961В КТ863Д
П702	КТ945Б
П702А	КТ945Б
КТ704А	КТ859А КТ838А
КТ704Б	КТ859А КТ838А
КТ704В	КТ859А КТ838А
КТ801А	КТ817 (Б—Г)
КТ801Б	КТ817 (В—Г)
КТ802А	КТ945Б
КТ804А	КТ819 (В, Г)
КТ805А	КТ805 (БМ, ВМ)
КТ805АМ	КТ805 (БМ, ВМ)
КТ805Б	КТ805БМ
КТ807А	КТ961 (А—В)
КТ807АМ	КТ961 (А—В)
КТ807Б	КТ961 (А—В)
КТ807БМ	КТ961 (А—В)
КТ808А	КТ854Б
КТ809А	КТ838А, КТ858А, КТ859А
КТ812А	КТ854 (А, Б)
КТ812Б	КТ854 (А, Б)
КТ812В	КТ854 (А, Б)
КТ814А	КТ816 (Б—Г)
КТ814Б	КТ816 (Б—Г)
КТ814В	КТ816 (Б—Г)
КТ814Г	КТ816 (Б—Г)
КТ815А	КТ817 (Б—Г)
КТ815Б	КТ817 (Б—Г)
КТ815В	КТ817 (Б—Г)
КТ815Г	КТ817 (Б—Г)
КТ816А	КТ816 (Б—Г)

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
КТ817А	КТ817 (Б—Г)	КТ911Б	КТ983А, КТ919 (А—В)
КТ818А	КТ818 (Б—Г)	КТ911В	КТ983А, КТ919 (А—В)
КТ819А	КТ819 (Б—Г)	КТ911Г	КТ983А, КТ919 (А—В)
КТ820А-1	КТ822 (А-1—В-1)	КТ912А	КТ956А
КТ820Б-1	КТ822 (А-1—В-1)	КТ912Б	КТ956А
КТ820В-1	КТ822 (А-1—В-1)	КТ913А	КТ983А
КТ821А-1	КТ823 (А-1—В-1)	КТ913Б	КТ983А
КТ821Б-1	КТ823 (А-1—В-1)	КТ913В	КТ983Б
КТ821В-1	КТ823 (А-1—В-1)	КТ919Г	КТ919 (А—В)
КТ826А	КТ872 (А, Б), КТ945Б	КТ926А	КТ945Б
КТ826Б	КТ872 (А, Б), КТ945Б	КТ926Б	КТ945Б
КТ826В	КТ872 (А, Б), КТ945Б	КТ927А	КТ945Б, КТ956А
КТ827А	КТ838А, КТ872 (А, Б)	КТ927Б	КТ945Б, КТ956А
КТ828Б	КТ838А, КТ872 (А, Б)	КТ927В	КТ945Б, КТ956А
КТ839А	КТ945Б, КТ838А, КТ872 (А, Б)	КТ928А	КТ645А
КТ841А	КТ854 (А, Б)	КТ928Б	КТ645А, КТ646 (А, Б)
КТ841В	КТ854 (А, Б)	КТ935А	КТ945Б
КТ842Б	КТ855 (А, Б)	КТ938Б-2	КТ948Б
КТ844А	КТ854 (А—В), КТ848А	КТ939А	КТ948Б
КТ845А	КТ858А, КТ859А	КТ939Б	КТ948Б
КТ902А	КТ945Б	КТ942В	КТ948 (А, Б)
КТ902АМ	КТ945Б	КТ943А	КТ817 (В—Г)
КТ903А	КТ934 (А—Д)	КТ943Б	КТ817 (Б—Г)
КТ903Б	КТ934 (А—Д)	КТ943В	КТ817 (Б—Г)
КТ904А	КТ934 (А, Б)	КТ943Г	КТ817 (Б—Г)
КТ904Б	КТ934 (А, Б)	КТ943Д	КТ817 (Б—Г)
КТ907А	КТ934 (А—В)	КТС394А-2	КТ3151 (А9—Е9), КТ3129 (А9—Е9)
КТ907Б	КТ934 (А—В)	КТС394Б-2	КТ3151 (А9—Е9), КТ3129 (А9—Е9)
КТ908А	КТ945Б	КТС395А-1	КТ3130 (А9—Ж9)
КТ908Б	КТ945Б	КТС395А-2	КТ3130 (А9—Ж9)
КТ909А	КТ934 (А—В)	КТС395Б-2	КТ3130 (А9—Ж9)
КТ909Б	КТ934 (А—В)	КТС395В-2	КТ3130 (А9—Ж9)
КТ909В	КТ934 (А—В)	КТС398А-1	КТС398А-5
КТ909Г	КТ934 (А—В)	КТС398Б-1	КТС398Б-5
КТ911А	КТ983А, КТ919 (А—В)	КТС3130А	КТС3103А1

АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРИБОРОВ, ВОШЕДШИХ В СПРАВОЧНИК

Выпрямительные и импульсные диоды

Варикапы

Стабилитроны и стабисторы

Выпрямительные столбы и блоки

Транзисторы германиевые

Транзисторы кремниевые

Продолжение

Продолжение

Продолжение

Транзисторы полевые

ПРЕДЛАГАЕМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРЕДПРИЯТИЯМ, КООПЕРАТИВАМ И СОВМЕСТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ!

Публиковать текстовую рекламную информацию о разработках Вашей отрасли, изделиях Ваших предприятий в книгах нашего издательства.

Текст для публикации должен быть отпечатан в двух экземплярах. Желательно, чтобы объем материала не превышал одной машинописной страницы.

Срок публикования до трех месяцев.

В сопроводительном письме надо указать: гарантии оплаты за публикацию, номер Вашего расчетного счета и отделение Госбанка.

Наш адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 40,

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАДИО И СВЯЗЬ»

ТЕЛЕФОН 923-05-03
923-49-04

Справочное издание

Массовая радиобиблиотека. Вып. 1190

АКСЕНОВ Алексей Иванович, НЕФЕДОВ Анатолий Владимирович, ЮШИН Анатолий Михайлович

ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМ БЫТОВОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ

ДИОДЫ. ТРАНЗИСТОРЫ

Справочник

Заведующий редакцией Ю. Н. Рысев
Редактор Г. Н. Астафуров
Переплет художника Ю. А. Давыдова
Художественный редактор Н. С. Шеин
Технический редактор А. Н. Золотарева
Корректор Н. Л. Жукова

ИБ № 2454

Т –

Сдано в набор 19.02.92. Подписано в печать 30.06.92. Формат 84×108[1]/16. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 23,94. Уч. изд. л. 24,10. Доп. тираж 50 000 экз. Изд. № 23406. Заказ № 59. С-017.

Издательство «Радио и связь», 101000 Москва, Почтамт, а/я 693
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Министерства печати и информации Российской Федерации
142300, г. Чехов Московской области

ПОДПИСКА

на журнал

"РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СХЕМОТЕХНИКА"

№ 2, 1992 г.

Подписку принимают в отделениях связи "Роспечать" на № 2 за 1992 г. (ф. 145 × 200 мм, 32 стр.). Цена подписки 15 руб., индекс 73323.

♦

Номер посвящен основам схемотехники транзисторных усилителей, применению малошумящих и высоковольтных операционных усилителей на дискретных компонентах в усилителях звуковой частоты, новинкам зарубежной звукотехники.

♦

Издатель журнала — Орлов В. В., известный читателям по брошюрам "Применение операционных усилителей в радиолюбительских конструкциях" и "Применение полевых транзисторов в усилителях звуковой частоты", выпущенных издательством "Радио и связь" (см. "Радио", 6/89, с. 78).

♦

Подписка принимается до 1 декабря 1992 г. Доставка журнала подписчикам в январе—феврале 1993 г.